

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.102/18/2010
501104612

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Siemens Aktiengesellschaft	03/31/1998
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	Infineon Technologies AG
Street Address:	Str. - Martin- Str. 53
City:	Munich
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	81541
PROPERTY NUMBERS Total: 161	
Property Type	Number
Patent Number:	6001684
Patent Number:	6103592
Patent Number:	6100131
Patent Number:	5867420
Patent Number:	6399977
Patent Number:	5831916
Patent Number:	6063530
Patent Number:	6074935
Patent Number:	5899701
Patent Number:	5783476
Patent Number:	5885137
Patent Number:	5881013
Patent Number:	5995436
Patent Number:	5899706
Patent Number:	6051497

CH \$6440.00 6001684

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE

4/235

Fax Server

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Patent Number:	6033977
Patent Number:	6300235
Patent Number:	5937288
Patent Number:	5889420
Patent Number:	5875138
Patent Number:	5821592
Patent Number:	5831917
Patent Number:	5804490
Patent Number:	5962069
Patent Number:	5986624
Patent Number:	6150072
Patent Number:	5835425
Patent Number:	5978931
Patent Number:	5937541
Patent Number:	5992046
Patent Number:	6034913
Patent Number:	6537418
Patent Number:	5899738
Patent Number:	5956142
Patent Number:	5959471
Patent Number:	5891807
Patent Number:	5848008
Patent Number:	6136877
Patent Number:	6078534
Patent Number:	5831912
Patent Number:	6048503
Patent Number:	6013937
Patent Number:	5877994
Patent Number:	6232233
Patent Number:	5939937
Patent Number:	5923805
Patent Number:	5955380
Patent Number:	5977635
Patent Number:	5998253
Patent Number:	5864496

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Patent Number:	5807439
Patent Number:	5034209
Patent Number:	5935873
Patent Number:	5981332
Patent Number:	6163045
Patent Number:	6174756
Patent Number:	6020091
Patent Number:	6071820
Patent Number:	5942925
Patent Number:	6376348
Patent Number:	5866315
Patent Number:	5880007
Patent Number:	6001740
Patent Number:	6066589
Patent Number:	6127721
Patent Number:	5907771
Patent Number:	6090671
Patent Number:	5982673
Patent Number:	6096654
Patent Number:	6048475
Patent Number:	5866485
Patent Number:	5847988
Patent Number:	6016281
Patent Number:	5917744
Patent Number:	6069815
Patent Number:	5903343
Patent Number:	6033984
Patent Number:	5872694
Patent Number:	5970009
Patent Number:	6033997
Patent Number:	5865901
Patent Number:	6124208
Patent Number:	5940717
Patent Number:	6960816
Patent Number:	6830074

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE

6/235

Fax Server

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Patent Number:	6162564
Patent Number:	6436281
Patent Number:	6506306
Patent Number:	6385289
Patent Number:	6147376
Patent Number:	6184045
Patent Number:	6087233
Patent Number:	5994746
Patent Number:	6277761
Patent Number:	6216248
Patent Number:	6329703
Patent Number:	6068928
Patent Number:	6359296
Patent Number:	6258658
Patent Number:	6028815
Patent Number:	6401224
Patent Number:	6097049
Patent Number:	6281079
Patent Number:	7012313
Patent Number:	6044009
Patent Number:	6352894
Patent Number:	6044006
Patent Number:	6388283
Patent Number:	6693447
Patent Number:	6125068
Patent Number:	6293291
Patent Number:	6403440
Patent Number:	6486493
Patent Number:	6117790
Patent Number:	6529028
Patent Number:	6432792
Patent Number:	6756820
Patent Number:	6204119
Patent Number:	6359457
Patent Number:	6127220

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Patent Number:	6593814
Patent Number:	6403473
Patent Number:	6144590
Patent Number:	6617096
Patent Number:	6215351
Patent Number:	6160747
Patent Number:	6509599
Patent Number:	6828191
Patent Number:	6292008
Patent Number:	6229208
Patent Number:	6294841
Patent Number:	6548848
Patent Number:	6101141
Patent Number:	6468896
Patent Number:	6175531
Patent Number:	6157589
Patent Number:	6188642
Patent Number:	6130549
Patent Number:	6258153
Patent Number:	6386110
Patent Number:	6557130
Patent Number:	6190964
Patent Number:	6278285
Patent Number:	6675322
Patent Number:	6133779
Patent Number:	6728902
Patent Number:	6262478
Patent Number:	6656376
Patent Number:	6307263
Patent Number:	6399433
Patent Number:	6302729
Patent Number:	6415406
Patent Number:	6313656
Patent Number:	6677520
Patent Number:	6081469

Patent Number:	6627496
Patent Number:	6376913
Patent Number:	6418069
Patent Number:	6188638
Patent Number:	6670668
Patent Number:	6078745

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (703)760-7777

Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.

Email: ajohnson@mfo.com

Correspondent Name: Barry E. Bretschneider

Address Line 1: c/o Morrison & Foerster LLP

Address Line 2: 1850 Tysons Boulevard, Suite 400

Address Line 4: McLean, VIRGINIA 22102

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 609612800100

NAME OF SUBMITTER: Barry E. Bretschneider

Total Attachments: 223

source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page1.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page2.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page3.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page4.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page5.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page6.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page7.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page8.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page9.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page10.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page11.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page12.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page13.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page14.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page15.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page16.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page17.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page18.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page19.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page20.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page21.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page22.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page23.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page24.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page25.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page26.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page27.tif
source=1EinbringungsvertragSAGIFXsingledualuseSchutzrechte20011220#page28.tif

REEL: 024120 FRAME: 0008

REEL: 024120 FRAME: 0009

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page8.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page9.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page10.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page11.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page12.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page13.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page14.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page15.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page16.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page17.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page18.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page19.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page20.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page21.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page22.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page23.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page24.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page25.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page26.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page27.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page28.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page29.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page30.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page31.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page32.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page33.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page34.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page35.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page36.tif
source=2SiemenslFXEinbringungsvertrag#page37.tif



TRANSPERFECT

AFFIDAVIT OF ACCURACY

I, Carrie Russ, hereby certify that the following is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate translation of the accompanying document [Siemens IFX Einbringungsvertrag] from German into English.

Carrie Russ
TransPerfect Translations, Inc.
601 Thirteenth Street, NW
Suite 370 South
Washington, DC 20005

Sworn to before me this
15th day of March 2010

Signature, Notary Public

ALLISON SNITZER
NOTARY PUBLIC
District of Columbia
My Commission Expires
January 1, 2015

Stamp, Notary Public

Washington, DC

Contribution Agreement

between

Siemens Aktiengesellschaft [Corporation],
Berlin and Munich,
- hereinafter referred to as "Siemens"-

and

Infincon Technologies AG [Corporation] i.Gr., Munich
- hereinafter referred to as "Infincon"-

Today, on the thirty-first of March
nineteen ninety-nine

- March 31, 1999-

the following parties appeared before me

Dr. Manfred Asam,

notary, located in Munich, at the office in 80333 Munich, Residenzstrasse 25-26 II:

- 1) a) Mr. Niels Hartwig,
Attorney at law in Tutzing
with business address in 80333 Munich,
Finkenstrasse 10,
- b) Mr. Michael von Eickstedt,
Attorney at law in Planegg,
with business address in 81379 Munich,
Hofmanstrasse 51,

I, the notary, have verified both of their identities,

according to their statements, they are hereby not acting on their own behalf, but on behalf of

Siemens Corporation
with offices in Berlin and Munich,

(mailing address: 80312 Munich,
Attn. Mr. Hartwig)

and namely, under a power of attorney dated December 3, 1998 and under a sub-power of attorney dated March 23, 1999, both of which were drawn up today and are enclosed with this instrument as certified copies;

I, the notary, hereby certify that, after it had been verified by the Commercial Register of the Munich District Court HRB 6684 on March 23, 1999, that Mr. Hartwig and Mr. von Eickstedt are authorized to represent the respective companies;

2) a) Dr. Ulrich Schumacher,
Graduate Engineer in Starnberg,

b) Mr. Peter Fischl,
Industrial Manager in Murnau,

both of whom have their business address in 81541 Munich,
St. Martin Strasse 53,

I, the notary, have verified their identities, according to their statements, they are hereby not acting on their own behalf, but as officers of and on behalf of

Infineon Technologies AG
located in Munich
(mailing address: 81541 Munich, St. Martin Str. 53),

which was incorporated with document no. A...../1999 of the notary Dr. Manfred Asam; the certified copies of the authorization of these gentlemen as the representative officers of the founded corporations constituent board of directors' meeting of March 30, 1999 have been enclosed with this instrument.

Upon request of the parties before me, I certify that the following statements have been made in their simultaneous presence and before me

Contribution Agreement

Recitals

With document no. A...../1999 of the notary Dr. Manfred Asam in Munich, Siemens Aktiengesellschaft (Siemens Corporation) with offices in Berlin and Munich (hereinafter referred to as "Siemens") and Siemens Nederland N.V. with offices in Den Haag (hereinafter referred to as "Siemens Nederland") incorporated Infineon Technologies AG with offices in Munich (hereinafter referred to as "Infineon") on March 30, 1999.

Thereby, Siemens, as founder, acquired 80,912,544 no par value shares of Infineon, without having incurred any obligation to make an advance payment, in exchange for the in kind capital contribution, by transferring its semiconductor business unit.

Section 1 Subject Matter of the Contribution

1. With economic effect as of 12:00 a.m. on 04/01/99 (hereinafter referred to as the "Effective Date"), by way of singular succession and by way of an in kind capital contribution, Siemens shall transfer to Infineon all of its semiconductor business unit with the capital that is derived solely from this business unit, as it shall be described in more detail in this Agreement, (hereinafter referred to as "Independent Business Division").

Section 4 Transfer of Intangible Assets

1. With economic effect as of the Effective Date, Siemens, insofar as authorized, shall transfer to Infineon the registered patents, utility patents, design patents, topography rights as well as its registered trademarks and copyrights (hereinafter referred to as "Property Rights") as they exist as of March 26, 1999 and which are set forth in Appendix D. Infineon accepts the transfer of such rights. Siemens shall submit all declarations, statements and signatures necessary for the transfer of the Property Rights to the competent authorities and courts. Insofar as the consent of third parties is required in order to effectuate a valid transfer of such rights, Siemens shall obtain such rights. If such consent is not given, Siemens shall endeavor to ensure that Infineon will be given exploitation rights in the respective Property Right, and namely, to the extent provided in paragraph 5. All other claims against Siemens are hereby excluded. If there is a modification of such Property Rights by the Effective Date, such modifications shall be set forth in a supplementary instrument as Appendix D1.
2. Insofar as authorized, Siemens shall transfer to Infineon as of the Effective Date the know-how of the transferred Independent Business Division, including all rights with respect to inventions, trade secrets, methodology, secret formulas and other intangible assets which are not subject to special protection, as well as business secrets, administrative procedures and distribution processes (hereinafter referred to as "Know-how"). Siemens hereby assigns and

transfers to Infineon all the tangible representations of such Know-how, which are located at the offices and operating sites of the Independent Business Division. Infineon accepts the transfer of such transfer.

3. Insofar as authorized, Siemens shall transfer to Infineon as of the Effective Date, all of Siemens' rights which exist as of the Effective Date in connection with the software that is exclusively belongs to the Independent Business Division, specifically, all object code and source code and all data associated with the software, in particular, the associated documentation. Insofar as authorized, Siemens shall assign and transfer the tangible representations of the object and source codes of the abovementioned software as well as all associated documentation which are in the possession of the Independent Business Division on the Effective Date. Infineon accepts this assignment and transfer.
4. All third parties shall remain unaffected by the transfer of rights effectuated pursuant to paragraphs 1 through 3.
5. In addition to the Property Rights transferred pursuant to paragraph 1 and Appendix D, Siemens shall transfer to Infineon the Property Rights, including the right to exploit either for its own use or the right to license them to third parties, including prohibitive rights, which shall be set forth in detail in a yet to be prepared Appendix D2, which shall be attached to a supplementary instrument to this Contribution Agreement.

Furthermore, a yet to be prepared Appendix D3, which shall be attached to a supplementary instrument to this Contribution Agreement, shall set forth the following terms with respect to the Property Rights transferred pursuant to paragraph 1, Appendix D:

Infineon shall be free to utilize these Property Rights within the scope of the activities performed by the transferred Independent Business Division. Inasmuch as Infineon utilizes the Property Rights set forth in Appendix D3 outside of the scope of the activities performed by the Independent Business Division or if it enforces its prohibitive rights against third parties or licenses such Property Rights to third parties and if such utilization of the aforementioned Property Rights affects the business activities of either Siemens or those of any of its domestic or international affiliates within the meaning of Sections 15 et seq. of the AktG (Aktiengesetz [*German Stock Companies Act*]), then Infineon shall be required to obtain the prior written consent of Siemens. This consent shall not be unreasonably withheld.

6. Siemens and its domestic and international affiliates within the meaning of Sections 15 et seq. of the AktG shall retain the non-exclusive, irrevocable rights to use, without restriction as to contents, time and space, the Property Rights which have been transferred pursuant to paragraph 1, Appendix D2 for its business needs.

Siemens and its domestic and international affiliates within the meaning of Sections 15 et seq. of the AktG, shall retain non-exclusive exploitation rights, without restriction as to contents, time and space, with respect to the Property Rights transferred pursuant to

paragraph 1 and Appendix D3 as well as with respect to the software transferred pursuant to Section 3, with the right to use such Property Rights at its discretion and the right to license such Property Rights to third parties and the right to enforce the prohibitive rights.

Furthermore, Siemens and its domestic and international affiliates within the meaning of Sections 15 et seq. of the AktG shall have the right to use the transferred Know-how for the purpose of meeting its potential legal obligations, which may be asserted against Siemens in connection with the transferred Independent Business Division, at its discretion.

7. Insofar as not financially obligated to any third parties, as of the Effective Date Siemens shall transfer to Infineon and its affiliates within the meaning of Sections 15 et seq. AktG, in addition to the Property Rights transferred pursuant to paragraph 1, the Know-how transferred pursuant to paragraph 2 and the software transferred pursuant to paragraph 3 by Siemens and its affiliates within the meaning of Sections 15 et seq. of the AktG, all such Property Rights, Know-how and software in object and source codes, which have been licensed to Siemens and which have been utilized by the transferred Independent Business Division prior to the Effective Date or if the necessary steps have been taken by the transferred Independent Business Division to exercise the non-exclusive, irrevocable right to use, without restriction as to contents, time and space, such Property Rights, Know-how or software, in order to carry out the business activities of the Independent Business Division.
8. The rights granted pursuant to Section 4, paragraphs 5, 6 and 7 are gratuitous. The licensing details shall be governed by a separate cross licensing agreement which shall be entered into by the Contracting Parties.

Section 9 Warranties

Siemens warrants that:

1. the items transferred to Infineon and listed in the Effective Balance Sheet on the Effective Date are correct and, with the exception of proprietary rights which is customary in the business, and are the sole and unencumbered property of Siemens;
2. all assets of the transferred Independent Business Division, including the obligations and risks as of the Effective Day, have been accounted for in the Effective Balance Sheet and have been valued in accordance with the generally accepted accounting principles. In particular, that the obligations with respect to the personnel and insofar as for example, vacation time, retirement benefits, disability benefits and other liabilities or obligations, insofar as these have been incurred prior to the Effective Date, they have been included in the liabilities.
3. All warranty claims with respect to the real properties to be transferred pursuant to Section 3 of this Agreement are exclusively governed by the provisions of Section 3.

4. All warranty claims with respect to the shares to be transferred pursuant to Section 7 of this Agreement are exclusively governed by the provisions of Section 7.
5. Any other warranties or liabilities of Siemens, unless they had been expressly undertaken in this Agreement, with respect to the items and rights transferred pursuant to this Agreement are expressly excluded, by mutual agreement of the Contracting Parties.

Section 13 Miscellaneous

1. All the appendices enclosed with this instrument constitute an integral part of this Contribution Agreement; however, Appendices A, B, C1 and C2 are yet to be executed. [illegible redacted handwritten text].

The Contracting Parties have decided not to read Appendices A and D through G, asserting that they are thoroughly familiar with the contents of these documents. These documents have been once again presented to the Contracting Parties and each page has been signed by them.

URNr.

Dr. A

Einbringungsvertrag

zwischen der

Siemens Aktiengesellschaft,
Berlin und München,
- nachstehend "Siemens" genannt -

und der

Infineon Technologies AG i.Gr., München,
- nachstehend "Infineon" genannt -

Heute, den einunddreißigsten März
neunzehnhundertneunundneunzig
- 31. März 1999 -
erschieden vor mir,

Dr. Manfred A s a m ,

Notar mit dem Amtssitz in München, an der Geschäfts-
stelle in 80333 München, Residenzstraße 25-26 II:

- 1) a) Herr Niels H a r t w i g ,
Rechtsanwalt in Tutzing
geschäftsansässig in 80333 München,
Finkenstraße 10,
- b) Herr Michael v o n E i c k s t e d t ,
Rechtsanwalt in Planegg,
geschäftsansässig in 81379 München,
Hofmannstraße 51,

- 2 -

beide mir, Notar, persönlich bekannt,

nach ihrer Erklärung hier h a n d e l n d
nicht im eigenen Namen, sondern für die

Siemens Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Berlin und München,

(Zuschriften: 80312 München,
z.Hd. Hr. Hartwig)

und zwar zugleich aufgrund Vollmacht vom 3. Dezember 1998 und Untervollmacht vom 23. März 1999, die jeweils heute in Urschrift vorgelegt wurden und dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift beigelegt sind;

hierzu Bescheinige ich, Notar, nachdem das Handelsregister des Amtsgerichts München HRB 6684 am 23. März 1999 eingesehen worden war, daß die Herren Hartwig und von Eickstedt als Prokuristen zur gemeinschaftlichen Vertretung der vorgenannten Gesellschaft berechtigt sind;

2) a) Herr Dr. Ulrich S c h u m a c h e r ,
Diplom-Ingenieur in Starnberg,

b) Herr Peter F i s c h l ,
Industriekaufmann in Murnau,

beide geschäftsansässig in 81541 München,
St.-Martin-Straße 53,
mir, Notar, persönlich bekannt,

Notar

- 3 -

nach ihrer Erklärung hier h a n d e l n d
nicht im eigenen Namen, sondern als Vorstandsmit-
glieder für die mit Urkunde Nr. A/1999 des
Notars Dr. Manfred Asam in München gegründete

Infineon Technologies AG
mit dem Sitz in München
(Zuschriften: 81541 München, St.-Martin-Str. 53);

beglaubigte Abschrift des die Bestallung dieser
Herrn zu gemeinschaftlich vertretungsberechtig-
ten Vorstandsmitgliedern der in Gründung befindli-
chen Aktiengesellschaft ausweisenden Protokolls
über die konstituierende Aufsichtsratsitzung vom
30. März 1999 ist dieser Urkunde beigelegt.

Auf Ansuchen der Erschienenen beurkunde ich ihren
bei gleichzeitiger Anwesenheit vor mir abgegebenen
Erklärungen entsprechend folgenden

E i n b r i n g u n g s v e r t r a g

Präambel

Mit Urkunde des Notars Dr. Manfred Asam in München
Nr. A/1999 haben die Siemens Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Berlin und München (nachstehend
"Siemens" genannt) und die Siemens Nederland N.V.
mit dem Sitz in Den Haag (im folgenden als "Siemens
Nederland" bezeichnet) am 30. März 1999 die Infineon
Technologies AG mit dem Sitz in München (nachstehend
als "Infineon" bezeichnet) errichtet.

- 4 -

Siemens hat dabei als Gründerin 80.912.544 nennetragslose Stückaktien an der Infineon ohne Übernahme einer Aufgeldverpflichtung gegen Sacheinlage durch Einbringung ihrer Aktivitäten im Bereich Halbleiter übernommen.

§ 1

Gegenstand der Einbringung

1. Siemens bringt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.04.1999, 00:00 Uhr, (nachstehend "Stichtag" genannt), ihre gesamten Aktivitäten im Bereich Halbleiter mit dem ausschließlich diesen Aktivitäten dienenden Vermögen, wie in diesem Vertrag näher beschrieben (nachfolgend insgesamt "Teilbetrieb" genannt), zur Leistung ihrer Sacheinlage im Wege der Einzelrechtsnachfolge in das Vermögen der Infineon ein.
2. Die Einbringung des Teilbetriebs erfolgt zu den nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelten Buchwerten nach Maßgabe der für den eingebrachten Teilbetrieb auf den Stichtag unter Beibehaltung der bisherigen und bei der Erstellung der nach genannten vorläufigen Einbringungsbilanz angewendeten Bilanzierungsgrundsätze aufzustellenden und von einem Wirtschaftsprüfer zu bestätigenden endgültigen Einbringungsbilanz (nachfolgend "Stichtagsbilanz"). Da diese Bilanz derzeit noch nicht vorliegt, erfolgt die Einbringung zunächst auf Grundlage einer auf den 28.02.1999 aufgestellten vorläufigen Einbringungsbilanz, die dieser

- 18 -

auf der Basis der derzeitigen Nutzungskonditionen abzuschließen.

§ 4

Einbringung immaterieller Wirtschaftsgüter

1. Soweit hierzu berechtigt, überträgt Siemens die in der beigelegten Anlage D aufgeführten, am 26. März 1999 bestehenden bzw. angemeldeten Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographieschutzrechte, die in der beigelegten Anlage E aufgeführten, am 26. März 1999 bestehenden bzw. angemeldeten Marken sowie ihre Copyrights (nachfolgend insgesamt "Schutzrechte" genannt) mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag auf die Infineon. Die Infineon nimmt die Übertragung an. Siemens wird die für die Übertragung der Schutzrechte erforderlichen Erklärungen, Erläuterungen und Unterschriften gegenüber den zuständigen Behörden und Gerichten abgeben. Sofern für die Übertragung der Schutzrechte die Zustimmung Dritter erforderlich ist, wird Siemens diese Zustimmung einholen. Wenn diese Zustimmung nicht erteilt wird, wird Siemens sich darum bemühen, daß die Infineon an dem betreffenden Schutzrecht ein Verwertungsrecht erhält, und zwar in dem Umfang, wie er sich aus Abs. 5 ergibt. Andere oder weitergehende Ansprüche gegen Siemens sind hiermit ausgeschlossen. Veränderungen hinsichtlich dieser Schutzrechte bis zum Stichtag werden in einer noch zu erstellenden und der Nachtragsurkunde zu diesem Einbringungsvertrag als Anlage D 1 beizufügenden Veränderungsliste aufgeführt.

PATENT
FOERSTER

- 19 -

2. Soweit hierzu berechtigt, überträgt Siemens der Infineon mit Wirkung zum Stichtag das in dem eingebrachten Teilbetrieb vorhandene Know-how einschließlich aller Rechte an Erfindungen, Betriebsgeheimnissen, Verfahren, Formeln und anderen immateriellen Gegenständen, die keinem Sonderrechtsschutz für geistiges Eigentum unterliegen, sowie Geschäftsgeheimnisse, Verwaltungs- und Vertriebsverfahren (nachstehend "Know-how" genannt). Hierzu übergibt und übereignet Siemens der Infineon sämtliche in den Geschäftsräumen und in den Betriebsstätten des Teilbetriebs vorhandenen Verkörperungen dieses Know-how. Die Infineon nimmt diese Übertragung und Übereignung an.
3. Soweit hierzu berechtigt, überträgt Siemens der Infineon mit Wirkung zum Stichtag alle Siemens zum Stichtag zustehenden Rechte an der dem eingebrachten Teilbetrieb ausschließlich zuzuordnenden Software in Objektcode und in Quellcode sowie an allen zur übertragenen Software gehörigen Unterlagen, insbesondere an der dazugehörigen Dokumentation. Dazu übergibt und übereignet Siemens - soweit hierzu berechtigt - die sachlichen Verkörperungen des Objekt- und Quellcodes der oben genannten Software sowie sämtliche zu dieser Software gehörenden Unterlagen, insbesondere die dazugehörige Dokumentation, die sich zum Stichtag im Besitz des Teilbetriebs befinden. Die Infineon nimmt diese Übertragung und Übereignung an.

- 20 -

4. Alle Dritten vor den Übertragungen gemäß Abs. 1 bis 3 eingeräumten Rechte bleiben von der jeweiligen Übertragung unberührt.

5. Von den gemäß Abs. 1 übertragenen Schutzrechten laut Anlage D werden diejenigen Schutzrechte zusätzlich in einer noch zu erstellenden und der Nachtragsurkunde zu diesem Einbringungsvertrag beizufügenden Anlage D 2 aufgeführt, bei deren Verwertung, einschließlich eigener Benutzung, Lizenzerteilung an Dritte und Durchsetzung von Verbotungsrechten, Infineon frei ist.

Weiterhin werden in einer ebenfalls noch zu erstellenden und der Nachtragsurkunde zu diesem Einbringungsvertrag beizufügenden Anlage D 3 diejenigen gemäß Abs. 1 übertragenen Schutzrechte der Anlage D aufgeführt, für welche folgendes gilt:

Infineon ist in der Benutzung dieser Schutzrechte auf dem vom übertragenen Teilbetrieb ausgeübten Tätigkeitsgebiet frei. Soweit Infineon die Schutzrechte der Anlage D 3 außerhalb des vom übertragenen Teilbetrieb ausgeübten Tätigkeitsgebiet benutzen oder gegenüber Dritten als Verbotungsrecht einsetzen oder lizensieren will, bedarf sie hierzu, soweit dadurch Tätigkeitsgebiete von Siemens oder von in- und ausländischen, mit Siemens verbundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 ff. AktG mit berührt werden, der vorherigen Zustimmung von Siemens. Diese Zustimmung darf jedoch nicht unbillig verweigert werden.

- 21 -

6. Siemens und ihre in- und ausländischen verbundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 ff. AktG behalten an den gemäß Abs. 1 Übertragenen Schutzrechten der Anlage D 2 jeweils unwiderrufliche, nicht ausschließliche, inhaltlich, zeitlich und örtlich unbegrenzte Benutzungsrechte für die Erfordernisse ihres Geschäftes.

An den gemäß Abs. 1 Übertragenen Schutzrechten der Anlage D 3 und der gemäß Abs. 3 Übertragenen Software behalten Siemens und ihre in- und ausländischen verbundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 ff. AktG jeweils unwiderrufliche, nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Verwertungsrechte mit dem Recht zur eigenen beliebigen Benutzung, der Lizenzerteilung an Dritte und der Durchsetzung von Verbotungsrechten.

Siemens und ihre in- und ausländischen verbundenen Gesellschaften sind im Sinne der §§ 15 ff. AktG weiterhin berechtigt, das Übertragene Know-how zur Erfüllung eventueller rechtlicher Verpflichtungen, die noch im Zusammenhang mit dem Übertragenen Teilbetrieb gegenüber Siemens geltend gemacht werden, beliebig zu nutzen.

7. Soweit ohne Zahlung an Dritte berechtigt, gewährt Siemens der Infineon und ihren verbundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 ff AktG an zum Stichtag neben den gemäß Abs. 1 Übertragenen Schutzrechten, dem gemäß Abs. 2 Übertragenen Know-how und der gemäß Abs. 3 Übertragenen Software bei Siemens und ihren verbundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 ff AktG ebenfalls bestehenden und an Siemens lizenzierten Schutzrechten, Know-how

- 22 -

und Software in Objekt- und in Quellcode, die vom Übertragenen Teilbetrieb vor dem Stichtag benutzt wurden, oder für deren Benutzung vom Übertragenen Teilbetrieb bereits erforderliche Maßnahmen getroffen wurden, ein unwiderrufliches, nicht ausschließliches, zeitlich und örtlich unbegrenztes Benutzungsrecht auf dem vom eingebrachten Teilbetrieb ausgeübten Tätigkeitsgebiet.

8. Die in § 4 Abs. 5, 6 und 7 gewährten Rechte sind kostenlos. Die Einzelheiten der Lizenzeinräumung werden die Vertragsparteien in einem gesondert zu vereinbarenden Lizenztauschvertrag regeln.

§ 5

Einbringung von Verbindlichkeiten und Risiken

Die Infineon übernimmt mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag alle in der Stichtagsbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten und alle mit dem Teilbetrieb verbundenen Risiken, selbst wenn die Ursache für diese Risiken vor dem Stichtag gesetzt wurde. Siemens überträgt zum Stichtag sämtliche für den Teilbetrieb gebildeten und in der Stichtagsbilanz ausgewiesenen Rückstellungen auf die Infineon.

§ 6

Verträge, öffentlich-rechtliche Erlaubnisse

1. Siemens bringt sämtliche, insbesondere die in Anlage F aufgeführten, ausschließlich den einge-

- 30 -

betreffenden Mitarbeiter gebildeten Rückstellungen in der Einbringungsbilanz ein Ausgleich durch die Infineon an Siemens geleistet wird.

Die Vertragsparteien werden erforderlichenfalls in angemessener Zeit nach dem Stichtag ergänzende Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Übergang der Arbeitsverhältnisse treffen.

3. Sofern Siemens nach dem Stichtag für übergegangene Arbeitsverhältnisse Personalaufwendungen entstehen, wird Infineon Siemens diese Aufwendungen erstatten.

§ 9

Gewährleistungen

Siemens gewährleistet,

1. daß die von Siemens in die Infineon eingebrachten und in der Stichtagsbilanz aufgeführten Gegenstände zum Stichtag vorhanden sind und - geschäftsübliche Eigentumsvorbehalte ausgenommen - im unbelaasteten Eigentum von Siemens stehen;
2. daß sämtliche, dem eingebrachten Teilbetrieb ausschließlich zuzuordnenden Vermögensgegenstände einschließlich der Verpflichtungen und Risiken zum Stichtag in der Stichtagsbilanz berücksichtigt und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung bewertet worden sind. Insbesondere, daß für solche Verbindlichkeiten, die das Personal betreffen, und soweit für

- 31 -

diese keine gesetzliche Pflicht zum Ausweis als Verbindlichkeit in der Bilanz besteht, wie z.B. Urlaub, Altersversorgung, Hinterbliebenenversorgung und andere Verpflichtungen oder Zusagen, soweit diese vor dem Stichtag begründet worden sind, ausreichende Rückstellungen gebildet worden sind.

3. Sämtliche Gewährleistungsansprüche bezüglich der gemäß § 3 dieses Vertrages einzubringenden Grundstücke sind abschließend in § 3 geregelt.
4. Sämtliche Gewährleistungsansprüche bezüglich der gemäß § 7 dieses Vertrages einzubringenden Beteiligungen sind abschließend in § 7 geregelt.
5. Außer den in diesem Vertrag ausdrücklich übernommenen Gewährleistungen ist jegliche Gewährleistung oder Haftung von Siemens für die gemäß diesem Vertrag eingebrachten Gegenstände und Rechte ausdrücklich und einvernehmlich ausgeschlossen.

§ 10

Freistellungsansprüche

Soweit ein Dritter gegen Siemens Ansprüche geltend macht, für die nach den Regelungen dieses Vertrages im Innenverhältnis Infineon verantwortlich ist, wird Infineon Siemens vollumfänglich von derartigen Ansprüchen freistellen.

- 32 -

§ 11 Schiedsgericht

Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V., Bonn, unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das Schiedsgericht kann auch über die Gültigkeit dieser Schiedsklausel bindend entscheiden.

Sitz des Schiedsgerichts ist München.

§ 12 Kosten, Steuern

Die mit diesem Vertrag verbundenen Kosten und Steuern einschließlich anfallender Grunderwerbsteuer trägt Siemens.

§ 13 Sonstiges

1. Sämtliche dieser Urkunde beigelegten Anlagen sind förmliche Bestandteile dieses Einbringungsvertrages; mitauszufertigen sind jedoch nur die Anlagen A, B, C 1, und C 2. *(Handwritten: 1. Export + Import)*

(Handwritten notes and signatures)
Vorläuf.
Karte
Verträge
Handwritten signature

- 33 -

Hinsichtlich der Anlagen A sowie D fortlaufend bis einschließlich G haben die Beteiligten auf das Vorlesen mit der Erklärung verzichtet, daß ihnen der Inhalt dieser Anlagen genau bekannt ist. Sie wurden den Beteiligten zur nochmaligen Kenntnisanahme vorgelegt und von ihnen auf jeder einzelnen Seite unterschrieben.

2. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch der übrige Inhalt des Vertrages nicht berührt.

Die Vertragspartner werden freundschaftlich zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die im wirtschaftlichen Ergebnis den unwirksamen Bestimmungen möglichst weitgehend entspricht; entsprechendes gilt, falls sich eine ergänzungsbedürftige Lücke des Vertrages herausstellen sollte.

4. Von dieser Urkunde erhalten jeder Vertragsteil eine Ausfertigung und drei beglaubigte Abschriften, die Grundbuchämter München und Regensburg je eine Ausfertigung im Auszug (Urkundeneingang, § 3, § 12, § 13 und Schlußvermerk), die Grunderwerbsteuerstellen der Finanzämter Mühldorf am Inn und Regensburg je eine einfache Abschrift im vorgenannten Auszug, sowie das Registergericht München und das Finanzamt München für Körperschaften je eine beglaubigte Abschrift.

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

197701077	VERFAHREN ZUM PASSIVIEREN VON HALBLEITERELEMENTEN	single use
197707141	KERN-MANTEL-GLASFASER MIT LAENGSSSEITIGEM KOPPELBEREICH	single use
197801063	GEHAEUSE FUEER HALBLEITERANORDNUNG	single use
197801077	STROMZUFUEHRUNG FUEER EINE IDUKTIONSHHEIZSPULE	single use
197801123	VERFAHREN ZUM ABSCHIEDEN VON SILICIUM IN FEINKRISTALLINER FORM	single use
197808154	THYRISTORTRIODE MIT INTEGRIERTEM HILFSTHYRISTOR UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG	single use
197808155	THYRISTOR	single use
197901083	STROMZUFUEHRUNG IN KOAXIALBAUWEISE	single use
197901089	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON HALBLEITEREIGENSCHAFTEN AUFWEISENDEM SILICIUM	single use
197901155	VORRICHTUNG ZUM TIEGELFREIEN ZONENZIEHEN	single use
197901177	HALBLEITERBAUELEMENT MIT MEHREREN HALBLEITERKOEPPERN	dual use
197807019	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN ABSTANDS- ODER DICK ENMESSUNG MIT EINER REGELUNG DER RICHTUNG DES LICHTSTRAHLBUENDELS	single use
197907025	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES GLASFASER-LICHTWELLENLEITERS	single use
197907036	BAUELEMENT MIT OPTISCHEN LICHTWELLENLEITERN	single use
197907515	VERFAHREN ZUR PHOTOTECHNISCHEN HERSTELLUNG VON RELIEFSTRUKTUREN	dual use
197907535	WAERMEBESTAENDIGE POSITIVRESISTS UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNGWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTUREN	dual use
197907540	POLYIMID-POLYISOINDOLOCHINAZOLINDION-POLYOXAZINDION-und POLYCHINAZOLINDION-VORSTUFEN , DEREN HERSTELLUNG UND VERWENDUNG	dual use
197907541	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG HOCHWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTUREN,DANACH HERGESTELLTE RELIEFSTRUKTUREN UND DEREN VERWENDUNG	dual use
197907544	POLYOXAZOL-VORSTUFEN, DEREN HERSTELLUNG UND VERWENDUNG	single use
197907545	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG HOCHWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTUREN,DANACH HERGESTELLTE RELIEFSTRUKTUREN UND DEREN VERWENDUNG	single use
197908096	THYRISTORTRIODE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 1 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198001023	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINERGAAS-HALBLEITERANORDNUNG.	single use
198001037	INTEGRIERTE MOS-HALBLEITERSCHALTUNG	single use
198001051	PLANARE HALBLEITERANORDNUNG MIT ERHOEHTER DURCHBRUCHSSPANNUNG	single use
198001066	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG	single use
198001070	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG MONOLITHISCH INTEGRIERTER MOS-UNDBIPOLAR-HALBLEITERANORDNUNGEN FUER DEN VHF-UND UHF-BEREICH	single use
198001120	TRANSISTERANORDNUNG MIT HOHER KOLLEKTOR-EMITTER-DURCHBRUCHSPANNUNG	single use
198001130	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER DIE PRUEFUNG VON SPEICHERZELLENPROGRAMMIERBARER MOS-INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER	single use
198001152	INTEGRIERBARE LEISTUNGSTRANSISTORANORDNUNG.	single use
198001166	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER MONOLITHISCHEN INTEGRIERTENZWEI-TRANSISTOR-SPEICHERZELLE IN MOS-TECHNIK.	single use
198001167	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ELEKTRONISCHENSTABILISIERUNG DES BETRIEBSSTROMES EINES MINDESTENSEINE GATEELEKTRODE AUFWEISENDEN BETRIEBSFELDEFFEKTTRANSISTORS	single use
198001184	TONGENERATOR	dual use
198001187	FOTOTRANSISTOR	single use
198002059	DECODIEREINRICHTUNG	single use
198002060	HALTESCHALTUNG ZUR DEFINIERTEN POTENTIALFESTLEGUNG VONDECODERGATTERAUSGAENGEN ZUR SPEICHERADRESSIERUNG	single use
198006131	GEHAEUSELOSES SCHALTUNGSMODULUND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG	dual use
198006250	ANORDNUNG ZUM VERTEILEN VON INFORMATIONEN UND ZUM RASCHENUND GEZIELTEN AUFFINDEN VON EINEN ADRESSENTEILAUFWEISENDEN NFORMATIONSEINHEITEN	single use
198006568	VERFAHREN ZUR VERRINGERUNG DER WARTEZEITEN BEIINFORMATIONSSYSTEMEN	dual use
198007179	VERFAHREN ZUM KORRIGIEREN EINES MESSIGNALS	single use
198007197	DYNAMISCHE HALBLEITER-SPEICHERZELLE MIT WAHLFREIEMZUGRIFF UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG.	single use
198007537	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG HOCHWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTURENUND DEREN VERWENDUNG	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 2 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198007538	STRAHLUNGSREAKTIVE VORSTUFEN HOCHWAERMEBESTAENDIGER POLYMERERUND DEREN VERWENDUNG	dual use
198007808	UEBERTRAGERFREIE GABELSCHALTUNG	dual use
198008042	MONOLITHISCH INTEGRIERTE SCHALTUNG ZU- UND/ODER ABSCHALTBARENSCHALTUNGSTEILEN.	single use
198008260	METHOD FOR MAKING DISPLAY DEVICE	single use
198101005	MONOLITHISCH INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER	single use
198101007	MONOLITHISCH INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER	single use
198101034	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DUENNER POLYIMIDSCHICHTEN	dual use
198101071	INTEGRIERTE NACHLAUF-SYNCHRONISATIONSSCHALTUNG	single use
198101082	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SCHOTTKY-DIODEN	single use
198101111	LEISTUNGS-MOS-FELDEFFEKTTRANSISTOR UND VERFAHREN ZUSEINER HERSTELLUNG	single use
198101123	INTEGRIERBARE SIGNALVERARBEITENDE HALBLEITERSCHALTUNG	single use
198101127	ERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR DIGITALEN REGELUNG DER PHASE DESSYSTEMTAKTES EINES DIGITALEN SIGNALVERARBEITUNGSSYSTEM	single use
198101138	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINER VON SCHWANKUNGEN EINER VERSORGUNGSGLEICHSPANNUNG UNABHAENGIGEN AUSGANGSGLEICHSPANNUNG	dual use
198101157	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES VON SCHWANKUNGEN EINER VERSORGUNGSGLEICHSPANNUNGSFREIEN GLEICHSPANNUNGSPEGELS	single use
198101166	PILOTTON-DEMODULATOR FUER DEN STEREO- FERNSEHEMPFANG	single use
198101169	INTEGRIERTE SCHALTUNG	single use
198101170	PLANARES HALBLEITERBAUELEMENT	single use
198101180	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR UEBERWACHTEN UEBERGABE VON STEUERSIGNALEN AN SCHNITTSTELLEN DIGITALER SYSTEME.	dual use
198101192	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR A/D WANDLUNG	single use
198101197	INTEGRIERBARE SCHALTUNG FUER DIGITAL/ANALOG- WANDLER	single use
198107173	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON SCHICHTEN AUS HOCHSCHMELZENDEN METALLEN BEI NIEDRIGEN SUBSTRATTEMERATUREN.	single use
198201187	SPANNUNGSFESTER MOS-TRANSISTOR FUER HOECHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 3 von 188

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198201174	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHALTEN ELEKTRISCHERLASTEN	single use
198201212	VERFAHREN ZUM VERHINDERN DER BILDUNG VON GRATEN BEIDER UMHUELLUNG VON BAUELEMENTEN	single use
198201248	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON INTEGRIERTEN MOS-FELDEFFEKTTRANSISTORSCHALTUNGEN IN SILIZIUMGATE-TECHNOLOGIE MIT SILIZID BESCHICHTETENDIFFUSIONSGBIETEN ALS NIEDEROHMIGE LEITERBAHNEN	single use
198201372	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON STRUKTUREN VON AUS METALLSILIZID UND POLYSILIZID BESTEHENDEN DOPPELSCHICHTEN AUF INTEGRIERTE HALBLEITER-SCHALTUNGEN ENTHALTENDEN SUBSTRATEN DURCH REAKTIVES IONENÄTZEN.	single use
198201382	INTEGRIERTER IMPULSFORMER.	single use
198201406	MONOLITHISCH INTEGRIERTER SCHALTKREIS	single use
198201423	HALBLEITERBAUELEMENT MIT PLANARSTRUKTUR.	single use
198201727	MONOLITHISCH INTEGRIERTE DIGITALE HALBLEITERSCHALTUNG.	single use
198201778	HALBLEITER-LASERDIODE.	single use
198201785	AUF HALBLEITERMATERIAL FÜR DIFFUSION ZU VERWENDEnde FESTKÖRPERQUELLE.	single use
198201993	VERFAHREN ZUM STEuern EINES DATENTRANSFERS ZWISCHEN EINEM DATENSENDER UND EINEM DATENEMPFANGER ÜBER EINEN BUS MIT HILFE EINER AM BUS ANGESCHLOSSENEN STEUEREINRICHTUNG	single use
198201996	VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG DES KANALSTARTS BEI EINER INTEGRIERTEN MIKROPROGRAMMIERTEN VORRICHTUNG MIT MINDESTENS ZWEI UNABHÄNGIGEN KANÄLEN ZUM HANDHABEN VON INFORMATIONEN UND VERFAHREN ZU IHREM BETRIEB.	single use
198201998	INTEGRIERTE MIKROPROGRAMMIERTE VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG VON INFORMATIONSVERRARBEITUNGSABLAUFEN UND VERFAHREN ZU IHREM BETRIEB.	single use
198202002	VORRICHTUNG ZUR MIKROPROGRAMM-STEUERUNG EINES INFORMATIONSTRANSFERS UND VERFAHREN ZU IHREM BETRIEB.	single use
198202022	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM DYNAMISCHEN SCHREIB-LESE-SPEICHER.	single use
198202033	INTEGRIERTE HALBSCHALTUNG MIT EINER AUS EINER ALUMINIUM/SILIZIUM-LEGIERUNG BESTEHENDEN KONTAKTLEITERBAHNEBENE	single use
198202058	HALBLEITERBAUELEMENT MIT KONTAKTLOCH.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 4 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198301049	VERFAHREN ZUM EINSTELLEN VON REFERENZSPANNUNGEN AN EINEM A/D-WANDLER	single use
198301193	DIGITALER PHASENDETEKTOR.	single use
198301216	INTEGRIERTER DYNAMISCHER SCHREIB-LESESPEICHER.	single use
198301259	SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL	single use
198301287	VERFAHREN ZUR BESCHICHTUNG SCHEIBENFÖRMIGER HALBLEITERSUBSTRATE MIT PHOTOLACK.	single use
198301290	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON HOCHINTEGRIERTEN KOMPLEMENTÄREN MOS-FELDEFFEKTTRANSISTOR-SCHALTUNGEN.	single use
198301292	VERFAHREN ZUR DIGITALEN QUADRATURAMPLITUDENMODULATION	dual use
198301300	VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES ALS NICHTFLUECHTIGEN SCHREIB-LESE-SPEICHERS AUSGEBILDETEN ANWENDUNGSSPEICHERS UND ANORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS.	single use
198301317	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON SPEICHERZELLEN MIT EINEM EINSCHWEBENDES GATE AUFWEISENDEN MOS-FELDEFFEKTTRANSISTOR	single use
198301351	INTEGRIERTE DIGITALE MOS-HALBLEITERSCHALTUNG.	single use
198301384	INTEGRIERBARES, BUSORIENTIERTES ÜBERTRAGUNGSSYSTEM	single use
198301394	VERFAHREN ZUM KUNSTSTOFFUMHÜLLEN VON ELEKTRISCHEN BAUELEMENTEN	single use
198301454	DIGITALES RECHENWERK	single use
198301499	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINER AUS ALUMINIUM ODER AUS EINER ALUMINIUMLEGIERUNG BESTEHENDEN ÄUSSEREN KONTAKTLEITERBAHNEBENE	single use
198301525	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR KOMPENSATION VON ECHOSIGNALEN	dual use
198301587	LEISTUNGSTRANSISTOR	single use
198301590	DATENÜBERTRAGUNGSVERFAHREN IN EINEM DIGITALEN ÜBERTRAGUNGSNETZWERK UND VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS	dual use
198301604	SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL	single use
198301681	INTEGRIERBARE OSZILLATORSCHALTUNG	single use
198301700	HALBLEITERDIODE	single use
198301834	SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 5 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198301878	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FESTSTELLUNG DES VORHANDENSEINS ODER NICHTVORHANDENSEINS MINDESTENS EINER FREQUENZ BEKANNTEN WERTES IN EINEM AUS MEHREREN FREQUENZEN ZUSAMMENGESETZTEN EINGANGSIGNAL	single use
198301919	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR KOMPENSATION VON ÜBERSPRECHUNGS- UND/ODER ECHOSIGNALEN.	dual use
198301949	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DIGITALSIGNALVERARBEITUNG NACH ART EINES VORZUGSWEISE ADAPTIVEN TRANSVERSALFILTERS	dual use
198401028	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON BOR-DOTIERTEN POLY-KRISTALLINEN SILIZIUMSCHICHTEN UND VERWENDUNG	single use
198401045	HALBLEITERBAUELEMENT MIT KONTAKTLOCH	single use
198401230	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER HOCHINTEGRIERTEN MOS-FELDEFFEKTTRANSISTORSCHALTUNG	single use
198401264	DURCH FELDEFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT	single use
198401291	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON METALLSILID-SCHICHTEN DURCH ABSCHIEDUNG AUS DER GASPHASE BEI VERMINDERTEM DRUCK UND DEREN VERWENDUNG	single use
198401329	EIN-TRANSISTOR-SPEICHERZELLE FÜR HOCHINTEGRIERT DYNAMISCHE HALBLEITERSPEICHER UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG	single use
198401387	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON AUS DOPPELSCHICHTEN AUS HOCHSCHMELZENDEN METALLSILIZIDEN UND DOTIERTEM POLYKRISTALLINEM SILIZIUM BESTEHENDEN GATE-ELEKTRODEN.	single use
198401432	DIFFERENZVERSTÄRKERSCHALTUNG	single use
198401434	OSZILLATOR-MISCHERSCHALTUNG	single use
198401509	OSZILLATOR/DEMULATOR-SCHALTUNGSANORDNUNG FÜR EINEN INDUKTIVEN ANNÄHERUNGSSCHALTER	single use
198401538	INTEGRIERTE SCHALTUNG FÜR EINEN IN KOMPLEMENTÄRER SCHALTUNGSTECHNIK AUFGEBAUTEN DYNAMISCHEN HALBLEITER-SPEICHER.	single use
198401549	MONOLITHISCH INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG	single use
198401565	INTEGRIERTER SCHREIB-LESESPEICHER	single use
198401574	ANORDNUNG ZUM ERZEUGEN EINES MEHRFREQUENZSIGNALS	dual use
198401594	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TEMPERATURSICHERUNG MIT HYSTERESE	single use
198401627	DATEN ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN ÜBER EINEN MULTIPROZESSORBUS.	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 6 von 186

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198401704	ZELLENSTRUKTURIERTER DIGITALER MULTIPLIZIERER MIT SEMISYSTOLISCHEM AUFBAU	single use
198401764	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER LASERDIODE MIT VERGRABENER AKTIVER SCHICHT UND MIT SEITLICHER STROMBEGRENZUNG DURCHSELBSTJUSTIERTEN PN-UEBERGANG.	single use
198401803	MOS-SCHALTUNG MIT EINEM E2PROM	single use
198401812	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG IN KOMPLEMENTÄRER SCHALTUNGSTECHNIK MIT UEBERSPANNUNGSSCHUTZ-STRUKTUR	single use
198401817	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES PN-UEBERGANGS MIT HOHER DURCHBRUCHSSPANNUNG.	single use
198401823	D/A-WANDLER	single use
198401828	SCHALTUNG ZUR LOGIKGENERIERUNG MIT MULTIPLEXERN	single use
198401837	VERFAHREN ZUR INTEGRIERTEN HERSTELLUNG EINES DFB-LASERS MIT ANGEKOPPELTEM STREIFENWELLENLEITER AUF EINEM SUBSTRAT	single use
198401882	SCHOTTKY-KONTAKT AUF EINER HALBLEITEROBERFLÄCHE UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
198401905	WELLENWIDERSTANDSGETREUER CHIPTRÄGER FÜR MIKROWELLENHALBLEITER	single use
198402028	HALBLEITER-LEISTUNGSSCHALTER.	single use
198403116	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYIMID- und POLYISOINDOLOCHINAZOLINDION-VORSTUFEN	dual use
198403117	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYIMID- und POLYISOINDOLOCHINAZOLINDION-RELIEFSTRUKTUREN	dual use
198404080	KONFERENZSCHALTUNG FÜR DIGITALE KOMMUNIKATIONSSYSTEME	dual use
198405301	INTEGRIERBARER ANALOG/DIGITALWANDLER.	single use
198407440	HIGHLY ALIGNED OPTICAL DEVICE	single use
198408064	INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER.	single use
198501171	VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES HALBLEITERSPEICHERS MIT INTEGRIERTER PARALLELTTESTMÖGLICHKEIT UND AUSWERTSCHALTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS	single use
198501227	LICHTZUENDBARER THYRISTOR MIT VERLUSTARMER ZUFÜHRUNG DER ANSTEUERLEISTUNG.	dual use
198501302	ANORDNUNG ZUM DOTIEREN VON HALBLEITERSTÄBEN MIT FESTEN DOTIERSTOFFEN	dual use
198501356	ELEKTRONISCHER SCHALTER.	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 7 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198501409	INTEGRIERTE SCHALTUNG UND VERFAHREN ZUM SICHERN VON GEHEIMENCODEDATEN.	dual use
198501417	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON KREUZKOPPLUNGENZWISCHEN N-UND-P-KANAL-CMOS-FELDEFFEKT-TRANSISTOREN VON STATISCHEN SCHREIB-LESE-SPEICHERN, INSBESONDERE BEI 6-TRANSISTOR-SPEICHERZELLEN-ANORDNUNGEN.	single use
198501428	MOSFET MIT TEMPERATURSCHUTZ	dual use
198501472	LEISTUNGS-MOSFET UND HERSTELLVERFAHREN	single use
198501517	LEISTUNGSTRANSISTORANORDNUNG	single use
198501570	INTEGRIERTE SCHALTUNG IN KOMPLEMENTAERER SCHALTUNGS-TECHNIK MIT EINEM SUBSTRATVORSPANNUNGS-GENERATOR UND EINER SCHOTTKY-DIODE.	single use
198501571	INTEGRIERTE SCHALTUNG IN KOMPLEMENTAERER SCHALTUNGS-TECHNIK MIT EINEM SUBSTRATVORSPANNUNGS-GENERATOR.	single use
198501594	GESTEUERTE STROMQUELLENANORDNUNG.	single use
198501606	OPTISCHE ANORDNUNG.	single use
198501611	INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER.	single use
198501662	INTEGRIERBARE DEKODIERSCHALTUNG.	single use
198501731	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON STRUKTUREN IN DER MIKROMECHANIK	single use
198501743	ADDIERERZELLE FÜR CARRY-RIPPLE-ADDIERER IN CMOS-TECHNIK.	single use
198501744	MEHRSTELLIGER CARRY-RIPPLE-ADDIERER IN CMOS-TECHNIK MIT ZWEI TYPEN VON ADDIERERZELLEN	single use
198501796	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM ELEKTRISCH LEITENDEN FLÄCHENELEMENT.	single use
198501857	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON P-UND N-KANAL-MOS-TRANSISTOREN ENTHALTENDEN HOCHINTEGRIERTEN SCHALTUNGEN MIT AUS EINER DOTIERTEN DOPPELSCHICHT AUS POLYSILIZIUM UND METALLSILIZID BESTEHENDEN GATE-ELEKTRODEN.	single use
198501902	VERFAHREN ZUM GLEICHZEITIGEN HERSTELLEN VON SELBSTJUSTIERTEN BIPOLAREN TRANSISTOREN UND KOMPLEMENTÄREN MOS-TRANSISTOREN AUF EINEM GEMEINSAMEN SILIZIUMSUBSTRAT	single use
198501903	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON SELBSTJUSTIERTEN BIPOLAR-TRANSISTORSTRUKTUREN MIT REDUZIERTEM BASISBAHNWIDERSTAND.	single use
198505302	DYNAMISCHES REGELUNGSSYSTEM.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 8 von 186

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198505304	SCHALTBARE BIPOLARE STROMQUELLE.	single use
198505305	TRIMMBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINER TEMPERATURUNABHÄNGIGEN REFERENZSPANNUNG.	single use
198505307	DIGITAL-ANALOG-UMSETZER MIT TEMPERATURKOMPENSATION	single use
198508131	TEST INTERFACE FOR AN MOS TECHNOLOGY INTEGRATED CIRCUIT.	single use
198601040	GESCHALTETE STROMQUELLE	single use
198601105	THYRISTOR MIT EINSTELLBAREM BASIS-EMITTER-WIDERSTAND.	dual use
198601120	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES MIT SOURCESEITIGER LAST VERBUNDENEN MOSFET.	single use
198601144	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ANSTEUERUNG EINES IC-BAUSTEINS MIT DIGITALSIGNALEN.	single use
198601156	MOSFET-SCHALTER MIT INDUKTIVER LAST.	dual use
198601157	ANSTEUERSCHALTUNG FÜR EINEN LEISTUNGS-MOSFET MIT SOURCESEITIGER LAST.	dual use
198601179	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER BIPOLARTRANSISTORSTRUKTUR FÜR HOCHGESCHWINDIGKEITSSCHALTUNG.	single use
198601191	SENDE-UND EMPFANGSMODUL FÜR EIN BIDIREKTIONALES KOMMUNIKATIONSNETZ, INSBESONDERE EIN BREITBAND-ISDN.	single use
198601202	ARRAY MIT VERKOPPELTEN OPTISCHEN WELLENLEITERN	single use
198601203	VERFAHREN ZUR DATENREDUKTION DIGITALER BILD-SIGNALE DURCH VEKTORQUANTISIERUNG VON DURCH ORTHONORMALE TRANSFORMATION MITTELS EINER SYMMETRISCHEN, FAST-ZYKLISCHEN HARDAMARD-MATRIX GEWONNENEN Koeffizienten-	dual use
198601212	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON OPTIMIERTEN KOMPLEMENTÄREN MOS-FELDEFFEKTTRANSISTOREN IN VLSI-TECHNIK.	single use
198601242	VERFAHREN ZUR BEFESTIGUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN AUF EINEM SUBSTRAT.	single use
198601285	SCHALTUNGSANORDNUNG FÜR DAS TIEGELFREIE ZONENZIEHEN VON HALBLEITERSTÄBEN	single use
198601286	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERMITTELN DES SYNCHRONZUSTANDES EINER DATENÜBERTRAGUNGSANLAGE	dual use
198601293	EMPFANGER FÜR OPTISCHE DIGITALSIGNALS MIT UNTERSCHIEDLICHER AMPLITUDE.	single use
198601303	TAKTREGENERIERSCHALTUNG.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 9 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198601397	INTEGRIERTE BIPOLAR-UND KOMPLEMENTAERE MOS-TRANSISTOREN AUF EINEM GEMEINSAMEN SUBSTRAT ENTHALTENE SCHALTUNG UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG.	single use
198601425	INTEGRIERBARE SCHALTUNG ZUR PEGELUMSETZUNG	single use
198601456	INDUKTIONSSHEIZER ZUM TIEGELFREIEN ZONENSCHMELZEN	single use
198601477	SPANNUNGSZUFUEHRUNGSANORDNUNG FUER EINE INTEGRIERTE HALBLEITER-SCHALTUNG	single use
198601495	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DRUCKSENSORS	single use
198601497	VERFAHREN ZUR STABILISIERUNG VON PN-UEBERGAENGEN.	single use
198601507	INTEGRIERTE BIPOLAR-UND KOMPLEMENTAERE MOS-TRANSISTOREN AUF EINEM GEMEINSAMEN SUBSTRAT ENTHALTENDE SCHALTUNG UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG.	single use
198601524	TRANSISTORVARAKTORANORDNUNG FUER DYNAMISCHE HALBLEITERSPEICHER	single use
198601610	DIODE MIT WEICHEM ABRISSEVERHALTEN	dual use
198601636	HALBLEITERBAUELEMENTE MIT LEISTUNGS-MOSFET UND STEUERSCHALTUNG.	single use
198601667	IMPULSFORMER.	single use
198601705	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PN-UEBERGANGS HOHER SPANNUNGS- FESTIGKEIT.	single use
198601706	VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINES P-DOTIERTEN HALBLEITERGEBIETS IN EINEM N-LEITENDEN HALBLEITERKOEPPER.	single use
198601720	SILIZIUM-TEMPERATURSENSOR.	single use
198601733	ELEKTRONISCHE SPRECHSCHALTUNGSANORDNUNG-	dual use
198601756	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUM TESTEN VON MEGA-BIT-SPEICHER-BAUSTEINEN MIT BELIEBIGEN TESTMUSTERN IM MULTI-BIT-TESTMODUS.	single use
198601765	SPEICHERZELLENANORDNUNG FUER DYNAMISCHE HALBLEITERSPEICHER.	single use
198601814	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT ALS DUENNSCHICHTSTEGE AUF DEN DIE AKTIVEN TRANSISTORBEREICHE TRENNENDEN FELD-OXIDBEREICHEN ANGEORDNETEN LASTWIDERSTAEENDE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG.	single use
198601815	MOS-FELDAFFEKT-TRANSISTORSTRUKTUR MIT EXTREM FLACHEN SOURCE/DRAIN ZONEN UND SILIZID-ANSCHLUSSBEREICHEN, SOWIE VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG IN EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 10 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198601823	FERNBEDIENUNG FÜR EIN EMPFANGSGERÄT DER UNTERHALTUNGS-ELEKTRONIK	single use
198601824	PROGRAMMIERBARES GERÄT ZUM EINSTELLEN EINES EMPFANGS-GERÄTES DER UNTERHALTUNGSELEKTRONIK	single use
198601840	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT MINDESTENS ZWEI AUSALUMINIUM ODER EINER ALUMINIUM-VERBINDUNG BESTEHENDENMETALLISIERUNGSEBENEN SOWIE VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG.	single use
198601866	VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINER DEFINIERTEN ARSENDOTIERUNG INSILIZIUMHALBLEITERSUBSTRATEN.	single use
198601867	VERFAHREN ZUR STEUERUNG UND KONTROLLE VON DURCH IM PLASMAAKTIVIERTE IONEN,RADIKALE UND/ODER NEUTRALE TEILCHEN BEWIRKTENAETZPROZESSEN,INSBESONDERE FÜR HOECHSTINTEGRIERTE HALBLEITER-SCHALTUNGEN.	single use
198601892	VERFAHREN ZUR BEFESTIGUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN AUF EINEM SUBSTRAT,FOLIE ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER FOLIE.	dual use
198605302	ANALOG-DIGITAL-UMSETZER MIT KAPAZITAETSNETZWERK.	single use
198605303	ANALOG-DIGITAL-UMSETZER NACH DEM WAEGEVERFAHREN.	single use
198605304	SUKZESSIVES APPROXIMATIONS-REGISTER.	single use
198605305	STROMSPIEGEL-SCHALTUNGSANORDNUNG	single use
198608008	DIGITALE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ABSTRAKTENAENDERUNGUND SIGNALFILTERUNG UND VERFAHREN ZU IHREM ENTWURF.	single use
198608013	VERFAHREN ZUM POSITIONSGERECHTEN FUEGEN VON LICHT- WELLENLEITERN IN KOPPELSTELLEN UND KOPPELELEMENTENFÜR LICHTWELLENLEITER-SCHALTER.	single use
198608049	INTEGRIERBARE BEWERTERSCHALTUNG.	single use
198608067	"INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH-UP SCHUTZSCHALTUNG INKOMPLEMENTAERER MOS SCHALTUNGSTECHNIK"	single use
198608068	"INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH- UP"SCHUTZSCHALTUNG IN KOMPLEMEN-TAERER MOS SCHALTUNGSTECHNIK"	single use
198608075	HALBLEITERBAUELEMENT MIT MINDESTENS EINEM LEISTUNGS-MOSFET.	dual use
198701019	HALBLEITERANORDNUNG MIT MINDESTENS EINEM HALBLEITERKOEPPER.	dual use
198701032	HALBLEITERSPEICHER MIT WAHLFREIEM ZUGRIFF ÜBER ZWEI GETRENNT EINEIN/AUSGAENGE	single use
198701059	BRÜCKENZWEIG MIT FREILAUFDIODEN.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 11 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198701066	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER ALS KONTAKT-UND BARRIERESCHICHTWISKENDEN TITAN/TITANNITRID-DOPPELSCHICHT IN HOECHSTINTEGRIERTENSCHALTUNGEN.	single use
198701082	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM UNTERDRUECKEN VON ECHOSIGNALEN	single use
198701099	OPTOELEKTRONISCHES KOPPELELEMENT UND VERFAHREN ZU DESSENHERSTELLUNG.	single use
198701135	DREIDIMENSIONALE 1-TRANSISTORZELLENANORDNUNG FUER DYNAMISCHEHALBLEITERSPEICHER MIT GRABENKONDENSATOR UND VERFAHREN ZURHERSTELLUNG DES BITLEITUNGSKONTAKTES.	single use
198701159	ASERANORDNUNG MIT GETRENNT ANSTEUERBAREN GEKOPPELTEN HALB-LEITERLASERN	single use
198701192	INTEGRIERT-OPTISCHE ANORDNUNG FUER DIE BIDIREKTIONALE OPTISCHENACHRICHTEN-ODER SIGNALUEBERTRAGUNG	single use
198701225	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR UEBERWACHUNG EINES MIT-INTEGRIERTEN OSZILLATORS.	single use
198701259	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BESCHLEUNIGTEN UMLADUNG DES SPANNUNGS-PEGELS EINER BUS-LEITUNG EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG.	single use
198701318	LASERDIODENARRAY MIT LATERALER VERKOPPELUNG.	single use
198701355	GENERATORSCHALTUNG.	single use
198701356	SCHALTUNGSANORDNUNG IN EINER INTEGRIERTEN HALBLEITERSCHALTUNG.	single use
198701416	HOCHINTEGRIERBARE SPEICHERZELLE	single use
198701481	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON DURCH ISOLATIONSGRAEBEN GETRENNTENWANNEN FUER CMOS-TRANSISTOR-SCHALTUNGEN	single use
198701526	STATISCHER HALBLEITERSPEICHER MIT EINER SIGNALWECHSEL-ERKENNUNGSSCHALTUNG	single use
198701527	LESEVERSTAERKER FUER STATISCHE SPEICHER IN CMOS-TECHNOLOGIE	single use
198701559	ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR FESTSTELLUNG UND LOKALISIERUNG VONFEHLERHAFTEN SCHALTKREISEN EINES SPEICHERBAUSTEINS.	single use
198701569	OPTOKOPPLER.	single use
198701658	ABSAUGELEKTRODE ZUR VERKUERZUNG DER AUSSCHALTZEIT BEI EINEM HALB-LEITERBAUELEMENT	single use
198701660	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MESFET MIT SELBSTJUSTIERTEM GATE.	single use
198701751	VERFAHREN ZUM AETZEN VON (100)-SILIZIUM.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 12 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

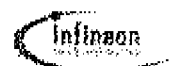
198701755	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES VERSENKTEN OXIDS	single use
198701756	KOPPELANORDNUNG ZUM EINKOPPELN VON LICHT EINER HALBLEITERLASER-DIODE IN EINE MULTIMODE-GLASFASER	single use
198701757	OPTOKOPPLER	single use
198701761	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG VON FILTERSIGNALEN.	dual use
198701770	VERFAHREN ZUM QUERSTROMFREIEN BETREIBEN EINER GEGENTAKTSCHALTUNG UND ANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.	dual use
198701780	DATENUEBERTRAGUNGSVERFAHREN FUER EIN DIGITALES VERMITTLUNGSSYSTEM UND ANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.	single use
198701781	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES BIPOLARTRANSISTORS MIT ISOLIERTER GATEELEKTRODE	single use
198701785	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PLANAREN SELBSTJUSTIERTEN HETEROBIPOLARTRANSISTORS.	single use
198701788	VERFAHREN ZUR BASISSTROMREGELUNG EINES SCHALTTRANSISTORS UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
198701819	SPHAERISCHE PLANKONVEXLINSE ZUR OPTISCHEN KOPPLUNG EINES HALBLEITERLASERS AN EINEN OPTISCHEN WELLENLEITER	single use
198701823	VERFAHREN ZUR TEMPERATURREGELUNG VON GLUEHKERZEN BEI DIESELMOTOREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.	dual use
198701844	MONOLITHISCH INTEGRIERBARER PHASENSCHIEBER-VCO.	single use
198701847	HYRISTOR MIT EINSTELLBARER KIPPSPANNUNG.	dual use
198701860	DREIDIMENSIONALE 1-TRANSISTORZELLENANORDNUNG FUER DYNAMISCHE HALBLEITERSPEICHER MIT GRABENKONDENSATOR UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG.	single use
198701886	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZ VOR VERPOLUNGSSCHADEN FUER LAST-KREISE MIT EINEM MOSFET ALS SCHALTTRANSISTOR	dual use
198701889	OPTISCHER SCHALTER.	single use
198701895	INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ABTRENNUNG VON FARBBILD-AUSTASTSYNCHRON-SIGNALANTEILEN.	single use
198701914	VERFAHREN UND DATENTRAEGERANORDNUNG ZUR ECHTHEITSERKENNUNG VON SPEICHERCHIPS.	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 13 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198701916	VERFAHREN UND SCHALTUNG ZUM MANIPULIERGESCHUETZTEN ENTWERTEN VON EE-PROM-SPEICHERN.	dual use
198701933	VERFAHREN ZUM GURTEN VON ABSTIMMDIODEN MIT FLIESSENDEM UEBERGANG DER KAPAZITAETSGLEICHLAUFGRUPPEN.	single use
198703170	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG HOCHWAERMEBESTAENDIGER DIELEKTRIKA.	dual use
198703171	WAERMEBESTAENDIGE POSITIV ARBEITENDE STRAHLUNGSEMPFINDLICHE GEMISCHTE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG WAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTUREN	dual use
198703172	WAERMEBESTAENDIGE POSITIV RESISTENZ UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG WAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTUREN.	dual use
198705303	VERFAHREN ZUR ANLAUFSTROMBEGRENZUNG EINES GLEICHSPANNUNGSWANDLERS.	dual use
198705304	KALIBRIERUNGSVERFAHREN FUER REDUNDANTE A/D- UND D/A-UMSETZER MIT GEWICHTETEM NETZWERK.	single use
198707410	SEMICONDUCTOR WAFER DICING TECHNIQUES	single use
198707446	LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR DEVICE.	single use
198708001	"INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH-UP"-SCHUTZSCHALTUNG IN KOMPLEMENTAERER MOS-SCHALTUNGSTECHNIK"	single use
198708013	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM PARALLELEN EINSCHREIBEN VON DATEN IN EINEN HALBLEITERSPEICHER.	single use
198708014	SCHALTUNGSANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM TESTEN VON SPEICHERZELLEN.	single use
198708018	MEHRSTUFIGE INTEGRIERTE DEKODEREINRICHTUNG.	single use
198708020	MEHRSTUFIGE INTEGRIERTE DEKODEREINRICHTUNG.	single use
198708039	STECKER FUER LICHTWELLENLEITER MIT ENTRIEGELUNGSHEBEL	single use
198708046	VERFAHREN UND MESSVORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER DIFFUSIONSLAENGE VON MINORITAETSLADUNGSTRAEGERN ZUR ZERSTOERUNGSFREIEN DETEKTION VON DEFekten UND VERUNREINIGUNGEN IN HALBLEITERKRISTALLKOERPERN.	single use
198708047	VERFAHREN ZUR KENNZEICHNUNG VON HALBLEITEROBERFLAECHEN	single use
198708123	"INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH-UP"-SCHUTZSCHALTUNG IN KOMPLEMENTAERER MOS-SCHALTUNGSTECHNIK"	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 14 von 185

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198708124	"INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH-UP"-SCHUTZSCHALTUNG IN KOMPLEMENTÄERER MOS-SCHALTUNGSTECHNIK"	single use
198708226	XXX	single use
198801034	VERFAHREN ZUR TEMPERATURKONTROLLE VON TEMPERPROZESSEN IN DER HALBLEITERTECHNIK.	single use
198801056	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZE EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG.	single use
198801075	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DURCH FELLEFFEKT STEUERBARENBIPOLARTRANSISTORS.	single use
198801083	VERFAHREN ZUM SICHERN VON IN EINEM DATENSPEICHER ABGELEGTE GEHEIMEN CODEDATEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.	dual use
198801103	VERFAHREN ZUM BEFESTIGEN VON ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN AUF SUBSTRATEN UND ANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DESSELBEN.	dual use
198801112	VERFAHREN ZUR BEDARFSWEISEN BENUTZUNG DES DATENSPEICHERS EINESMIKROCOMPUTERS ALS PROGRAMMSPEICHER.	dual use
198801172	VERFAHREN ZUR BEGRENZUNG DES AUSGANGSSTROMES EINER STROMVERSORGUNG	single use
198801183	HALTERUNG EINER KUGELLINSE IN EINEM METALLROEHRCHEN, INSBESONDEREFUER OPTOELEKTRONISCHE MODULE, UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG.	single use
198801197	SPRITZ-FORM-VORRICHTUNG FUEER QUARZGEFUELLTES KUNSTSTOFFMATERIAL	single use
198801198	SPRITZ-FORM-VORRICHTUNG	single use
198801230	VERSCHLIESSBARER BEHAELTER ZUM TRANSPORT UND ZUR LAGERUNG VONHALBLEITERSCHEIBEN.	single use
198801242	"ADDIERZELLE FUEER "CARRY-SAVE"-ARITHMETIK"	single use
198801260	VERFAHREN ZUM KURZZEITTEMPERN EINER HALBLEITERSCHEIBE DURCHBESTRAHLUNG.	single use
198801265	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERFASSEN DER UEBERTEMPERATUR EINES HALBLEITERBAUELEMENTS	dual use
198801266	MOS-HALBLEITERBAUELEMENT FUEER HOHE SPERRSPANNUNG.	single use
198801283	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON GITTERSTRUKTUREN MIT UM EINE HALBGITTERPERIODE GEGENEINANDER VERSETZTEN ABSCHNITTEN	single use
198801312	ANORDNUNG ZUR REDUZIERUNG VON RAUSCHEN UND FARBUUEBERSPRECHEN EIFERNSEHSIGNALEN.	single use
198801314	ABSCHALTBARER THYRISTOR.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 15 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198801322	BREITBANDSIGNAL-KOPPELEINRICHTUNG.	single use
198801324	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ENTNAHME VON IM WESENTLICHEN REIN SINUS-FOERMIGEN, NETZFREQUEMTEM STROM AUS WECHSELSPANNUNGSNETZEN UND ZURUEBERFUEHRUNG DER ENTNOMMENEN ELEKTRISCHEN ENERGIE IN GALVANISCHVERBUNDENE GLEICHSPANNUNGSSYSTEME.	single use
198801344	SCHALTNETZTEIL MIT SCHUTZ ZUR BEGRENZUNG EINER AUSGANGSSPANNUNG	single use
198801348	DIODE MIT VERBESSERTEM ABSCHALTVERHALTEN	single use
198801374	REINIGUNGSVERFAHREN FUER WASSERSTOFFPEROXID	single use
198801376	VERFAHREN ZUR ZERSTOERUNGSFREIEN BESTIMMUNG ELEKTRONISCHER INHOMO-GENITAETEN IN HALBLEITERSCHICHTEN	single use
198801380	JUSTIERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM JUSTIEREN EINES ROBOTERARMSZUM EINSATZ IN AUTOMATISIERTEN PRODUKTIONSBEREICHEN, INSBESONDEREIN DER HALBLEITERTECHNIK	single use
198801381	JUSTIERANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM JUSTIEREN EINER GREIFVORRICHTUNG EINES ROBOTERARMS ZUM HANDHABEN EINER HALBLEITERSCHEIBE	single use
198801396	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR PRIORITAETSAUSWAHL.	single use
198801399	LEISTUNGS-MOSFET MIT TEMPERATURSENSOR	dual use
198801416	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZE EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG VOREINEM AN EINER EINGANGSSTUFE ANLIEGENDEN UNZULAESSIGEN EINGANGS-POTENTIAL	single use
198801418	VERFAHREN ZUM UNTERSCHIEDBARMACHEN VON ELEKTRONISCHEN SCHALTUNGENMIT NICHTFLUECHTIGEM SPEICHER.	single use
198801419	VERFAHREN ZUM SCHUTZ VON SCHALTUNGSANORDNUNGEN MIT ALS ZAEHLEREINGESETZTEM ELEKTRISCH PROGRAMMIERBAREM NICHTFLUECHTIGEM SPEICHERVOR GRENZWERTIGER, NICHT EINDEUTIGER PROGRAMMIERUNG DIESES SPEICHERS UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.	dual use
198801440	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERFASSEN DES KURZSCHLUSSES EINER MIT EINEMFET IN REIHE LIEGENDEN LAST.	dual use
198801467	QUARZOSZILLATORSCHALTUNG FUER HOEHERE FREQUENZEN.	single use
198801469	PC-KARTE	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 16 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198801494	GATE-SOURCE-SCHUTZSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-MOSFET.	dual use
198801510	CHIPRESIDENTE ZWISCHENTREIBER FUER DISKRETE WSI-SYSTEME.	single use
198801533	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINE DIGITALE REGELUNG DER PHASE VON ABTASTTAKTIMPULSEN.	dual use
198801534	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINE DIGITALE REGELUNG DER FREQUENZ UND/ODER DER PHASE VON ABTASTTAKTIMPULSEN.	dual use
198801541	MULTIEINGANGS-VIER-QUADRANTEN-MULTIPLIZIERER.	single use
198801542	VERFAHREN ZUM VERBINDEN EINES HALBLEITERCHIPS MIT EINEM SUBSTRAT UND DESSEN VERBINDUNG	single use
198801543	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FESTSTELLUNG DES VORHANDEN-SEINS ODER NICHTVORHANDENSEINS MINDESTENS EINER FREQUENZ BEKANNTENWERTES IN EINEM AUS MEHREREN FREQUENZEN ZUSAMMENGESETZTEN EINGANGSSIGNAL.	single use
198801558	DIFFERENTIELLER OPERATIONSVERSTAERKER MIT GLEICHTAKT-RUECKKOPPEL-SCHALTUNG.	single use
198801578	LEISTUNGSDIODE	single use
198801598	PLANARER PN-UEBERGANG HOHER SPANNUNGSFESTIGKEIT.	single use
198801602	WIDERSTANDSSCHWEISSVERFAHREN FUER WERKSTUECKE MIT HOHEN SCHLANKHEITSGRAD	dual use
198801607	ABSTIMMBARER DFB-LASER.	single use
198801621	VERFAHREN ZUM IRREVERSIBLEN UNTERBINDEN DER DURCHFUEHRUNG DEFINIERTER SPEICHEROPERATIONEN IN MONOLITHISCH INTEGRIERTEN MIKROCOMPUTERSCHALTUNGEN.	dual use
198801641	HALBLEITERLASERANORDNUNG UND VERFAHREN ZU IHREM BETRIEB	single use
198801661	ANORDNUNG ZUM TIEGELLOSEN ZONENSCHMELZEN	single use
198801662	VERFAHREN ZUM GETTERN VON HALBLEITER-BAUELEMENTEN UND NACH DEM VERFAHREN ERHALTENE HALBLEITER-BAUELEMENTE	single use
198801670	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ENTZERREN VON IN ANALOGER FORM EMPFANGENER DIGITALSIGNALS.	dual use
198801671	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ENTZERREN VON IN ANALOGER FORM EMPFANGENER DIGITALSIGNALS.	single use
198801678	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHREN EINES ON-CHIP-ZEITVERSCHACHTELNS DES ZUGRIFFS AUF DYNAMISCHE RAM-BAUSTEINE	single use
198801700	OPTOELEKTRONISCHE SENDE- UND EMPFANGSVORRICHTUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 17 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198801731	ANORDNUNG ZUR BERUEHRUNGSFREIEN ERFASSUNG DER DREHZAHL EINES ROTIERENDEN ZAHNRADES.	dual use
198801733	INTEGRIERTE SPANNUNGSVERVIELFACHERSCHALTUNG FUER NIEDRIGE VER-SORGUNGSSPANNUNG.	dual use
198801748	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERKENNEN DES LEERLAUFS EINER MIT EINEMELEKTRONISCHEN SCHALTER IN REIHE LIEGENDEN LAST	dual use
198801762	HALBLEITERSCHALTER MIT EINEM HAUPTTHYRISTOR UND EINEM LICHTZUENDBAREN HILFSTHYRISTOR	dual use
198801763	HALBLEITERSCHALTER MIT EINEM HAUPTTYRISTOR UND EINEM GETRENNTEN, LICHTZUENDBAREN HILFSTHYRISTOR	dual use
198801764	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERHOEHUNG DES MAXIMALMOEGLICHEN WIRKUNGSGRADES, DER MAXIMAL MOEGLICHEN FREQUENZ UND DES MAXIMAL MOEGLICHEN AUSNUTZUNGSGRADES DER LEISTUNGS-BAUELEMENTE IN RESONANZWANDLER-SCHALTNETZTEILEN MIT NULLDURCHGANGSDETEKTOR.	single use
198801765	HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER GITTERSTRUKTUREN MIT UM EINE HALBEGITTERPERIODE GEGENEINANDER VERSETZTEN ABSCHNITTEN	single use
198801785	INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERZOEGERUNG IMPULSFOERMIGERSIGNALE	single use
198801786	ELEKTRISCH ABSTIMMBARER HALBLEITERLASER MIT STEGWELLENLEITER.	single use
198801813	VERFAHREN ZUR SELBSJUSTIERTEN HERSTELLUNG VON KONTAKTEN ZWISCHEN IN UEBEREINANDER ANGEORDNETEN VERDRAHTUNGSEBENEN EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG ENTHALTENEN LEITERBAHNEN.	single use
198801823	INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR RUECKSTROMVERRINGERUNG BEI EINEM INVERS BETRIEBENEN TRANSISTOR.	single use
198804078	VERFAHREN ZUM EINPASSEN EINER KUGELLINSE	single use
198804100	VERFAHREN ZUR FIXIERUNG VON LICHTWELLENLEITERN IN EINEM STECKERGEHAEUSE.	single use
198804116	STECKERSTIFT FUER EINEN LICHTWELLENLEITER-STECKER.	single use
198805302	CMOS-DIFFERENZIALKOMPARATOR MIT OFFSETSPANNUNG	single use
198805303	CMOS-PULSWEITENMODULATOR	single use
198805304	CMOS-SPANNUNGSREFERENZ.	single use
198805305	VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG UND VERARBEITUNG VON KORREKTURWERTEN FUER SELBSTKALIBRIERENDES A/D- UND D/A-WANDLER UND RECHENWERK ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
198805306	SELBSTKALIBRIERENDER A/D- UND D/A-WANDLER.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 18 von 196

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198805307	SENSORSCHALTANORDNUNG.	dual use
198805308	SELBSTKALIBRIERENDER A/D-D/A-WANDLER.	single use
198807460	DIGITALLY CONTROLLED MONOLITHIC ACTIVE PHASE SHIFTER APPARATUS	single use
198807465	MIXED CML/ECL MACRO CIRCUITRY	single use
198807468	WIDEBAND SOLID-STATE ANALOG SWITCH	single use
198807472	MONOLITHIC DOUBLE BALANCED MIXER WITH HIGH THIRD ORDER INTERCEPTPOINT EMPLOYING AN ACTIVE DISTRIBUTED BALUN	single use
198807474	IMPROVED GAIN VIA INCREASED DEPTH OF MODULATION OF INNER-PAIR TAILCURRENT OPEN LOOP AMPLIFIERS	single use
198808008	REDUNDANZDEKODER EINES INTEGRIERTEN HALBLEITERSPEICHERS.	single use
198808012	GATTERSCHALTUNG MIT MOS-TRANSISTOREN.	single use
198808062	ZAEHLER-/ZEITGEBER-SCHALTUNG FUER EINEN MICROCONTROLLER.	single use
198808070	ECL-CMOS-WANDLER	single use
198808078	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM SPEICHERBEREICH.	single use
198808079	BIPOLARTRANSISTOR ALS SCHUTZELEMENT FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN.	single use
198808102	VERFAHREN ZUR PLAZIERUNG VON MODULEN AUF EINEM TRAEGER.	single use
198808105	SENSORANORDNUNG ZUM NACHWEIS VON GASEN DURCH EXOTHERME KATALYTISCHE REAKTIONEN	dual use
198901032	ESD-SCHUTZSTRUKTUR	single use
198901042	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN FREISCHWINGENDES SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL.	single use
198901075	ABSTIMMBARER HALBLEITERLASER	single use
198901089	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINE VERSTAERKERSTUFE.	single use
198901122	INTEGRIERBARE AMPLITUDENGEREGELTE OSZILLATORSCHALTUNG.	single use
198901150	SCHUTZSCHALTUNG GEGEN UEBERSPANNUNGEN FUER MOS-BAUELEMENTE.	single use
198901153	ZUSAMMENSETZUNG EINES MIKROKONTROLLERS.	single use
198901166	THYRISTOR MIT VERBESSERTEM ABSCHALTVERHALTEN	single use
198901181	DOPPEL-PIN-PHOTODIODE MIT SPERRENDEM P-N UEBERGANG ZWISCHEN SUB-STRAT UND ABSORPTIONSSCHICHT.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 19 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198901183	SCHALTUNGSANORDNUNG UND VORRICHTUNG ZUR KONTAKTLOSEN SOLLWERTVORGABE FUER EINEN MIT NICHTMAGNETISCHEM WERKSTOFF UMHUELLTEN INTEGRIERTEN SCHALTKREIS	single use
198901192	VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINER PHOTORESISTSTRUKTUR.	single use
198901193	HOCHAUFLOESENDER PHOTORESIST	single use
198901220	INTEGRIERBARE VERSTAERKERSCHALTUNG.	single use
198901225	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PLANAREN PN-UEBERGANGS HOHERSPANNUNGSFESTIGKEIT	single use
198901256	INTEGRIERBARE FREILAUFSCHALTUNG	single use
198901259	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN SYNCHRONZAEHLER	single use
198901280	INTEGRIERBARE VERSTAERKERSCHALTUNG.	single use
198901300	STATISCHER SPEICHER MIT PIPELINEREGISTERN.	single use
198901301	STATISCHER SPEICHER	single use
198901302	STATISCHE SPEICHERZELLE	single use
198901309	PHOTOSTRUKTURIERUNGSVERFAHREN	single use
198901311	VERFAHREN ZUR MASSHALTIGEN STRUKTURUEBERTRAGUNG IN DER ZWEILAGEN-TECHNIK	single use
198901312	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG AETZRESISTENTER STRUKTUREN	single use
198901313	ROCKENENTWICKELBARES RESISTSYSTEM	single use
198901353	INTEGRIERBARER SIGMA-DELTA-MODULATOR IN SWITCHED-CAPACITOR-TECHNIK	single use
198901354	INTEGRIERBARER SIGMA-DELTA-MODULATOR IN SWITCHED-CAPACITOR-TECHNIK	single use
198901364	SCHALTUNGSSTRUKTUR MIT EINEM LATERALEN BIPOLARTRANSISTOR	single use
198901392	HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG MIT KONDENSATOREN MIT ZWEI IN EINEMGRABEN ANGEORDNETEN ELEKTRODEN UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG.	single use
198901404	MONOLITHISCH INTEGRIERTE LASERDIODE-WELLENLEITER-KOMBINATION	single use
198901411	ANORDNUNG ZUM OPTISCHEN KOPPELN EINES ELEKTROOPTISCHEN WANDLERMODULS MIT EINEM LICHTWELLENLEITER MITTELS ZWEIER LINSEN	single use
198901424	CMOS-ECL-WANDLER	single use
198801435	TRANSPORTVORRICHTUNG FUER EIN DOPPELLAGIGES FOLIENBAND	single use
198901438	HALBLEITERBAUELEMENT MIT PASSIVIERUNGSSCHICHT	dual use
198901441	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG WENIGSTENS EINER LEITERBAHNKREUZUNG.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 20 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198901442	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM INTERNEN PARALLELTEST VON HALB-LEITERSPEICHERN.	single use
198901454	THYRISTOR MIT ANODENSEITIGEN EMITTERKURZSCHLUESSEN	dual use
198901455	VERFAHREN ZUM VERBINDEN VON ZWEI SCHEIBENFOERMIGEN KOERPERN AUS MATERIALIEN UNTERSCHIEDLICHER THERMISCHER AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN UND DESSEN VERWENDUNG	single use
198901456	VERFAHREN ZUR ORTSAUFGELOESTEN BESTIMMUNG DER DIFFUSIONSLAENGE VON MINORITAETSLADUNGSTRAEGERN IN EINEM HALBLEITERKRISTALLKOERPER MIT HILFE EINER ELEKTROLYTISCHEN ZELLE.	single use
198901462	VERFAHREN ZUM GROSSFLAECHIGEN ELEKTRISCHEN KONTAKTIEREN EINES HALBLEITERKRISTALLKOERPERS MIT HILFE VON ELEKTROLYTEN	single use
198901463	VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER REKOMBINATIONSGESCHWINDIGKEIT VON MINORITAETSTRAEGERN AN GRENZFLAECHEN ZWISCHEN HALBLEITERN UND ANDEREN SUBSTANZEN.	single use
198901480	SCHUTZSCHALTUNG GEGEN UEBERSPANNUNGEN FUER MOS-BAUELEMENTE	single use
198901482	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERMEIDUNG VON UEBERLAEUFEN BEI EINEM ADAPTIVEN, REKURSIVEN WELLENDIGITALFILTER MIT FEST-KOMMAARITHMETIK.	single use
198901491	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZ ELEKTRONISCHER SCHALTUNGEN VOR UEBERSPANNUNG.	single use
198901507	VERFAHREN UND NETZWERKANORDNUNG ZUR ERZIELUNG EINER STETIGENAENDERUNG DER UEBERTRAGUNGSFUNKTION EINES ADAPTIVEN REKURSIVEN NETZWERKS ZUR VERARBEITUNG ZEITDISKRETER SIGNALE.	dual use
198901511	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR VERBESSERUNG DES DYNAMIKBEREICHES EINES ADAPTIVEN REKURSIVEN NETZWERKS ZUR VERARBEITUNG ZEITDISKRETER SIGNALE.	dual use
198901525	PIN-FET-KOMBINATION MIT VERGRABENER P-SCHICHT	single use
198901529	EINGANGSSCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN.	single use
198901546	OHMSCHER KONTAKT FUER EINE P-LEITENDE SCHICHT EINES INP-SUBSTRATES VON FOTODIODEN UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
198901555	HERSTELLVERFAHREN FUER EINE POLYKRISTALLINE SILIZIUMSCHICHT MIT DEFINIERTER KORNGROESSE UND TEXTUR.	single use
198901557	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 21 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198901564	VERFAHREN ZU EINER CODIERUNG EINER ELEMENTFOLGE UND EINRICHTUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.	single use
198901595	VERFAHREN ZUR SPEICHERUNG VON VIDEOSIGNALDATEN UND VORRICHTUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
198901599	NULLPUNKTDETEKTOR FUEER EINEN OPTISCH STEUERBAREN THYRISTOR.	single use
198901605	OPTISCH GEGENGEKOPPELTER VERSTAERKER.	single use
198901623	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR NACHLAUFSYNCHRONISATION.	single use
198901640	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON TITANSILIZID ERHOECHTER HOCH-TEMPERATURFESTIGKEIT BEI DER HERSTELLUNG VON HOCHINTEGRIERTEN HALBLEITERSCHALTUNGEN	single use
198901649	OFEN ZUM FLUSSMITTELFREIEN LOETEN ODER KLEBEN VON HALBLEITER-MIKROCHIPS.	single use
198901650	VERFAHREN ZUM VERBINDEN VON HALBLEITERCHIPS MIT EINEM WAFER	single use
198901680	LICHTSTEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT MIT EINEM FELDEFFEKT-TRANSISTOR	single use
198901685	OPTOELEKTRONISCHER WANDLER MIT EINER LINSENKOPPELOPTIK.	single use
198901699	EINGANGSSCHUTZSTRUKTUR FUEER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN.	single use
198901719	EINGANGSSCHUTZSTRUKTUR FUEER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN	single use
198901730	INTEGRIERT OPTISCHE ANORDNUNG MIT WENIGSTENS EINEM AUF EINEM SUBSTRAT AUS HALBLEITERMATERIAL INTEGRIERTEN OPTISCHEN WELLEN-LEITER	single use
198901741	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERHOEHUNG DER AUSGANGSSPANNUNG INERELEKTRONISCHEN SCHALTSTUFE	single use
198901744	OPTOKOPPLER.	single use
198901748	VERFAHREN ZUR GLOBALEN PLANARISIERUNG VON OBERFLAECHEN FUEER INTE-GRIERTE HALBLEITERSCHALTUNGEN	single use
198901752	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HETEROBIPOLARTRANSISTORS MIT SEPARATION DES KOLLEKTORANSCHLUSSES	single use
198901764	VORRICHTUNG ZUM PARALLELEN AUSRICHTEN DER AUFLAGEFLAECHEN ZWEIER BAUTEILE UND VERFAHREN ZUM BETRIEB DER VORRICHTUNG.	single use
198901790	VERFAHREN ZUR DURCHFUEHRUNG EINES DATENTRANSFERS ZWISCHEN AN EINEM BUS ANGESCHLOSSENEN MODULEN	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 22 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198901797	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GENERIERUNG KOMBINATORISCHER BINAERERLOGIK MIT MULTIPLEXERN UND INVERTERN	single use
198901798	BIPOLARTRANSISTOR MIT VERMINDERTER BASIS/KOLLEKTOR- KAPAZITAET UNDVERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
198901799	CMOS-KOMPATIBLER BIPOlarTRANSISTOR MIT VERRINGERTER KOLLEKTOR/SUB-STRAT-KAPAZITAET UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
198901801	VERFAHREN ZUM ANISOTROPEN AETZEN VON SILIZIUM	single use
198901817	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER CACHE-SPEICHER	single use
198901847	VERFAHREN ZUR ERHOEHUNG DER SPANNUNGSFESTIGKEIT EINES MEHRSCICH-TIGEN HALBLEITERBAUELEMENTS	single use
198901849	TYRISTOR MIT GROSSER SPERRFAEHIGKEIT IN BLOCKIERRICHTUNG	dual use
198901870	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KOERPERS AUS SILIZIUM.	single use
198901877	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN SCHALTNETZTEIL.	single use
198901882	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN GEREGETES SPERRWANDLER-SCHALTNETZ-TEIL.	single use
198901883	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN SPERRWANDLER- SCHALTNETZTEIL.	single use
198901885	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN SPERRWANDLER- SCHALTNETZTEIL.	single use
198901905	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BILD-IN-BILD-EINBLENDUNG IN EINEM FERNSEH-GERAET MIT NUR EINEM TUNER	single use
198901925	BERTIEBSSPANNUNG-UEBERWACHUNGSSCHALTUNG	single use
198901928	EINGANGSSCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN.	single use
198901944	INTEGRIERBARE FREQUENZVARIABLE OSZILLATORSCHALTUNG.	single use
198901951	MODUL MIT MINDESTENS EINEM HALBLEITERSCHALTELEMENT UND EINERANSTEUERSCHALTUNG	single use
198901966	HALBLEITERSCHEIBE MIT DOTIERTEM RITZRAHMEN	single use
198901990	VERFAHREN ZUM ANISOTROPEN TROCKENSAETZEN VON ALUMINIUM BZW.ALUMINIUMLEGIERUNGEN ENTHALTENDEN LEITERBAHNEN IN INTEGRIERTENHALBLEITERSCHALTUNGEN	single use
198902012	SONDERZEICHENSATZ FUER TELETEXT	single use
198903027	SCHUTZSCHICHT FUER ELEKTROAKTIVE PASSIVIERSCHICHTEN.	single use
198903029	ELEKTROAKTIVE PASSIVIERSCHICHT	single use
198903118	LICHTEMPFFINDLICHES GEMISCH.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 23 von 186

J:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

198903155	HERSTELLUNG HOCHWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTUREN.	single use
198903209	PLANARISIERENDES DIELEKTRIKUM	single use
198903292	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON EINKRISTALLINEM SILIUMKARBID.	dual use
198904023	VERBINDUNG ZWISCHEN EINEM OPTOELEKTRONISCHEN HALBLEITERBAUELEMENT UND EINEM LICHTWELLENLEITERENDE	single use
198905301	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TEMPERATURUEBERWACHUNG VON IN EINEM HALBLEITERSCHALTKREIS INTEGRIERTEN LEISTUNGSSCHALTTRANSISTOREN.	single use
198905304	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR IDENTIFIKATION INTEGRIERTER HALBLEITER-SCHALTKREISE.	single use
198905305	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR IDENTIFIKATION INTEGRIERTER HALBLEITER-SCHALTKREISE.	single use
198907412	HEMT STRUCTURE	single use
198907441	PROCESS FOR EXTRACTING LOGIC FROM TRANSISTOR AND RESISTOR DATA REPRESENTATIONS OF CIRCUITS	single use
198908002	INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER.	single use
198908009	INTEGRIERTE REFERENZSPANNUNGSQUELLE.	single use
198908018	INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER VOM TYP DRAM UND VERFAHREN ZUSEINEM TESTEN.	single use
198908032	SENSORANORDNUNG MIT EINEM GASENSOR UND EINEM KATALYSATOR ZUM NACHWEIS VON GASFOERMIGEN VERBINDUNGEN	dual use
198908039	VERFAHREN UND NETZWERKANORDNUNG ZUR GEWINNUNG DES GRADIENTEN DER AUSGANGSSIGNALE EINES GEGEBENEN NETZWERKES ZUR VERARBEITUNG ZEITDISKRETER SIGNALE BEZUEGLICH DER NETZWERKPARAMETER	dual use
198908042	OSZILLATORSCHALTUNG FUER DIFFERENTIELLE AUSGANGSSIGNALE.	dual use
198908073	VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN SPRACHRICHTUNGSSUMSCHALTUNG UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.	dual use
198908077	METALLIONENQUELLE	single use
198908079	HALBLEITERSPEICHER.	single use
199001001	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SELBSTJUSTIERTEN EMITTER-BASIS-KOMPLEXES	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 24 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199001041	CHIPTRAEGER FUER EIN MIKROWELLEN-HALBLEITERBAUELEMENT	single use
199001055	KOMPARATORSCHALTUNG.	single use
199001059	VERFAHREN ZUR DEMODULATION VON SECAM-CODIERTEN FARBFERNSEHSIGNALEN MIT ZEILENVERKOPPELTEM TAKT UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199001064	EINGANGSSCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN	single use
199001071	EINRICHTUNG ZUM EINBLENDEN EINES ERSTEN BILDES IN EIN ZWEITES BILD AUF EINEM BILDSCHIRM.	single use
199001085	ANALOG LEITUNGSANSCHALTUNG	dual use
199001102	ELEKTRONISCHER SCHALTER	dual use
199001111	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR PEGELUEBERWACHUNG	dual use
199001117	INTEGRIERBARE TRANSISTORSCHALTUNG ZUR ABGABE LOGISCHER PEGEL	single use
199001128	THYRISTOR MIT REFLEXIONSARMER LICHTZUENDSTRUKTUR	dual use
199001129	VERFAHREN ZUR DEFINIERTEN SPANNUNGSEINSTELLUNG BEI UEBERKOPFZUEND- FESTEN HALBLEITERBAUELEMENTEN UND HALBLEITERBAUELEMENTE MIT DEFINIERTER UEBERKOPFZUENDSPANNUNG	single use
199001159	LUMINESZENZDIODENVORRICHTUNG MIT SCHUTZEINRICHTUNG ZUR BEGRENZUNG DES DURCHLASSTROMES BEI ANLIEGENDER WECHSELSPANNUNG.	single use
199001160	ADAPTIVES REKURSIVES DIGITALFILTER.	single use
199001167	ZWEIDRAHT-VIERDRAHT-UMSETZER.	dual use
199001168	ZWEIDRAHT-VIERDRAHT-UMSETZER.	dual use
199001188	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER TITANNITRID-SCHICHT FUER HOECHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN MITTELS CHEMISCHER DAMPFPHASENABSCHIEDUNG	single use
199001189	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON LEITENDEN SCHICHTEN ODER STRUKTUREN FUER HOECHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN	single use
199001200	PHASENMASKE FUER DIE PROJEKTIONS PHOTOLITHOGRAPHIE UND VERFAHREN ZUDEREN HERSTELLUNG	single use
199001207	CORDIC-PROZESSOR FUER VEKTORDREHUNGEN IN CARRY-SAVE-ARCHITEKTUR	dual use
199001236	INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER MIT PARALLELTTESTMOEGLICHKEIT UND REDUNDANZVERFAHREN.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 25 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199001263	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BEREICHSUMSCHALTUNG IN TUNERN	single use
199001265	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BEREICHSUMSCHALTUNG IN TUNERN.	single use
199001266	VERFAHREN ZUR FARBKANTENVERBESSERUNG BEI DER DARSTELLUNG VON FARB-FERNSEHBILDERN UND FERNSEHGERAET ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.	single use
199001287	INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER	single use
199001294	HERSTELLVERFAHREN FUER EINEN LEISTUNGS-MISFET	single use
199001300	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON BIPOLARTRANSISTOREN MIT EXTREM RE-DUZIERTER BASIS-KOLLEKTOR-KAPAZITAET	single use
199001312	UEBERABTASTENDER ANALOG-DIGITAL-UMSETZER MIT RAUSCHFILTERUNG IN SWITCHED-CAPACITOR-TECHNIK	single use
199001319	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DOTIERTES POLYSILIZIUM UND METALL-SILIZID ENTHALTENDEN MEHRSCICHTGATEELEKTRODE FUER EINEN MOS-TRANSISTOR.	single use
199001324	INDUKTIVER ANNAEHERUNGSSCHALTER MIT GERINGER TEMPERATURABHAENGIQ-KEIT	single use
199001328	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR REGELUNG DER AMPLITUDEN EINES OSZILLATORS.	single use
199001338	VERFAHREN ZUR KOMPENSATION VON PHASEN-und FREQUENZFEHLERN EINESQUADRATURPHASENMODULIERTEN TRAEGER SIGNALS UND ANORDNUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES VERFAHRENS	dual use
199001340	VERFAHREN ZUM MESSEN KLEINER PHASENDIFFERENZEN UND SCHALTUNGSAN-ORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.	dual use
199001349	SENDE- UND EMPFANGSMODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE OPTISCHE NACH-RICHTEN- UND SIGNALUEBERTRAGUNG.	single use
199001369	ANORDNUNG MIT SELBSTVERSTAERKENDEN DYNAMISCHEN MOS-TRANSISTOR-SPEICHERZELLEN.	single use
199001371	QUERSTROMFREIE C-MOS-VERSTAERKERSCHALTUNG	single use
199001372	SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL	single use
199001379	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN PEGELWANDLER ZUM UMWANDELN VONTTL-EINGANGSSIGNALEN IN ECL-AUSGANGSSIGNALE.	single use
199001392	ANORDNUNG ZUM OPTISCHEN KOPPELN EINES LASERVERSTAERKER-CHIPS ANEINE LICHTLEITFASER MITTELS EINER LINSE.	single use
199001395	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERBESSERUNG DER ZEITLICHEN AUFLUESUNGAUF EINANDERFOLGENDER IMPULSFOERMIGER SIGNALE.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 26 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199001407	VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN VON LOETKONTAKTSTELLEN AUF EINEN HALB-LEITERCHIP.	single use
199001410	EINRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN DATEN-und ENERGIEUEBERTRAGUNGSOWIE VERWENDUNG EINER SOLCHEN	dual use
199001412	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BIPOLARTRANSISTORS	single use
199001427	MICROPROCESSOR WITH MULTIPLE BUS CONFIGURATIONS	single use
199001493	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR AUTOMATISCHEN STEUERUNG VON TRANSIS-TOREN.	single use
199001511	THYRISTOR MIT DEFINIERTEM LATERAL-WIDERSTAND UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG.	dual use
199001517	VORRICHTUNG ZUR LEUCHTWEITENREGELUNG IN KRAFTFAHRZEUGEN	single use
199001525	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES SMD-HALBLEITERBAUELEMENTES	single use
199001528	VERFAHREN ZUR BILD-IM-BILD-EINBLENDUNG UND EINRICHTUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199001529	DIGITALE FERNSPRECH EINRICHTUNG.	dual use
199001591	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM TESTEN EINES HALBLEITERSPEICHERS MITTELS PARALLELTESTS MIT VERSCHIEDENEN TESTBITMUSTERN.	single use
199001617	DYNAMISCHER HALBLEITERSPEICHER MIT LOKALEN UND HINSICHTLICH IHRER ANSTEUERFUNKTION OPTIMIERTEN LESEVERSTAERKER-TREIBERSCHALTUNGEN.	single use
199001618	DYNAMISCHER HALBLEITERSPEICHER MIT LESEVERSTAERKER-ANSTEUERSCHALTUNG ZUR ERZIELUNG KURZER ZUGRIFFSZEITEN BEI NIEDRIGEM GESAMT-SPITZENSTROM.	single use
199001622	BIPOLARTRANSISTOR FUEER HOHE LEISTUNG IM MIKROWELLENLAENGENBEREICH	single use
199001624	WELLENLEITERGITTER BESTEHEND AUS EINER SICH VERZWEIGENDEN STRUKTUR MIT MEHREREN NEBENEINANDER ANGEORDNETEN AUSKOPPEL-ENDFLAECHEN OPTISCHER WELLENLEITER	single use
199001626	BRECH EINRICHTUNG ZUM VEREINZELN VON ANGESAEGETEN UND/ODER ANGERITZTEN HALBLEITERWAFERN ZU CHIPS	single use
199001640	VORRICHTUNG ZUR ABTRENNUNG EINER DER HALTERUNG VON HALBLEITER-SYSTEMEN DIENENDEN FOLIE VON EINEM RAHMENFOERMIGEN TRAEGER SOWIE VERFAHREN ZUM BETRIEB DER VORRICHTUNG	single use
199001641	EINGANGSSCHUTZSTRUKTUR FUEER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 27 von 166

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199001643	VORRICHTUNG ZUM TRANSPORT VON HALBLEITERBAUELEMENTEN	single use
199001659	ABSCHALTBARER THYRISTOR	single use
199001678	ECL-MULTIPLEXERANORDNUNG	single use
199001725	STEUERBARER INTEGRIERT OPTISCHER RICHTKOPPLER.	single use
199001731	HALBLEITERCHIP MIT MINDESTENS EINER ELEKTRISCHEN WIDERSTANDSEIN-RICHTUNG	single use
199001732	KUNSTSTOFFGEHAEUSE FUER EINEN HALBLEITERCHIP	single use
199001744	EINRICHTUNG ZUR SYNCHRONDEMULATION AMPLITUDENMODULIERTERSIGNALE.	single use
199001757	TRANSISTORANORDNUNG FUER BIPOLARE INTEGRIERTE HALBLEITER-SCHALTUNGEN	single use
199001767	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DOTIERTEN POLYZIDSCHICHT AUF EINEMHALBLEITERSUBSTRAT	single use
199001783	SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL	single use
199001788	MOSFET-SCHALTER FUER EINE INDUKTIVE LAST.	dual use
199001789	HALBLEITERBAUELEMENT FUER HOHE SPERRSPANNUNG.	single use
199001812	MONOLITHISCH INTEGRIERTE LASERDIODE-WELLENLEITER-KOMBINATION.	single use
199001821	VERFAHREN ZUM BELOTEN VON LEITERPLATTEN.	single use
199001839	VERFAHREN ZUR SELEKTIVEN ABSCHIEDUNG VON WOLFRAM AUF EINER SILI-ZIUMOBERFLAECHE.	single use
199001848	KOMPRESSIONSVERSTAERKER MIT OFFSETKOMPENSATION IN SCHALTER/KONDEN-SATOR-TECHNIK (SC-TECHNIK)	single use
199001849	KOMPRESSIONSVERSTAERKER MIT EINRICHTUNG ZUR VERMEIDUNG VON AB-SCHNUEEREFFekten	single use
199001859	ADAPTIVES BALANCEFILTER.	dual use
199001867	LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT	dual use
199001894	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ELEKTRISCH LEITENDEN SPITZE AUSEINEM DOTIERTEN HALBLEITERMATERIAL.	single use
199001899	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER MIT ARSEN DOTIERTEN GLATTEN POLY-KRISTALLINEN SILIZIUMSCHICHT FUER HOECHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN	single use
199003111	HOCHWAERMEBESTAENDIGE NEGATIVRESISTS UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNGHOCHWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTUREN	dual use
199003385	RESISTS UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON RESISTSTRUKTUREN	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 28 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199003561	STANDARD-KUNSTSTOFFGEHAEUSE MIT DARIN VERKAPSELTEN HALBLEITERCHIPS	dual use
199004053	VERFAHREN ZUM KONFEKTIONIEREN EINES LICHTWELLENLEITERSCHALTERS.	single use
199005301	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR BILDUNG DES LEITUNGSABSCHLUSSES EINER TELEFONLEITUNG.	single use
199005303	ANALOG-DIGITAL-UMSETZER NACH DEM ERWEITERTEN PARALLELVERFAHREN	single use
199005305	PARALLELER ANALOG/DIGITAL-UMSETZER	single use
199005306	CODIERSCHALTUNG.	single use
199005307	VORRICHTUNG ZUR STUFENLOSEN STEUERUNG ELEKTRISCHER VERBRAUCHER NACH DEM PHASENANSCHNITTPRINZIP, INSBESONDERE HELLIGKEITSREGLER UND VERWENDUNG EINER SOLCHEN VORRICHTUNG.	single use
199005308	VORRICHTUNG ZUR STUFENLOSEN STEUERUNG ELEKTRISCHER VERBRAUCHER NACH DEM PHASENANSCHNITTPRINZIP, INSBESONDERE HELLIGKEITSREGLER UND VERWENDUNG EINER SOLCHEN VORRICHTUNG.	single use
199005309	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DIGITALEN BIT-SERIELLEN SIGNALVERARBEITUNG	single use
199007430	INTEGRATED CIRCUIT PACKAGING	single use
199008011	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZ VON ANSCHLUESSEN INTEGRIERTER SCHALTKREISE	single use
199008028	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MIKROKRISTALLIN KUBISCHEN BORNITRID-SCHICHTEN	single use
199008029	HALBLEITERELEMENT MIT EINER SCHWACH DOTIERTEN SILIZIUM-SCHICHT MIT EINER PIN-DIODENSTRUKTUR.	single use
199008030	HALBLEITERELEMENT MIT EINER SILIZIUM-SCHICHT.	single use
199008039	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR NACHLAUF SYNCHRONISATION	single use
199008040	VERFAHREN ZUM SCHUTZ EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG GEGEN DAS AUS-LESEN SENSITIVER DATEN	single use
199008067	PASSIVIERTES HALBLEITERBAUELEMENT	single use
199008079	VORRICHTUNG ZUR BEFEHLSBEREITSTELLUNG IN EINEM MIKROPROZESSOR	single use
199008080	VERFAHREN ZUR EINSTELLUNG DES MASSENFLUSSES EINER GASKOMPONENTE IN EINEM GASGEMISCH MITTELS OPTISCHER ABSORPTION UND ANWENDUNG DES VERFAHRENS.	single use
199008529	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER RESISTSTRUKTUR	single use
199008535	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER RESISTSTRUKTUR	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 29 von 166

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199008598	PHOTOSTRUKTURIERUNGSVERFAHREN	single use
199008599	N-TERT.-BUTOXYCARBONYL-MALEINIMID	single use
199008600	MISCHPOLYMERE.	single use
199008601	PHOTORESIST	single use
199008602	PHOTOLITHOGRAPHISCHE STRUKTURERZEUGUNG	single use
199101001	SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL	single use
199101002	SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN BETRIEB.	single use
199101003	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ABBILDUNG DES LOGISCHEN ADRESSRAUMS EINERPROZESSOREINHEIT AUF DEN PHYSIKALISCHEN ADRESSRAUM EINES SPEICHERS	single use
199101005	VERFAHREN ZUM TESTEN EINES ALS MAKROZELLE AUF EINEM HALBLEITER-BAUSTEIN ANGEORDNETEN SPEICHERS NACH DEM SELBSTTESTPRINZIP.	single use
199101010	ANORDNUNG ZUM UMWANDELN EINER OPTISCHEN WELLE KLEINER FLECKWEITEIN EINE WELLE GROESSERER FLECKWEITE	single use
199101012	AMPLITUDENREGELEINRICHTUNG.	single use
199101013	VERPOLUNGS-und UEBERSPANNUNGSSCHUTZ FUER SCHALTUNGSANORDNUNGEN.	dual use
199101022	INTEGRIERTE SCHALTUNG ZUR ERZEUGUNG EINES RESET-SIGNALS	single use
199101027	VERFAHREN ZUR REDUZIERUNG DER VERLUSTLEISTUNG BEI EINRICHTUNGENZUR BERUEHRUNGSLOSEN DATEN-und ENERGIEUEBERTRAGUNG SOWIE ANORD-NUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.	dual use
199101028	VERFAHREN ZUR REDUZIERUNG DER VERLUSTLEISTUNG BEI EINRICHTUNGENZUR BERUEHRUNGSLOSEN DATEN- UND ENERGIEUEBERTRAGUNG SOWIE ANORD-NUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199101030	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER TRAGBAREN DATENTRAEGERANORDNUNG.	single use
199101037	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GENERIERUNG EINES RUECKSETZSIGNALS	single use
199101060	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN EINES TAKTSIGNALES MIT EINUMPHASENRECHENWERK	single use
199101064	INTEGRIERBARE TONGEBERSCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199101065	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BIPOLARTRANSISTORS	single use
199101069	OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT FUER DIE KOPPLUNG ZWISCHEN UNTER-SCHIEDLICH DIMENSIONIERTEN WELLENLEITERN	single use
199101086	INTEGRIERBARER SHUNT-REGLER.	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 30 von 185

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199101093	REGELSCHALTUNG FUER EINEN SUBSTRATVORSPANNUNGSGENERATOR.	single use
199101096	STEUERVERFAHREN FUER EINEN SPANNUNGSWANDLER MIT GROSSEM EINGANGS-SPANNUNGSBEREICH UND DIE VERWENDUNG EINES SOLCHEN VERFAHRENS.	single use
199101111	VERFAHREN ZUR DATENUEBERTRAGUNG VON EINER STATIONAEREN EINHEIT ZUEINER EINEN DATENSPEICHER UND EINEN ZUGEHOERIGEN SCHUTZSPEICHERAUFWEISENDEN BEWEGLICHEN EINHEIT	dual use
199101119	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM TESTEN INTEGRIERTER SCHALTUNGEN	single use
199101120	VERFAHRENU NSCHALTUNGSANORDNUNG ZURNICHTLINEARE N VERKNUEPFUNGZWEIERBINAERWORTE.	single use
199101133	PROZESSORSCHALTUNG.	single use
199101144	GEOMETRISCHERMOS-TRANSISTOR	dual use
199101147	TREIBERSCHALTUNG MIT VERRINGERTER VERLUSTLEISTUNG	single use
199101154	PEGELUMSETZSCHALTUNG	single use
199101162	VERFAHREN ZUM KURZZEITTEMPERN EINER HALBLEITERSCHEIBE DURCHBESTRAHLUNG	single use
199101164	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER STHYRISTORS MIT EINSTELLBARER KIPPSPANNUNG	single use
199101170	VERFAHREN ZUM TESTEN EINES DATENSPEICHERS UNOZ UGEH OERIGENSCHUTZ- SPEICHERS UNO ANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFA HRENS.	single use
199101186	SIGNALPEGELWANDLER	single use
199101188	FREILAUF-TRANSISTORSCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199101190	AUSGANGSPUFFER VERSTAERKER MIT GROSSEM SIGNALHUB	single use
199101191	AUSGANGSPUFFER VERSTAERKER	single use
199101195	EINRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN DATEN-UND ENERGIEUEBERTRAGUNGSOWIE VERFAHREN ZUM BETRIEB EONER SOLCHEN.	dual use
199101196	OSZILLATORSCHALTUNG	single use
199101208	EINRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN DATEN-und ENERGIEUEBERTRAGUNG	dual use
199101211	SSCHALTUNGSANORDNUNG ZUR SIGNALBEGRENZUNG UNDFELD STAERKEDETEKTION	single use
199101214	PHOTODETEKTOR IN SILIZIUM FUER DEN BEREICH VON 1,3UM	single use
199101215	OPTOELEKTRONISCHESENDEVORRICHTUNG	single use
199101223	DURCH FELDEFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT	single use
199101224	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MOS-TRANSISTORS	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 31 von 185

D:\BARRY E. BRETSCHEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199101226	SONDERZEICHENSATZ FUER TELETEXT	single use
199101232	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHALTEN VON ANALOGSIGNALEN AN EINE AUS-GANGSKLEMME	single use
199101234	SCHALTUNG ZUR KLEMMUNG VON VIDEOSIGNALEN	single use
199101235	VERFAHREN ZUR DATENUEBERTRAGUNG FUER EINEN HALBLEITERSPEICHER UNDHALBLEITERSPEICHER ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199101237	SCHALTNETZTEIL	single use
199101239	LOGIKSCHALTUNG FUER ASYNCHRONE SCHALTUNGEN MIT N-KANAL-LOGIKBLOCK UND DAZU INVERSEM P-KANAL-LOGIKBLOCK	single use
199101246	LEITBAHNANORDNUNG FUER HOECHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN	single use
199101280	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR KONTAKTLOSEN ENERGIE-und DATENUEBERTRA-GUNG MIT HILFE VON WECHSELSPANNUNG UND INDUKTIVEM UEBERTRAGER	dual use
199101301	HALBLEITERBAUELEMENT UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG	single use
199101306	DREH-TISCH ZUM EINSATZ IN SPRUEHPROZESSANLAGEN	single use
199101338	LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT UND VERFAHREN ZU DESSEN HER-STELLUNG.	dual use
199101345	INTEGRIERBARER STROMSPIEGEL	single use
199101355	OPTOKOPPLER	single use
199101357	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN STROMGESTEUERTEN VERSTAERKER	dual use
199101365	TTG-DFB-LASERDIODE.	single use
199101366	DURCHSTIMMBARER HALBLEITERLASER AUF SEMIISOLIERENDEM SUBSTRAT.	single use
199101371	KOMPAKTE HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HER-STELLUNG.	single use
199101376	FILTER MIT EINSTELLBARER FLANKENSTEILHEIT	single use
199101403	INTEGRIERTER FREQUENZSYNTHESIZER-SCHALTKREIS FUER SENDE UND EMPFANGSBETRIEB	single use
199101405	VERFAHREN ZUM BELOTEN UND MONTIEREN VON LEITERPLATTEN MIT BAU-ELEMENTEN.	single use
199101445	DIGITALE LOGIKSCHALTUNG ZUR BESTIMMUNG DES MINIMUMS ODER DESMAXIMUMS VON ZWEI OPERANDEN	dual use
199101457	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN FREISCHWINGENDES SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL.	single use
199101469	INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM ANALOGEN NETZWERK	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 32 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199101470	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM ANALOGEN NETZWERK	single use
199101473	INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERSCHALTUNG UND VERFAHREN ZU IHREMBETREIBEN	single use
199101474	INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERSCHALTUNG UND VERFAHREN ZU IHREMBETREIBEN	single use
199101491	GERAET ZUM VERARBEITEN VON IN ZEILEN AUFGETEILTEN VIDEOSIGNALEN	single use
199101493	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SEITLICH BEGRENZTEN, EINKRISTALLINEN GEBIETES AUF EINEM SUBSTRAT UND DESSEN VERWENDUNG ZUR HERSTELLUNG EINES MOS-TRANSISTORS UND EINES BIPOLARTRANSISTORS	single use
199101504	EMPFANGSGERAET FUER HOCHFREQUENZSIGNALE	single use
199101513	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SELBSTJUSTIERTEN KONTAKTLOCHAN-ORDNUNG UND SELBSTJUSTIERTE KONTAKTLOCHANORDNUNG	single use
199101514	VERSTEIFUNGSRING FUER NADELKARTEN	single use
199101515	GERAET ZUM VERARBEITEN VON IN ZEILEN AUFGETEILTEN VIDEOSIGNALEN MIT EINER DIGITALEN SYNCHRONABTRENNSTUFE	single use
199101519	VERFAHREN ZUR SERIELLEN UEBERTRAGUNG VON DIGITALEN DATEN	single use
199101556	AKTIVES OBERWELLENFILTER	single use
199101558	GERAET ZUM VERARBEITEN VON IN ZEILEN AUFGETEILTEN VIDEOSIGNALEN.	single use
199101566	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GRABENSTRUKTUR IN EINEM SUBSTRAT	single use
199101567	STEUERBARER SPANNUNGSREGLER	single use
199101578	DATEN-SLICER-SCHALTUNG	single use
199101579	EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR GEWINNUNG DER BINAEREN DATEN-INFORMATION EINES IN EINEM VIDEO-BASISBANDSIGNAL ENTHALTENENDATENSIGNALES	single use
199101586	VERFAHREN ZUR STRUKTURIERUNG EINER SCHICHT	single use
199101589	ADDIER-VERGLEICHS-AUSWAHL(ACS)SCHMETTERLINGSSCHALTUNG FUER VITERBIDEKODIERE, BEI DER DIE ADDIERVORGAE NGE VON ZAEHLERN AUSGEFUEHRT WERDEN	single use
199101590	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR SIGNALBEGRENZUNG UND FELDSTAERKEDETEKTION.	single use
199101592	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZ INTEGRIERTER SCHALTKREISE	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 33 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199101604	ANORDNUNG ZUM OPTISCHEN ANSCHLUSS MINDESTENS EINES OPTISCHENSENDE-EMPFANGSELEMENTES AN EINEN LICHTWELLENLEITER	single use
199101615	HERSTELLVERFAHREN FUER EINEN LEISTUNGS-MISFET	single use
199101634	INTEGRIERTE KOMPARATORSCHALTUNG	single use
199101639	VERFAHREN ZUM SELBSTTEST VON MIKROPROGRAMMIERTEN PROZESSOREN	single use
199101648	BITLEITUNGSANORDNUNG FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN	single use
199101649	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR PULSWEITENMODULATION	single use
199101656	DIGITALE NACHRICHTENVERMITTLUNGSEINHEIT	dual use
199101685	VERFAHREN ZUR SCHNELLEN ABKUEHLUNG BEIM KURZZEITTEMPERN EINERHALBLEITERSCHEIBE	single use
199103201	HOCHWAERMEBESTAENDIGE POSITIVRESISTS UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNGHOCHWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTUREN	dual use
199103508	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES BOTTOM-RESISTS	single use
199104001	POSITIONIEREINRICHTUNG ZUR EXAKTEN POSITIONIERUNG EINES ZYLINDRISCHEN STIFTES	single use
199104015	OPTISCHER SCHALTER	single use
199104016	VORRICHTUNG ZUR KOPPLUNG VON LICHTWELLENLEITERN	single use
199104109	VERFAHREN ZUM TRENNEN EINER OPTISCHEN WELLENLEITERFASER UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES ENDSTUECKES EINER OPTISCHEN WELLENLEITERFASER	single use
199104809	MULTICAST SERVER APPARATUS	single use
199105301	VERFAHREN ZUM SCHUTZ EINES NACH DEM PHASENANSCHNITTPRINZIP GE-STEUERTEN ELEKTRISCHEN VERBRAUCHERS UND ANORDNUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES VERFAHRENS.	dual use
199105302	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ANSTEUERUNG EINES MOS-LEISTUNGSTRANSISTORS	dual use
199105303	ANALOGE VERZOEGERUNGSSCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199107473	PROTECTION APPARATUS FOR SERIES PASS MOSFETS	single use
199107474	METHOD OF FORMING SHALLOW JUNCTIONS IN FIELD EFFECT TRANSISTORS	single use
199107478	METHOD OF DEPOSITING CONDUCTORS IN HIGH ASPECT RATIO APERTURES UNDER HIGH TEMPERATURE CONDITIONS	single use
199108010	VERFAHREN ZUM ANISOTROPEN TROCKENAETZEN VON ALUMINIUM BZW. ALU-MINIUMLEGIERUNGEN ENTHALTENDEN LEITERBAHNENEBENEN IN INTEGRIERTENHALBLEITERSCHALTUNGEN	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 34 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199108017	DEKODIERTE AUSLESESCHALTUNG	single use
199108033	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DOTIERTEN GEBIETES IN EINEM SUB-STRAT	single use
199108047	SCHALTUNGSSTRUKTUR MIT MINDESTENS EINEM KONDENSATOR UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
199108053	FUZZY LOGIC CONTROLLER MIT OPTIMIERTER SPEICHERORGANISATION	single use
199108060	VERFAHREN ZUR PLASMAUNTERSTUEZTEN ABSCHIEDUNG VON SCHICHTEN AUS DER GASPHASE (PECVD) MIT EXTERNER MIKROWELLENANREGUNG BEI DER HERSTELLUNG INTEGRIERTER HALBLEITERSCHALTUNGEN	single use
199108061	VERFAHREN ZUR PLASMAUNTERSTUEZTEN SCHEIBENREINIGUNG BEI DER HERSTELLUNG INTEGRIERTER HALBLEITERSCHALTUNGEN	single use
199108063	VERFAHREN ZUM PLASMAAETZEN MIT MIKROWELLENENERGIEGESPEISTERVORANREGUNG DER AETZGASE BEI DER HERSTELLUNG INTEGRIERTER HALBLEITERSCHALTUNGEN UND VERWENDUNG DES VERFAHRENS	single use
199108064	VERFAHREN ZUM ISOTROPEN DOWNSTREAM-PLASMAAETZEN MIT MIKROWELLENANREGUNG BEI DER HERSTELLUNG INTEGRIERTER HALBLEITERSCHALTUNGEN	single use
199108149	EIN-TRANSISTOR-SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use
199201006	VERFAHREN ZUM UEBERWACHSEN VON III-V-HALBLEITERMATERIAL	single use
199201021	ABSTIMMBARE LASERDIODE.	single use
199201024	HALBLEITERMODUL MIT HOHER ISOLATIONS-UND WÄRMELEITFÄHIGKEIT	dual use
199201032	VERFAHREN ZUR SCHNELLEN UND SCHONENDEN REINIGUNG VON INSBESONDERE BEIM ABSCHNEIDEN UND AETZEN VON SCHICHTEN AUF SILIZIUMSUBSTRATEN VERWENDETE REAKTIONSKAMMERN DURCH PLASMAAETZEN	single use
199201036	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PERFORIERTEN WERKSTÜCKES.	single use
199201056	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONTAKTES ZU EINER GRABENKONDENSATORELEKTRODE	single use
199201057	SCHMITT-TRIGGER	single use
199201065	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199201068	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ZWISCHENSPEICHERN EINES BITS UND DEREN VERWENDUNG ALS ADRESSZWISCHENSPEICHER.	single use
199201079	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR LASTSTROMBEGRENZUNG EINES LEISTUNGS-MOSFET	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 35 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199201088	SYNCHRONES, DIGITALES SCHALTWERK	single use
199201110	SCHUTZSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-MOSFET, DER EINE INDUKTIVELAST TREIBT	dual use
199201114	LEISTUNGSTRANSISTOR MIT MULTIFINGERKONTAKTEN	single use
199201116	SIGMA-DELTA-MODULATOR	single use
199201119	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM UEBERWACHEN EINER VERSORGUNGSSPANNUNG	single use
199201120	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES ALUMINIUM-DOTIERUNGSPROFILS	single use
199201127	INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT TRANSFERELEMENT	single use
199201128	VERFAHREN ZUM DARSTELLEN VON TEXTSEITEN AUF DEM BILDSCHIRM EINES FERNSEHGERAETS	single use
199201134	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERMINDERUNG VON MINORITAETSTRAEGERINJEKTION	single use
199201141	INTEGRIERTER MIKROPROZESSOR	single use
199201169	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES FELDEFFEKTTRANSISTORS	single use
199201172	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BIPOLARTRANSISTORS IN EINEM SUBSTRAT	single use
199201209	TONRUF-SCHALTUNG	dual use
199201210	INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER MIT REDUNDANZEINRICHTUNG	single use
199201234	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONTAKTLOCHS ZU EINEM DOTIERTEN BEREICH	single use
199201248	ASYNCHRONE LOGIKSCHALTUNG FUER DEN 2-PHASEN-BETRIEB	single use
199201255	THYRISTOR MIT DURCHBRUCHBEREICH	dual use
199201266	AKTIVES FREILAUFELEMENT	dual use
199201268	INFORMATIONSMUEBERTRAGUNGSSYSTEM, BESTEHEND AUS EINER SCHREIB/LESEEINHEIT UND EINER TRAGBAREN DATENTRAEGERANORDNUNG	dual use
199201279	SCHALTBARE STROMQUELLENSCHALTUNG UND VERWENDUNG EINER SOLCHEN IN EINER PHASENDETEKTORANORDNUNG	single use
199201280	VERFAHREN UND DATENTRAEGERANORDNUNG ZUR ECHTHEITSERKENNUNG VON SPEICHERCHIPS	single use
199201281	VERFAHREN ZUM EINSTELLEN VON PLL-PARAMETERN	single use
199201282	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER PLANAREN A1-HALTIGEN SCHICHT AUF EINEM SUBSTRAT MIT LOCHSTRUKTUREN AN DER OBERFLAECHE	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 36 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199201307	ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-FET MIT SOURCESEITIGER LAST	dual use
199201311	INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG	single use
199201312	INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG	single use
199201316	OPERATIONSVERSTAERKER MIT HOHER GLEICHTAKTUNTERDRUECKUNG	single use
199201320	FUZZY LOGIC CONTROLLER MIT HOHER VERARBEITUNGSGESCHWINDIGKEIT	single use
199201340	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES INTEGRIERTEN HALBLEITERSPEICHERS MIT VORGEGEBENER SPEICHERKAPAZITAET	single use
199201367	HERSTELLVERFAHREN FUER EINE HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG	single use
199201369	HERSTELLVERFAHREN FUER EINEN SCHUESSELKONDENSATOR	single use
199201370	GLOBALES PLANARISIERUNGSVERFAHREN FUER INTEGRIERTE HALBLEITER-SCHALTUNGEN ODER MIKROMECHANISCHE BAUTEILE	single use
199201380	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER MODENSPLITTER-STRUKTUR	single use
199201383	SCHALTSTUFE	dual use
199201389	INTEGRIERBARE TREIBERSCHALTUNG FUER EINE REAKTIVE LAST	dual use
199201393	MODULIERBARE LASERDIODE FUER HOHE FREQUENZEN.	single use
199201394	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SPEICHERKONDENSATOREN FUER DRAM-ZELLEN	single use
199201406	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR REFERENZSPANNUNGSERHOEHUNG	single use
199201414	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR LASTAUFSCHALTUNG UND LASTUEBERWACHUNG	dual use
199201415	ELEKTRONISCHE SCHALTEINRICHTUNG FUER EINE KALTLEITERLAST	single use
199201444	OPTISCHER WELLENLEITERKOPPLER	single use
199201457	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR RAUSCHREDUKTION BEI FERNSEH-ODERVIDEO-SIGNALEN	dual use
199201468	VERFAHREN ZUR LOKAL UND GLOBAL PLANARISIERENDEN CVD-ABSCHIEDUNG VON SiO ₂ -SCHICHTEN AUF STRUKTURIERTEN SILIZIUMSUBSTRATEN	single use
199201469	SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER WIRTS-RECHENEINHEIT (HOST-CPU), EINEM FUZZY-LOGIC-COPROZESSOR UND EINEM WISSENSBASIS-SPEICHER	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 37 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199201471	ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-MOSFET MIT SOURCESEITIGERLAST	single use
199201487	LEISTUNGS-MOSFET MIT VERBESSERTER AVALANCHE-FESTIGKEIT	single use
199201489	DRAM-ZELLENANORDNUNG	single use
199201513	DIGITALER STROMSCHALTER	single use
199201522	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER AUS SCHALTKREISEN BESTEHENDENSCHALTUNG MIT HILFE EINES RECHNERS	single use
199201534	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PLANARISIERUNG EINER SCHICHT AUF EINEM HALBLEITERSUBSTRAT	single use
199201536	INTEGRIERBARE TONGEBERSCHALTUNG	single use
199201537	TREIBERSTUFE FUER LOGIKSCHALTUNGEN	single use
199201540	LEISTUNGSHALBLEITER-MODUL	single use
199201548	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM VERSTAERKEN UND HALTEN VON DATEN MIT VER-SCHIEDENEN VERSORGUNGSSPANNUNGEN	single use
199201592	ANORDNUNG ZUR GEOMETRIEERFASSUNG MIT HALL-ELEMENTEN	single use
199201593	ANORDNUNG ZUR ERFASSUNG DER DROSSELKLAPPENSTELLUNG IN EINEM VER-BRENNUNGSMOTOR MIT HALL-ELEMENTEN	single use
199201594	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM UMFORMEN EINES SYMMETRISCHEN GEGENPHASIGENEINGANGSSIGNALES IN EIN UNSYMMETRISCHES EINPHASIGES AUSGANGSSIGNAL	single use
199201595	MOS-TRANSISTOR	single use
199201614	HALBLEITERKOERPER MIT VERLOETETER TRAEGERPLATTE	single use
199201616	CMOS-PUFFERSCHALTUNG	single use
199201621	SPEICHERELEMENT	single use
199201622	HALBLEITERLASER AUS EINER AKTIVEN SCHICHT UND ZWEI DIODEN	single use
199201624	ANORDNUNG ZUR TAKTRUECKGEWINNUNG	single use
199201626	VERFAHREN UND SCHALTUNG ZUR BILDKORREKTUR BEI EINER BILD-IN-BILD-DARSTELLUNG VON ZEILENVERKAEMMTEN VIDEOSIGNALEN	single use
199201628	INTEGRIERTE PUFFERSCHALTUNG	single use
199201629	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BAUELEMENTES MIT POROESEM SILIZIUM	single use
199201630	INTEGRIERTE PUFFERSCHALTUNG	single use
199201631	ANTIREFLEXSCHICHT UND VERFAHREN ZUR LITHOGRAFISCHEN STRUKTURIERUNG EINER SCHICHT	single use
199201633	INTEGRIERBARER SHUNT-REGLER	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 38 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199201639	HALBLEITERVORRICHTUNG MIT EINEM SYSTEMTRAEGER UND EINEM DAMIT VERBUNDENEN HALBLEITERCHIP SOWIE VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
199201641	MIKROPROZESSOR MIT CPU UND EEPROM	dual use
199201656	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199201664	STRAHLKOPPLER	single use
199201676	ELEKTRONISCHER BAUSTEIN MIT EINER SCHIEBEREGISTERPRUEFARCHITEKTUR (BOUNDARY-SCAN)	single use
199201683	VERFAHREN ZUM PLASMACHEMISCHEN TROCKENNETZEN VON Si3N4-SCHICHTEN HOCHSELEKTIV ZU SiO2-SCHICHTEN	single use
199201686	KERAMIKGEHAEUSE MIT AUFGELOETETEM METALLDECKEL	single use
199201692	HALBLEITERVORRICHTUNG AUS EINEM HALBLEITERCHIP UND EINEM SYSTEM-TRAEGER	single use
199201694	STRAHLROEHRE FUEER EINE IONENIMPLANTATIONSANLAGE	single use
199201705	CMOS-EINGANGSSTUFE	single use
199201708	HERSTELLVERFAHREN FUEER EIN SELBSTJUSTIERTES KONTAKTLOCH UND HALBLEITERSTRUKTUR	single use
199201720	VERFAHREN ZUR VORSTEUERUNG EINES SCHALTNETZTEILES ZUM AUSGLEICH VON SCHWANKUNGEN DER SPEISESPANNUNG UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	dual use
199201723	INTEGRIERTE SCHALTUNG ZUR ERZEUGUNG EINES RESET-SIGNALS	single use
199201731	OPTISCHE UEBERTRAGUNGSEINRICHTUNG FUEER DIE UEBERTRAGUNG OPTISCHER SIGNALE IN WELLENLAENGENMULTIPLEX AUF EINER VIELZAHL BENACHBARER OPTISCHER TRAEGERWELLENLAENGEN	dual use
199201732	ANORDNUNG ZUR FREQUENZUMSETZUNG	single use
199201740	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES HALBLEITER-MODULAUFBAUS	single use
199201748	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM UMWANDELN VON DIGITALEN TONSIGNALEN	dual use
199201761	ABSCHALTBARER THYRISTOR	dual use
199201762	GTO-THYRISTOR	dual use
199201775	MONOLITHISCH INTEGRIERTE LASERDIODE-KOPPLER-KOMBINATION	single use
199201780	SENSORANORDNUNG ZUR ERFASSUNG VON FINGERABDRUECKEN UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	dual use
199201791	VORRICHTUNG ZUM KUEHLEN EINER IN EINEM GEHAEUSE ANGEORDNETEN ELEKTRONISCHEN SCHALTUNGSANORDNUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 39 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte**



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199201792	SCHALTSTUFE IN STROMSCHALTERTECHNIK	single use
199201855	SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL MIT SINUSFOERMIGER STROMAUFNAHME	single use
199201856	ZEICHENSATZ FUER TELETEXT	single use
199201877	VERFAHREN ZUM ANZEIGEN VON AUS VIDEOTEXTSIGNALEN GEWONNENEN INFORMATIONEN AUF EINEM BILDSCHIRM UND VORRICHTUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199201881	SPANNUNGSGESTEUERTER MIKROWELLEN-OSZILLATOR	single use
199201886	MIKROPROZESSOR MIT EINER INTEGRIERTEN BUSSTEUEREINHEIT	single use
199201887	BIGMOS-OPERATIONSVERSTAERKER UND SEINE VERWENDUNG	single use
199201888	DIREKTIONALER OPTISCHER SENDE- UND EMPFANGSMODUL	single use
199201895	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SEITLICH BEGRENZTEN, EINKRISTALLINEN GEBIETES MITTELS SELEKTIVER EPITAXIE UND DESSEN ANWENDUNG ZUR HERSTELLUNG EINES BIPOLARTRANSISTORS SOWIE EINES MOS-TRANSISTORS	single use
199201903	TRISTATE-FAEHIGE TREIBERSCHALTUNG	single use
199201911	VERFAHREN UND DATENTRAEGERANORDNUNG ZUR ECHTHEITSERKENNUNG VON SPEICHERCHIPS	single use
199201912	GTO-THYRISTOR	dual use
199201916	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SYNCHRONISIERUNG EINES SIGNALGENERATORS AUF EIN EXTERNES TAKTSIGNAL	single use
199201919	BIPOLARER HOCHFREQUENZTRANSISTOR	single use
199201935	VORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON BAUELEMENTEN UNTER VERWENDUNG EINES ADAPTERS	single use
199203428	POSITIVRESIST	single use
199203723	MAGNETOWIDERSTANDS-SENSOR MIT VERKUERZTEN MESSSCHICHTEN	dual use
199204011	OPTISCHER SCHALTER	single use
199204138	ZENTRIERHUELSE	single use
199204139	KOPPLUNGSTEIL	single use
199205301	LEITUNGSABSCHLUSS EINER TELEFONLEITUNG	single use
199205302	DIGITAL-ANALOG-WANDLER MIT GEWICHTETEM KAPAZITIVEN WANDLERNETZWERK	single use
199205303	SYNCHRONISIERBARER OSZILLATOR	single use
199205304	INTEGRIERBARER NULLPUNKTDETEKTOR	single use
199207433	EFFRATORY METAL CAPPED LOW RESISTIVITY METAL CONDUCTOR LINES AND VIAS	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 40 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199207434	ZAS FUSE FOR REDUCED BLOW-CURRENT REQUIREMENTS	single use
199207437	PRINTED CIRCUIT BOARD FOR MOUNTING SEMICONDUCTORS AND OTHER ELECTRONIC COMPONENTS	single use
199207478	METHOD OF MAKING A CONDUCTIVE CONTACT ON A SEMICONDUCTOR BODY	single use
199207510	PROCESS FOR THE MANUFACTURE OF A HIGH DENSITY CELL ARRAY OF GAIN MEMORY CELLS	single use
199207513	A DECODED-SOURCE SENSE AMPLIFIER WITH SPECIAL COLUMN SELECT DRIVER VOLTAGE	single use
199207515	SIGNAL SENSING CIRCUITS FOR MEMORY SYSTEM USING DYNAMIC GAIN MEMORY	single use
199208010	ADAPTIVES NICHTREKURSIVES DIGITALFILTER.	single use
199208011	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BEWEGUNGSVEKTORGESTUETZTEN FLIMMERREDUKTION BEI EINEM FERNSEHEMPFÄNGER	single use
199208015	HALBLEITERSPEICHER	single use
199208025	HALBLEITERANORDNUNG MIT MEHREREN HALBLEITERKÖRPERN	single use
199208029	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON CPM (CONTINUOUS PHASE MODULATION)-SIGNALEN	dual use
199208051	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES ALUMINIUM-DOTIERUNGSPROFILS	single use
199208058	PROGRAMMIERBARE LOGISCHE SCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199208068	INTEGRIERT-OPTISCHE ANORDNUNG ZUR UMWANDLUNG EINER OPTISCHEN WELLE RELATIV KLEINEREN QUERSCHNITTS IN EINE OPTISCHE WELLE RELATIV GRÖßEREN QUERSCHNITTS	single use
199208073	SCHALTER FÜR LICHTLEITER	single use
199208077	SCHALTUNGSANORDNUNG IN EINER INTEGRIERTEN HALBLEITERSCHALTUNG	single use
199301007	GERÄT ZUM VERARBEITEN VON IN ZEILEN AUFGETEILTEN VIDEOSIGNALEN MIT EINER EINRICHTUNG ZUM ERKENNEN DER ART DER VIDEOSIGNALQUELLE	single use
199301008	VERFAHREN UND DATENTRAGERANORDNUNG ZUR ECHTHEITSERKENNUNG VON SPEICHERCHIPS	dual use
199301009	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KONTAKTE UND DIESE VERBINDENDE LEITERBAHNEN UMFASSENDE METALLISIERUNGSEBENE	single use
199301015	INTEGRIERBARE STROMQUELLENSCHALTUNG	single use
199301016	STECKVERBINDERANORDNUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 41 von 156

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte****Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.**

199301034	VERFAHREN ZUM BEGRENZEN DER FREQUENZ EINES SPANNUNGSGESTEUERTENOSZILLATORS IN EINER STEUERSCHALTUNG EINES RESONANZWANDLER-SCHALTNETZTEILS UND STEUERSCHALTUNG FUER EIN RESONANZWANDLER-SCHALTNETZ-TEIL	single use
199301035	VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR TAKTGEWINNUNG UND ZEITBASIS KORREKTUR BEI EINEM SYSTEM ZUR BILDSPEICHERGESTUETZTEN WIEDERGABE VON VIDEO-SIGNALEN	single use
199301041	ANSTEUERSCHALTUNG FUER EIN MOS-HALBLEITERBAUELEMENT MIT SOURCE-SEITIGER LAST	single use
199301043	VERFAHREN ZUR SYNCHRONISIERUNG EINES SIGNALGENERATORS AUF EIN EXTERNES TAKTSIGNAL UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DESSELBEN	dual use
199301044	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN SCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199301045	MULTIPLEXERANORDNUNG IN STROMSCHALTERTECHNIK	single use
199301053	INTEGRIERT OPTISCHE ANORDNUNG AUS RIPPENWELLENLEITERN AUF EINEM SUBSTRAT	single use
199301064	MOSFET MIT TEMPERATURSCHUTZ	single use
199301066	FREILAUFDIODE FUER EINEN GTO-THYRISTOR	single use
199301070	SPALTEN-REDUNDANZ-SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN SPEICHER	single use
199301094	VERFAHREN ZUR ERHOEHUNG DER SPANNUNGSFESTIGKEIT EINES MEHR-SCHICHTIGEN HALBLEITERBAUELEMENTS	single use
199301156	VERFAHREN ZUR LICHTINDUZIERTEN BEHANDLUNG EINER OBERFLAECHE EINES SUBSTRATS	single use
199301165	LEISTUNGS-MOSFET	single use
199301181	DRUCKSENSOR	single use
199301182	BESCHLEUNIGUNGSSENSOR	single use
199301198	ZWEIDRAHT-EIN-AUS-SCHALTER	single use
199301201	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG STABFOERMIGER SILIZIUMSTRUKTUREN	single use
199301206	TUNNELEFFEKT-BESCHLEUNIGUNGSSENSOR	single use
199301207	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON TUNNELEFFEKT-SENSOREN	single use
199301214	SENDER-/EMPFANGERANORDNUNG FUER HOEHERE FREQUENZEN	single use
199301217	VORRICHTUNG ZUR INFERENZBILDUNG UND DEFUZZIFIKATION UND IHRE VERWENDUNG IN EINEM HOCHAUFLOESENDEN FUZZY-LOGIC-COPROZESSOR.	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.CPC IC
Seite 42 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte****Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.**

199301220	DIFFRAKTIVE OPTISCHE EINRICHTUNG ZUR OPTISCHEN ABBILDUNG EINES RAUMPUNKTES AUF ANDERE RAUMPUNKTE	single use
199301231	EINRICHTUNG ZUM DARSTELLEN EINES ERSTEN BILDES UND EINES ZWEITENBILDES AUF EINEM BILDSCHIRM	single use
199301251	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR UEBERWACHUNG DER VERSORGUNGSSPANNUNG EINER PROZESSOREINHEIT	dual use
199301252	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM SCHUTZMITTEL	single use
199301258	KONTAKTSTRUKTURIERUNG FUER VERTIKALE CHIPVERBINDUNGEN	single use
199301259	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HALBLEITERBAUELEMENTS MIT STROM-ANSCHLUESSEN FUER HOHE INTEGRATIONSDICHTEN	single use
199301260	HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER VERTIKAL KONTAKTIERTE HALBLEITERBAU-ELEMENTE	single use
199301263	LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT PUFFERSCHICHT	dual use
199301268	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN EINER PSEUDOZU-FALLS FOLGE SOWIE DEREN VERWENDUNG	dual use
199301269	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ENTWERTEN EINER DEBIT-KARTE	dual use
199301271	MOS-HALBLEITERBAUELEMENT	single use
199301282	HALBLEITERBAUELEMENT MIT PASSIVIERUNGSSCHICHT	single use
199301294	BIDIREKTIONALE OPTISCHE SENDE- UND EMPFANGSANORDNUNG.	single use
199301300	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER PYRODETEKTORANORDNUNG.	single use
199301301	MIKROMECHANISCHES BAUTEIL UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG	single use
199301305	VERFAHREN ZUR AUTHENTIFIKATION ZWISCHEN ZWEI ELEKTRONISCHEN EINRICHTUNGEN	dual use
199301308	VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES BUSSYSTEMS SOWIE ANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	dual use
199301309	HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER LATERALEN BIPOLARTRANSISTOR	single use
199301310	VERFAHREN ZUR VEREINZELUNG VON CHIPS AUS EINEM WAFER	single use
199301311	VERFAHREN ZUM ANISOTROPEN AETZEN EINER ALUMINIUMHALTIGEN SCHICHT UND VERWENDUNG EINER HIERZU GEEIGNETEN AETZGASMISCHUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.CPC IC
Seite 43 von 156

D:BARRY E. BRETSCHEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199301346	VERFAHREN ZUR WOLFRAM-KONTAKTLOCHAUFFUELLUNG DURCH GANZFLECHIGEWOLFRAM-ABSCHIEDUNG MIT REDUZIERTER SCHICHTDICKE UND RUECKAETZUNG MIT INVERSEM LOADING-EFFEKT	single use
199301357	QUASIRESONANZWANDLER-SCHALTNETZTEIL	single use
199301362	VERFAHREN ZUR SCHNELLEN INFERENZBILDUNG IN EINEM FUZZY-LOGIC-PROZESSOR	single use
199301367	ZF-VERSTAERKER FUER EINEN SATELLITEN-EMPFAENGER	single use
199301369	OSZILLATOR-DEMODULATOR-ANORDNUNG FUER EINEN INDUKTIVEN NAEHERUNGS-SCHALTER MIT MEHREREN SCHALTPUNKTEN	single use
199301370	VORRICHTUNG ZUR DIREKTEN VERARBEITUNG VON LINGUISTISCHEN NICHT-UND ODER-OPERATOREN IN EINEM FUZZY-INFERENCE-PROZESSOR	single use
199301371	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ISOLATIONSGRABENS IN EINEM SUBSTRAT FUER SMART-POWER-TECHNOLOGIEN	single use
199301372	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ISOLATIONSGRABENS IN EINEM SUBSTRAT FUER SMART-POWER-TECHNOLOGIEN.	single use
199301383	DIGITALE SCHALTSTUFE MIT STROMSCHALTER	single use
199301384	LEITUNGSTREIBERSCHALTSTUFE IN STROMSCHALTERTECHNIK	single use
199301399	STANDBY-SCHALTUNG FUER ELEKTRISCHE VERBRAUCHER	single use
199301401	HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER LATERALEN BIPOLARTRANSISTOR	single use
199301402	HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER LATERALE BIPOLARTRANSISTOREN	single use
199301403	HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER LATERALEN BIPOLARTRANSISTOR	single use
199301408	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN RINGOSZILLATOR	single use
199301417	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES GRABENS IN EINEM SUBSTRAT UNDESSEN VERWENDUNG IN DER SMART-POWER-TECHNOLOGIE	single use
199301439	ANORDNUNG ZUR AUSWERTUNG EINES HALL-SENSORS	single use
199301452	SPANNUNGSERZEUGUNGSSCHALTUNG	single use
199301454	AUSGANGSSTUFE FUER DIGITALE STROMSCHALTER	single use
199301455	LADUNGSPUMPE	single use
199301456	VERFAHREN ZUR ABSCHIEDUNG EINER SCHICHT AUF EINER SUBSTRATSCHIED DURCH SPUTTERN DURCH VERWENDUNG EINES KOLLIMATORS	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 44 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte****Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.**

199301461	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HALBLEITERSCHICHTAUFBAUS MIT PLANARISIERTER OBERFLÄCHE UND DESSEN VERWENDUNG BEI DER HERSTELLUNG EINES BIPOLARTRANSISTORS SOWIE EINES DRAM	single use
199301479	PHASENREGELANORDNUNG	single use
199301483	EINRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN SIGNAL-UND ENERGIEUEBERTRAGUNG	dual use
199301492	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FESTSTELLUNG DES VORHANDENSEINS ODER NICHTVORHANDENSEINS MINDESTENS EINER FREQUENZ BEKANNTEN WERTES IN EINEM AUS MEHREREN FREQUENZEN ZUSAMMENGESETZTEN EINGANGSSIGNALS	single use
199301495	DOPPLERRADARMODUL IN MIKROSTREIFENTEILUNGSTECHNIK	single use
199301496	LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT MIT DRUCKKONTAKT	dual use
199301497	SIGNALVERARBEITUNGSEINRICHTUNG	dual use
199301502	INTEGRIERTE LEISTUNGSSTUFE	single use
199301504	CHIPKARTENMODUL	single use
199301512	VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN EINES OPTISCHEN KOPPELMEDIUMS	single use
199301514	DUENNFILMTRANSISTOR UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
199301527	VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES Busses UND BussSYSTEM ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199301542	ANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG VON BILDSCHIRMSTEUERSIGNALEN FÜR AM BILDSCHIRM DASTELLBARE ZEICHEN	single use
199301543	VERFAHREN ZUM AQUIRIEREN VON TELETEXTDATEN	single use
199301565	MESSVORRICHTUNG FÜR DIE TREPPENSTUFEN-VOLTAMETRIE	single use
199301570	SWITCHED-CAPACITOR-NETZWERK	single use
199301571	SWITCHED-CAPACITOR-NETZWERK	single use
199301572	DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM	dual use
199301590	VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN SPRACHRICHTUNGSUMSCHALTUNG UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	dual use
199301591	STROMSPIEGEL	single use
199301592	STROMSPIEGEL	single use
199301593	STROMSPIEGEL	single use
199301594	GEGENTAKTENDSTUFE MIT EINER EINSTELLUNG DES QUERSTROMS DER GEGEN-TAKTENDSTUFE	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 45 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199301597	LICHTWELLENLEITERVERZWEIGUNGSANORDNUNG	single use
199301605	HERSTELLVERFAHREN FUER EIN BITLEITUNGSKONTAKTLOCH EINER SPEICHER-ZELLE	single use
199301621	VERFAHREN ZUR KONTAKTLOCHAUFFUELLUNG IN EINEM HALBLEITERSCHICHT-AUFBAU	single use
199301626	BICMOS-OPERATIONSVERSTAERKER FUER SCHALTER-KONDENSATOR-SCHALTUNGEN	single use
199301630	SENDE- UND EMPFANGSMODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE OPTISCHE MEHR-KANAL-UEBERTRAGUNG	single use
199301631	SENDE- UND EMPFANGSMODUL MIT TEMPERATURSTABILISierter SENDEWELLEN-LAENGE	single use
199301644	VERFAHREN ZUR BESCHLEUNIGTEN REGELAUSWERTUNG IN EINEM FUZZY-IN-FERENCE-PROZESSOR UND VORRICHTUNG ZU DESSEN DURCHFUEHRUNG.	single use
199301645	ANORDNUNG ZUR REGELDEKODIERUNG UND REGELAUSWERTUNG FUER EINENFUZZY-IN-FERENCE-PROZESSOR MIT HOHER AUFLUESUNG.	single use
199301649	INTEGRIERTE MIKROMECHANISCHE SENSORVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUDEREN HERSTELLUNG	single use
199301660	OPTOKOPPLER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
199301666	DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM	dual use
199301677	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ISOLATIONSGRABENS IN EINEM SOILSUBSTRAT	single use
199301678	MIKROMECHANISCHEN VORRICHTUNG UNDVERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use
199301713	VERFAHREN ZUR NASSCHEMISCHEN AETZEN EINES HALBLEITERSUBSTRATS	single use
199301714	VORRICHTUNG ZUM UMHUELLEN EINES HALBLEITERBAUELEMENTS UND EINERDAMIT VERBUNDENEN WAERMESENKE MIT KUNSTSTOFFEN	single use
199301717	PROZESSOR ZUM VERGLEICH VON BILDPUNKT-BLOECKEN (BLOCK-MATCHING-PROZESSOR)	single use
199301718	ANORDNUNG ZUM RAEUMLICHEN TRENNEN UND EMPFANGEN MEHREREROPTISCHER WELLENLAENGEN	single use
199301719	HALTEVORRICHTUNG FUER EINE HORDE ZUR AUFNAHME VON HALBLEITER-SCHEIBEN	single use
199301724	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BEGRENZUNG DER AUSGANGSSPANNUNG EINESGETAKTETEN SPANNUNGSREGLERS	dual use
199301729	EINRICHTUNG MIT EINEM FOKUSSIERENDEN OPTISCHEN GITTER ZUMMULTIPLEXEN UND/ODER MULTIPLEXEN SOWIE EIN VERFAHREN ZURERZEUGUNG EINES SOLCHEN GITTERS UND ZUM BETRIEB EINER SOLCHENEINRICHTUNG	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 46 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199301731	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES INTEGRIERTEN SCHALTKREISES	single use
199301748	SCHALTUNGSSTRUKTUR MIT MINDESTENS EINEM BIPOLAREN LEISTUNGS-BAUELEMENT UND VERFAHREN ZU DEREN BETRIEB	single use
199301749	KUEHLKOERPER MIT INTEGRIERTER BEFESTIGUNG	single use
199301755	KONDENSATORANORDNUNG UND HERSTELLVERFAHREN DAFUER.	single use
199301757	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FLIMMERREDUZIERUNG BEI FERNSEHGERAETEN	single use
199301778	INTEGRIERTE KOMPARATORSCHALTUNG	single use
199301782	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONTAKTLOCHS ZU EINEM DOTIERTENBEREICH	single use
199301783	ANORDNUNG ZUM ERWAERMEIN EINES BONDSTELLE BEIM GOLDDRAHT-THERMO-SONIC WIREBONDEN	single use
199301784	RINGOSZILLATOR	single use
199301786	HALBLEITER-MODUL	single use
199301789	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS EINEM LEISTUNGSBAU-ELEMENT UND NIEDERSpannungSELEMENTEN	single use
199301808	SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL	single use
199301809	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR SYNCHRONEN TAKTERZEUGUNG WENIGSTENS ZWEIERTAKTSIGNALE	single use
199301813	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR DATENUEBERTRAGUNG	dual use
199301814	VERFAHREN ZUR AUTHENTIFIZIERUNG EINES SYSTEMTEILS DURCH EINANDERES SYSTEMTEIL EINES INFORMATIONENUEBERTRAGUNGSSYSTEMS NACHDEM CHALLENGE-AND-RESPONSE-PRINZIP	dual use
199301818	HERSTELLVERFAHREN FUER EINE AUS SILIZID BESTEHENDE ANSCHLUSS-FLAECHE FUER EIN SILIZIUMGEBIET	single use
199301829	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES SYMMETRISCHEN AUSGANGS-TAKTSIGNALS	single use
199301830	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS EINEM MOS-TRANSISTOR	single use
199301834	ESD-SCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN	single use
199301835	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199301836	VERSTAERKERSTUFE	single use
199301837	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS EINEM CMOS-NAND-GATTER UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 47 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199301838	STEUERBARES LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT PUFFERZONE UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG.	single use
199301841	VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERHINDERN EINER UNBERECHTIGTENDATENAENDERUNG BEI EINEM NICHTFLUECHTIGEN SPEICHER	dual use
199301847	SCHNELLE LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENTE	single use
199301849	VOLLADIERSTUFE U. VERWENDUNG	single use
199301850	VERFAHREN ZUR AUTHENTIFIKATION ZWISCHEN EINEM MOBILEN DATEN-TRAEGER UND EINER STATIONAEREN DATENSTATION	dual use
199301872	OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
199301873	SENDE-UND EMPFANGSMODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE OPTISCHENACHRICHTEN- UND SIGNALUEBERTRAGUNG	single use
199301881	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT KONDENSATOREN GENAU DEFINIERTER KAPAZITAET	single use
199303346	TEMPERATURSENSOR MIT EINEM P-N-UEBERGANG	dual use
199304007	OPTISCHE VERBINDERANORDNUNG	single use
199304016	AUFNAHMEANORDNUNG FUER EIN KABEL-ENDSTUECK	single use
199304017	ELEKTRO-OPTISCHES MODUL	single use
199304029	OPTISCHES VERBINDUNGSKABEL	single use
199304030	OPTISCHES KOPPELTEIL	single use
199304047	KOPPLUNGSANORDNUNG	single use
199304097	OPTISCHER STECKVERBINDER UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES OPTISCHEN STECK-VERBINDERS.	single use
199304117	STECKVERBINDER	single use
199304142	ELEKTRISCHE BAUGRUPPE	single use
199304152	VERZWEIGUNGSEINRICHTUNG UND VERF. ZUM HERSTELLEN EINER VERZWEIGUNG EINES MEHRADRIGEN LWL-KABELS.	single use
199304157	ELEKTROOPTISCHES MODUL	single use
199304158	ELEKTROOPTISCHES MODUL	single use
199305301	STROMQUELLENANORDNUNG	single use
199305302	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG ZWEIER KOMPLEMENTAERER SIGNALE	single use
199305303	STROMQUELLENANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG MEHRFACHER REFERENZSTROEME	single use
199305304	VERFAHREN ZUM SCHALTEN EINER MEHRZAHL VON EINEM VORGEGEBENEN UEBERTRAGUNGSVERHALTEN ABWEICHENDER ELEMENTE	single use
199305305	MOS-SCHALTSTUFE	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 48 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199305306	PROZESSORSCHALTUNG MIT TESTEINRICHTUNG	single use
199305307	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINER LEITUNGSABSCHLUSSIMPEDANZ	dual use
199307406	FORMATION OF SILICIDED JUNCTIONS IN DEEP SUB-MICRON MOSFETS BY DEFECT ENHANCED COSI2 FORMATION	single use
199307420	TRANSISTOR ISOLATION PROCESS	single use
199307422	METHOD OF DEFECT DETERMINATION AND DEFECT ENGINEERING ON PRODUCT WAFERS OF ADVANCED SUBMICRON TECHNOLOGIES	single use
199307424	HIGH-VOLTAGE, VERTICAL-TRENCH SEMICONDUCTOR DEVICE	single use
199307425	A PEDESTAL LEAD FRAME FOR SUPPORTING A SEMICONDUCTOR CHIP	single use
199307428	A REVERSE FIELD PLATE JUNCTION-TERMINATING STRUCTURE	single use
199307461	SILICON CONTROLLED RECTIFIER WITH A VARIABLE BASE-SHUNT RESISTANCE	single use
199307468	MONOLITHIC, MULTIPLE-CHANNEL OPTICAL COUPLER	single use
199307477	OPTICALLY-COUPLED DIFFERENTIAL LINE RECEIVER	single use
199307478	OPTICALLY-COUPLED DIFFERENTIAL LINE DRIVER	single use
199307479	MONOLITHIC OPTICAL EMITTER-DETECTOR	single use
199307480	LINEAR BIDIRECTIONAL OPTOCOUPLER	single use
199307491	MOSFETS WITH IMPROVED SHORT CHANNEL EFFECTS AND METHOD OF MAKING THE SAME	single use
199308001	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN EINER PSEUDOZUFALLS FOLGE SOWIE DEREN VERWENDUNG	dual use
199308013	MIKROELEKTRONISCHE SCHALTUNGSSTRUKTUR UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use
199308031	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG FÜR EIN FERNSEHGERÄT ZUR VERMINDERUNG DES FLIMMERNS	single use
199308036	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SANFTEN ABSCHALTEN EINES FET-HALBLEITER-BAUELEMENTES BEI ÜBERSTROM	single use
199308056	GEWINNGEKOPPELTE LASERDIODE	single use
199308062	GERÄT FÜR CMOS-LOGIKFAMILIE FÜR GEMISCHT ANALOG-DIGITALE ANWENDUNGEN.	single use
199308065	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SUSPENDED GATE FIELDEFFECT TRANSISTORS	single use
199308504	AMORPHER WASSERSTOFFHALTIGER KOHLENSTOFF	single use
199308544	STRAHLUNGSEMPFINDLICHE LACKZUSAMMENSETZUNG	single use
199308554	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES SILIZIUM-HALBLEITERSUBSTRATS MIT INTEGRIERTEM WELLENLEITER UND DARAN ANGEKOPPELTER OPTISCHER FASER	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 49 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199401004	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SCHICHT MIT REDUZIERTEN MECHANI-SCHEN SPANNUNGEN	single use
199401007	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR EINBINDUNG ANALOGER SIGNALE AN EINEN BOUNDARY-SCAN-PRUEFVERFAHREN	single use
199401013	OPTISCHE ANORDNUNG AUS STREIFENFOERMIGEN OPTISCHEN WELLENLEITERN	single use
199401014	VORRICHTUNG FUER REVERSIBLE CHIPKONTAKTIERUNG	single use
199401015	TESTVERFAHREN FUER HALBLEITERSCHALTUNGSEBENEN	single use
199401016	VERFAHREN ZUM FUELLEN VON KONTAKTLOECHERN	single use
199401017	INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERSCHALTUNG UND VERFAHREN ZU IHREMBETRIEB	single use
199401018	INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG UND VERFAHREN ZU IHREMBETRIEB	single use
199401023	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN SCHALTUNGSAN-ORDNUNG	single use
199401027	TUNNELEFFEKT-SENSOR	dual use
199401028	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BESCHLEUNIGUNGSSENSORS	single use
199401032	ABSTIMMBARE LASERDIODE	single use
199401033	MIKROELEKTRONISCHE BAUELEMENT	single use
199401038	LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT MIT TEMPERATURSENSOR	single use
199401061	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM MODULAREN TESTEN	single use
199401062	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KUBISCH INTEGRIERTEN SCHALTUNGS-ANORDNUNG	single use
199401064	HALBLEITER-SPEICHERBAUTEIL MIT MEHREREN SPEICHERCHIP IN EINERGEMEINSAMEN UMHUELLUNG	single use
199401065	OSD-ZEICHENSATZ FUER BILD-IM-BILD-BAUSTEINE	single use
199401066	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG PULSWEITEN MODULIERTER SIGNALE UND ZUR MESSUNG VON IMPULSFLANKENABSTAENDEN	single use
199401067	SCHALTNETZTEIL FUER STROMSPARENDEN STAND-BY-BETRIEB	single use
199401078	ANORDNUNG ZUR GESONDERTEN BEHANDLUNG VON FUZZY-REGELN MIT UNTER-SCHIEDLICHER WICHTIGKEIT	single use
199401080	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES EINEM GRABEN BENACHBARTEN DIFFUSIONS GEBIETES IN EINEM SUBSTRAT	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 50 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199401081	INTEGRIERT OPTISCHE ANORDNUNG ZUR UNI- UND/ODER BIDIREKTIONALOPTISCHEN SIGNALUEBERTRAGUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINESCHICHTSTRUKTUR EINES DFB-WASERS UND EINES OPTISCH AN DIESESCHICHTSTRUKTUR GEKOPPELTEN OPTISCHEN WELLENLEITERS	single use
199401082	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN SCHALTUNGSAN-ORDNUNG	single use
199401097	VERFAHREN ZUR PLASMAUNTERSTUETZTEN RUECKSEITENAETZUNG EINERHALBLEITERSCHEIBE BEI BELACKUNGSFREIER SCHEIBENVORDERSEITE	single use
199401113	SELBSTPROGRAMMIERENDE SCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199401121	OPTISCHER SENDER FUER DIE OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK	single use
199401130	HALBLEITERBAUELEMENT FUER DEN UEBERSPANNUNGSSCHUTZ VON MOSFET UNDIGBT	single use
199401133	SCHALTNETZTEIL MIT INFORMATIONSMUEBERTRAGUNG VON DER PRIMAERSEITEZUR SEKUNDAERSEITE	single use
199401134	SCHALTNETZTEIL MIT SINUSFOERMIGER STROMAUFNAHME	single use
199401142	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES DIGITALEN SINUSSIGNALES MIT EINERVORGEGEBENEN ABTASTRATE UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNGDES VERFAHRENS	dual use
199401143	VERFAHREN ZUM ANSTEUERN EINES UMRICHTERS UND ANORDNUNG ZUR DURCH- FUEHRUNG DES VERFAHRENS	dual use
199401165	SCHLUESSELLOSE ZUGANGSKONTROLLEINRICHTUNG	single use
199401170	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BILDUNG VON ZUGEHORIGKEITSFUNKTIONSWERTENLINGUISTISCHER ZWISCHENWERTE	single use
199401182	VERLUSTARME INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT REDUZIERTEM TAKTHUB	single use
199401189	LEISTUNGSDIODE	dual use
199401197	HALBLEITERBAUELEMENT MIT ANODENSEITIGER GETTERUNG	dual use
199401205	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES HALBLEITERBAUELEMENTES FUER VER-TIKALE INTEGRATION UND VERWENDUNG FUER TEST-ZWECKE	single use
199401218	OPTISCHER WELLENLAENGENKONVERTER	single use
199401222	VERFAHREN ZUM RUECKSEITEN-DUENNEN VON STRUKTURIERTEN SILIZIUM-WAFERN	single use
199401225	INTEGRIERTE TREIBERSCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN INDUKTIVESTASTELEMENT	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 51 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199401226	VERFAHREN ZUM UEBERTRAGEN UND EMPFANGEN VON AN EINEM BILDSCHIRMDARSTELLBAREN VIDEOSIGNALEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199401268	CHIPKARTE	single use
199401271	MIKROSYSTEM MIT INTEGRIERTER SCHALTUNG UND MIKROMECHANISCHEMBAUTEIL UND HERSTELLVERFAHREN	single use
199401272	MIKROMECHANISCHES BAUTEIL MIT EINER DIELEKTRISCHEN BEWEGLICHENSTRUKTUR, MIKROSYSTEM UND HERSTELLVERFAHREN	single use
199401273	MIKROMECHANISCHES BAUTEIL MIT EINEM SCHALTELEMENT ALS BEWEGLICHERSTRUKTUR, MIKROSYSTEM UND HERSTELLVERFAHREN	single use
199401278	VERFAHREN ZUR FUZZIFIZIERUNG VON AN EINGAENGEN EINES FUZZYPRO-ZESSORS ANLIEGENDEN EINGANGSSIGNALEN UNTER VERWENDUNG VON EINGANGSZUGEHORIGKEITSFUNKTIONEN	single use
199401283	PHASENREGELKREIS	single use
199401292	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES MOS-HALBLEITERBAUELEMENTS	single use
199401296	HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER MOSFETS MIT LDD 94P1296DE	single use
199401320	HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER MOSFETS MIT LDD 94P1296DE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES REFERENZSTROMS	single use
199401326	GAIN CELL DRAM STRUKTUR UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG	single use
199401329	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM TEILEN EINES TAKTSIGNALS	single use
199401347	BIPOLARTRANSISTOR UND HERSTELLUNGSVERFAHREN	single use
199401348	THERMISCHER SENSOR/AKTUATOR IN HALBLEITERMATERIAL	single use
199401353	FREQUENZVERAENDERBARE OSZILLATORANORDNUNG	single use
199401387	SCHALTNETZTEIL MIT NIEDRIGER VERLUSTLEISTUNG IM STANDBY-BETRIEBS-ZUSTAND	single use
199401397	ELEKTRONISCHES BERUEHRUNGSLOSES DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM	single use
199401403	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BEGRENZUNG DER AUSGANGSSPANNUNG EINESGETAKTETEN SPANNUNGSREGLERS	single use
199401417	EINRICHTUNG ZUR RAEUMLICHEN TRENNUNG UND/ODER ZUSAMMENFUEHRUNGOPTISCHER WELLENLAENGENKANAELE	single use
199401441	VERFAHREN ZUR HIERARCHISCHEN LOGIK-VERIFIKATION HOCHINTEGRIERTERSCHALTUNGEN	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 52 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199401443	KRYPTO-SCHALTKREIS	dual use
199401444	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN SCHALTUNGSAN-ORDNUNG	single use
199401445	MODULKARTE	single use
199401448	INTEGRIERTES LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT MIT SCHUTZSTRUKTUR	single use
199401451	GERAET ZUR VERARBEITUNG VON VIDEOSIGNALEN MIT EINER TELETEXT-VERARBEITUNGSEINRICHTUNG	single use
199401458	VERSTAERKERANORDNUNG FUER HOCHFREQUENZSIGNALE	single use
199401460	VERSTAERKERANORDNUNG UND EMPFAENGERSCHALTUNG, DIE DIE VERSTAERKER-ANORDNUNG ENTHAELT	dual use
199401463	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MOS-TRANSISTOREN UND BIPOLAR-TRANSISTOREN AUF EINER HALBLEITERSCHEIBE	single use
199401474	SCHALTUNGSANORDNUNG, INSBESONDERE FUER DIGITALE MODULATIONSEUNI-RICHTUNGEN	dual use
199401475	SCHALTUNGSSTRUKTUR MIT MINDESTENS EINEM FELDEFFEKTGESTEUERTENBAUELEMENT UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use
199401476	SCHALTUNGSANORDNUNG FUER IF-SAMPLINGSYSTEME	dual use
199401491	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR CODIERUNG UND DEKODIERUNGVON ZUSATZINFORMATUON IN EINEM DIGITALEN SIGNAL	dual use
199401492	OSZILLATORVERSTAERKER MIT EINER AMPLITUDENREGELUNG	single use
199401517	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR STOERSIGNALUNTERDRUECKUNG	single use
199401521	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR UMSETZUNG EINER EINGANGS-BILDFOLGE AUF EINE AUSGANGS-BILDFOLGE MIT ZEILENRASTERABHAENGIGERBILDVERARBEITUNG	single use
199401522	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ZWISCHENFREQUENZDEMODULATION	single use
199401523	DEFUZZIFIKATIONS-VORRICHTUNG FUER EINEN HOCHAUFLOESENDENFUZZY-LOGIC-CONTROLLER.	single use
199401540	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN SCHALTUNGSAN-ORDNUNG	single use
199401551	BIPOLARE KASKADIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR SIGNALBEGRENZUNGUND FELDSTAERKEDETEKTION	single use
199401559	HALBLEITERBAUELEMENT MIT PASSIVIERUNGSSCHICHT	single use
199401560	HALBLEITERBAUELEMENT MIT ISOLIERENDEM GEHAEUSE	dual use
199401561	REDUNDANZ-SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN INTEGR-ERTEN HALBLEITER-SPEICHER	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 53 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199401564	ANSTEUERSCHALTUNG FUER EIN FELDEFFEKTGESTEUERTES LEISTUNGS-HALB-LEITERBAUELEMENT	dual use
199401574	HALBLEITERBAUELEMENT MIT ZWEI MONOLITHISCH INTEGRIERTEN SCHALT-ELEMENTEN UND EINEM VERGRABENEN STRUKTURIERTEN STEUER GEBIET	single use
199401575	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BILD-IM-BILD-EINBLENDUNG	single use
199401576	VERFAHREN ZUR FEHLERRUECKVERFOLGUNG	single use
199401577	PHASENREGELKREIS	single use
199401590	VERFAHREN ZUR DECODIERUNG KOMPRIMIERTER VIDEO-DATEN MIT REDUZIER-TEM SPEICHERBEDARF	dual use
199401618	VERFAHREN ZUR REINIGUNG DER RUECKSEITE VON CHIPS	single use
199401630	CHIPKARTENMODUL FUER KONTAKTLOSE CHIPKARTEN UND VERFAHREN ZUSEINER HERSTELLUNG	single use
199401631	SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM CHIPKARTENMODUL UND EINER DAMITVERBUNDENEN SPULE	single use
199401635	TRAEGERELEMENT	single use
199401647	VERFAHREN ZUR RUECKSEITENAETZUNG EINER MIT SILIZIUMDIOXIDBESCHICHTETEN HALBLEITERSCHEIBE MIT FLUORWASSERSTOFFGAS	single use
199401656	INTEGRIERTE SCHALTUNGSSTRUKTUR MIT EINEM AKTIVEN MIKROWELLENBAU-ELEMENT UND MINDESTENS EINEM PASSIVEN BAUELEMENT.	single use
199401678	VERFAHREN ZUR PLANARISIERENDEN SPUTTERABSCHIEDUNG EINER ALUMINIUM-HALTIGEN SCHICHT BEI DER HERSTELLUNG INTEGRIERTER SCHALTUNGEN	single use
199401682	VERFAHREN ZUR VERMEIDUNG DER RE-DEPOSITION VON AETZPRODUKTEN AUF SUBSTRATOBERFLAECHEN WAEREND DES WOLFRAM-RUECKAETZPROZESSES BEIDER HERSTELLUNG HOCHINTEGRIERTER SCHALTUNGEN	single use
199401692	JUSTIERANORDNUNG ZUM JUSTIEREN ZWEIER MIKROOPTISCHER ZEILENBAU-TEILE UND KOPPELANORDNUNG ZUM OPTISCHEN KOPPELN ZWEIER MIKROOP-TISCHER ZEILENBAUTEILE	single use
199401693	DOPPELBRECHUNGSARMER PLANARER OPTISCHER WELLENLEITER UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG	single use
199401694	CHIPKONFIGURATION UND VERWENDUNG EINES ENTSPRECHENDEN CHIPS	single use
199401700	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES NIEDEROHMIGEN KONTAKTES ZWISCHENEINER METALLISIERUNGSSCHICHT UND EINEM HALBLEITERMATERIAL	single use
199401711	AUSLESESCHALTUNG FUER EINEN KAPAZITIVEN SENSOR.	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 54 von 186

O: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199401719	FESTWERT-SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HER-STELLUNG	single use
199401724	ADAPTIVES NETZWERK	single use
199401726	LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT MONOLITHISCH INTEGRIERTER SEN-SORANORDNUNG SOWIE SEINE HERSTELLUNG UND VERWENDUNG	dual use
199401727	LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT MONOLITHISCH INTEGRIERTEM MESS-WIDERSTAND UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG.	dual use
199401731	VERFAHREN ZUM FREILEGEN EINER OBEREN STEGFLAECHE EINES AUF DER OBERFLAECHE EINES SUBSTRATS AUSGEBILDETEN UND MIT EINEM MATERIALUMFORMTEN SCHMALEN STEGES IM MIKROMETERBEREICH UND ANWENDUNG EINES SOLCHEN VERFAHRENS ZUR KONTAKTIERUNG SCHMALER STEGE	single use
199401733	VERFAHREN ZUM ERZEUGEN ELEKTRONISCHER SIGNATUREN UND VERWENDUNG EINES PSEUDO-ZUFALLSGENERATOR HIERZU	dual use
199401734	TRAEGERANORDNUNG ZUM EINBAU IN EINE KONTAKTLOSE CHIPKARTE	single use
199401735	DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM MIT EINEM TERMINAL UND EINER TRAGBAREN DATENTRAEGERANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM WIEDERAUFLADEN DER TRAG-BAREN DATENTRAEGERANORDNUNG MITTELS DES TERMINALS	single use
199401741	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER LEAD-ON-CHIP(LOC=)ANORDNUNG	single use
199401742	SCHUTZSCHICHT FUER WAFER UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use
199401744	DATENTRAEGERANORDNUNG	single use
199401745	EIN DATENBUS BETREIBBARE TRAGBARE DATENTRAEGERANORDNUNG	single use
199401746	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TAKTGEWINNUNG AUS EINEM DATENSIGNAL	single use
199401752	ABSCHALTbares HALBLEITERBAUELEMENT	single use
199401755	DURCH FELLEFFEKT STEUERbares HALBLEITERBAUELEMENT	single use
199401756	VERFAHREN ZUM TROCKENAETZEN EINES HALBLEITERSUBSTRATS	single use
199401763	SENDE- UND EMPFANGSMODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE OPTISCHENACHRICHTEN- UND SIGNALUEBERTRAGUNG	single use
199401773	SCHALTNETZTEIL	single use
199401776	INTEGRIERTER TEMPERATURSENSOR	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 55 von 166

O:BARRY E. BRETSCHEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199401778	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER FESTWERTSPEICHERZELLENANORDNUNG MIT VERTIKALEN MOS-TRANSISTOREN.	single use
199401784	SYSTEM ZUR KONTAKTLOSEN ENERGIE- und DATENUEBERTRAGUNG	dual use
199401785	SYSTEM ZUR KONTAKTLOSEN ENERGIE- und DATENUEBERTRAGUNG	dual use
199401802	INTEGRIERBARER SPANNUNGSBEGRENZER	single use
199401808	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON DURCH FELLEFFEKT STEUERBAREN HALB-LEITERBAUELEMENTEN	single use
199401822	ANORDNUNG ZUR KAPAZITIVEN SIGNALUEBERTRAGUNG ZWISCHEN CHIPLAGEN EINER VERTIKAL INTEGRIERTEN SCHALTUNG.	single use
199401823	ANORDNUNG ZUR INDUKTIVEN SIGNALUEBERTRAGUNG ZWISCHEN DEN CHIPLAGEN EINER VERTIKAL INTEGRIERTEN SCHALTUNG	single use
199401825	VERFAHREN ZUR BEFESTIGUNG EINES ERSTEN SUBSTRATES AUF EINEM ZWEITEN SUBSTRAT UND DESSEN VERWENDUNG ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN SCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199401832	BIPOLARTRANSISTOR AUF SOI-SUBSTRAT	single use
199401833	MOSFET AUF SOI-SUBSTRAT UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
199401834	KORROSIONSSCHUTZ FÜR MIKROMECHANISCHE METALLSCHICHTEN	single use
199401835	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HALBLEITERBAUELEMENTES	single use
199401836	LATERALER BIPOLARTRANSISTOR	single use
199401837	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM AUSSCHALTEN EINES LEISTUNGS-HALBLEITER-BAUELEMENTES	dual use
199401850	ABSTIMMBARES ELEKTRONISCHES FILTER	single use
199401851	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINER GEREGLTEN AUSGANGS-SPANNUNG	dual use
199401873	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES RUECKSETZSIGNALS	single use
199401883	GTO-THYRISTOR	dual use
199401884	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR LASTSTROMREGELUNG EINES LEISTUNGS-MOSFET	single use
199401885	TREIBERSCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199401886	SENSOR ZUM NACHWEIS ELEKTROMAGNETISCHER STRAHLUNG UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
199401893	SCHALTNETZTEIL MIT SINUSFOERMIGER STROMAUFNAHME	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 56 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199401901	FERNSEHGERAET	single use
199401902	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TELETEXTVERARBEITUNG UND BILD-IM-BILDEIN-BLENDUNG	single use
199401911	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES LEISTUNGS-MOSFET	single use
199403087	MIS-STRUKTUR AUF SILICIUMCARBID-BASIS MIT HOHER LATCH-UP-FESTIGKEIT	dual use
199403250	MEHRLAGENLEITERPLATTEN UND MULTICHIPMODULSUBSTRATE	dual use
199403256	TROCKENENTWICKELBARER POSITIVRESIST	single use
199403327	VERBINDUNGS- UND AUFBAUTECHNIK FUER MULTICHIP-MODULE	dual use
199403519	PHOTOLITHOGRAPHISCHE STRUKTURERZEUGUNG	single use
199403520	PHOTOLITHOGRAPHISCHE STRUKTURERZEUGUNG	single use
199404059	OPTOELEKTRONISCHE BAUGRUPPE	single use
199404087	VERBINDUNGSEINRICHTUNG FUER LICHT-WELLENLEITERKABEL	single use
199404109	OPTISCHER KURZSCHLUSSSTECKER	single use
199404137	OPTISCHE KOPPLUNGSANORDNUNG	single use
199404179	ELEKTROOPTISCHES MODUL	single use
199404180	ELEKTROOPTISCHES MODUL	single use
199405301	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR SPEISUNG EINER TEILNEHMER-ANSCHLUSSLEITUNG	single use
199405302	INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR STOERSICHEREN ABHEBEER-KENNUNG BEI FERNSPRECH-EINRICHTUNGEN	single use
199405303	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GLEICHSPANNUNGSSPEISUNG EINER FERNSPRECH-LEITUNG	dual use
199405304	VERFAHREN ZUR STOERSICHEREN ABHEBEERKENNUNG BEI RUF-SIGNALEIN-SPEISUNG IN DIGITALEN FERNSPRECHVERMITTLUNGSEINRICHTUNGEN UNDSCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199405305	VERFAHREN ZUR FILTERUNG EINER DIGITALEN WERTEFOLGE MIT VER-BESSERTEM RAUSCHVERHALTEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199405306	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GEBUEHRENIMPULSFILTERUNG	dual use
199405307	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR STROMBEGRENZUNG	single use
199405308	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR SPANNUNGSBEGRENZUNG	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 57 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199405309	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR UNTERSpannungs- ERKENNUNG	dual use
199407403	OPTICALLY-COUPLED DATA ACCESS ARRANGEMENT AND TRANSHYBRID	single use
199407409	FLEXIBLE ECC/PARITY BIT ARCHITECTURE	single use
199407418	LOW JUNCTION LEAKAGE MOSFETS	single use
199407442	OPTICAL ENCODER	single use
199407443	A METHOD OF ALIGNING A LIGHT PATHWAY FOR AN OPTICS APPARATUS	single use
199407450	OFF-CHIP DRIVER WITH VOLTAGE REGULATED PREDRIVE	single use
199407468	METHOD FOR REDUCING METAL CONTAMINATION OF SILICON WAFERS DURING SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	single use
199407489	DEEP TRENCH DRAM PROCESS ON SOI FOR LOW LEAKAGE DRAM CELL	single use
199407508	UNIT CELL LAYOUT AND TRANSFER GATE DESIGN FOR HIGH DENSITY DRAMS	single use
199407514	METHODS FOR REDUCING ANOMALOUS NARROW CHANNEL EFFECT IN TRENCH-BOUNDED BURIED-CHANNEL P-MOSFETS	single use
199407518	POLYSILICON/POLYCID ETC PROCESS FOR SUB-MICRO GATE STACKS	single use
199407519	EMBEDDED PHASE SHIFTING PHOTOMASKS AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME	single use
199407520	GLOBAL PLANARIZATION USING SELF ALIGNED POLISHING OR SPACER TECHNIQUE AND ISOTROPIC ETCH PROCESS	single use
199407521	IMPROVED PLASMA ETCHING METHOD	single use
199407524	APPARATUS AND METHOD FOR CLEANING PHOTOMASKS	single use
199407539	DOUBLE DENSITY FUSE BANK FOR THE LASER BREAK- LINK PROGRAMMING OF AN INTEGRATED CIRCUIT	single use
199407540	FUSE STRUCTURE FOR AN INTEGRATED CIRCUIT DEVICE	single use
199407541	DRAM-TRENCH FILL EMPLOYING SELECTIVE EPITAXY	single use
199407544	METHOD FOR ACCENTUATING PMOSFET ANOMALOUS NARROW CHANNEL EFFECT FOR ENHANCED PERFORMANCE	single use
199407545	PERSONALIZED AREA LEADFRAME COINING AND HALF ETCHING FOR REDUCED MECHANICAL STRESS AT DEVICE EDGE	single use
199407546	SHALLOW TRENCH ISOLATION WITH THIN NITRIDE LINER	single use
199408007	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BAUELEMENTS MITTELS MOLEKULAR-STRAHLEPITAXIE	single use
199408014	MIKROELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	single use
199408015	VORRICHTUNG ZUR KONTROLLE VON HALBLEITERSCHEIBEN	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 58 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199408016	VERFAHREN ZUR KONTROLLE VON HALBLEITERSCHEIBEN UND VORRICHTUNGEN ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199408017	VERFAHREN ZUR UMSETZUNG EINER BILDFOLGE VON HALBBILDERN MIT ZEILENSPRUNG AUF EINE BILDFOLGE VON ZEILENSPRUNGFREIEN BILDERN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199408020	OPERATIONSVERSTAERKER MIT HOHER GLEICHTAKTUNTERDRUECKUNG	single use
199408027	VERFAHREN ZUR PROGRESSIVEN KONVERSION VON FERNSEHBILDERN MIT ZEILENSPRUNG	single use
199408031	SCHALTNETZEIL MIT SINUSFOERMIGER STROMAUFNAHME	single use
199408041	ENTLADUNGSKAMMER FUEER EINE PLASMAAETZANLAGE IN DER HALBLEITER-FERTIGUNG	single use
199408043	ANTENNENSPULE	single use
199408045	VERFAHREN ZUR REKONSTRUKTION VON IN RASTERFORM VORLIEGENDEN LINIENSTRUKTUREN	dual use
199408046	VERFAHREN ZUM NASSCHEMISCHEN ENTFERNEN VON KONTAMINATIONEN AUF HALBLEITERKRISTALLOBERFLAECHEN	single use
199408047	VERFAHREN ZUR DETEKTION VON SOLLAGEABWEICHUNGEN EINES SCHNITT-KOERPERS	single use
199408051	KOPPELANORDNUNG ZUM OPTISCHEN ANEINANDERKOPPELN EINES OEIC-BAU-STEINS UND OPTISCHER FASERN	single use
199408052	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FLIMMERREDUKTION FUEER EINGERAET ZUR VIDEOSIGNALVERARBEITUNG	single use
199408064	DRUCKSENSOR	single use
199408065	DRUCKSENSOR	single use
199408071	MEHRSTUFIGE ZUGRIFFSSTEUERUNG AUF DATENTRAEGERKARTEN	single use
199408074	MIKROMECHANISCHES BAUELEMENT UND HERSTELLVERFAHREN	single use
199408077	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN INTEGRIERTENSCHALTUNG	single use
199408078	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VERTIKALEN INTEGRIERTEN SCHALTUNGSSTRUKTUR	single use
199408079	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN INTEGRIERTENSCHALTUNG UNTER ERREICHUNG HOHER SYSTEMAUSBEUTEN	single use
199408548	CVD-VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER EINKRISTALLINEN SILICIUMCARBIDSCHICHT	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 59 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199501006	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHALTEN HOEHERER SPANNUNGEN AUF EINEMHALBLEITERCHIP UND VERFAHREN ZU DESSEN BETREIBEN	single use
199501007	INTEGRIERTE SCHALTUNGSSTRUKTUR UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG.	single use
199501012	ROTATIONSFREQUENZDETEKTOR	single use
199501031	MOS-SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHALTEN HOHER SPANNUNGEN AUF EINEMHALBLEITERCHIP	single use
199501032	SCHUTZANORDNUNG GEGEN ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNGEN IN MIT FELD-EFFEKT STEUERBAREN HALBLEITERBAUELEMENTEN	single use
199501033	MIKROMECHANISCHES BAUELEMENT	single use
199501054	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GEWINNUNG VON IN EINEMVIDEOSIGNAL ENTHALTENER DIGITALER DATENINFORMATION	single use
199501056	INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG	single use
199501057	VERFAHREN ZUR UEBERPRUEFUNG EINER HALBLEITER-SPEICHERVORRICHTUNG	single use
199501058	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES KONDENSATORS UND EINER HALBLEITER-SPEICHERVORRICHTUNG	single use
199501059	HALBLEITER-SPEICHERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG	single use
199501079	TRANSIMPEDANZVERSTAERKERSCHALTUNG	single use
199501080	INTEGRIERBARE STROMQUELLENSCHALTUNG	single use
199501084	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG ODER VERBESSERUNG BERANDETER FOTOLACK-SCHICHTEN	single use
199501085	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG SILIZIUMHALTIGER MASKEN	single use
199501091	VERSCHLUESSELUNGSVORRICHTUNG	dual use
199501093	INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ARBEITSSTROMSTABILISIERUNG EINES TRANSISTORS DURCH GEGENKOPPLUNG, INSBESONDERE GEEIGNET FUER BATTERIEBETRIEBENE GERAETE	single use
199501095	MEHRWERTIGE FESTWERTSPEICHERZELLE MIT VERBESSERTEM STOEERABSTAND	single use
199501097	VERFAHREN ZUR DARSTELLUNG VON IN NICHT AEQUIDISTANTER FORM UEBER-TRAGENEN BILDSIGNALEN AUF EINEM DATENSICHTGERAET, DAS NUR AEQUI-DISTANTE BILDSIGNALE ANZEIGT	dual use
199501101	VERFAHREN ZUM DAMAGE-AETZEN DER RUECKSEITE EINER HALBLEITERSCHEIBE BEI GESCHUETZTER SCHEIBENVORDERSEITE	single use
199501103	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR PHASENDIFFERENZMESSUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 60 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199501114	ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM EINSEITIGEN, NASSCHEMISCHEN AETZENEINER SUBSTRATSCHLEIBE.	single use
199501123	PRUEFSCHALTUNG UND PRUEFVERFAHREN ZUR FUNKTIONSPRUEFUNG VON ELEK-TRONISCHEN SCHALTUNGEN	single use
199501125	ADAPTIVES BALANCEFILTER	single use
199501126	VERFAHREN ZUM FREIAETZEN (SEPARIEREN) UND TROCKNENMIKROMECHANISCHER KOMPONENTEN	single use
199501127	BESCHLEUNIGUNGSSENSOR	single use
199501128	VERFAHREN ZUM FREIAETZEN (SEPARIEREN) MIKROMECHANISCHERFUNKTIONSELEMENTE	single use
199501132	TAKTERZEUGUNGSSCHALTUNG	single use
199501136	INTEGRIERT OPTISCHER RIPPENWELLENLEITER MIT EINER EINEN STEUERBA-REN KOMPLEXEN BRECHUNGSINDEX AUFWEISENDEN WELLENLEITENDEN SCHICHT	single use
199501137	INTEGRIERT OPTISCHER WELLENLEITER MIT EINER EINEN STEUERBARENKOMPLEXEN BRECHUNGSINDEX AUFWEISENDEN WELLENLEITENDEN SCHICHT	single use
199501138	HALBLEITERVORRICHTUNG MIT GUTEM TERMISCHEN VERHALTEN	single use
199501141	ANORDNUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN AUF EINEM TRAEGERSTREI-FEN	single use
199501143	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS EINEM IGBT	single use
199501145	HALBLEITERSPEICHER, DESSEN SPEICHERZELLEN ZU EINZELN ADDRESSIER-BAREN EINHEITEN ZUSAMMENGEFASST SIND UND VERFAHREN ZUM BETRIEBSOLCHER SPEICHER	single use
199501146	HALBLEITERBAUELEMENT MIT SCHUTZSTRUKTUR ZUM SCHUTZ VORELEKTROSTATISCHER ENTLADUNG	single use
199501147	VERFAHREN ZUR MONTAGE VON CHIPS.	single use
199501151	PLATINE MIT MEHREREN INTEGRIERTEN SCHALTUNGEN	single use
199501154	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES INTEGRIERTEN WIDERSTANDES	single use
199501165	ELEKTRONISCHE BOERSENKARTE UND VERFAHREN ZUM WIEDERAUFLADEN EINERELEKTRONISCHEN BOERSENKARTE	single use
199501177	OPTOELEKTRONISCHER WANDLER UND HERSTELLVERFAHREN	single use
199501179	INTEGRIERTE HALBLEITER-SPEICHERVORRICHTUNG	single use
199501180	INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER	single use
199501191	VERFAHREN ZUR ERKENNUNG EINER SIGNALPAUSE ZWISCHEN ZWEI MUSTERN, WELCHE IN EINEM ZEITVARIANTEN MESSIGNAL VORHANDEN SIND.	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 61 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199501212	PLATINE MIT EINGEBAUTER KONTAKTFUEHLERPRUEFUNG FUEHRT INTEGRIERTESCHALTUNGEN	single use
199501214	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG MIKROMECHANISCHER BAUELEMENTE	single use
199501218	FESTWERT-SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HER-STELLUNG.	single use
199501223	VERFAHREN ZUR HANDHABUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN	single use
199501224	VERFAHREN ZUR HANDHABUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN IN DERENDMONTAGE	single use
199501230	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM EMPFANG VON CODIERTENVIDEOSIGNALEN	dual use
199501237	CHIP-ABDECKUNG	single use
199501239	CHIP-ABDECKUNG	single use
199501240	CHIP-ABDECKUNG	single use
199501241	BIPOLARER SILIZIUMTRANSISTOR	single use
199501253	SCHALTUNGSANORDNUNG UND HALBLEITERKOERPER MIT EINEM LEISTUNGS-SCHALTER	single use
199501254	SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM LEISTUNGSSCHALTER	dual use
199501255	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERKENNEN DES LEERLAUFS EINER LAST	single use
199501256	INTEGRIERTE KOMPARATORSCHALTUNG	single use
199501258	VERFAHREN ZUR DYNAMISCHEN VERIFIKATION EINES SCHRIFTZUGES ANHAND EINES REFERENZSCHRIFTZUGES	dual use
199501259	VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG EINES REFERENZSCHRIFTZUGES ANHAND EINER MENGE VON SCHREIBERIDENTISCHEN MUSTERSCHRIFTZUEGEN	dual use
199501265	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERFASSEN DER TEMPERATUR EINES LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENTS	dual use
199501267	SPEICHERANORDNUNG MIT EINEM ALS RINGSPEICHER BETREIBBAREN SPEICHER	single use
199501268	TRAEGERMODUL	single use
199501272	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KOPPELANORDNUNG ZUM ANEINANDERKOP-PELN EINES PHOTONISCHEN BAUSTEINS UND OPTISCHER FASERN UND NACHDIESEM VERFAHREN HERGESTELLTE KOPPELANORDNUNG.	single use
199501273	INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT DER FUNKTION EINES SYMMETRISCHSPERRENDEN TRIACS.	single use
199501278	KARTENFOERMIGER DATENTRAEGER UND LEADFRAME ZUR VERWENDUNG IN EINEMSOECHEN DATENTRAEGER	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC 10
Seite 62 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199501289	SERIELL ZUGREIFBARE SPEICHERVORRICHTUNG MIT HOHER FEHLERKORRIGIER-BARKEIT	single use
199501291	FELDEFFEKT STEUERBARER HALBLEITERBAUELEMENT MIT EINEM INTEGRIER- TENOHMISCHEN WIDERSTAND	dual use
199501300	ANORDNUNG VON LEISTUNGS- UND KONTROLLHALBLEITERELEMENTEN	single use
199501306	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DIGITALEN PHASENDIFFERENZMESSUNG	single use
199501309	SPEICHERVERWALTUNGSVERFAHREN	dual use
199501311	HALBLEITERCHIP	single use
199501314	VERFAHREN ZUM RECHNERGESTUETZTEN AUSTAUSCH KRYPTOGRAPHISCHERSCHLUESSEL ZWISCHEN EINER NETZCOMPUTEREINHEIT N UND EINER BENUTZERCOMPUTEREINHEIT U	dual use
199501318	Verfahren zum Betrieb eines RTP-Reaktors	single use
199501329	Verfahren zum Betrieb eines RTP-Reaktors 95P1318DE FESTWERTSPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DERENHERSTELLUNG.	single use
199501330	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BILD-IM- BILD-EINBLENDUNG	single use
199501340	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES LEISTUNGS-MOSFET	dual use
199501354	GTL-Ausgangsverstärker zum Einkoppeln eines am Eingangs anliegenden Eingangssignales in eine am Ausgang anliegende Übertragungsleitung	single use
199501358	SOI-BICMOS-VERFAHREN	single use
199501360	Verfahren zum selektiven Entfernen von Siliziumdioxid	single use
199501366	KONTAKTLOSE CHIPKARTE	dual use
199501370	VERFAHREN ZUR ABSCHIEDUNG EINER SILIZIUMOXIDSCHICHT	single use
199501377	KONFIGURIERBARE INTEGRIERTE SCHALTUNG	single use
199501395	VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG EINER EMPFÄNGERUHRZEIT ZUM EMPFANGS-ZEITPUNKT EINER IN EMPFANGENEN DATENELEMENTEN ENTHALTENEN SENDE-ZEITMARKE	dual use
199501396	FESTWERT-SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DERENHERSTELLUNG	single use
199501397	Festwert-Speicherzellenvorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199501402	SPEICHER MIT DYNAMISCHEN SPEICHERZELLEN	single use
199501404	Halbleiterspeichervorrichtung	single use
199501405	HALBLEITERSPEICHERVORRICHTUNG	single use
199501407	HALBLEITER-BAUELEMENT	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 63 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199501408	OPTISCHER SCHALTER	single use
199501410	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER EEPROM-HALBLEITERSTRUKTUR	single use
199501411	HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER EINE POLYSILIZIUM-STRUKTUR	single use
199501413	VERFAHREN ZUR CHARAKTERISIERUNG DUENNER SCHICHTEN IN DER HALB-LEITERPRODUKTION	single use
199501415	ELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINESELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS	single use
199501417	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SUBLITHOGRAPHISCHEN AETZMASKEN	single use
199501418	INTEGRIERTER SCHALTKREIS MIT CMOS-SCHALTUNG UND VERFAHREN ZURHERSTELLUNG VON ISOLIERTEN, AKTIVEN BEREICHEN EINER CMOS-SCHALTUNG	single use
199501419	Verfahren zur Herstellung einer DFB-Laserdiode mit angekoppeltem Wellenleiter und DFB-Laserdiodenschichtstruktur	single use
199501421	VERFAHREN ZUM RECHNERGESTUETZTEN AUSTAUSCH KRYPTOGRAPHISCHERSCHLUESSEL ZWISCHEN EINER BENUTZERCOMPUTEREINHEIT U UND EINER NETZCOMPUTEREINHEIT N	single use
199501430	TRANSIMPEDANZVERSTAERKERSCHALTUNG	single use
199501435	KONSTANTSTROMQUELLE MIT EINER EEPROM-ZELLE	single use
199501438	HALBLEITERANORDNUNG MIT SELBSTJUSTIERTEN KONTAKTEN UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG	single use
199501450	DRAM-ZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use
199501451	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199501460	DFB-LASERDIODENSTRUKTUR MIT KOMPLEXER OPTISCHER GITTERKOPPLUNG	single use
199501461	VERFAHREN ZUR SELEKTIVEN PROGRAMMIERUNG EINES NICHT-FLUECHTIGENSPEICHERS	single use
199501475	BIBOLARTRANSISTOR VOM PNP-TYP	single use
199501489	LASERSYSTEM	single use
199501493	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERFASSEN DES LASTSTROMS EINES LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENTES MIT SOURCESEITIGER LAST	dual use
199501496	OBERFLAECHE NEMITTIERENDE LASERDIODE	single use
199501503	Schaltungsanordnung zum Vergleich zweier elektrischer Groessen	single use
199501505	Schaltungsanordnung zum Vergleich zweier elektrischer Groessen, die von einem ersten Neuron-MOS-Feldeffekttransistor und einer Referenzquelle zur Verfuegung gestellt werden.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 64 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199501507	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR REALISIERUNG VON DURCHSCHWELLENWERTGLEICHUNGEN DARSTELLBAREN LOGIKELEMENTEN	single use
199501515	PROZESSROHR MIT ENDVERSCHLUSS	single use
199501517	MOS-HALBLEITERBAUELEMENT MIT VERBESSERTEN DURCHLASSEIGENSCHAFTEN.	single use
199501518	LEISTUNGS-HALBLEITERMODUL MIT ANSCHLUSSTIFTEN	dual use
199501526	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ABSCHALTEN EINES LEISTUNGS-MOSFET BEIUEBERTEMPERATUR	single use
199501527	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ABSCHALTEN EINES LEISTUNGS-MOSFET BEIUEBERTEMPERATUR	single use
199501533	FUSEBANK	single use
199501542	LEISTUNGSTRANSISTOR MIT KURZSCHLUSSCHUTZ	dual use
199501543	SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM LEISTUNGSSCHALTER	single use
199501544	ANLAUFSCALTUNG UND HALBLEITERKOEPPER FUEER EINE SOLCHE ANLAUF-SCHALTUNG	single use
199501545	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES FET	dual use
199501546	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES LEISTUNGS-ENHANCEMENT-MOSFET	single use
199501552	Vorrichtung und Verfahren zur Erfassung und Bewertung einesraeumlich diskreten Punktmusters	single use
199501553	Verfahren zum Lesen und Auffrischen eines dynamischenHalbleiterspeichers	single use
199501554	Verfahren zum Lesen und Schreiben von Dateninhalten einesdynamischen Halbleiterspeichers	single use
199501556	SPEICHERVORRICHTUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN	single use
199501561	OPTOELEKTRONISCHE SENDE-EMPFANGS-VORRICHTUNG	single use
199501562	WELLENLAENGENABSTIMMBARE LASERVORRICHTUNG	single use
199501579	VORRICHTUNGEN ZUR UMWANDLUNG VON SINGLE-ENDED-SIGNALEN ZUVOLLDIFFERENTIELLEN SIGNALEN UND UMGEKEHRT.	single use
199501587	Elektrisch schreib- UND loeschbare Festwertspeicherzellenanordnungund Verfahren zu derer Herstellung.	single use
199501590	SPANNUNGSUMSETZER ZUM ERZEUGEN EINER GEREGETEN AUSGANGSSPANNUNGAUS EINER EINGANGSSPANNUNG	single use
199501592	VERFAHREN ZUR DEKODIERUNG UND KODIERUNG EINES KOMPRIMIERTENVIDEODATENSTROMS MIT REDUZIERTEM SPEICHERBEDARF	dual use
199501594	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR CODIERUNG UND DECODIERUNG VON EINEMVIDEODATENSTROM FUEER ALLE BILDELEMENTE DES VIDEODATENSTROMS	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 65 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199501598	BOOTSTRAPSCHALTUNG	single use
199501601	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN CMOS-SCHALTUNG	single use
199501602	Elektrisch schreib- UND loeschbare Festwertspeicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199501604	Integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens zwei gegeneinanderisolierten Bauelementen und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199501610	VIDEOSIGNALEMPFANGSEINRICHTUNG MIT AUFZEICHNUNGSSCHUTZ	dual use
199501615	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DECODIERUNG EINES VIDEO-DATENSTROMS	dual use
199501622	ELEKTRISCH LOESCH- UND PROGRAMMIERBARE NICHT-FLUECHTIGE SPEICHER-ZELLE	single use
199501626	BILDSIGNALVERARBEITUNGSEINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG DIGITALER DATENSIGNALE	dual use
199501631	Verfahren zur Herstellung eines MOS-Transistors.	single use
199501637	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MINDESTENS ZWEI TRANSISTOREN IN EINEM HALBLEITERKOEPPER	single use
199501643	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MIKROELEKTRONISCHEN STRUKTUREN	single use
199501644	TRANSPONDER UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES TRANSPONDERS	dual use
199501645	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GATEELEKTRODE	single use
199501646	REINIGUNGSVERFAHREN FUER EIN ZU STRUKTURENDES, BESCHICHTETES WERKSTUECK	single use
199501647	VERFAHREN ZUR KONTAKTLOCHHERSTELLUNG	single use
199501648	MIKROELEKTRONISCHER, INTEGRIERTER SENSOR UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES SENSORS	single use
199501649	MIKROELEKTRONISCHER, INTEGRIERTER SENSOR UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES SENSORS	single use
199501650	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VIELZAHL VON MIKROELEKTRONISCHEN SCHALTUNGEN AUF SOI	single use
199501651	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VIELZAHL VON MIKROELEKTRONISCHEN SCHALTUNGEN AUF SOI	single use
199501652	SYSTEM ZUM TRANSPORT VON TESTBOARDS	single use
199501658	Verfahren zur Metallisierung von Submikron- (bzw. ~m-) Kontaktlochern in Halbleiterkoepfern	single use
199501659	TINTENSTRAHLDRUCKKOPF UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES OLCHENTINTENSTRAHLDRUCKKOPFES	single use
199501661	LEITERRAHMEN FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 66 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199501665	Optische Struktur und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199501666	INTEGRIERTE SCHALTUNG	single use
199501670	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199501673	VERPACKUNG FUER EIN ELEKTRONISCHES BAUELEMENT	single use
199501674	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONDENSATORS IN EINER HALB-LEITERANORDNUNG	single use
199501676	OPTOELEKTRONISCHER WANDLER UND HERSTELLUNGSVERFAHREN	single use
199501680	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SELBSTJUSTIERTEN KONTAKTES UNDEINES DOTIERTEN BEREICHS	single use
199501681	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG KOMPLEMENTAERER MOS-TRANSISTOREN	single use
199501687	CHIPKARTE	single use
199501688	Vorrichtung zur Mehrfachnutzung einer Regelbasis in einem Fuzzy-Logic-Coprozessor.	single use
199501716	CHIPMODUL	single use
199501717	CHIPMODUL	single use
199501718	Schaltungsanordnung zur Versorgung eines elektronischen Lastkreises	dual use
199501719	SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER TESTSCHALTUNG	single use
199501720	KONTAKTLOSE CHIPKARTE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DERSELBEN	single use
199501721	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER ANORDNUNG AUS EINEM TRAEGER UND EINER LUFTSPULE (Z.B. CHIPKARTE)	single use
199501726	VERFAHREN ZUR ZUGRIFFSSTEUERUNG VON EINER DATENSTATION AUF MOBILE DATENTRAEGER	dual use
199501733	INTEGRIERTE SCHALTUNG	single use
199501757	Optischer Schalter zum Schalten zweier oder mehrerer optischer Wellenlaengenbaender	single use
199501778	INTEGRIERBARE KOMPARATORSCHALTUNG MIT EINSTELLBARER ANSPRECH-SCHWELLE	single use
199501792	TEILNEHMERENDSTELLE	dual use
199501794	DIGITALES NACHRICHTENVERMITTLUNGSSYSTEM	dual use
199501795	ANSAUGPLATTE FUER WAFER	single use
199501813	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUM ANPASSEN DER UEBERTRAGUNGSBITRATE EINER NACH DEM ASYNCHRONEN TRANSFERMODUS ARBEITENDEN DATENMULTI-PLEXEINRICHTUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 67 von 186

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte**



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199501814	ORDNUNGSVERFAHREN FUER ZUGEHORIGKEITSFUNKTIONSWERTELINGUISTISCHER EINGANGSWERTE IN EINEM FUZZY-LOGIC-PROZESSOR UNDANORDNUNGEN ZU DEREN DURCHFUEHRUNG	single use
199501868	VORRICHTUNG ZUM MESSEN DER SIGNALLAUFEIT EINEER DIGITALEN UEBER-TRAGUNGSEINRICHTUNG	dual use
199501869	TREIBERSCHALTUNG FUER EINE LEUCHTDIODE	dual use
199501881	Koppellordnung zum selbstjustierenden Aneinanderkoppeln einesOEIC-Bausteins und optischer Fasern	single use
199501884	Verfahren zur Befestigung elektronischer Bauelemente auf einem Substrat durch Drucksintern	single use
199501896	ANORDNUNG ZUR DARSTELLUNG VON MINDESTENS ZWEI BILDFOLGEN	single use
199501897	Einrichtung zum sprungweisen Adressieren bestimmter Leitungeneines seriell arbeitenden digitalen Speichers	single use
199501899	Speicherzellenanordnung aus matrixfoermig angeordnetenSpeicherzelle	single use
199501908	DURCH FELDEFFEKT STEUERBARES LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT	single use
199501919	DURCH FELDEFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT MIT MEHRERENTEMPATURSENSOREN ZUM SCHUTZ VOR UEBERLASTUNG	single use
199501927	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES FREIGABESIGNALS FUER EINETAKTSTEUERBARE SCHALTUNG	single use
199501928	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BILD-IM-BILD-EINBLENDUNG	single use
199501930	HALBLEITERANORDNUNG UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG	single use
199501932	VERFAHREN ZUM ERZEUGEN SEHR KLEINER STRUKTURWEITEN AUF EINEMHALBLEITERSUBSTRAT	single use
199501933	VERFAHREN ZUM ERZEUGEN DER SOURCEBEREICHE EINES FLASH-SPEICHER-ZELLENFELDES UND FLASH-SPEICHERZELLENFELDES	single use
199501950	Anordnung mit einem pn-Uebergang und einer Massnahme zurHerabsetzung der Gefahr eines Durchbruchs des pn-Uebergangs	single use
199501952	INTEGRIERTER MIKROWELLEN-SILIZIUM-BAUSTEIN	single use
199501962	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN CMOS-SCHALTUNG.	single use
199501965	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES DEPLETION-MOSFET	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 68 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199501972	ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM ELEKTRISCHEN VERBINDEN EINES HALB-LEITERCHIPS MIT ZUMINDEST EINER KONTAKTFLAECHE	single use
199501976	DRAM-Zellenanordnung mit dynamischen selbstverstaerkenden Speicherzellen.	single use
199501981	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES BIASPOTENTIALS	single use
199501984	Diode mit hoher Stossstromfestigkeit und weichem Abschaltverhalten.	single use
199501986	BIDIREKTIONALE TREIBERSCHALTUNG FUER PCI-BUSSYSTEME	single use
199501989	CHIPMODUL	single use
199501994	DOPPLERRADARMODUL	dual use
199501995	Schaltungsanordnung zur Frequenzverdoppelung	single use
199502001	TESTBARE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MEHREREN IDENTISCHENSCHALTUNGSBLOECKEN	single use
199502003	Einrichtung zum Emittieren von Elektronen, Anordnung aus mehreren solchen Einrichtungen und Verfahren zur Herstellung einer solchen Einrichtung	single use
199502015	VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR PROZESSIERUNG VON HALBLEITER-ELEMENTEN	single use
199502021	SMD-SPULE	single use
199502028	BEWERTER- UND VERSTAERKERSCHALTUNG	single use
199502030	VERFAHREN ZUR SYNCHRONISATION AUF EINE FOLGE VON DIGITALENDATENWERTEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS	dual use
199502043	INTEGRIERBARER KONDENSATOR UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG	single use
199502048	LASERDIODENBAUELEMENT MIT WAERMESSENKE	single use
199502050	KOMPAKTE HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DERENHERSTELLUNG	single use
199502055	Prozessor-Analysesystem	single use
199502056	Vorrichtung und Verfahren zur Kommunikation zwischen Sendee- und/oder Empfangsstationen und einer Vermittlungsstation	dual use
199502057	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR IMPLANTATION VON DOTIERSTOFF	single use
199502071	Feldgesteuerter Bipolartransistor.	single use
199502072	VERFAHREN ZUM BESEITIGEN VON KRISTALLFEHLERN IN SILIZIUMSCHEIBEN	single use
199502083	VERFAHREN ZUR KONTROLLE VON SCHEIBEN	single use
199502093	VIDEOEMPFANGSGERAET MIT EINER TELETEXTVERARBEITUNGSEINRICHTUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 69 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199502103	HALBLEITER-BAUELEMENT, INSB. MIT EINER OPTOELEKTRONISCHEN SCHALTUNGBZW. ANORDNUNG	single use
199502111	VERFAHREN ZUR CODIERUNG EINES VIDEO DATENSTROMS EINER AUSBILDBLOCKEN BESTEHENDEN VIDEOSEQUENZ.	dual use
199502118	SCHALTUNGSANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR MEHRFACHNUTZUNG EINES DIGITALEN TRANSVERSALFILTERS	single use
199502120	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM UEBERBLENDEN ZWISCHEN BILD-FOLGEN	single use
199502124	VERFAHREN ZUM SELBSTTÄTIGEN ERMITTELN DER NOTIGEN HOCHSPANNUNG ZUM PROGRAMMIEREN/LOESCHEN EINES EEPROMS	single use
199502125	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERKENNUNG EINES DURCH EINE LAST FLIESSENDEN LASTSTROMS	dual use
199502126	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERKENNEN DES LEERLAUFS EINER LAST	dual use
199502128	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES EINE GEWÖLBTE MEMBRANE AUFWEISEN-DEN DRUCKSENSORS	single use
199502130	EEPROM und Verfahren zur Ansteuerung desselben	single use
199502131	CMOS-Anordnung	single use
199502133	Festspeicher und Verfahren zur Ansteuerung desselben	single use
199502144	Leistungshalbleiter-Modul	single use
199502145	Verfahren zum Herabsetzen der Trägerspeicherladung in Halbleiterbauelementen	single use
199502146	VERFAHREN ZUR ANSTEUERUNG EINES FELDEFFEKTTRANSISTORS	single use
199502148	UEBERTRAGUNGSSYSTEM	dual use
199502149	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SPEICHERZELLENANORDNUNG	single use
199502150	VERTIKAL INTEGRIERTES HALBLEITERBAUELEMENT MIT ZWEI MITEINANDERVERBUNDENEN SUBSTRATEN UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR	single use
199502157	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZ VON GLEICHSTROM-BORDNETZEN GEGEN KURZSCHLUSS	dual use
199502162	Halbleiterbauelement mit Schottkykontakt	single use
199502166	Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Leistungsbauelementes und Leistungshalbleiterbauelement	single use
199502167	Verfahren zur Montage eines Rahmens auf ein Trägermaterial und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens	single use
199502169	Mikrochip mit einem diesen ganz oder teilweise umgebenden lichtundurchlässigen Ummantelungsabschnitt	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 70 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199502170	Chipkartenkoerper zur Herstellung einer eine Spule enthaltenden Chipkarte	single use
199502171	Chipkartenkoerper	single use
199502176	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS EINEM MOS-TRANSISTOR.	single use
199502182	SPEICHERZELLE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER NICHTFLUECHTIGEN SPEICHERZELLE	single use
199502183	Hochintegrierte, nichtfluechtige Halbleiter-Speicherzelle	single use
199502184	HOCHINTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES HALBLEITERSPEICHERS	single use
199502186	Kunststofftraeger mit Induktionsspule	single use
199502187	Chipkarte mit einer Induktionsspule und Verfahren zu ihrer Herstellung	single use
199502189	Chipkarte	dual use
199502190	CHIPKARTE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER CHIPKARTE	single use
199502191	Auftrennbare Verbindungsbruecke (Fuse) und verbindbare Leitungsunterbrechung (Anti-Fuse), sowie Verfahren zur Herstellung und Aktivierung einer Fuse und einer Anti-Fuse	single use
199502192	SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER ANZAHL VON ELEKTRONISCHEN SCHALTUNGSKOMPONENTEN	single use
199502193	HALBLEITERSPEICHERVORRICHTUNG	single use
199502209	INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT PROGRAMMIERBAREM PAD-TREIBER.	single use
199502210	Festwertspeicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199502212	DIGITALE SIGNALPROZESSOR-ANORDNUNG ZUM VERGLEICH VON MERKMALSVektoren UND DEREN VERWENDUNG SOWIE ZUGEHÖRIGES BETRIEBSVERFAHREN	dual use
199502220	Einrichtung zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Verpackung von elektrischen Bauteilen, insbesondere integrierter Schaltkreise	single use
199502221	Einrichtung zur Überprüfung von elektrischen Bauteilen, insbesondere integrierter Schaltungen	single use
199502222	VERFAHREN ZUM TESTEN VON BURN-IN-BOARDS UND DARIN EINGESETZTEN BAUTEILEN WAHREND DES BESTÜCKUNGSVORGANGES	single use
199502224	Einrichtung in einer Halbleiterfertigungsanlage, insbesondere fuer integrierte Schaltungen	single use
199502225	EINRICHTUNG IN EINER HALBLEITERFERTIGUNGSANLAGE, INSBESONDERE FÜR INTEGRIERTE SCHALTUNGEN	single use
199502229	Verfahren zur Bestimmung eines elektrischen Oberflächenwiderstandes und Messvorrichtung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 71 von 166

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199502246	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONDENSATORS IN EINERHALBLEITERANORDNUNG.	single use
199502247	FREQUENZMISCHER FUER EIN DOPPLERRADARMODUL	dual use
199502248	VERFAHREN ZUR BEARBEITUNG VON GEDUENNTEN HALBLEITERSCHEIBEN	single use
199502264	Durch Feldeffekt steuerbares Leistungs-Halbleiterbauelement mit Temperatursensor	single use
199502270	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GATEELEKTRODE FUER EINEMOS-STRUKTUR.	single use
199502271	VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER SRAM MOS-TRANSISTOR-SPEICHERZELLE	single use
199502273	SCHMELZSICHERUNG IN EINER INTEGRIERTEN HALBLEITERSCHALTUNG	single use
199502276	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MOS-TRANSISTORS .	single use
199502278	VERFAHREN ZUR RECHNERGESTUETZTEN BEWEGUNGSSCHAETZUNG FUER BILDPUNKTE ZEITLICH AUF EINANDER FOLGENDER BILDER EINER VIDEOSEQUENZ	dual use
199502282	VERFAHREN ZUR RECHNERGESTUETZTEN BEWEGUNGSSCHAETZUNG FUER BILDPUNKTE ZEITLICH AUF EINANDER FOLGENDER BILDER EINER VIDEOSEQUENZ	dual use
199502288	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES NEURON-MOS-TRANSISTORS AUF DER BASIS EINES CMOS-PROZESSES	single use
199502293	Leistungs-Halbleiter-Modul mit parallelgeschalteten IGBT-Chips	dual use
199503034	SENSOR AUF FET-BASIS	dual use
199503058	VERFAHREN ZUR PHOTOLITHOGRAPHISCHEN STRUKTURERZEUGUNG	single use
199503214	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYBENZOXAZOL-VORSTUFEN UND ENTSPRECHENDER RESISTLOESUNGEN	single use
199503381	VERSTAERKER MIT MINIMALER LEISTUNGS-AUFNAHME	single use
199503392	MAGNETISIERUNGSEINRICHTUNG FUER EIN MAGNETORESISTIVES DUENN-SCHICHT-SENSORELEMENT MIT EINEM BIASSCHICHTTEIL	dual use
199503393	MAGNETISIERUNGSVORRICHTUNG FUER MAGNETORESISTIVE DUENN-SCHICHT-SENSORELEMENTE IN EINER BRUECKENSCHALTUNG	dual use
199503440	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN	single use
199503441	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN	single use
199503516	RASTERKRAFTMIKROSKOPIESONDEN UND RASTERTUNNELMIKROSKOPIESPITZEN	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 72 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte**



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199503532	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON SILICIUMCARBID-EINKRISTALLEN	dual use
199503614	HALBLEITERBAUELEMENT AUF SILICIUMBASIS MIT HOCHSPERRENDEM RANDAB-SCHLUSS	dual use
199503618	NEUE DICARBONSAEUREDERIVATE	single use
199503624	HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O-MERCAPTOAMIDEN	single use
199503625	HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O-MERCAPTOAMIDEN	single use
199503626	HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O-MERCAPTOAMIDEN	single use
199503627	HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O-MERCAPTOAMIDEN	single use
199503628	HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMDIEN UND POLY-O-MERCAPTOAMIDEN	single use
199503882	STRAHLUNGSEMPFINDLICHER WANDLER	dual use
199503936	Halbleiteranordnung zur Strombegrenzung	dual use
199504051	EINTEILIGER HALTER ZUR LOESBAREN OBER-FLAECHENMONTAGE.	single use
199504108	EINRICHTUNG ZUM UEBERWACHEN EINESLEISTUNGSGEREGETEN LASERS.	single use
199504130	OPTISCHE KOPPLUNGSANORDNUNG	single use
199504147	OPTISCHER STECKVERBINDER.	single use
199504148	STECKVERBINDER FUER EIN LICHTWELLENLEITER-KABEL.	single use
199504175	OPTISCHER STECKVERBINDER	single use
199504181	AUFNAHMEANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER AUFNAHMEANORDNUNG FUER MINDESTENS EINEN UMHUELLTEN LICHTWELLENLEITER	single use
199504182	OPTISCHE KOPPLUNGSANORDNUNG	single use
199505301	DIFFERENZVERSTAERKER	single use
199505302	INTEGRIERBARER UMSCHALTER FUER HOEHERE SPANNUNGEN	dual use
199505303	TEMPERATURKOMPENSIERTE SENSORANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR TEMPERATURKOMPENSATION EINER SENSORANORDNUNG	single use
199505304	SENSORANORDNUNG	dual use
199505305	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR UMSETZUNG EINES 1-BIT-DIGITALSIGNALS IN EIN ANALOGSIGNAL	single use
199505306	VERFAHREN ZUR SELBSTKALIBRIERUNG EINES A/D- ODER D/A-WANDLERS	single use
199505307	ANALOG-DIGITAL-UMSETZER	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 73 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte**



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199505308	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES TAKTSIGNALS	single use
199505309	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERRINGERUNG EINER MINORITAETSTRAEGER-INJEKTION IN EIN SUBSTRAT	dual use
199505312	TRANSFORMATIONSSCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199505313	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR STROMTRANSFORMATION	single use
199505314	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GLAETTUNG EINER SPANNUNG	dual use
199505316	STROMTREIBERSCHALTUNG MIT QUERSTROMREGELUNG	dual use
199505317	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GLEICHSPANNUNGS- UND WECHSELSPANNUNGS-AUSKOPPLUNG	single use
199507420	INTEGRATED CIRCUIT INTERCONNECTION EMPLOYING TUNGSTEN/ALUMINIUM LAYERS	single use
199507421	AN ISOLATION COLLAR NITRIDE LINER FOR DRAM PROCESS INVOLVEMENT	single use
199507433	WIRE ARRAY DICING FOR A DAMAGE FREE-SEPARATION OF WAFERS OR SUBSTRATES	single use
199507434	ABLATION PATTERNING OF MULTI-LAYERED STRUCTURES	single use
199507436	ISOTROPIC SILICON ETCH PROCESS THAT IS HIGHLY SELECTIVE TOTUNGSTEN	single use
199507437	LOW POWER SENSE AMPLIFIER FOR GAIN MEMORY CELLS	single use
199507441	TWO-STEP CHEMICAL MECHANICAL POLISH SURFACE PLANARIZATIONTECHNIQUE	single use
199507479	MONOLITHIC LINEAR OPTOCOUPLER	single use
199507480	MONOLITHIC LINEAR COUPLER STRUCTURE	single use
199507481	AN DATA ACCESS ARRANGEMENT HAVING IMPROVED TRANSMIT RECEIVSEPARATION	single use
199507482	A COMBINATION HOOK/SWITCH CONTROL AND POLARITY GUARDWITH INTEGRAL DRIVE TRANSISTORS	single use
199507483	A METHOD OF MANUFACTURING A SEMICONDUCTOR DEVICE	single use
199507497	SCANNING ELECTRON MICROSCOPE RULER AND METHOD	single use
199507498	METAL INTERCONNECT STRUCTURE FOR AN INTEGRATED CIRCUIT WITHIMPROVED ELECTRO MIGRATION RELIABILITY	single use
199507501	IN-SITU WAFER TEMPERATURE CONTROL APPARATUS FOR SINGLEWAFER TOOLS	single use
199507502	OFF-STATE GATE-OXIDE FIELD REDUCTION IN CMOS	single use
199507508	ETCH CHAMBER HAVING THREE INDEPENDENTLY CONTROLLEDELECTRODES	single use
199507511	AVOIDANCE OF PATTERN SHORTENING BY USING AN OFF AXISILLUMINATION WITH TWISTING DIPOLE AND POLARIZING APERTURES	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 74 von 188

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199507512	APPLICATION OF THIN CRYSTALLINE Si3N4 LINERS IN SHALLOW TRENCH ISOLATION (STI) STRUCTURES	single use
199507513	ETCH PROFILE SHAPING THROUGH WAFER TEMPERATURE CONTROL	single use
199507514	FORMATION OF SELF-ALIGNED OVERLAPPING BITLINE CONTACTS WITH SACRIFICIAL POLYSILICON FILL-IN STUD	single use
199507532	AN IMPROVED SEMICONDUCTOR DEVICE	single use
199507534	ENHANCED DEEP TRENCH STORAGE NODE CAPACITANCE FOR DRAM	single use
199507535	FUSE ELEMENT FOR EFFECTIVE LASER BLOW IN AN INTEGRATED CIRCUIT DEVICE	single use
199507536	IN-SITU TEMPERATURE MEASUREMENT USING X-RAY DIFFRACTION	single use
199507537	INTEGRATED POLYSILICON DIODE CONTACT FOR GAIN MEMORY CELLS	single use
199507538	BORDERLESS CONTACT ETCH PROCESS WITH SIDEWALL SPACER AND SELECTIVE ISOTROPIC ETCH PROCESS	single use
199507542	LOW PROFILE OPTICAL DEVICE WITH MULTIPLE MOUNTING CONFIGURATIONS	single use
199507543	DEEP DEPLETION MODE DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY (DRAM) CELL	single use
199507562	INTERFACE FOR PROVIDING CALL CONTROL FOR A HEADSET ATTACHED TO A TELEPHONE	single use
199507564	CLOSED-MOLD FOR LED ALPHANUMERIC DISPLAYS	single use
199507568	IMPROVED FUSE LINK STRUCTURES THROUGH THE ADDITION OF DUMMY STRUCTURES	single use
199507569	PLANARIZED FINAL PASSIVATION FOR SEMICONDUCTOR DEVICES	single use
199507570	METHOD TO FORM A BURIED, IMPLANTED PLATE FOR DRAM TRENCH STORAGE CAPACITORS	single use
199507571	SINGLE OR MULTIPLE PATTERNED ETCH STOP LAYERS FOR FUSE ETCH	single use
199507572	CONTROLLED RECRYSTALLIZATION OF BURIED STRAP IN A SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE	single use
199507573	PROCESS FOR REDUCING CIRCUIT DAMAGE DURING PECVD IN SINGLE WAFER PECVD SYSTEM	single use
199507574	SEMICONDUCTOR STRUCTURE USING MODULATION DOPED SILICATE GLASSES	single use
199508002	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FLIMMERREDUKTION FÜR EINGERÄTE ZUR VIDEO-SIGNALVERARBEITUNG	single use
199508014	INTEGRIERTE PUFFERSCHALTUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 75 von 186

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM PAGE 88/235 Fax Server

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199508015	INTEGRIERTE PUFFERSCHALTUNG	single use
199508016	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BESTIMMUNG VON KAPAZITAETSDIFFERENZEN	single use
199508018	Vorrichtung zur Takterzeugung fuer CMOS-Schaltungen mit dynamischen Registern.	single use
199508023	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES GEGENUEBER EINEM EINGANGS-SIGNAL ORTHOGONALEN AUSGANGSSIGNALS SOWIE VERWENDUNG DIESER SCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199508036	SCHALTUNGSANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM MESSEN EINES KAPAZITAETS-UNTERSCHIEDES ZWISCHEN EINER ERSTEN KAPAZITAET UND EINER ZWEITEN KAPAZITAET C2	dual use
199508041	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR BESTIMMUNG DES EMISSIONSFAKTORS VON HALBLEITERMATERIALIEN DURCH BESTRAHLUNG MIT ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN	single use
199508044	Mikromechanisches Bauelement mit Membran	dual use
199508057	CHIPKARTE	single use
199508065	VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINER SILIZIUMDIOXIDSCHICHT AUFOBERFLAECHENABSCHNITTEN EINER STRUKTUR	single use
199508067	SRAM-SPEICHERZELLE	single use
199508081	Optoelektronisches Bauelement mit kodirektionaler Modenkopplung	single use
199508088	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR RAUSCHREDUKTION FUER VIDEO-SIGNALE	dual use
199508094	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DATENKARTE	single use
199508101	VERFAHREN ZUR VERTIKALEN INTEGRATION MIKROELEKTRONISCHER SYSTEME	single use
199508559	ERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O-MERCAPTOAMIDEN	single use
199508560	HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O-MERCAPTOAMIDEN	single use
199508596	VERSCHLUSSTEIL	single use
199508597	LOESBARER STECKER	single use
199508605	Plaettchenfoermige, hydrophobe Kohlenstoffaerogele mit einer Faserverstaerkung aus elektrisch nichtleitenden, anorganischen Materialien und ein Verfahren zu deren Herstellung	dual use
199509809	ECHOKOMPENSATOR IV	single use
199509810	SENDEFILTER FUER EINEN ECHOKOMPENSATOR	single use
199601002	Doppelheterostruktur-HEMT	single use
199601004	Herstellverfahren fuer eine Siliziumoxid-Schicht auf einer Topographie	single use
199601005	Herstellverfahren fuer ein mikromechanisches Bauteil mit einer beweglichen Struktur	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 76 von 186

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM PAGE 89/235 Fax Server

C:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199601006	Elektrisch programmierbare Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199601008	Mikromechanisches Bauteil mit planarisiertem Deckel auf einem Hohlraum und Herstellungsverfahren	single use
199601009	Elektrisch programmierbare Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199601010	Matrix-Speicher (Virtual Ground)	single use
199601012	Halbleiterbauelement	single use
199601015	Mobiles Fernsprechengerät	dual use
199601017	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FARBCODIERUNG UND -DEZIMIERUNG FÜR EIN VIDEO-SIGNAL	single use
199601020	Schaltnetzteil mit verlustleistungsarmem Standby-Betrieb	single use
199601037	VORRICHTUNG ZUR SPANNUNGSVERVIELFACHUNG, INSB. VERWENDBAR ZUR ERZEUGUNG DER LOESCHSPANNUNG FÜR EIN EEPROM	single use
199601038	STATISCHE HALTEGLIEDER MIT EINPHASIGEM STEUERSIGNAL.	single use
199601043	ELEKTRISCHE SCHALTUNG ALS OHMMETER	single use
199601049	Verfahren zur rechnergestützten iterativen Bestimmung des Einschwingverhaltens einer Quarzresonatorschaltung	single use
199601058	VERFAHREN ZUR FAX-UEBERTRAGUNG IN DIGITALEN NETZEN	dual use
199601061	Verfahren zur Herstellung strukturierter Metallisierungen	single use
199601064	Halbleiterneuron mit variablen Eingangsgewichten.	single use
199601071	Vorrichtung zum Aufnehmen und Halten eines Teils, insbesondere eines einer Mikrolinse haltenden Trägerkörpers	single use
199601073	Optische Koppelanordnung aus einem Paar streifenartiger optischer Wellenleiterabschnitte	single use
199601083	VERFAHREN ZUM LOETEN EINES HALBLEITERKÖRPERS AUF EIN TRÄGERPLATTE UND HALBLEITERKÖRPER ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS	single use
199601098	ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR CODIERUNG UND DECODIERUNG VON MIT EINEM BLOCKBASIERTEM CODIERUNGSVERFAHREN CODIERTEN BILDERN	dual use
199601099	Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelement	single use
199601100	Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelement	single use
199601101	SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use
199601117	ADRESSIERUNG VON DATEIEN IN SEQUENTIELL ARBEITENDEN MATRIX-SPEICHERN	single use
199601120	SCHIEBEREGISTER	single use
199601135	TREIBERSCHALTUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 77 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199601138	ANORDNUNG ZUR FUZZIFIZIERUNG EINES AN EINEM EINGANG ANLIEGENDENEINGANGSSIGNALES, DAS ALS SCHARFER EINGANGSWERT ODER ALS UNSCHARFEMENGE VON EINGANGSWERTEN VORLIEGT	single use
199601140	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR ADAPTION EINES FUZZY-REGLERS	single use
199601141	Integrierte Schaltungsanordnung zum Ansteuern eines Leistungs-MOSFET mit sourceseitiger Last	single use
199601148	Halbleiterkoerper mit Lotmaterialschiicht	single use
199601177	DATENUEBERTRAGUNGSVERFAHREN	dual use
199601183	Haltungsanordnung fuer einen programmierbaren nichtfluechtigen Speicher	single use
199601201	Chipkarte mit ESD-Schutz	single use
199601202	ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR FORMATWANDLUNG VON BILDBLOECKEN VONEINEM ERSTEN CODIERUNGSFORMAT IN EIN ZWEITES CODIERUNGSFORMAT	dual use
199601210	Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelement	single use
199601214	Vorrichtung zur wellenlaengenmaessigen Stabilisierung eines optischen Filters	dual use
199601215	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES FELDEFFEKTTRANSISTORS MIT SOURCESEITIGER LAST	single use
199601224	SCHWELLWERTLOGIK MIT VERBESSERTEM SIGNAL-RAUSCH-ABSTAND	single use
199601227	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199601234	Vorrichtung zur Analog/Digital-Wandlung mit unbedingter Stabilitaet	single use
199601249	Verfahren zur Abschaetzung der Lebensdauer eines Leistungshalbleiter-Bauelements	single use
199601270	MONOSTATISCHES HOMODYNES RADARSYSTEM	dual use
199601275	Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelement	single use
199601290	Bipolartransistor mit Hochenergie-implantiertem Kollektor und Herstellverfahren	single use
199601291	Schaltungsanordnung zur Bild-im-Bild-Einblendung	single use
199601292	Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines an einem Bildschirm darstellbaren Bildsignals	single use
199601299	Schaltungsanordnung zur Leitungsanpassung und Echounterdruockung	single use
199601305	Verfahren zur Sicherung von Datenpaketen und Schaltungsanordnung zur Durchfuehrung eines solchen Verfahrens	single use
199601319	Elektrooptisches Verbundbauelement	single use
199601322	Integrierte Halbleiterschaltung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 78 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199601331	Programmierbarer Speicher und Verfahren zur Herstellung eines programmierbaren Speichers	single use
199601338	SCHALTUNGSSTRUKTUR MIT MINDESTENS EINEM MOS-TRANSISTOR UNDVERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG.	single use
199601349	Halbleiterbauelement mit einstellbarer, auf einem tunnelstromgesteuerten Lawinendurchbruch basierenderStromverstaerkung	single use
199601350	Halbleiterbauelement mit einem geteilten Floating Gate	single use
199601353	Verfahren zur Personenidentifikation	dual use
199601354	Kommunikationssystem mit einer Meisterstation und mindestens einerSklavenstation	single use
199601355	Kommunikationssystem mit einer Meisterstation und mindestens einerSklavenstation	single use
199601369	Verfahren zur Steuerung des Zugriffs auf einen von mehrerenDatenquellen gemeinsam benutzten Uebertragungskanal	single use
199601371	Programmierbarer Festwertspeicher mit verbesserter Zugriffszeit	single use
199601386	Videodecoder und entsprechendes Verfahren	dual use
199601392	SCHOTTKYDIODENANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG	single use
199601404	Integrierte Takterzeugungsschaltung	single use
199601405	Integrierte Schaltungsanordnung zur Reduzierung der Stromaufnahme	single use
199601408	Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbausteines mit einemWaermeverteiler	single use
199601410	Treiberstufe	single use
199601413	LDD-MOSFET	single use
199601414	Synchronisierbare Stromversorgung	single use
199601428	SPEICHERZELLENANORDNUNG UND EIN VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use
199601430	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN ZUFAELLIGER BITFOLGEN	single use
199601431	Leiterverbundsystem und Verfahren zur Herstellung elektrischleitender Verbindungen zwischen zwei oder mehr Leiterstrukturen	single use
199601432	Verfahren zur Herstellung einer Mehrlagen-Verbundstruktur mitelektrisch leitenden Verbindungen	single use
199601433	Traegerelement mit wenigstens einem integrierten Schaltkreis sowieVerfahren zur Herstellung eines solchen Traegerelementes	single use
199601434	CHIPKARTENMODUL MIT BESCHICHTUNG AUS LEITFAEHIGEM KUNSTSTOFF UNDVERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG	dual use
199601435	Kondensator mit einer Carbid- ODER Boridbarriereschicht	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 79 von 188

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199601436	Verfahren zur Herstellung einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen einem ummantelten Kupferdraht und einem elektrischen Leiter	single use
199601437	Taktsignalgenerator	single use
199601448	Vorrichtung zur ortsgenauen Fixierung von Mikrochips	single use
199601450	BANDGAP-REFERENZSPANNUNGSSCHALTUNG ZUR ERZEUGUNG EINER TEMPERATURKOMPENSIERTEN REFERENZSPANNUNG	dual use
199601458	Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines Referenzpotentials	single use
199601459	Schaltungsanordnung zur Ubertemperaturerfassung	single use
199601476	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GEWINNUNG VON IN EINEM SIGNAL ENTHALTENER DIGITALER DATENINFORMATION	single use
199601481	SCHALTNETZGERAET	single use
199601482	Schaltungsanordnung zum Schutz eines Leistungs-MOSFET	single use
199601487	Schaltungsanordnung zur Parametereinstellung	single use
199601490	HALBLEITERBAUELEMENT MIT KOMPENSATIONSIMPLANTATION UND HERSTELLVERFAHREN	single use
199601492	VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN JUSTIERUNG EINER SCHALTEINRICHTUNG ZUM AUTOMATISCHEN UMSCHALTEN ZWISCHEN EINER EMPFANGSBETRIEBSART UND EINER SENDEBETRIEBSART BEI EINER FREISPRECHEINRICHTUNG EINES KOMMUNIKATIONSENDGERAETES	single use
199601493	Verfahren zur hochratigen digitalen Signaübertragung	dual use
199601494	Trägerelement fuer einen Halbleiterchip	single use
199601498	Thyristor mit integriertem dU/dt-Schutz	dual use
199601500	MOSFET mit Temperaturschutz	single use
199601502	Mehrschichtkondensator mit hoher spezifischer Kapazität und Herstellverfahren dafür.	single use
199601509	DRAM-ZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG.	single use
199601512	Verfahren zum Betreiben eines Schadstoffbehandlungsgerätes	single use
199601518	Herstellverfahren fuer eine Aluminiumschicht	single use
199601522	EIN-/AUSSCHALTBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES REFERENZPOTENTIALS	single use
199601523	Verfahren zum Ätzen eines Halbleitersubstrats sowie Ätzanlage	single use
199601528	Optoelektronischer Wandler und dessen Herstellungsverfahren	single use
199601537	VERFAHREN ZUM ÄTZEN VON ZERSTÖRUNGSZONEN AN EINEM HALBLEITERSUBSTRAT RAND SOWIE ÄTZANLAGE	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 80 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199601539	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN EINES WIDERSTANDSVERHALTENS MITEINSTELLBAREM POSITIVEN TEMPERATURKOEFFIZIENTEN SOWIE VERWENDUNG DIESER SCHALTUNGSANORDNUNG	dual use
199601540	Verfahren zum Uebertragen von Daten zwischen einer Sendestation und einer dieser zugeordneten Empfangsstation	dual use
199601546	Stromversorgungsnetz	dual use
199601557	EINZELELEKTRON-SPEICHERZELLENANORDNUNG.	single use
199601563	HALBLEITERSTRUKTUR FUER EINEN MOS-TRANSISTOR UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER HALBLEITERSTRUKTUR	single use
199601565	Redundanzkonzept fuer integrierte Speicher mit ROM-Speicherzellen	single use
199601566	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KOMPENSATION VON LUFTDRUCKSCHWANKUNGEN BEI THERMISCHEN OXIDATIONSPROZESSEN	single use
199601567	CMOS-Halbleiterstruktur und Verfahren zur Herstellung derselben	single use
199601570	Schaltungsanordnung mit verringerter EMV-Abstrahlung	dual use
199601571	FILTERSCHALTUNG MIT FREQUENZREGELUNG	single use
199601572	Verfahren zum kryptographischen Schluesselfmanagement zwischeneiner ersten Computereinheit und einer zweiten Computereinheit	dual use
199601573	VERFAHREN ZUM GRUPPENBASIERTEM KRYPTOGRAPHISCHEN SCHLUESSELMANAGEMENT ZWISCHEN EINER ERSTEN COMPUTEREINHEIT UND GRUPPENCOMPUTEREINHEITEN	dual use
199601576	Verfahren zur Herstellung mechanisch fester Klebstoffverbindungen zwischen Oberflächen	dual use
199601577	Optoelektronische Sendevorrichtung	single use
199601580	MOS-Transistor fuer biotechnische Anwendungen	single use
199601582	VERFAHREN ZUR GENERIERUNG EINES ZUR STEUERUNG EINER DATENAUSGABEVERWENDBAREN AUSGABETAKTSIGNALS IN ABHAENGIGKEIT VON EINEM VON MEHREREN EINGABETAKTSIGNALEN	dual use
199601586	AUTOMATISCHE LEUCHTENSTEUERUNGSVORRICHTUNG MIT DOPPLERRADARMODUL, WELCHES IN EINE UNTERPUTZDOSE EINBAUBAR IST.	single use
199601592	Traegerelement fuer Halbleiterchips sowie Verfahren zur Herstellung eines Traegerelements	single use
199601593	Schaltungsanordnung zur Spannungsumpolung	single use
199601594	Schaltungsanordnung zur Spannungsumpolung in einem Mobilfunkgeraet	single use
199601595	ELEKTRONISCHE SPRECHSCHALTUNGSANORDNUNG	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

OPC IC
 Seite 81 von 186

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199601596	Kommunikationssystem und Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder	single use
199601605	ASERDIODE-MODULATOR-KOMBINATION	single use
199601606	Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines Referenzpotentials	single use
199601616	VORRICHTUNG ZUR KOMPENSATION DER SIGNALLAUFEITUNTERSCHIEDE VON DIGITALEN ÜBERTRAGUNGSEINRICHTUNGEN	dual use
199601617	SYSTEMTRAEGER FÜR DIE MONTAGE EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG IN EINEM SPRITZGUSSGEHÄUSE	single use
199601625	Vorrichtung zum Messen magnetischer Feldstärken	single use
199601636	Verfahren zum Betreiben einer Datenspeichereinrichtung, insbesondere einer fehlerhaften Speicherbereiche aufweisenden Datenspeichereinrichtung	single use
199601637	MIKROPROZESSORVORRICHTUNG	single use
199601639	Schaltungsanordnung zur digitalen Einstellung analoger Parameter	single use
199601649	AUSLESESCHALTUNG UND KAPAZITIV MESSENDER SENSER	dual use
199601651	HALBLEITERSPEICHERVORRICHTUNG	single use
199601652	Speicherzelle	single use
199601661	Bauelementgehäuse für eine Oberflächmontage eines Halbleiter-Bauelementes	dual use
199601662	Halbleiter-Bauelement	single use
199601665	Elektronische Nachlaufsteuerung	single use
199601666	Drucksensorvorrichtung für eine Montage auf der Bestückungsoberfläche einer Leiterplatte	single use
199601667	Auf der Bestückungsoberfläche einer Leiterplatte montierbares Drucksensor-Bauelement	dual use
199601669	Auf der Bestückungsoberfläche einer Leiterplatte montierbares Sensor-Bauelement	single use
199601670	Integrierte Halbleiterschaltung	single use
199601677	Schaltungsanordnung zur Verstärkungsregelung	single use
199601691	ERFAHREN ZUR RECHNERGESETZTEN ERMITTLUNG EINER SYSTEMZUSAMMENHANGSFUNKTION	single use
199601694	VORRICHTUNG ZUR SPANNUNGSVERVIELFACHUNG MIT GERINGER ABHÄNGIGKEIT DER AUSGANGSSPANNUNG VON DER VERSORGUNGSSPANNUNG	single use
199601700	CMOS-SCHALTUNG AUS CMOS-SCHALTUNGSBLOECKEN, DIE IN BITPARALLELEN DATENPFADEN ANGEORDNET SIND	single use
199601710	Chipkarten und Verfahren zu ihrer Herstellung	single use
199601712	Schaltungsanordnung zur Offset-Kompensation	dual use
199601713	FILTERSCHALTUNG	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 82 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte**



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199601715	Halbleiterbauelement mit niedrigem Kontaktwiderstand zu hochdotierten Gebieten	single use
199601725	Halbleiterbauelement mit einer Steuerstruktur zur Modulation der Leitfähigkeit eines Kanalbereichs	single use
199601740	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZ EINES LEISTUNGS-MOSFET	dual use
199601741	Tragbare Datenübertragungsvorrichtung und Befestigungselement	dual use
199601742	Verfahren zum Empfang von Fernsehprogramminformation	single use
199601743	Datensystem zur Dokumentation und/oder zur Auswertung von Transaktionen eines Benutzers	dual use
199601749	Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils, insbesondere zur Herstellung einer Induktionsspule fuer Chipkarten	single use
199601753	Phasenregelkreis mit Technologiekompensation	dual use
199601756	Anschlussrahmen fuer Halbleiter-Chips	single use
199601760	Halbleiterbauelement mit isolierenden Gehaeuse	single use
199601761	Herstellverfahren von Shallow-Trench-Isolationen auf einem Substrat	single use
199601763	Verfahren zum Testen eines Produktes und Vorrichtung zum Durchfuehren des Verfahrens	single use
199601765	Schaltungsanordnung zur Einstellung des Arbeitspunktes	single use
199601768	Nichtfluechtige Speicherzelle.	single use
199601769	Nichtfluechtige Speicherzelle.	single use
199601771	Eingangsstufe fuer einen Transimpedanzverstaerker	single use
199601773	Verfahren zur Sprecherverifikation anhand mindestens eines von einem Sprecher eingesprochenen Sprachsignals, durch einen Rechner	dual use
199601775	Chipkarte mit einer Kontaktzone und Verfahren zum Herstellen einer solchen Kontaktzone	single use
199601777	Halbleiterschalter	dual use
199601779	Herstellverfahren fuer eine Lackmaske	single use
199601781	Verfahren zum Erzielen einer gewuenschten Solidifferenz zwischendem Zaehlstand eines durch ein erstes Taktsignal zum Zaehlenveranlassten ersten Zaehlers und dem Zaehlstand eines durch ein zweites Taktsignal zum Zaehlen veranlassten zweiten Zaehlers	dual use
199601782	VERFAHREN ZUM SYNCHRONISIEREN EINES IN EINER DATENEMPFANGSSTATION ZU GENERIERENDEN TAKTSIGNALS MIT EINEM IN EINER DATENSENDESTATION VERWENDETEN TAKTSIGNAL	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

OPC IC
Seite 83 von 166

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199601785	VORRICHTUNGEN ZUR SELBSTJUSTIERENDEN ARBEITSPUNKTEINSTELLUNG INVERSTAERKERSCHALTUNGEN MIT NEURON-MOS-TRANSISTOREN.	single use
199601786	VERSTAERKER MIT NEURON-MOS-TRANSISTOREN.	single use
199601794	Dotiertes Siliziumsubstrat	single use
199601805	MATRIX-SPEICHER IN VIRTUAL-GROUND-ARCHITEKTUR	single use
199601816	Schnittstellenschaltung	single use
199601819	CHIPKARTE	single use
199601820	Fuse-Refresh-Schaltung	single use
199601831	Verfahren zum Betrieb einer Speicherzellenanordnung.	single use
199601833	Verfahren zum Betrieb einer Speicherzellenanordnung	single use
199601837	Verfahren zur Herstellung von integrierten kapazitiven Strukturen	single use
199601840	Ansteuerschaltung fuer ein Feldeffekt gesteuertesLeistungs-Halbleiterbauelement	dual use
199601841	Elektronisches Sensor-Bauelement	single use
199601843	Verfahren zur Herstellung eines Feldeffekttransistors	single use
199601845	Verfahren zum plasmaunterstuetzten anisotropen Aetzen vonMetallen, Metalloxiden und deren Gemische	single use
199601847	ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-FET MIT SOURCESEITIGER LAST	dual use
199601857	Chipkarte, Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte,Halbleiterchip zur Verwendung in einer Chipkarte	single use
199601860	Waferrahmen	single use
199601863	DATENTRAEGER ZUR UEBERTRAGUNG VON ELEKTRISCHEN SIGNALEN	single use
199601866	Voll differentieller Digital/Analog-Wandler mit geringer Anzahlvon Widerstaenden	single use
199601867	VERFAHREN ZUR MULTIPLIKATION EINES MULTIPLIKANDEN UND EINESMULTIPLIKATORS NACH DEM BOOTH-VERFAHREN IN ITERATIVEN SCHRITTEN	single use
199601874	Verfahren zur Herstellung eines Kondensators in einerHalbleiteranordnung	single use
199601876	Kondensator mit einer Sauerstoff-Barriereschicht und einer erstenElektrode aus einem Nichtedelmetall	single use
199601877	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG FEINER STRUKTUREN UND DESSEN VERWENDUNGZUR HERSTELLUNG EINER MASKE UND EINES MOS-TRANSISTORS	single use
199601879	Verfahren zur Herstellung eines Kalkkathoden-Emitters	single use
199601884	Schaltungsanordnung zum Erfassen des Laststroms einesLeistungs-Halbleiterbauelements mit sourcesseitiger Last	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 84 von 186

C:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199601885	Geraet zum chemisch-mechanischen Polieren von Wafern	single use
199601891	Ansteuerschaltung fuer ein Feldeffekt gesteuertes Halbleiterbauelement	dual use
199601894	Vorrichtung zum Ausgeben chemischer Fluessigkeiten	single use
199601896	Schaltung zur Anzeige von Betriebszuständen eines Geraetes	single use
199601897	VORRICHTUNG ZUM AUFBRINGEN EINES KLEBEBANDS AUF EIN LEADFRAME	single use
199601900	Verfahren zum elektrischen Verbinden von internen Anschlussklemmen eines Halbleiterkoerpers und Vorrichtung zur Durchfuehrung des Verfahrens	single use
199601901	Integrierte Schaltung	single use
199601920	LEISTUNGS-HALBLEITERSCHALTER	single use
199601921	Schaltungsanordnung zum Ansteuern einer elektrischen Antriebseinheit	single use
199601928	Mikroprozessor, insbesondere zur Verwendung in einer Chipkarte, mit einer Steuerungseinheit und mit einem die Steuerungseinheit umgebenden Gehaeuse	dual use
199601932	"Halbleiterschaltung, insbesondere zur Verwendung in einem integrierten Baustein"	dual use
199601933	Verfahren zum Uebertragen von Daten zwischen einem Terminal und einem tragbaren Datentraeger ueber eine drahtlose elektromagnetische Uebertragungsstrecke	dual use
199601954	Verfahren und Anordnung zur Identifikation von Personen	dual use
199601960	Verfahren zur Optimierung der Adhaesion zwischen Pressmasse und Passivierungsschicht	single use
199601965	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM TREIBEN EINER KAPAZITIVEN LAST	single use
199601966	Uebertragung von dreidimensionaler Bildinformation	single use
199601978	Leistungs transistor mit Kurzschluss-Schutz	dual use
199601989	Optoelektronisches Sende- UND/oder Empfangsmodul	single use
199601991	Leistungs-Halbleiterbauelement	single use
199602000	Current-Mode Sense Amplifier	single use
199602005	Traegerelement fuer einen Halbleiterchip	single use
199602015	Verfahren zur maschinellen Erzeugung einer optimierten Wissensbasis fuer einen Fuzzy-Logik-Prozessor.	single use
199602023	Traegerelement fuer einen Halbleiterchip	single use
199602043	Verfahren zur Erzeugung einer einseitigen galvanischen Metallschicht auf Chipmodulen	single use
199602044	Teilnehmerschaltung	dual use
199602045	Verfahren zum Auffuellen eines Grabens	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 85 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199602053	Datenstromkonvertierungseinrichtung	dual use
199602056	Schaltung zur Ermittlung und Speicherung eines Signalmittelwertes	dual use
199602061	Schaltung zur Ermittlung und Bewertung eines Datensignals	dual use
199602088	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DRAM-ZELLENANORDNUNG.	single use
199602090	Funktelefon	single use
199602099	Koppelanordnung zum Aneinanderkopfen von Wellenleitern	single use
199602100	Integrierte Schaltung mit einem diese in sich aufnehmenden Gehäuse	single use
199602101	Verfahren, durch welches Saetzen von verschiedene Parameterrepraesentierenden Werten Adressen zuweisbar sind	dual use
199602113	CMOS-Komparator	single use
199602114	Temperaturgeschuetztes elektrisches Schalter-Bauelement	dual use
199602116	Stromanschluss fuer Leistungshalbleiterbauelement	dual use
199602124	Vorrichtung und Verfahren zum Verbiegen der Leads von Gehaeusen fuer Halbleiterchips	single use
199602127	Verfahren zum Abloesen von mittels Lead-On-Chip-Montage an einem Leadframe befestigten Chips	single use
199602140	Halbleiteranordnung mit geschuetzter Barriere fuer eine Stapelzelle	single use
199602141	Speicherzelle mit Polymerkondensator	single use
199602147	Verzoegerungsstufe mit steilen Flanken.	single use
199602155	Zuleitungsrahmen fuer ein mikroelektronisches Bauelement	single use
199602167	Durch Feldeffekt steuerbares, vertikales Halbleiterbauelement	single use
199602168	Durch Feldeffekt steuerbares, vertikales Halbleiterbauelement	single use
199602169	Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelement	single use
199602171	FERNSEHEMPFANGENGER MIT TELETEXTVERARBEITUNG	single use
199602175	Verfahren zum Herstellen eines oder mehrerer abgeloeester optischer Wellenleiter	single use
199602177	Halbleiteranordnung mit einer Schicht aus einem Edelmetall und Verfahren zum Herstellen derselben	single use
199602178	Optischer Wellenleiter und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199602184	SCHMELZSICHERUNG MIT EINER SCHUTZSCHICHT IN EINER INTEGRIERTENHALBLEITERSCHALTUNG SOWIE ZUGEHÖRIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN	single use
199602186	Anschlussrahmen fuer ein mikroelektronisches Bauteil, Verfahren zu dessen Herstellung und den Anschlussrahmen umfassendes mikroelektronisches Bauteil	single use
199602189	Kondensator mit einem Elektrodenkern und einer duennen Edelmetallschicht als erster Elektrode	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 86 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199602194	Anordnung aus zwei auf der Oberflaeche eines Substratsintegrierten optischen Wellenleitern	single use
199602196	Speicheranordnung mit Ferroelektrikum als Speicherdielektrikum	single use
199602199	Vorrichtung zum Schutz von geldwerten und/oder schuetzenswertelInformationen tragenden elektronischen Anordnungen	dual use
199602203	SELBSTJUSTIERTE NICHTFLUECHTIGE SPEICHERZELLE	single use
199602204	ANALYSIERSCHUTZ FUER EINEN HALBLEITERCHIP	dual use
199602205	Chipmodul und Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls	single use
199602218	Anschlussrahmen fuer ein mikroelektronisches Bauteil, Verfahren zudessen Herstellung und den Anschlussrahmen umfassendesmikroelektronisches Bauteil	single use
199602232	Halbleiterkoerper mit Lotmaterialschiicht	single use
199602237	Herstellverfahren fuer eine polykristalline Siliziumschicht mitglatter Oberflaeche	single use
199602240	Halbleitervorrichtung und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199602241	Regelschaltung fuer Ladungspumpen	single use
199602245	Verfahren zum Testen von unbestueckten Burn-in-Boards	single use
199602247	Parametrisierbare Standardzellen.	single use
199602251	SPENDEVORRICHTUNG	single use
199602257	Traegerband und Verfahren zum Herstellen eines solchenTraegerbandes	single use
199602269	SCHALTUNGSANORDNUNG MIT ZWISCHEN REGISTERN ANGEORDNETENKOMBINATORISCHEN BLOECKEN	single use
199602273	Anordnung aus einem integrierten streifenartigen optischenRippenwellenleiter und einer optisch an den Wellenleitergekoppelten integrierten Photodiode	single use
199602275	Schaltungsanordnung mit zwischen Registern angeordnetenkombinatorischen Bloecken	single use
199602276	Verfahren zur Flipchip-Kontaktierung eines Halbleiterchips mitgeringer Anschlusszahl	single use
199602282	Halbleiter-Festwertspeicher und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199602283	Integrierte CMOS-Schaltungsanordnung und Verfahren zu derenHerstellung.	single use
199602284	VERFAHREN ZUR QUALITAETSSICHERUNG IN EINER FERTIGUNG	single use
199602287	Verfahren zur Herstellung eines MOS-Transistors.	single use
199602288	Speicheranordnung	single use
199602292	Optischer Filter nach dem Phased-Array-Prinzip	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 87 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199602298	Verfahren und Vorrichtung zur Aktionssteuerung in einem Zeitschlitzverfahren	dual use
199602300	Leistungs-MOS-Bauelement	single use
199602301	Kontaktlose Chipkarte	single use
199602305	Schaltungsanordnung mit einem Mikroprozessor und einem Stapelspeicher	single use
199602307	Schaltungsanordnung zum Entstören eines Signales	dual use
199602311	Gehäuse zur Aufnahme von elektrischen Einrichtungen	dual use
199602313	Mikroelektronisches Bauteil in Sandwich-Bauweise	single use
199602314	HERSTELLVERFAHREN FÜR EINE HOCH-E-DIELEKTRISCHE ODER FERROELEKTRISCHE SCHICHT UND VERWENDUNG DES VERFAHRENS	single use
199602316	Schutzschaltungsanordnung	dual use
199602317	Verfahren zur Waferidentifizierung in der Chipfertigung und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens	single use
199602320	Verfahren zum Herstellen einer Halbleiteranordnung	single use
199602321	Temperatursensorschaltung	single use
199602322	Kathodenanordnung für GTO-Thyristor	dual use
199602328	Kathodenanordnung für GTO-Thyristor	dual use
199602331	Verfahren zur Herstellung eines Stegwellenleiters in III-V-Verbindungshalbleiter-Schichtstrukturen und Halbleiterlaservorrichtung	single use
199602335	Anordnung zur Durchführung eines Add/Drop-Verfahrens im Wellenlängenmultiplex übertragenen optischen Leistungen	single use
199602337	Verfahren zur nass-chemischen Ätzung bzw. Oberflächenreinigung von arsenhaltigen Mischkristallverbindungen	single use
199602341	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HALBLEITERBAUELEMENTS	single use
199602345	Optoelektronisches Modul zur bidirektionalen optischen Datenübertragung	single use
199602346	DRAM	single use
199602347	Optoelektronisches Modul zur bidirektionalen optischen Datenübertragung	single use
199602354	Schutzschaltung für integrierte Schaltkreise	single use
199602356	Verfahren zum Herstellen eines Strahlleiterformkörpers und Verwendung des Strahlleiterformkörpers in einem optoelektronischen Modul	single use
199602358	Verfahren zur Erhöhung der Reichweite in einem Zeitschlitzverfahren	dual use
199602361	Integrierte Halbleiterspeicheranordnung	single use
199602362	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG BARRIERENFREIER HALBLEITERSPEICHER-ANORDNUNGEN	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 88 von 186

D: BARRY E. BRETSCHEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199602366	Verfahren zur Vektorquantisierung und zur inversen Vektorquantisierung eines digitalisierten Bildes	dual use
199602369	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG BARRIERENFREIER HALBLEITERSPEICHER-ANORDNUNGEN	single use
199602373	Verfahren zur Herstellung barrierenfreier Halbleiterspeicheranordnungen	single use
199602374	Mehrfach-Vorstufenschaltung fuer Fernseh-Tuner	single use
199602376	"Integrierte Halbleiterspeicheranordnung mit "Buried-Plate-Elektrode"	single use
199602377	SPEICHERANORDNUNG MIT SELBSTJUSTIERENDER NICHT INTEGRIERTER KONDENSATORANORDNUNG	single use
199602378	Chipmodul insbesondere zur Implantation in einen Chipkartenkoerper	single use
199602379	Chipmodul insbesondere zur Implantation in einen Chipkartenkoerper	single use
199602381	Schaltungsanordnung fuer eine getaktete Schaltregleranordnung	single use
199602383	Schaltungsanordnung zum Erzeugen einer stabilisierten Gleichspannung	single use
199602384	Integrierte Halbleiterspeicheranordnung	single use
199602386	Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelement	single use
199602388	Verpolschutzschaltung fuer integrierte Schaltkreise	single use
199602390	Vorrichtung zur einfachen Erzeugung von Taktsignalen mit nichtganzzahligen Teilverhaeltnissen aus einem Master-Takt.	dual use
199602393	VERFAHREN ZUM AUSTAUSCH KRYPTOGRAPHISCHEN SCHLUESSELMATERIALS ZWISCHEN MINDESTENS EINER ERSTEN COMPUTEREINHEIT UND EINER ZWEITEN COMPUTEREINHEIT	single use
199602402	Getaktete Stromversorgung von Schaltnetzteilen	single use
199602413	Elektronische Datenverarbeitungsschaltung	dual use
199602415	Chipkarte mit einer Kontaktzone sowie Verfahren zur Herstellung einer solchen Chipkarte	single use
199602416	Datenuebertragungsschaltung mit einer Station und mit einer Antwortschaltung	dual use
199602421	Schaltungsanordnung zur Farbkodierung eines Videosignals	single use
199602445	Traegerelement fuer einen Halbleiterchip zum Einbau in eine Chipkarte	single use
199602446	Traegerelement fuer einen Halbleiterchip zum Einbau in eine Chipkarte	single use
199602461	Schwellwertlogik-Schaltungen mit geringem Flaechenbedarf.	single use
199602462	Folienkondensator zum Einbau in eine Chipkarte	single use
199602469	Bauteil-Testvorrichtung	single use
199602483	Schaltung mit einer Halbleiterstruktur mit Tunnel-dielektrikum und Betriebsverfahren	single use
199602485	Die Erfindung betrifft ein mikroelektronisches Bauteil gemass der Patentansprueche 1 und 5	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 89 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte**



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199602486	Integrierbarer Kondensator, Verfahren zu seiner Herstellung sowie Speicherfeld unter Verwendung des Kondensators	single use
199602487	Kontaktlose Chipkarte mit Hochprägebereichen	single use
199602492	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ELEKTRISCH SCHREIB- UND LOESCHBAREN FESTWERTSPEICHERZELLENANORDNUNG.	single use
199602493	Verfahren zum Herstellen eines Leadframe-Elementes	single use
199602494	OPTIMIERUNG DER LEISTUNGSVERBINDUNG ZWISCHEN CHIPS UND LEADFRAME FÜR LEISTUNGSSCHALTER	single use
199602497	Verfahren zum Testen eines in Zellenfelder unterteilten Speicherchips im laufenden Betrieb eines Rechners unter Einhaltung von Echtzeitbedingungen	single use
199602499	Mehrstufige Multiplexeranordnung	single use
199602501	Mehrstufige Multiplexeranordnung	single use
199602503	Metallisierung auf Halbleiterbauelement	single use
199602504	Zur Abarbeitung von Softwareprogrammen ausgelegte integrierte Schaltung	single use
199602511	Rechnergestütztes Verfahren zur Partitionierung einer elektrischen Schaltung	single use
199602532	Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Funktionselemente	single use
199602535	Mikromechanischer Sensor	single use
199602541	Verfahren zur Herstellung von mikromechanischen Sensoren	single use
199602552	Verfahren zur Erhebung von Abrechnungsdaten für die Nutzung von programmierten oder programmtechnisch verfügbaren Diensten	dual use
199602554	Schaltnetzteil mit Regelung der Ausgangsspannung	single use
199602556	Schaltungsanordnung zur Analog-Digital-Wandlung	single use
199602563	Halbleiterchip und Wafer mit Schutzschicht, insbesondere aus Keramik	single use
199602567	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN EINER FOLGE VON PROGRESSIVEN BILDERN	single use
199602575	Vorrichtung und Verfahren zur Aufnahme von Fingerabdrucken	single use
199602583	Spannung-Strom-bzw. Strom-Strom-Umsetzer	single use
199602591	EEPROM-Speicherzelle	single use
199602605	Schaltungsanordnung zur Erzeugung einer erhöhten Ausgangsspannung	single use
199602608	TRÄGERELEMENT FÜR HALBLEITERCHIPS	single use
199602611	PARALLEL/SERIELL-WANDLER	single use
199602612	Verfahren zur Ermittlung der Temperatur eines Halbleiterchips	single use
199602613	Integrierte Halbleiterschaltung mit Redundanz-Kapazität	dual use
199602615	Optoelektronisches Bauelement mit MQW-Strukturen	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 90 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199602616	Transponder mit einer Mikrowellen-Empfangsantenne	single use
199602618	Optoelektronischer Modul	single use
199602620	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199602621	Anordnung zur Ansteuerung paralleler Leitungen einer Speicherzellenanordnung.	single use
199602642	Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schaltungsanordnung.	single use
199602649	Verfahren und Vorrichtung zur Reduktion des Stromverbrauchs in mobilen Multimode-Kommunikationsendgeräten	single use
199602652	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SPEICHERZELLENANORDNUNG	single use
199602677	Nicht-leitendes, ein Band oder einen Nutzen bildendes Substrat, auf dem eine Vielzahl von Trägerelementen ausgebildet ist	single use
199603058	Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von SiC durch CVD mit verbesserter Gasausnutzung	single use
199603143	MAGNETFELDEMPFINDLICHER SENSOR MIT EINEM DUENNSCHICHTAUFBAU UND VERWENDUNG DES SENSORS	dual use
199603194	EINRICHTUNG MIT EINEM KIPPBAREN STEUERHEBEL UND SIGNALERZEUGENDEN MITTELN	dual use
199604003	Optoelektronische Sendebaugruppe	single use
199604014	AUFNAHMELAGER	single use
199604046	MEHRKANALIGE LICHTWELLENLEITERVERBINDUNGSSTECKER-ANORDNUNG	single use
199604052	VERZWEIGUNGSANORDNUNG FÜR EIN VIELADRIGES LICHTWELLENLEITERKABEL	single use
199604059	ELEKTROOPTISCHES MODUL	single use
199604072	Optische Sendeeinrichtung	single use
199604122	Kopplungsmodul	single use
199604128	Verfahren zum Herstellen eines elektrooptischen Moduls	single use
199604131	ELEKTROOPTISCHES MODUL	single use
199604180	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES ELEKTRO-OPTISCHEN MODULS.	single use
199604186	Elektrooptisches Modul	single use
199604190	Optisches Modul	single use
199604200	Anordnung zum Einkoppeln von Licht in ein Ende eines Mehrmoden-Lichtwellenleiters	single use
199604211	Koppelanordnung	single use
199604224	Anordnung zum optischen Ankoppeln eines lichtaussendenden Elementes an ein lichtempfindendes Element	single use
199604237	Optische Datenübertragungseinrichtung mit einer Laserdiode	single use
199604238	Optische Datenübertragungseinrichtung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 91 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte**



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199607406	Optische Datenuebertragungseinrichtung	single use
199607410	SIMPLIFIED STORAGE NODE PROCESS FOR DEEP TRENCH BASED DRAM	single use
199607411	NITRIDE CAP FORMATION IN A DRAM TRENCH CAPACITOR	single use
199607412	INDEPENDENTLY CONTROLLABLE SHUTTERS AND VARIABLE AREAAPERTURES FOR OFF AXIS ILLUMINATION	single use
199607413	ETCHING HIGH ASPECT CONTACT HOLES IN SOLID STATE DEVICE	single use
199607455	AN AUTOMATED NON-VISUAL METHOD OF LOCATING PERIODICALLYARRANGED SUB-MICRON OBJECTS	single use
199607470	PREVENTION OF ABNORMAL WSI OXIDATION BY IN-SITUAMORPHOUS SILICON DEPOSITION	single use
199607474	UNIFORM TRENCH FILL RECESS BY MEANS OF ISOTROPIC ETCHING	single use
199607478	PROCESS FOR FORMING DEEP TRENCH DRAMS WITH SUB-GROUNDRULE GATES	single use
199607482	CRACK STOP FORMATION FOR HIGH-PRODUCTIVITY PROCESSES	single use
199607483	DEVICE STRUCTURE WITH LAYER FOR FACILITATING PASSIVATION OFSURFACE STATES	single use
199607484	ETCHING WITH HCL AND CHLORINE	single use
199607508	DIFFUSED TITANIUM RESISTOR AND METHOD FOR FABRICATING SAME	single use
199607522	GAPFILL AND PLANARIZATION PROCESS FOR SHALLOW TRENCH ISOLATION	single use
199607524	LOW POWER Cl ₂ /HCl PROCESS FOR SUB-MICRON METAL ETCHING	single use
199607528	AN INTEGRATED CIRCUIT CHIP	single use
199607529	AN INSULATED GATE FIELD EFFECT TRANSISTOR	single use
199607530	A METHOD OF MANUFACTURING AN INSULATED GATE FIELD EFFECTTRANSISTOR	single use
199607582	DISTRIBUTION PLATE FOR A REACTION CHAMBER WITH MULTIPLE GASINLETS AND SEPARATE MASS FLOW CONTROL LOOPS	single use
199607585	ADVANCED DAMASCENE PLANAR STACK CAPACITOR FABRICATION METHOD	single use
199607592	METHOD OF MAKING AN ALUMINUM CONTACT	single use
199607594	UNIFORM DISTRIBUTION OF REACTANTS IN A DEVICE LAYER	single use
199607595	A MOS TRANSISTER	single use
199607596	MEMORY CELL THAT INCLUDES A VERTICAL TRANSISTOR AND A TRENCHCAPACITOR	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 92 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199607601	PAD STACK WITH A POLY SI ETCH STOP FOR TEOS MASK REMOVAL WITH RIE	single use
199607612	CIRCUIT AND METHOD TO EXTERNALLY ADJUST INTERNAL CIRCUIT TIMING	single use
199607615	GEOMETRICAL CONTROL OF DEVICE CORNER THRESHOLD	single use
199607616	METHOD FOR SUPPRESSING PATTERN DISTORTION ASSOCIATED WITHBPSG REFLOW AND INTEGRATED CIRCUIT CHIP FORMED THEREBY	single use
199607617	DEEP TRENCH CELL CAPACITOR WITH INVERTING COUNTER ELECTRODE	single use
199607618	ENERGY RELIEVING CRACK STOP	single use
199608001	Prozessor zur Bildverarbeitung.	dual use
199608003	Vorrichtung zum Verarbeiten und Speichern von Daten.	single use
199608007	Oszillatorschaltung	single use
199608012	Schaltungsanordnung zur Analog-Digital-Wandlung einesEingangssignals	single use
199608013	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES BILDSIGNALS FUER EINEBILD-IM-BILDEINBLENDUNG	single use
199608021	Halbleiteranordnung mit Leiterraahmen	dual use
199608024	Verfahren zur Herstellung einer Datentraegerkarte undDatentraegerka rte	single use
199608033	LESEVERSTAERKER FUER EINEN HALBLEITERSPEICHER MIT EINEREINRICHTUNG ZUR KOMPENSATION VON SCHWELLENSPANNUNGSUNTERSCHIEDENBEI DEN LESEVERSTAERKERTRANSISTOREN.	single use
199608043	Verfahren zur Herstellung einer MOS-Struktur auf Siliziumkarbid	dual use
199608044	Herstellverfahren fuer eine als Intermetalldielektrikumfungierende Isolatorschicht	single use
199608048	Vorrichtung zur elektronischen Kontaktierung eines Bauelements	single use
199608050	WAESSRIGE REINIGUNGSLOESUNG FUER EIN HALBLEITERSUBSTRAT	single use
199608052	Chipkarten-Modul, diesen enthaltende Kombi-Chipkarte und Verfahrenzu deren Herstellung	single use
199608053	Kombikarte und Verfahren zu ihrer Herstellung	single use
199608058	Verfahren zur Rauschreduktion eines Bildsignals	dual use
199608059	Verfahren zur Detektion von Kanten in einem Bildsignal	dual use
199608062	Method for Displaying Teletext Data	single use
199608063	Frequenzsteuerbarer Oszillator	single use
199608065	Geschaltete Stromquelle	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 93 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199608072	VERFAHREN ZUM PLANARISIEREN EINER SUBSTRATOBERFLAECHE	single use
199608073	Ultraschallwandler in Oberflaechen-Mikromechanik	single use
199608075	Rechnergestuetztes Verfahren zur Partitionierung einerelektrischen Schaltung	single use
199608078	Drehratensensor	single use
199608084	A DEVICE AND METHOD FOR MULTI-LEVEL CHARGE STORAGE AND A DEVICEAND METHOD FOR READING OUT SAID DEVICE	single use
199608086	VERTIKALE TRANSISTOREN, BEI DENEN DAS GATE DURCH PLANARISIERUNGUND RUECKAETZEN QUASI SELBSTJUSTIEREND STRUKTURIERT WIRD	single use
199608088	VERFAHREN UND VERBINDUNGSANORDNUNG ZUM HERSTELLEN EINER CHIPKARTE	single use
199608089	PROZESSOR MIT PIPELING-AUFBAU	single use
199608594	Kraftmikroskopiesonde	dual use
199608625	Halbleiterkoerper mit Heizeinrichtung zum Beeinflussen von Licht	single use
199608641	Herstellung von Polybenzoxazol- UND Polybenzothiazol-Vorstufen	single use
199701001	Mikromechanische Halbleiteranordnung und Verfahren zur Herstellungeiner mikromechanischen Halbleiteranordnung	single use
199701002	Gehaeuse fuer Halbleiter-Sensoranordnung und Verfahren zu dessenHerstellung	dual use
199701013	Elektrische Schaltung insbesondere fuer eine Chipkarte	dual use
199701015	Elektrische Schaltvorrichtung	single use
199701016	Verfahren zur Bildung von Lochstrukturen in einemSiliziumsubstrat.	single use
199701017	CHIPKARTE	single use
199701018	Digital/Analog-Umsetzer.	dual use
199701019	Chipkarte	single use
199701021	Verfahren zur Ueberwachung der bestimmungsgemaessen Ausfuehrungvon Softwareprogrammen	single use
199701022	CHIPKARTENMODUL	single use
199701034	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Steuerung vonBetriebszustaenden einer zweiten Einrichtung durch eine ersteEinrichtung	dual use
199701035	Sende- UND Empfangsanordnung fuer Hochfrequenzsignale	single use
199701036	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Flimmerreduktion einesBildsignals	single use
199701038	Verfahren zur Herstellung von vertikalen Chipverbindungen	single use
199701039	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SILIZIUMKONDENSATORS.	single use
199701049	Elektronisches Bauelement	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 94 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199701050	Vertikaler pnp-Transistor	single use
199701051	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ZWEIDRAHT-VIERDRAHT-UMSETZUNG	dual use
199701057	Elektronischer Kompass	single use
199701059	VERFAHREN ZUM KODIEREN UND DEKODIEREN VON DATEN	dual use
199701062	Verfahren zum Erzeugen einer edelmetallhaltigen Struktur auf einer Unterlage und Halbleiterbauelement mit einer solchen edelmetallhaltigen Struktur	single use
199701076	Drucksensor-Bauteil mit Schlauchanschluss	single use
199701078	Vorrichtung und Verfahren zur Halterung und zum Schutz von Halbleiter-Wafern	single use
199701079	Schalteranordnung fuer elektrische Steuergeraete	single use
199701081	DURCH FELD-EFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT	single use
199701082	Verfahren zum Entfernen siliciumhaltiger Beschichtungen	single use
199701089	Asymmetrischer Thyristor	single use
199701092	Anwendungsspezifisches integriertes Halbleiterprodukt mit Dummy-Elementen	single use
199701100	Montageverfahren fuer Halbleiterbauelemente	single use
199701102	SENDE-EMPFANGS-UMSCHALTEANORDNUNG	single use
199701110	Leadframe und Montagevorbereitungsverfahren fuer ein Leadframe	dual use
199701119	Halbleiterkoerper	single use
199701121	Verfahren zur Schichterzeugung auf einer Oberflaeche	single use
199701126	LASERMODUL MIT ANKOPPELOPTIK UND VERFAHREN ZUR FEINJUSTIERUNG DER ANKOPPELOPTIK	single use
199701131	Verfahren zur Minimierung der Zugriffszeit bei Halbleiterspeichern	single use
199701144	Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterkoerpers	single use
199701146	Thermischer Schutz	single use
199701147	Smart-Schalter sowie Verfahren zur Open-Load-Diagnose desselben	dual use
199701148	INTEGRIERTE BUFFER-SCHALTUNG	single use
199701151	Herstellverfahren fuer eine erhabene Kondensatorelektrode	single use
199701161	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Flimmerreduktion eines Bildsignals	single use
199701163	Verfahren zur Erzeugung eines Kontaktes zwischen einer Metallisierungsschicht und einem Halbleitermaterial	single use
199701179	Leistungs-MOSFET	single use
199701191	Verfahren zur Erzeugung einer Transistorstruktur	single use
199701194	CMOS-Schaltung mit rundum dielektrisch isolierten Source-Drain-Bereichen und Verfahren zu ihrer Herstellung	single use
199701196	Halbleiter-Schaltungsanordnung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 95 von 186

C:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199701201	Taktversorgungssystem fuer ein Microcomputersystem	single use
199701206	Verfahren zur Herstellung dotierter Polysiliciumschichten und-schichtstrukturen und Verfahren zum Strukturieren von Schichten und Schichtstrukturen, welche Polysiliciumschichten umfassen.	single use
199701217	Selbstkalibrierende Sensoranordnung	dual use
199701225	Drucksensor-Bauelement und Verfahren zur Herstellung	single use
199701227	Verfahren und Vorrichtung zum Verarbeiten und Generieren von Daten unter Verwendung eines digitalen Signalprozessors	dual use
199701230	Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelement	single use
199701237	Schaltungsanordnung zur Dekodierung variabler Laengencodes	dual use
199701239	PULSWEITENMODULATOR	single use
199701241	Strombegrenzungsschaltung	single use
199701243	Verfahren zur Herstellung eines Kondensators fuer eine Halbleiteranordnung.	single use
199701245	Verfahren zur Herstellung eines Kondensators fuer eine Halbleiteranordnung.	single use
199701249	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNGSEINRICHTUNG UND -SYSTEM	dual use
199701251	Datenspeicher mit einer Redundanzschaltung	single use
199701259	Datenspeicher mit einer Redundanzschaltung	single use
199701261	CHIPKARTENMODUL UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG SOWIE DIESEN UMFASSENDE CHIPKARTE	single use
199701262	CHIPKARTENMODUL UND DIESEN UMFASSENDE CHIPKARTE	single use
199701265	Schaltungsanordnung zur Generierung eines Ruecksetzsignals	single use
199701266	Komparatorschaltung	single use
199701269	Zwischenfrequenzverstaerker	single use
199701273	KOMMUNIKATIONSSYSTEM	dual use
199701275	Traegererelement fuer kontaktlose Chipkarten	single use
199701276	Traegererelement fuer Chipkarten	single use
199701277	Datenspeicher	single use
199701279	Verfahren zur Erzeugung von ueberbrueckten, dotierten Zonen	single use
199701285	Steckbuchse zur Kontaktierung wenigstens einer Kontaktflaeche in einer Oberflaeche eines Steckelementes	single use
199701297	Verfahren zur Erzeugung einer Transistorstruktur	single use
199701304	SO-SCHNITTSTELLE FUEER EINEN ISDN-BASISANSCHLUSS	dual use
199701308	Halbleiterschaltungsvorrichtung und Halbleitersensorvorrichtung	dual use
199701309	Schaltungsanordnung zur Filterung und Dezimation eines Videosignals	single use
199701310	Mikrocomputer	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 96 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte**



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199701333	Integrierte Schaltung mit einem Speicher und einer Prüfschaltung	single use
199701346	Hermetisch dichtes optisches Sendemodul	single use
199701359	Integrierte Schaltung und Verfahren zum Testen der integrierten Schaltung	dual use
199701363	Anordnung zur Bearbeitung einer Substratscheibe und Verfahren zu deren Betrieb	single use
199701376	Operationsverstärker mit dynamischen Ausgangswiderstand	dual use
199701381	Oszillatorschaltung	single use
199701384	HERSTELLVERFAHREN FÜR EINE KONDENSATORELEKTRODE AUS EINEM PLATINMETALL	single use
199701393	Verfahren zum Herstellen eines Glaskörpers und optoelektronisches Modul mit einem derart	single use
199701396	Verfahren zur Wellenlängenstabilisierung eines Lasers und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens	dual use
199701407	Vorrichtung zur Umsetzung mehrerer Lichtstrahlen in eine kompaktere Anordnung dieser Lichtstrahlen	single use
199701410	ROM-Speicher	single use
199701424	KOMPARATOR FÜR GROSSE VERSÖRGUNGSSPANNUNGSBEREICH	dual use
199701430	Kondensatorstruktur	single use
199701437	Schaltnetzteil	single use
199701438	EINGANGSVERSTÄRKER FÜR EINGANGSSIGNALE MIT STEILEN FLANKEN	single use
199701439	Eingangsverstärker mit einseitiger Stromabschaltung für Eingangssignale mit steilen Flanken	single use
199701445	Verfahren zur Erzeugung einer leitenden Verbindung zwischen zumindest zwei Gebieten eines ersten Leitfähigkeitstyps	single use
199701452	Verfahren und Vorrichtung zum Synchronisieren eines Taktgenerators	dual use
199701456	Halbleiter-Schaltungsvorrichtung	dual use
199701462	KONTAKTLOSES TRANSPONDERSYSTEM	dual use
199701463	Bildsensor mit einer Vielzahl von Bildpunkt-Sensorbereichen	dual use
199701486	Synchronisationsverfahren und Synchronisationsvorrichtung	dual use
199701488	Synchronisationsverfahren und Synchronisationsvorrichtung	dual use
199701489	Integrierte Schaltungsanordnung mit mehreren Bauelementen und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199701491	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINER INTERNEN VERSÖRGUNGSSPANNUNG	single use
199701493	Elektrische Spannungsquelle für Halbleiterbauelemente	single use
199701494	Karteneinlage für Chipkarten	single use
199701495	LASERVORRICHTUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

OPC IC
Seite 97 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199701496	Halbleiter-Bauteil	dual use
199701505	Schaltungsanordnung zum Erzeugen einer PseudoZufallsfolge	dual use
199701510	Sensor mit Richtungserkennung	dual use
199701511	Verstellverfahren fuer eine Platinmetall-Struktur mittels einesLift-off-Prozesses	single use
199701524	Programmierbare Phasenanpassung	single use
199701525	VERFAHREN ZUM ERSATZSCHALTEN VON UEBERTRAGUNGSEINRICHTUNGEN ZURBIDIREKTIONALEN UEBERTRAGUNG VON ATM-ZELLEN.	single use
199701531	Vertikaler Transistor mit Kompatiblem Layout zu planarerTechnologie	single use
199701540	MOS-Transistor und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199701541	Verfahren zur Herstellung einer CMOS-Schaltungsanordnung.	single use
199701547	Selbstjustierte 4-FHoch2-Trench-DRAM-Zelle mit vertikalemTransistor	single use
199701550	Verfahren zum Aufbringen einer Substanz auf eine Oberflaeche	single use
199701553	Chipkarte mit Mikrocontrollerschaltung	single use
199701561	Halbleiterbauelement	single use
199701574	Verfahren zur Codierung und Decodierung eines digitalisiertenBildes mit Bildpunkten	dual use
199701577	Verfahren und Vorrichtung zur Codierung eines digitalisiertenBildes	dual use
199701579	Verfahren zur Anpassung eines Referenzdatensatzes anhand mindestens eines Eingabedatensatzes durch einen Rechner	dual use
199701599	Integrierte CMOS-Schaltungsanordnung und Verfahren zu derenHerstellung.	single use
199701604	Integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens zwei vertikalenMOS- Transistoren und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199701609	Integrierte CMOS-Schaltungsanordnung und Verfahren zu derenHerstellung.	single use
199701611	Einrasterkennungsschaltung fuer einen Phasenregelkreis	single use
199701621	POLIERVORRICHTUNG UND POLIERTUCH	single use
199701626	RISC-Prozessor	single use
199701636	Schaltungsanordnung zur Ansteuerung eines FET	dual use
199701659	EINGANGSSCHALTUNG FUER EINE INTEGRIERTE SCHALTUNG	single use
199701661	Multiple Input Shift Register zur Bildung einer Pruefsumme	single use
199701666	Verfahren und Anordnung zur Steuerung von Zugriffen vonNetzabschlusseinheiten auf vorgegebene Ressourcen einespaketorientierten Kommunikationsnetzes.	single use
199701668	Verfahren und Vorrichtung zur Uebertragung eines kontinuierlichenDatenstroms in paketierter Form	dual use
199701676	Geschuetzter Halbleiterchip	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 98 von 186

D:BARRY E. BRETSCHEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199701677	Vorrichtung zur Digital-Analog-Wandlung mit hoher Linearität.	single use
199701687	Verfahren zur Optimierung von Signallaufzeiten in einem reprogrammierbaren Schaltkreis und reprogrammierbarer Schaltkreis mit optimiertem Programmcode	single use
199701696	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199701697	Drucksensor-Bauelement und Verfahren zur Herstellung	single use
199701698	Drucksensor-Bauelement und Verfahren zur Herstellung	single use
199701717	CHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN DIGITALER SIGNALE	single use
199701722	Rechnergestütztes Simulationsverfahren zur Bestimmung eines elektromagnetischen Feldes eines Körpers	dual use
199701723	Verfahren zum Löschen einer elektrischen programmierbaren Speicherzelle	single use
199701730	Ansteuerschaltung für nichtflüchtige Halbleiter-Speicheranordnung	single use
199701731	Verfahren zur Berechtigungsüberprüfung und Anordnung zum Durchführen dieses Verfahrens	dual use
199701733	Bauteilträger für Multi-Chip-Module	dual use
199701748	Ansteuerschaltung für nichtflüchtige Halbleiter-Speicheranordnung	single use
199701756	Integrierte Vollbrückenschaltung mit vier Transistoren	single use
199701758	Verfahren und Vorrichtung zur Ansteuerung eines Halbleiterschalters	single use
199701763	Leistungshalbleiter-Anordnung auf DCB-Substrat	dual use
199701765	Schaltungsanordnung zur Erzeugung einer lastunabhängigen Gleichspannung	single use
199701766	Regelvorrichtung	single use
199701773	Verfahren und Anordnung zur Frequenzsynthese	dual use
199701774	Nichtflüchtige Speicherzelle.	single use
199701777	CHIPCARD	single use
199701789	Halbleiterschaltungsanordnung und Verfahren zur Herstellung	single use
199701809	Schaltungsanordnung zum Erfassen des Überschreitens einer kritischen Temperatur eines Bauelements	single use
199701811	Vorrichtung und Verfahren zum gleichzeitigen Benetzen mehrerer elektrischer Kontaktflächen mit einer Flüssigkeit	single use
199701812	Teilnehmerendgerät für das ISDN	dual use
199701813	DRAM-Zellenanordnung mit dynamischen selbstverstärkenden Speicherzellen und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199701816	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199701819	SRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 99 von 186

D:BARRY E. BRETSCHEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199701822	Verfahren zum Herstellen einer Barrierenschicht in einem Halbleiterkörper und Halbleiterbauelement mit einer solchen Barrierenschicht	single use
199701824	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Bild-im-Bild-Einblendung	single use
199701828	ZWEI-CHIP-LEISTUNGS-IC MIT VERBESSERTEM KURZSCHLUSSVERHALTEN	single use
199701832	Hochfrequenz-Signalgenerator	single use
199701833	Ansteuerschaltung fuer ein steuerbares Halbleiterbauelement	dual use
199701837	Polyphasenfilter mit einstellbarer Uebertragungsfunktion	single use
199701843	Herstellverfahren fuer einen Isolationsgraben in einem SOI-Substrat	single use
199701858	Verfahren zum Betreiben eines ISDN-Netzabschlusses	dual use
199701859	Strukturierungsverfahren	single use
199701861	Elektrodenanordnung	single use
199701862	Strukturierungsverfahren	single use
199701864	Schaltungsanordnung zum Umschalten und Abregeln von parallel zueinander verschalteten Frequenzbereichsfilterzweigen	single use
199701865	Bandpassfilter	single use
199701872	IC-Baustein	dual use
199701873	Halbleitermodul	single use
199701880	Anordnung zur Uebertragung von Strukturen	single use
199701881	Gehaeuse fuer zumindest einen Halbleiterkoerper	dual use
199701885	Chipkarte und Verfahren zur Kontaktierung einer in einer Chipkarteeingebetteten Antenne	single use
199701901	Redundanzschaltung fuer Halbleiterspeicher	single use
199701903	Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Chip-Substrat-Verbindung	single use
199701904	Verfahren zur Herstellung einer integrierten CMOS-Schaltung.	single use
199701905	Verfahren zur Herstellung von Duennfilmen aus oxidischer Keramik	single use
199701906	Halbleiterspeicher mit nicht-fluechtigen Zwei-Transistor-Speicherzellen	single use
199701907	Kontaktierung einer Halbleiterzone	single use
199701910	Hochspannungsfeste Randstruktur fuer Halbleiterbauelemente	single use
199701911	Integrierte Fotozellenarray mit PN-Isolation	single use
199701918	Schutzschaltung	dual use
199701924	Vertikaler Leistungs-MOSFET	single use
199701933	Verfahren zur Herstellung eines vertikalen MOS-Transistors.	single use
199701934	CMOS-Schaltung und Verfahren zu ihrer Herstellung	single use
199701935	Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 100 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199701937	Herstellverfahren fuer ein durch Feldeffekt gesteuertes Halbleiterbauelement	single use
199701939	Verstaerkerstufe mit konstanter Eingangsimpedanz	single use
199701944	Pufferspeichereinrichtung	single use
199701949	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VERGRABENEN, LATERAL ISOLIERTENZONE ERHOECHTER LEITFAEHIGKEIT IN EINEM HALBLEITERSUBSTRAT	single use
199701953	Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Chip-Substrat-Verbindung	single use
199701954	Durch Feldeffekt steuerbarer Bipolartransistor und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199701956	PEGELWANDLER	dual use
199701968	Ueberpruefung und Korrektur fehlerhafter Kontaktanordnungen von integrierten Halbleiterbauelementen	single use
199701970	Freischwingendes Schaltnetzteil	single use
199701974	Festwert-Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199701975	Reformatierschaltung	single use
199701978	Verfahren und Vorrichtung zum Anzeigen von Bildern	single use
199701981	Leistungshalbleiterbauelement auf Kuehlkoerper	single use
199701985	Poliermittel fuer Halbleitersubstrate	single use
199701988	Digitaler Schaltkreis in MOS-Technologie	single use
199701989	Digitaler Schaltkreis in MOS-Technologie	single use
199701990	MOS-Ausgangstreiber	single use
199701991	Transportsystem und Verfahren zur Steuerung des Transportsystems	single use
199701995	TRANSISTOR-VERSTAERKERSTUFE	single use
199701998	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER CHIPKARTE FUER KONTAKTLOSE DATEN- UND/ODER ENERGIEUEBERTRAGUNG SOWIE CHIPKARTE	single use
199701999	Nur-Lese-Speicher und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199702006	ENDSTUFENTRANSISTOR-SCHALTUNGSANORDNUNG	single use
199702007	Schaltungsanordnung zum manipuliergegeschuetzten Empfangen eines OOK-modulierten Signals	dual use
199702010	Schaltung zum bedarfsgerechten Ein- UND Ausschalten eines Verbrauchers	single use
199702012	Nichtfluechtige Speicherzelle mit hoher Koppelkapazitaet	single use
199702016	Kaskoden-MOS-Thyristor	single use
199702017	Schaltungsanordnung zur Ansteuerung einer Last	dual use
199702019	Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 101 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702029	Schaltungsanordnung zur Ansteuerung eines Leuchtdioden-Arrays	dual use
199702035	Verfahren zur Herstellung eines MOSFET's	single use
199702037	CHIPKARTE FUER KONTAKTLOSE DATEN- UND/ODER ENERGIEUEBERTRAGUNGSOWIE VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use
199702039	Leistungs-MOSFET und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199702040	Verfahren zur Identifizierung von Wafern	single use
199702041	Kaskoden-IGBT	single use
199702042	Wafermarkierung	single use
199702044	Anordnung zur automatischen Beschriftung oder Nachbeschriftung von Wafern	single use
199702045	Verfahren zur Unterstuetzung der einfachen Synchronisierung aufden Traeger eines energieverwischten QPSK-Signals	single use
199702046	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Bearbeitung digitalerSignale	single use
199702047	Strukturierungsverfahren	single use
199702049	Strukturierungsverfahren	single use
199702051	Verfahren zur Herstellung von integrierten MOS-Schaltungen	single use
199702053	Integrierte elektrische Schaltung	single use
199702056	Integrierte elektrische Schaltung mit Passivierungsschicht	single use
199702058	Programmierbarer Fernsehsignalempfaenger	single use
199702060	Schutzschaltung	single use
199702061	Vorrichtung und Verfahren zur Kontaktierung einer Mess-Sonde	single use
199702064	Datenbus	single use
199702072	Verfahren zur Bestimmung sehr kleiner Kapazitaeten und damit konzipierter Sensor	single use
199702076	Einrichtung zum sicheren Erstellen von elektronischenUnterschriften	dual use
199702077	Schaltung zur glitchfreien Umschaltung digitaler Signale	dual use
199702082	HALBLEITERKOERPER MIT RUECKSEITENMETALLISIERUNG UND VERFAHREN ZUDEREN HERSTELLUNG	single use
199702084	Integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens zwei unterschiedlich dotierten Gebieten, die elektrisch miteinander verbundensind, und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199702088	Schaltung zur Erzeugung eines Ruecksetz-Signals	single use
199702094	Leistungs transistorzelle	single use
199702096	Verfahren zur Echtheitspruefung eines Datentraegers	dual use
199702101	Datentraeger zum Speichern von Werteinheiten, Aufbuchstation und Abbuchstation fuer Werteinheiten sowie entsprechende Verfahren zumAufbuchen und Abbuchen	single use
199702103	Schaltungsanordnung zur Ansteuerung induktiver Lasten	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 102 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702104	Frequenzteileranordnung	single use
199702131	Schaltungsanordnung fuer die Bewertung des Dateninhalts von Speicherzellen	single use
199702133	Schaltungsvorrichtung fuer die Bewertung des Dateninhalts von Speicherzellen	single use
199702145	Traegerkarte und Halbleitermodul fuer eine derartige Traegerkarte	single use
199702147	Kaskoden-IGBT	single use
199702150	Halbleiterbauelement und Verfahren zum Testen und Betreiben eines Halbleiterbauelements	single use
199702153	TEILBAND FUEER DIE HERSTELLUNG EINES ENDLOSBANDES ALS CHIPTRAEGERZUR VERARBEITUNG IN EINER CHIPMONTAGESTRASSE UND ENTSPRECHENDESENDBAND	single use
199702154	Gasleitungssystem fuer einen Prozessreaktor, Vertikalofen zur Behandlung von Wafern und Verfahren zur Behandlung von Wafern in einem Prozessreaktor	single use
199702156	Gasleitungssystem fuer einen Prozessreaktor, Vertikalofen zur Behandlung von Wafern und Verfahren zur Behandlung von Wafern in einem Prozessreaktor	single use
199702161	Verfahren zur Stoerunterdrueckung eines bipolaren Datenstroms und Schaltungsanordnung zur Durchfuehrung des Verfahrens	dual use
199702168	Verfahren und Vorrichtung zur Synchronisation zweier Taktsignale und Signalwandler	single use
199702169	Verfahren zur Herstellung von duennen Scheiben, beispielsweise Wafern und nach dem Verfahren hergestellte duenne Scheibe	single use
199702170	Verfahren zum Herstellen einer Fuse	single use
199702174	Verfahren zum Herstellen einer Fuse	single use
199702177	Pressform sowie Verfahren zum Herstellen eines Kunststoffverbundkoerpers	single use
199702179	Verfahren zur Synchronisation von Sende-/Empfangsvorrichtungen bei DECT	dual use
199702181	Verfahren zur Ueberwachung der ordnungsgemaessen Funktion einer integrierten Schaltung	single use
199702183	Integrierte Schaltungen	single use
199702194	Anordnung zur Uebertragung von Strukturen	single use
199702199	Schaltungsanordnung mit mindestens vier Transistoren und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199702200	Verfahren und Vorrichtung zum Einstellen der Schwingungsfrequenz eines Oszillators	single use
199702201	Kontaktloser Nacherungsschalter	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 103 von 186

C:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702203	Verfahren und Vorrichtung zum Einstellen der Schwingfrequenz eines Oszillators	dual use
199702205	Auswahlverfahren und Anordnung zum Durchfuehren dieses Auswahlverfahrens	dual use
199702206	Verfahren zur Herstellung elektrisch leitfaehiger Strukturen sowie integrierte Schaltung mit deraartigen Strukturen	single use
199702211	Modem	dual use
199702214	Verfahren zur Simulation von Hard- und Softwarekomponenten.	dual use
199702228	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199702232	MULTI-BAND EXCITATION BASED NON-SQUARE TRANSFORM CODE OPERATING AT 2,4 KBPS	dual use
199702233	A Lead Frame for Electronic Semi-Conductor Devices	single use
199702234	REJECT DATA TRANSMISSION TO W/B AND REJECT IDENTIFICATION BY SHORTING OF 2 LEADS...	single use
199702235	MARK VISION INSPECTION USING OPTICAL CHARACTER RECOGNITION	single use
199702236	HOCHFREQUENZDIODE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG	single use
199702238	Kalibrierwafer	single use
199702243	Smart-Power-Schalter	dual use
199702247	MART-SCHALTER SOWIE VERFAHREN ZUR OPEN-LOAD-DIAGNOSE DESSELBEN IMAUS-ZUSTAND	single use
199702255	Fuse-Anordnung fuer Halbleiterspeichervorrichtung	single use
199702261	Vorrichtung und Verfahren zum Reinigen von Polierpads, beispielsweise Poliertuechern, insbesondere fuer das Polieren von Wafern	single use
199702264	Vorrichtung und Verfahren zum Bearbeiten von Polierpads, insbesondere Poliertuechern	single use
199702265	Vorrichtung und Verfahren zum Beheizen eines fluessigen oder zaehfluessigen Poliermittels sowie Vorrichtung zum Polieren von Wafern	single use
199702268	Transportsystem	single use
199702269	Schaltungsanordnung mit Einzelelektron-Bauelementen, Verfahren zu deren Betrieb und Anwendung des Verfahrens zur Addition von Binaerzahlen.	single use
199702273	Empfaenger fuer Mobilfunksysteme	dual use
199702277	Empfaenger fuer Mobilfunksysteme	dual use
199702279	Schwundausgleichsschaltung	single use
199702281	DMOS MIT GROSSER KANALWEITE UND HOHER AVALANCHE-FESTIGKEIT	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 104 von 186

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702287	Chipkarte mit einer ersten und mit einer zweiten elektrischen Baugruppe	single use
199702288	VERPACKTE INTEGRIERTE SCHALTUNG	dual use
199702291	Oszillatorschaltung mit einem Schwingquarz	single use
199702297	Schaltnetzteil	single use
199702298	Verfahren zum Herstellung eines Halbleiterchips oder Wafers mit Schutzschicht	single use
199702299	Elektrisches Bauelement mit einer Umhüllung und mit einem in der Umhüllung angeordneten Anschlussbereich	single use
199702301	Strukturierungsverfahren	single use
199702302	Nichtflüchtiger Speicher mit zu Subbloeken zusammengefassten Speicherzellen und Verfahren zu seiner Konfigurierung	single use
199702303	Integrierte Schaltung mit einem Schalttransistor	single use
199702304	Digitale PLL-Schaltung mit erhöhter Zeitaufloesung	single use
199702306	Verfahren zur Herstellung eines integrierten Schaltkreises	single use
199702308	CHARACTER SET FOR TELETEXT AND SIMILAR SERVICES	single use
199702310	Vorrichtung und Verfahren zum Bestücken eines Leadframes mit integrierten Schaltungen	single use
199702311	EINRICHTUNG ZUM SCHUTZ GEGEN MISSBRAUCH EINER CHIPKARTE	single use
199702313	Immersionssystem	single use
199702314	VERSTAERKERSCHALTUNG	single use
199702316	Steuerbarer Verstärker	single use
199702317	Elektronisch gesteuertes Relais	dual use
199702318	Digitale Telekommunikationseinrichtung	dual use
199702319	Digitale Telekommunikationseinrichtung	dual use
199702320	Digitale Telekommunikationseinrichtung	dual use
199702321	Digitale Telekommunikationseinrichtung	dual use
199702322	Digitale Schaltung mit einer Filtereinheit zur Unterdrückung von Störimpulsen	single use
199702325	Gated-Thyristor	single use
199702326	Ansteuerschaltung für ein Feldeffekt gesteuertes Leistungshalbleiterbauelement	dual use
199702327	Verfahren zur Erzeugung von Strukturen mit einem hohen Aspektverhältnis	single use
199702328	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES INTERRUPTSIGNALS FÜR EINEN MIKROPROZESSOR	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 105 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702331	Verfahren zur nachtraeglichen Erzeugung niederohmiger Verbindungen in Halbleiterbauelementen durch Laserbestrahlung.	single use
199702339	Eingangsschaltung	single use
199702340	Pegelumsetzschaltung	single use
199702352	Schaltungsanordnung	single use
199702353	Differenzverstaerker	single use
199702355	Halbleiterbauelement	dual use
199702356	Resonator mit einstellbarer Resonanzfrequenz	dual use
199702358	Oszillator	dual use
199702367	Planare, gekoppelte Spulenordnung	single use
199702373	Halbleiterbauelement mit Metall-Halbleiteruebergang mit niedrigem Sperrstrom	single use
199702374	Signalregenerierungsschaltung	single use
199702376	Verfahren zur Bestimmung des Gasdruckes in einem Hohlraum mit verformbarer Wandung eines Halbleiterbauelementes	dual use
199702408	Verfahren zur Herstellung von Isolationszonen zwischen Transistoren	single use
199702416	Verfahren zur Verwendung beim Einsatz von EEPROMs als Programmspeicher	single use
199702420	Verfahren zur empfangsseitigen automatischen Erkennung eines gemass dem QAM-Modus gesendeten Signals auf der Empfangsseite sowie Schaltung zur Durchfuehrung dieses Verfahrens	single use
199702421	Bussystem zur Gebaeudevernetzung	dual use
199702422	Halbleiteranordnung mit einstellbarer Emittereffizienz	single use
199702424	Halbleiterbauelement in VSMP-Bauform und eine Halbleiterbauelementanordnung mit einem derartigen Halbleiterbauelement	single use
199702426	Halbleiterbauelementanordnung	single use
199702432	Schaltungsanordnung zur Bestimmung der Ausgangsleistung eines Schaltnetzteils	single use
199702434	Verfahren zum Beseitigen von Sauerstoff-Restverunreinigungen an ausstiegsggezogenen Siliziumwafern	single use
199702435	Dynamischer Speicher mit zwei Betriebsarten	single use
199702436	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199702437	Speicherzellenanordnung und deren Verwendung als magnetisches RAM und als assoziativer Speicher.	single use
199702438	Verfahren zum Ansteuern eines elektrisch programmierbaren Datenspeichers und Schaltungsanordnung zur Durchfuehrung des Verfahrens	single use
199702440	Verfahren zum Beseitigen von Sauerstoff-Restverunreinigungen an ausstiegsggezogenen Siliziumwafern	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 106 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702442	Integriertes Tiefpassfilter	dual use
199702444	Filteranordnung und Slope-Detector fuerquadraturamplitudenmodulierte Signale	single use
199702453	TEMPERATURGESCHUETZTER HALBLEITERSCHALTER	single use
199702455	Anordnung zur Reduktion von Rauschen bei Mikrowellentransistoren und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199702456	Verfahren und Vorrichtung zur Ueberwachung der ordnungsgemaessen Ausfuehrung eines automatisch ablaufenden Vorganges	dual use
199702457	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR ABBILDUNG EINER HOHEN EINGANGSSIGNALDYNAMIK AUF EINE REDUZIERTER AUSGANGSSIGNALDYNAMIK FUEER BILDSENSOREN MIT EINER EINRICHTUNG ZUM ABLEITEN VON UEBERLAUFLADUNG.	dual use
199702461	Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben eines ueber einen Schreib- und/oder einen Lesezeiger adressierbaren Umlaufspeichers	single use
199702462	Verfahren zum Testen einer elektronischen Schaltung	single use
199702468	SOI-FET	single use
199702470	Frequenzteiler mit geringem Stromverbrauch.	dual use
199702471	ZELLULARER AUTOMAT ALS NEURONALES NETZWERK UND DESSEN VERWENDUNG	single use
199702473	Linearer Interpolator zur Interpolation eines abgetasteten Signals und Interpoationsverfahren	single use
199702475	Elektronisches Bauteil mit verbesserter Gehaeusepressmasse	dual use
199702477	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines auf einem Bildschirm darstellbaren Bildes	single use
199702479	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DATENSPEICHERUNG	single use
199702485	Abtrennstufe zum Abtrennen eines Signals, das in Auslastlueckeneines Videosignals uebertragen wird und Entzerrungsverfahren fuer ein solches Signal	single use
199702488	Halbleitersensor mit einem Grundkoerper und wenigstens einem Verformungskoeerper	single use
199702495	Verfahren zur Erzeugung von Isolationen in einem Substrat	single use
199702500	Schaltungsanordnung zum Erzeugen negativer Spannungen	single use
199702508	VERFAHREN ZUR DOTIERUNG EINER SCHICHT IN EINEM AUS EINEM HALBLEITER BESTEHENDEN ERZEUGNIS, SOWIE ENTSPRECHENDE ERZEUGNISSE	single use
199702509	Randstruktur mit Halbleiterbauelement mit hoher Durchbruchspannung	single use
199702512	SOI-Zellen und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199702513	Optisches System zum Einkoppein von Lasersrahlung in einen Lichtwellenleiter und Verfahren zu dessen Herstellung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 107 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702515	Verfahren zum Herstellen Direct-Wafer-Bond Si/SiO ₂ /Si-Substrate	single use
199702517	Rekursives Filter, Anwendung des Filters und Speicherzeleineinheit	dual use
199702521	Verfahren zur Ausbildung einer Grabenstruktur in einem Siliziumsubstrat	single use
199702523	Kammfilter	single use
199702528	Traegerelement fuer einen Halbleiterchip	single use
199702530	Verfahren zum elektrochemischen Verbinden und Verbundteil	single use
199702534	ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-MOSFET	dual use
199702539	Halbleiterschalter	dual use
199702547	Getaktetes Stromversorgungsgeraet mit An aufschaltung	single use
199702548	Vorrichtung und Verfahren zur Formatanpassung von Fernseh- und/oder Videobildern	dual use
199702555	Platine	single use
199702556	Sende-UND/oder Empfangsstation fuer ein TDMA-Funksystem	dual use
199702559	Tragbarer Datentraeger mit Aktivierungsschalter	dual use
199702564	Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterstruktur	single use
199702572	Verfahren zur Herstellung einer Lackmaske	single use
199702580	Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterstruktur	single use
199702589	Digitaler Speicher und Betriebsverfahren fuer einen digitalen Speicher	single use
199702591	Schaltung zur Erzeugung eines das Einschalten einer Versorgungsspannung signalisierenden Reset-Signals	single use
199702592	Integrierter Speicher und Verfahren zur Herstellung von Layouts von integrierten Speichern	single use
199702593	Ringspeicher fuer eine TDMA-Datenuebertragungsstation undentsprechende Datenuebertragungsstation	single use
199702596	Herstellung fuer einen vertikalen Bipolartransistor	single use
199702601	Filter zur Zeitmultiplexfilterung mehrerer Datenfolgen und Betriebsverfahren dafuer	single use
199702605	Verfahren und Vorrichtung von Rahmen um Videobilder	single use
199702613	Poliermittel und die Verwendung dieses Poliermittels zum Planarisieren eines Halbleitersubstrats	single use
199702614	Pointer-Schaltung mit geringem Flaechenbedarf, hoher Geschwindigkeit und geringer Verlustleistung	single use
199702615	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR IN-CIRCUIT-EMULATION EINES MIKROCONTROLLERS	single use
199702617	Verfahren zum chemisch-mechanischen Planarisieren und Vorrichtung zur Durchfuehrung des Verfahrens	single use
199702619	Komparatoranordnung mit Schalthysterese	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

GPC IC
Seite 108 von 186

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702625	Verfahren zur Ausbildung eines niederohmigen Leitbahnbereichs auf einem Halbleitersubstrat	single use
199702631	LEISTUNGSSCHALTER MIT UEBERLASTSCHUTZ	dual use
199702634	Halbleiterbauelement und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199702637	Verfahren zum Aufzeichnen eines digitalisierten Audiosignals und Telefonanrufbeantworter	dual use
199702638	Deemphasefilter mit integrierter Unbuntwert-Ermittlung	single use
199702639	Verfahren zum Testen von Halbleiterspeichern	single use
199702644	Umschaltvorrichtung fuer analoge und digitale Signale	single use
199702645	Sender zum Erzeugen eines hochfrequenten Sendesignals	single use
199702650	Verfahren und Schaltungsanordnung zum Anzeigen matrixfoermiger Zeichen	single use
199702660	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Leuchtweitenregulierung eines Scheinwerfers	dual use
199702663	Testschaltung auf einem Halbleiter-Chip	single use
199702666	Schaltungsanordnung zur getakteten Stromregelung von induktiven Lasten.	dual use
199702668	Assoziativspeicher und Verfahren zu dessen Betrieb.	single use
199702675	Verfahren und Vorrichtung zur Speicherung von mindestens einem digitalen Bild	single use
199702676	Verfahren zum Schutz von Schaltungskomponenten einer integrierten Schaltung gegen zu hohe Betriebstemperaturen sowie entsprechend ausgelegte Schutzschaltung	single use
199702679	Halbleiter-Leistungselement mit erhoelter Latch-up-Festigkeit	single use
199702681	Verfahren zum Verbinden von integrierten Schaltkreisen und Anordnung	single use
199702684	Verfahren zur Herstellung einer Emulationsschaltkreisanordnung sowie Anordnung mit zwei integrierten Schaltkreisen	single use
199702686	Feldeffekttransistor hoher Packungsdichte und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199702690	Registeranordnung	single use
199702699	Schaltungsanordnung zur Reduzierung von Störungen infolge des Schaltens eines Ausgangstreibers	single use
199702703	Logikgatter	single use
199702704	Verfahren zur Kompaktierung von Leiterbahnen-Layouts von integrierten Schaltungen	single use
199702705	Photodetektorchip	single use
199702707	Impulsformerschaltung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 109 von 186

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702709	Integrierte Halbleiterschaltung mit Schutzstruktur zum Schutz vorelektrostatischer Entladung	single use
199702711	RS-Flip-Flop oemit Enable Eingangen	single use
199702713	Integrierte Halbleiterschaltung mit Schutzstruktur zum Schutz vorelektrostatischer Entladung	single use
199702714	Sender zum Erzeugen eines hochfrequenten Sendesignals	single use
199702716	Mikromechanischer Sensor	dual use
199702717	"LINEAREN ANORDNUNG METALLISCHER SICHERUNGSTRECKENAUF WAFERN ,WOBEI DURCH"SCHESSEN"DERSICHERUNGSTRECKEN SCHALTUNGSKENNGROESSEN EINSTELLBAR SIND"	single use
199702718	Integrierte Halbleiterschaltung mit Schutzstruktur zum Schutz vorelektrostatischer Entladung	single use
199702720	Sender zum Erzeugen eines hochfrequenten Sendesignals	single use
199702724	Integrierte Halbleiterschaltung mit Schutzstruktur zum Schutz vorelektrostatischer Entladung	single use
199702727	Anordnung und Verfahren zur Kompensation des Offsets einesMischers	dual use
199702729	Integrierte Halbleiterschaltung mit Schutzstruktur zum Schutz vorelektrostatischer Entladung	single use
199702730	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER OFFENEN FORM.	single use
199702733	Erzeugnis umfassend eine Funktionsschicht enthaltend Silizium und eine Trägerschicht aus Siliziumdioxid, sowie Verfahren zu seiner Herstellung.	single use
199702734	Kondensator mit einer Barrierschicht aus einem Uebergangsmetall Phosphid, Arsenid oder Sulfid	single use
199702735	SCHALTBARE STROMQUEELLENSCHALTUNG	single use
199702737	Herstellverfahren fuer eine keramische Schicht	single use
199702738	Verfahren zur Suche nach Pilottonen	dual use
199702740	Herstellverfahren fuer eine Bi-haltige keramische Schicht	single use
199702748	Bild-in-Bild-Prozessor	single use
199702757	Speicherzellenanordnung.	single use
199702762	Gegentaktmischer	dual use
199702771	System zur Identifikation von Trays fuer elektronischeHalbleiter-Bauelemente	single use
199702772	Halteeinrichtung fuer integrierte Schaltungen	single use
199702773	Vorrichtung und Verfahren zum Einstellen derQuantisierungskennlinien einer PCM-Codierung	dual use
199702778	Tragerelement fuer einen Halbleiterchip zum Einbau in Chipkarten	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 110 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702785	Integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens einem Kondensator und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199702786	Verfahren zur Herstellung einer CMOS-Schaltungsanordnung.	single use
199702788	Vertikaler MOS-Transistor und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199702789	Halbleiterdiode	single use
199702791	Elektrisches Halbleiterbauelement	single use
199702792	Verfahren zur Herstellung eines vertikalen MOS-Transistors.	single use
199702808	Anordnung zur Bearbeitung einer Substratscheibe und Verfahren zu deren Betrieb.	single use
199702820	Vorrichtung zum Auftragen eines viskosen Fluids	single use
199702825	TEST-CHIPKARTE	dual use
199702827	Verfahren zur Ermittlung realisierbarer Konfigurationen von Bearbeitungsanlagen	single use
199702832	Frequenzsynthesizer fuer ein Mobilfunkendgeraet	dual use
199702838	Anordnung aus optischen Wellenleitern	dual use
199702844	Optoelektronisches Sensormodul	single use
199702848	Anordnung aus einer zu beheizenden Schicht auf einem Substrat	single use
199702850	Halbleiterbauelement	single use
199702852	Hochspannungsfeste Randstruktur fuer Halbleiterbauelemente	single use
199702864	VIOS-Transistor und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199702866	Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung eines Gebiets anderer Brechzahl in einem optischen Substrat und integriert-optische Anordnung und Leistungslaser mit einem solchen Gebiet	single use
199702868	Vorrichtung zur Aufnahme von duennen Gegenstaenden, insbesondere von Tuechern oder dergleichen	single use
199702874	Verfahren zum Auftragen einer Suspension	single use
199702879	Tuecherbox	single use
199702888	Schaltungsstruktur mit mindestens einem Kondensator und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199702890	CMOS-Schaltung und Verfahren zu ihrer Herstellung.	single use
199702892	Differenzdrucksensor und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199702893	Siliziumfolie als Traeger von Halbleiterschaltungen als Teil von Karten	single use
199702894	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199702901	Programmgesteuerte Einheit	single use
199702903	Schnittstelle	single use
199702911	Verfahren zur Entwicklung des Layouts von digitalen Schaltungen	single use
199702922	Integrierte Halbleiterschaltung mit wenigstens zwei Versorgungsnetzen	single use
199702931	Speicherbaustein mit Latchbaugruppe	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 111 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199702932	Verfahren zur Herstellung einer integrierten elektrischen Schaltung.	single use
199702938	Halbleiterbauelement mit einer Tragevorrichtung und einem Zuleitungsrahmen und einem damit verbundenen Halbleiterchip	single use
199702939	HALBLEITERBAUELEMENT MIT DEFINIERTEM VERHALTEN BEI EINEM AUSFALL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SOLCHEN	single use
199702942	Vorrichtung zum Bearbeiten dünner Scheiben, insbesondere Wafern	single use
199702948	Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines elektrischen Bezugspotentials.	single use
199702949	Verfahren und Vorrichtung zum Auslesen, Modifizieren und Ueberschreiben von in einer Speichereinrichtung gespeicherten Daten	single use
199702951	Anordnung und Verfahren zur Anpassung von Ausgangstreibern von integrierten Schaltungen an die gegebenen Verhaeltnisse	single use
199702952	Verfahren zum Herstellen von Halbleiterchips mit sehr geringer Dicke	single use
199702956	Halbleitervorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199702958	Verfahren und Vorrichtung zur rechnergestuetzten Ermittlung eines Anschwingbereichs einer elektrischen Schaltung	single use
199702959	SRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199702967	Halbleiterschaltungsanordnung mit monolithisch integrierten Schaltkreisen und einer Spannungspumpenschaltung	single use
199702968	Halbleiterschaltungsanordnung mit monolithisch integrierten Schaltkreisen und einer Spannungspumpenschaltung	single use
199702977	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199702990	PN-UEBERGANG MIT ERHOEBTER DURCHBRUCHSPANNUNG	single use
199702996	Vorrichtung und Verfahren zur Endpunktkontrolle beim Polieren von Bauelementen, insbesondere Halbleiterbauelementen	single use
199703269	Chemisch verstaerkter Resist	single use
199703683	o-Nitro(thio)phenolderivate und deren Herstellung	single use
199703684	Bis-o-amino(thio)phenole und deren Herstellung	single use
199703688	is-o-amino(thio)phenole und deren Herstellung	single use
199703689	o-Amino(thio)phenol-carbonsaeuren und deren Herstellung	single use
199703692	o-Amino(thio)phenol-carbonsaeuren und deren Herstellung	single use
199703694	Polybenzoxazol- UND Polybenzothiazol-Vorstufen	single use
199703695	Polybenzoxazol- UND Polybenzothiazol-Vorstufen	single use
199703697	Sensoreinrichtung zur Richtungserfassung eines aeusseren Magnetfeldes mittels eines magnetoresistiven Sensorelementes	dual use
199703758	Verfahren zum thermischen Ausheilen von durch Implantation dotierten Siliziumcarbid-Halbleitern	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 112 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199703830	Verfahren zur Pruefung der Busanschluesse von beschreib- UNDiesbaren integrierten, elektronischen Schaltkreisen, insbesondere von Speicherbausteinen	single use
199703898	Chemisch verstaerkter Resist	single use
199704014	Verfahren zur Endflaechenpraeparation eines Lichtwellenleiters	single use
199704015	Anordnung zum Ankoppeln von optoelektronischen Elementen mit einer optisch empfindlichen Oberflaeche an Lichtwellenleiter	single use
199704027	SCHLEIFMITTEL UND VERFAHREN ZUM POLIEREN VON LICHTWELLENLEITER-ENDFLAECHEN	single use
199704030	Baugruppe	single use
199704036	ELEKTROOPTISCHE KOPPELBAUGRUPPE	single use
199704040	Verzweigende Lichtwellenleiteranordnung	single use
199704042	HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER EIN ELEKTROOPTISCHES MODUL	single use
199704043	Halter	single use
199704047	ELEKTROOPTISCHES MODUL	single use
199704090	OPTISCHES ENDSTUECK UND VERFAHREN ZUM PRUEFEN DER KOPPLUNGSFLAECHE EINES OPTISCHEN ENDSTUECKS	single use
199704094	Optischer Mehrfachverbinder	single use
199704113	Optische Sendeeinrichtung	single use
199704123	Endstueck fuer ein Lichtwellenleiterkabel	single use
199704129	Optische Sendeeinrichtung	single use
199704160	Elektrooptische Anordnung	single use
199704161	Verfahren zum Unterfuettern einer auf einem flaechentoermigen Tragkoerper montierten elektronischen Baueinheit mit einem flie ssfaehigen Fue llstoff und danach hergestellte Anordnung	single use
199704163	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES ELEKTROOPTISCHEN STECKER AUFNAHMEELEMENTES UND OPTOELEKTRONISCHER STECKER	single use
199704189	Faseroptisches Endstueck	single use
199704200	Verbinderkoerper	single use
199704201	Verbinder	single use
199704202	Optisches Verbindersystem	single use
199704203	Mehrkanalige optische Sendeeinrichtung	single use
199706404	Schaltungsanordnung zur Ansteuerung einer elektrischen Antriebseinheit	dual use
199706427	Schaltungsanordnung zur Erfassung eines Leerlaufes eines Leistungsschalters	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

OPC IC
Seite 113 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199706429	Verfahren zur Umformung eines Substrats mit Randkontakten in ein Ball Grid Array, nach diesem Verfahren hergestelltes Ball Grid Array und flexible Verdrahtung zur Umformung eines Substrats mit Randkontakten in ein Ball Grid Array	single use
199706432	COMMON-BUS INTERFACE UNIT(C-BIU) FOR EXTERNAL MEMORY INTERFACE	single use
199706433	Transportbehälter	single use
199706435	Pufferschaltung	single use
199706437	Halbleiter-Hochspannungsschalter	single use
199706439	Stromversorgungsvorrichtung fuer integrierte Halbleiterschaltungsanordnung	single use
199706440	Loesung von Tetramethylammoniumhydroxid in Wasser und Verfahren zur Herstellung der Loesung	single use
199706441	Hochvolt-SOI-Duennfilmtransistor	single use
199706443	Verfahren zur Ueberwachung von Bearbeitungsanlagen	single use
199706445	Schaltungsanordnung mit einem Datenspeicher und einem steuernden Baustein	single use
199706450	Ueberwachungssystem	single use
199706454	Pufferschaltung und integrierte Speicherschaltung mit einer Pufferschaltung	single use
199706457	Integrierte elektrische Schaltung und Verfahren zu ihrer Herstellung.	single use
199706463	Verfahren zum Herstellen eines Speicherzellen-Arrays	single use
199706466	Speicherzellenanordnung, Verfahren zu deren Herstellung und Verfahren zur deren Betrieb.	single use
199706471	Halbleiterspeicher und Implantationsmaske	single use
199706472	HALBLEITERSPEICHER UND IMPLANTATIONSMASKE	single use
199706476	Strom-Spannungs-Regler	single use
199706478	Verfahren und Vorrichtung zur Bilderfassung	single use
199706479	Vorrichtung zur Bilderfassung	dual use
199706481	Verfahren zur Speicherung in einem Videosignal enthaltener digitaler Datensignale und Videorecorder zur Durchfuehrung des Verfahrens	single use
199706484	Mikromechanische Vorrichtung und entsprechendes Herstellungsverfahren	single use
199706495	Kunststoffverbundkoerper	single use
199706496	Programmgesteuerte Einheit	single use
199706497	SOI-MOSFET	single use
199706498	Vorrichtung zur Multiplikation mit konstanten Faktoren und deren Verwendung zur Videokompression (MPEG).	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 114 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199706505	Verfahren zum sicheren Aendern eines in einem nicht-fluechtigen Speicher gespeicherten Wertes und Schaltungsanordnung hierzu	dual use
199706511	Nichtlinearer Echokompensator	single use
199706518	EEPROM-Anordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199706541	Zwei Halbleiterspeicherchips (HSC) werden auf eine flexible Verdrahtung aufgebracht und durch einfache Faltung der flexible Verdrahtung um eine mittige Biegelinie (BL1) zu einer platzsparenden Stapelanordnung (SO) umgeformt,	single use
199707414	SHALLOW TRENCH ISOLATION WITH OXIDE NITRIDE/OXYNITRIDE LINER	single use
199707423	CONTROL OF GAS CONTENT IN PROCESS LIQUIDS FOR IMPROVED MEGASONIC CLEANING OF SEMICONDUCTOR WAFERS AND MICROELECTRONICS SUBSTRATES	single use
199707431	CRACK STOPS.	single use
199707434	A VOLTAGE DISCHARGE CIRCUIT	single use
199707439	METHOD FOR PRODUCING VIAS HAVING VARIABLE SIDEWALL PROFILE	single use
199707445	IMPROVED ETCHING OF CONTACT HOLES	single use
199707446	FLEXIBLE FUSE PLACEMENT IN REDUNDANT SEMICONDUCTOR MEMORY	single use
199707447	METHODS AND APPARATUS FOR INCREASING DATA BANDWIDTH OF A DYNAMIC MEMORY DEVICE	single use
199707449	VOLTAGE DETECTION CIRCUIT AND INTERNAL VOLTAGE CLAMP CIRCUIT	single use
199707451	MICROSTRUCTURE AND METHODS FOR FABRICATING SUCH STRUCTURE	single use
199707452	METALIZATION IN SEMICONDUCTOR DEVICE	single use
199707453	DEVICE WITH ASYMMETRICAL CHANNEL DOPANT PROFILE	single use
199707469	DEVICE WITH ASYMMETRICAL CHANNEL DOPANT PROFILE	single use
199707470	INTEGRATED CIRCUITS AND MANUFACTURING METHODS	single use
199707482	IMPROVED INTEGRATED MULTI LAYER TEST PADS AND METHODS THEREFOR	single use
199707483	INTEGRATED CIRCUIT FABRICATION METHOD	single use
199707484	SELF-ALIGNED POLYSILICON FET DEVICES ISOLATED WITH MASKLESS SHALLOW TRENCH ISOLATION AND GATE CONDUCTOR FILL TECHNOLOGY AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF	single use
199707486	VERTICAL TRANSISTOR	single use
199707487	REDUCING OXIDATION STRESS IN THE FABRICATION OF DEVICES	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 115 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199707489	DECODED AUTOREFRESH MODE IN A DRAM	single use
199707492	PROTECTIVE LAYER FOR LASER BLOWN FUSES	single use
199707495	IMPROVED REDUNDANT CIRCUITS AND METHODS THEREFOR	single use
199707496	METHODS FOR METAL ETCHING WITH REDUCED SIDEWALLBUILD UP DURINGINTEGRATED CIRCUIT MANUFACTURING	single use
199707500	REDUCED SIGNAL TEST FOR DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY	single use
199707501	REDUCED SIGNAL TEST FOR DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY	single use
199707503	BACKING FILM FOR CHEMICAL MECHANICAL PLANARIZATION (CMP) OF ASEMICONDUCTOR WAFER	single use
199707506	METHOD OF REDUCING THE FORMATION OF WATERMARKS ON SEMICONDUCTORWAFERS	single use
199707507	IMPROVED SILICA STAIN TEST STRUCTURES AND METHODS THEREFOR	single use
199707508	INTEGRATED CIRCUIT DEVICES INCLUDING SHALLOW TRENCH ISOLATION	single use
199707509	IMPROVED CHEMICAL MECHANICAL POLISHING PAD CONDITIONER	single use
199707510	A LOW TEMPERATURE CVD PROCESS USING A DIKETONATE BI PRECURSERFOR THE PREPARATION OF BI CERAMICS THIN FILMS FOR INTEGRATIONIN FERROELECTRIC MEMORY DEVICES.	single use
199707511	RESIST DEVELOPMENT PROCESS	single use
199707512	APPARATUS FOR CONTROLLING CIRCUIT RESPONSE DURING POWER-UP	single use
199707513	PROCESS OF REMOVING CMP SCRATCHES BY BPSG REFLOW AND INTEGRATEDCIRCUITZ CHIP FORMED THEREBY	single use
199707520	METHODS FOR PROTECTING DEVICE COMPONENTS FROM CHEMICALMECHANICAL POLISH INDUCED DEFECTS	single use
199707524	A METHOD OF REDUCING LOADING VARIATION DURING ETCH PROCESSING	single use
199707530	FORMATION OF SUB-GROUNDRULE FEATURES	single use
199707533	IMPROVED DUAL DAMASCENE STRUCTURE	single use
199707534	METHOD OF FORMING MULTI-LEVEL COPLANER METAL/INSULATOR FILMSUSING DUAL DAMASCENE WITH SACRIFICIAL FLOWABLE OXIDE	single use
199707536	CMOS INTEGRATED CIRCUITS WITH REDUCED SUBSTRATE DEFECTS	single use
199707540	QCD WITH LOW OUTPUT CAPACITANCE	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 116 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199707541	CLOSED TRANSISTOR WITH SMALL W/L RATIOS	single use
199707543	IMPROVED DYNAMIC ACCESS MEMORY EQUALIZER CIRCUITS AND METHODSTHEREFOR	single use
199707544	IMPROVED DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY ARRAYS AND METHODS THEREFOR	single use
199707545	IMPROVED TECHNIQUES FOR REDUCING REDUNDANT ELEMENT FUSES IN ADYNAMIC RANDOM MEMORY ARRAY	single use
199707546	A METHOD OF FILLING SHALLOW TRENCHES	single use
199707559	PROCESS FOR FABRICATING LAYERED SUPERLATTICE MATERIALS AND ABO3TYPE METAL OXIDES AND MAKING ELECTRONIC DEVICES INCLUDING SAMEWITHOUT EXPOSURE TO OXYGEN AT HIGH TEMPERATURES	single use
199707562	A SEMICONDUCTOR STRUCTURE HAVING A CRYSTALLINE LAYER	single use
199707575	METHOD OF MANUFACTURING A SHALLOW TRENCH ISOLATION STRUCTUREFOR A SEMICONDUCTOR DEVICE	single use
199707577	DIMENSION PROGRAMMABLE FUSEBANKS AND METHODS FOR MAKING THE SAME	single use
199707578	TEMPERATURE INDEPENDENT OSCILATOR	single use
199707579	VARIABLE DOMAN REDUNDANCY REPLACEMENT CONFIGURATION FOR A MEMORYDEVICE	single use
199707580	METHOD OF MAKING A MEMORY DEVICE FAULT TOLERANT USING A VARIABLEDOMAIN	single use
199707583	DATA PROCESSING DEVICE	single use
199707584	DIRECT MEMORY ACCESS UNIT	single use
199707585	INTERRUPT SYSTEM	single use
199707586	DATA PROCESSING UNIT	single use
199707587	DATA PROCESSING UNIT WITH HARDWARE ASSISTED CONTEXT SWITCHINGCAPABILITY	single use
199707588	APPARATUS FOR READ/WRITE-ACCESS TO REGISTERS IN A CENTRALPROCESSING UNIT	single use
199707589	DATA PROCESSOR	single use
199707590	DATA PROCESSING UNIT WITH DEBUG CAPABILITIES	single use
199707591	DATA PROCESSING UNIT WITH DIGITAL SIGNAL PROCESSING CAPABILITIES	single use
199707594	IMPROVED LASER FUSE LINKS AND METHODS THEREFOR	single use
199707595	SEMICONDUCTOR WAFER TEMPERATURE MEASUREMENT AND CONTROL TEREOFUSING GASE TEMPERATURE MEASUREMENT	single use
199707601	APPARATUS AND METHOD FOR HIGH SPEED WORDLINE DRIVING WITH LOW REAOVERHEAD	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 117 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199707602	SPATIALLY UNIFORM GAS SUPPLY AND PUMP CONFIGURATION FOR LARGE WAFER DIAMETERS	single use
199707603	IMPROVED TECHNIQUES FOR FORMING ELECTRICALLY BLOWABLE FUSES ON AN INTEGRATED CIRCUIT	single use
199707604	DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY INCLUDING A POROUS TRENCH CAPACITOR	single use
199707605	A METHOD TO MINIMIZE WATERMARKS ON SILICON SUBSTRATES	single use
199707615	METHOD OF END POINT DETECTION FOR A WET ETCH PROCESS	single use
199707616	A METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING THE BIAS CURRENT IN A REFERENCE VOLTAGE CIRCUIT	single use
199707617	FORMATION OF A BOTTLE SHAPED TRENCH	single use
199707618	FLOATING BITLINE TEST MODE WITH DIGITALLY CONTROLLABLE BITLINE EQUALIZERS	single use
199707619	AN IMPROVED APPARATUS FOR CURRENT PULSE GENERATION IN VOLTAGE DOWN CONVERTERS	single use
199707620	METHOD OF MAXIMIZING CHIP YIELD FOR SEMICONDUCTOR WAFERS	single use
199707621	METHOD AND FABRICATING SEMICONDUCTOR CHIPS WITH SILICIDE AND IMPLANTED JUNCTIONS	single use
199707622	SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING REDUNDANCY CIRCUIT	single use
199707626	SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING REDUNDANCY CIRCUIT	single use
199707627	METALIZATION SYSTEM	single use
199707632	BUFFER LAYER FOR IMPROVING CONTROL OF LAYER THICKNESS	single use
199707635	SPACE-EFFICIENT MDQ SWITCH PLACEMENT	single use
199707636	IMPROVED METHODS FOR PERFORMING PLANARIZATION AND RECESS ETCHES AND APPARATUS THEREFOR	single use
199707637	CONSTANT CURRENT CMOS OUTPUT DRIVER CIRCUIT WITH DUAL GATE TRANSISTOR DEVICES	single use
199707638	SPACE-EFFICIENT SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING HIERARCHICAL COLUMN SELECT LINE ARCHITECTURE	single use
199707639	APPARATUS AND METHOD FOR IMPLEMENTING A BANK INTERLOCK SCHEME AND RELATED TEST MODE FOR MULTIBANK MEMORY DEVICES	single use
199707640	ENDPOINT DETECTION METHOD AND APPARATUS	single use
199707641	IMPROVED MULTI-LEVEL CONDUCTIVE STRUCTURE AND METHODS THEREFOR	single use
199707642	METHOD AND APPARATUS FOR MINIMIZING DOPANT OUT DIFFUSION IN GATE STRUCTURES	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 118 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199707643	HIGH DENSITY SEMICONDUCTOR MEMORY HAVIN GDIAGONAL BIT LINESAND DUAL WORD LINES	single use
199707644	APPARATUS AND METHOD FOR IMPROVED WASHING AND DRYING OFSEMICONDUCTOR WAFERS	single use
199707645	DUAL DAMASCENE WITH SELF ALIGNED VIA INTERCONNECTS	single use
199707646	DEPOSITION OF CARBON INTO NITRIDE LAYER FOR IMPROVED SELECTIVITYOF OXIDE TO NITRIDE ETHCHRATE FOR SELF ALIGNED CONTACT ETCHING	single use
199707851	ALPHANUMERIC DISPLAY WITH 21-DOT MATRIX FORMAT	single use
199707859	REDUCED PARASITIC LEAKAGE IN SEMICONDUCTOR DEVICES	single use
199707860	IMPROVED DEEP ULTRA VIOLET PHOTOLITHOGRAPHY	single use
199707861	INTEGRATED CIRCUIT FABRICATION METHOD AND STRUCTURE	single use
199707862	SPACERS TO BLOCK DEEP JUNCTION IMPLANTS AND SILICIDE FORMATIONINTEGRATED CIRCUITS	single use
199707863	HARD ETCH MASK	single use
199707864	METHOD FOR PATTERNING INTEGRATED CIRCUIT CONDUCTORS	single use
199707865	POWER-ON DETECTION AND ENABLING CIRCUIT WITH VERY FAST DETECTIONOF POWER-OFF	single use
199707867	RELIABLE POLICIDE GATE STACK WITH REDUCED SHEET RESISTANCE ANDTHICKNESS	single use
199707868	IMPROVED DISHING RESISTANCE	single use
199707869	SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING HIERARCHICAL BIT LINE ARCHITECTUREWITH NON-UNIFORM LOCAL BIT LINES	single use
199707870	TITANIUM POLYCIDE STABILIZATION WITH A POROUS BARRIER	single use
199707871	MEMORY CELL FOR DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY (DRAM)	single use
199707872	FORMATION OF NON-HOMOGENOUS DEVICE LAYER USING AN INERT GAS SHIELD	single use
199707873	IMPROVED NITRIDE ETCH STOP LAYER	single use
199707874	PLANARIZATION A NONCONFORMAL DEVICE LAYER IN SEMICONDUCTORFABRICATION	single use
199707875	A DUAL DAMASCENE PROCESS FOR METAL LAYERS AND ORGANICINTERMETAL LAYERS	single use
199707877	SOFT PASSIVATION LAYER IN SEMICONDUCTOR FABRICATION	single use
199707878	REDUCTION OF PAD EROSION	single use
199707879	REDUCTION OF GATE-INDUCED DRAIN LEAKAGE IN SEMICONDUCTORS DEVICES	single use
199707880	IMPROVED GAPFILL OF SEMICONDUCTOR STRUCTURE USING DOPEDSILICATE GLASSES WITH MULTI-STEP DEPOSITION/ANNEAL PROCESS	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 119 von 186

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199707881	MEMORY CELL FOR DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY(DRAM)	single use
199707882	SECONDARY SENSE AMPLIFIER WITH WINDOW DISCRIMINATOR FOR SELF-TIMED OPERATION	single use
199707883	IMPROVED GAPFILL OF SEMICONDUCTORS STRUCTURE USING DOPED SILICATE GLASSES	single use
199707888	METHOD AND APPARATUS FOR EXTRACTING DATA	single use
199707903	IMPROVED TECHNIQUES FOR ETCHING A SILICON DIOXIDE CONTAINING LAYER	single use
199707908	BI(THD)3-AN EXCELLENT PRECURSOR FOR CVD OF BI OXIDE CERAMICS	single use
199707909	ALKANES AS NEW SOLVENTS FOR STORAGE, HANDLING AND DELIVERY OF CVD PRECURSORS, ESPECIALLY FOR CVD OF $\text{SbI}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ WITH B-DIKETONATES AND ALCOXIDES	single use
199707910	METHOD AND SYSTEM TO ACHIEVE ZERO CYCLE PENALTY FOR ACCESS CROSSING A CACHE LINE	single use
199707929	A CVD PROCESS USING BI AMIDE PRECURSOR FOR THE PREPARATION OF BI CERAMIC THIN-FILMS FOR INTEGRATION INTO FERROELECTRIC MEMORY DEVICES	single use
199707930	A CVD PROCESS USING BI CARBOXYLATE PRECURSOR FOR THE PREPARATION OF BI CERAMIC THIN FILMS FOR INTEGRATION INTO FERROELECTRIC MEMORY DEVICES	single use
199707936	MEMORY ARRAY WITH REDUCED CHARGING CURRENT	single use
199707937	MEMORY WITH WORD LINE VOLTAGE CONTROL	single use
199707942	SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING HIERARCHICAL BIT LINE ARCHITECTURE WITH INTERLEAVED MASTER BIT LINES	single use
199707943	SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING HIERARCHICAL BIT LINE AND/OR WORDLINE ARCHITECTURE	single use
199707944	"SUPPLEMENT TO: "ADDITIVES FOR STABILIZATION AND EFFICIENCY ENHANCEMENT FOR CVD PROCESSES OF BI OXIDE CERAMICS"	single use
199707945	ADDITIVES FOR STABILISATION AND FOR ENHANCEMENT OF THE EFFICIENCY FOR CVD PROCESS OF BI OXIDE CERAMICS	single use
199707946	NEX ETCH AND WET CHEMICAL ETCHING PROCESS FOR BI CONTAINING FERROELECTRIC MATERIALS, ESPECIALLY FOR STRONTIUM BISMUTH TANTALATE (SBT) . 97P7945US01 ADDITIVES FOR STABILISATION AND FOR ENHANCEMENT OF THE EFFICIENCY FOR CVD PROCESS OF BI OXIDE CERAMICS	single use
199707947	METHODS OF PREVENT OR TO LOWER BI DIFFUSION INTO EXPOSED SiO_2 OR Si_3N_4 SUBSTRATE SURFACES DURING MANUFACTURING OF THIN FILMS OF BI OXIDE CERAMICS BY CVD AND POST ANNEALING	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 120 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199707948	METHOD AND APPARATUS FOR QUANTIFYING PROXIMITY EFFECT BY MEASURING DEVICE PERFORMANCE	single use
199707949	METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING CHEMICAL VAPOR DEPOSITION ON SILICIDE FILMS	single use
199707950	METHOD AND APPARATUS FOR MINIMIZING DIFFUSION IN STACKED CAPACITORS FORMED ON SILICON PLUGS	single use
199707951	SYNCHRONOUS DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY ARCHITECTURE FOR SEQUENTIAL BURST MODE	single use
199707955	INTERCONNECTION IN INTEGRATED CIRCUIT DEVICES	single use
199707957	METHOD FOR DETECTING UNDER-ETCHED VIAS	single use
199707958	DUAL DAMASCENE WITH BOND PADS	single use
199707959	METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING WAFER WARPAGE FOR OPTIMIZED ELECTROSTATIC CHUCK CLAMPING VOLTAGE	single use
199707960	METHOD FOR THE SELECTIVE DEPOSITION OF BISMUTH BASED FERROELECTRIC THIN FILMS BY CHEMICAL VAPOR DEPOSITION	single use
199707961	METHOD FOR NUCLEATION CONTROLLED CHEMICAL VAPOR DEPOSITION OF METAL OXIDE FERROELECTRIC THIN FILMS	single use
199707962	METHOD FOR NUCLEATION CONTROLLED CHEMICAL VAPOR DEPOSITION OF METAL OXIDE FERROELECTRIC THIN FILMS	single use
199707963	REDUCTION OF BLACK SILICON IN SEMICONDUCTOR FABRICATION	single use
199707964	WAFER SURFACE CLEANING APPARATUS AND METHOD	single use
199707965	REDUCED PAD EROSION	single use
199707971	RECESSED SHALLOW TRENCH ISOLATION STRUCTURE NITRIDE LINER AND METHOD FOR MAKING SAME	single use
199707974	LOW TEMPERATURE DIFFUSION PROCESS FOR DOPANT CONCENTRATION ENHANCEMENT	single use
199707975	LOW TEMPERATURE DIFFUSION PROCESS FOR DOPANT CONCENTRATION ENHANCEMENT	single use
199707976	MASK BLANK AND METHOD OF PRODUCING MASK	single use
199707977	METHOD FOR ETCHING ALUMINUM BASED LAYER	single use
199708007	Traeger element zum Einbau in Kombi-Chipkarten und Kombi-Chipkarte	single use
199708008	Halbleiterlaser-Bauelement	single use
199708009	Optoelektronisches Halbleiterbauelement	single use
199708021	VERTIKALER MOS-TRANSISTOR UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG.	single use
199708022	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES VERTIKALEN MOS-TRANSISTORS.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 121 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199708023	Verfahren zur Herstellung eines vertikalen MOS-Transistors.	single use
199708029	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Rauschreduktion bei Fernseh- ODER Videosignalen	single use
199708035	Leistungsdiode	single use
199708036	Leistungsdiode	single use
199708039	Vorrichtung zur Rueckhoerdaempfung	dual use
199708045	Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von Abwasser aus einem chemisch-mechanischen Polierprozess in der Chipfertigung	single use
199708047	Verfahren und Vorrichtung zur Codierung, Uebertragung und Decodierung digitaler Daten	dual use
199708050	KLEBEVERBINDUNG	dual use
199708054	Optoelektronisches Halbleiterbauelement	single use
199708059	Datenuebertragungsverfahren mit einer Mehrzahl von Frequenzbaendern	dual use
199708068	Materialtablette sowie Verfahren zum Herstellen eines Kunststoffverbundkoerpers	single use
199708069	OPEN-COLLECTOR-SCHALTUNG	single use
199708083	Verfahren zur Herstellung einer p-leitenden Schicht aus InGaAs, mit dem Verfahren hergestellte Schicht und Anwendung einer solchen Schicht	single use
199708095	Fluoreszierendes Material und Verfahren zu seiner Herstellung	dual use
199708099	Integriertes Tiefpassfilter	single use
199708101	Speicherarchitektur mit Mehrebenenhierarchie	single use
199708102	Schaltungsanordnung zur Behandlung von Zugriffskonflikten	single use
199708103	Randstruktur fuer Halbleiterbauelement	single use
199708105	Frequenzteiler mit geringem Stromverbrauch.	single use
199708106	VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES KUNSTSTOFFVERBUNDKOERPERS SOWIE KUNSTSTOFF-KOERPER	single use
199708107	Poliermittel, Verfahren zum chemisch-mechanischen Planarisieren und Verwendung des Poliermittels zum Planarisieren eines Halbleitersubstrats	single use
199708109	Bipolare Impedanzwandlerschaltung	single use
199708124	Kunststoffverbundkoerper sowie Verfahren und Werkstoff zum Herstellen eines Kunststoffverbundkoerpers	single use
199708125	Kunststoffmassen zur Umhuellung eines Metall- ODER Halbleiterkoerpers	single use
199708133	Beschichtung von Metalloberflaechen insbesondere fuer die Mikroelektronik	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 122 von 186

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199708140	VERFAHREN ZUM DETEKTIEREN EINES STROMS SPINPOLARISierter ELEKTRO-NEN IN EINEM FESTKOERPER	single use
199708147	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR KOMBINIERTEN MESSUNG DES ANFANGS EINES DATENBLOCKS UND DES TRAEGERFREQUENZVERSATZES IN EINEM MEHRTRAEGERUEBERTRAGUNGSSYSTEM FUEER UNREGELMAESSIGE UEBERTRAGUNG VON DATENBLOECKEN	dual use
199708148	SCHUTZSCHALTUNG	single use
199708150	METHOD AND APPARATUS FOR SIZE OPTIMIZATION OF STORAGE UNITS	single use
199708151	BEFEHLSTRANSFORMATOR FUEER PROZESSOREN U.A.	single use
199708200	SYSTEM ZUM ANZEIGEN VON INFORMATIONEN UEBER EIN ZU TRANSPORTIERENDES UND/ODER ZU BEARBEITENDES GUT	single use
199708503	Integriert-optische Schaltanordnung	single use
199801002	Halbleiterspeicheranordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801003	Verfahren und Anordnung zum Betreiben eines Bussystems	single use
199801006	Oszillatorstruktur mit wenigstens einem Oszillator-Schaltkreis und wenigstens einem Resonator	dual use
199801007	Befestigung eines Halbleiterkoerpers auf einer Leiterplatte	single use
199801010	SOI-Hochspannungsschalter	single use
199801012	Traegerelement fuer einen Halbleiterchip	single use
199801015	Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauelementes und einderart hergestelltes Halbleiterbauelement	single use
199801016	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801018	Verzoegerungsschaltung	single use
199801021	Vorrichtung und Verfahren zur Anpassung an eine durch einen ISDN-Datenuebertragungsstandard vorgegebene Pulsmaske	dual use
199801023	SOI-IGBT	single use
199801024	Leistungs-MOSFET	single use
199801025	Integrierte Halbleiterschaltung mit Grabenisolaton	single use
199801026	Halbleiterbauelement mit mehreren Substratlagen und zumindest einem Halbleiterchip und einem Verfahren zum Herstellen eines solchen Halbleiterbauelementes	single use
199801028	FET mit Source-Substratanschluss	single use
199801029	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung.	single use
199801033	Getaktete Stromversorgung	single use
199801038	Schaltung fuer sequentielle Steuerung im Hochfrequenzbereich	single use
199801039	Mobiltelefon und Verfahren zum Betreiben eines Mobiltelefons	dual use
199801042	Referenzspannungsgenerator	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 123 von 186

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199801048	Digital gesteuerte Schaltung zur Verringerung der Phasenmodulation eines Signals	single use
199801049	Verfahren zur Herstellung von Stacked Vias	single use
199801059	Schaltung zur Demodulation von Datensymbolen von durch getragene Datenübertragung gesendeten zweidimensionalen Datensymbolen	dual use
199801064	Verfahren zur Verarbeitung eines Signals aus Datensymbolen	single use
199801075	Chipkartenmodul fuer biometrische Sensoren	single use
199801076	Vorrichtung und Verfahren zur Veraenderung des Rauschverhaltens in einem Empfaenger eines Datenuebertragungssystems	dual use
199801081	Anordnung und Verfahren zum Bereitstellen von Daten zur Charakterisierung von verschiedenen Einheiten an einem Bussystem	single use
199801083	Mikromechanischer Abstandssensor	single use
199801087	ustreiber	single use
199801094	Transistor fuer analoge Schaltungsfunktionen	single use
199801107	Integrierter Speicher	single use
199801114	Verfahren zur Herstellung eines beidseitig sperrenden Leistungshalbleiters	single use
199801115	Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements	single use
199801121	Transportvorrichtung	single use
199801122	Drucksystem fuer einen Reaktorraum	single use
199801123	Thermisch haertbare Ein-Komponenten-Underfill-Masse	dual use
199801125	Contact between a monocrystalline silicon region and a polycrystalline silicon structure and method of making such a contact	single use
199801126	Method for producing a polycrystalline silicon structure	single use
199801130	Leistungshalbleiterdiode	single use
199801136	Leistungshalbleiterdiode	single use
199801145	Optische Struktur und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199801152	Diodenschaltung mit idealer Diodenkennlinie	single use
199801155	Halbleiterbaugruppe	single use
199801156	Schaltungsanordnung mit mindestens einem Kondensator und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801160	Halbleiterbauelement mit Struktur zur Vermeidung von Querstroemen	single use
199801162	Speicherzellenanordnung und entsprechendes Herstellungsverfahren	single use
199801163	Vorrichtung und Verfahren zum Holen von Befehlen fuer eine programmgesteuerte Einheit	single use
199801164	EEPROM und Verfahren zur Ansteuerung eines EEPROM	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 124 von 186

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199801165	Verfahren zum Abschalten des Laststromes eines Leistungshalbleiter-Bauelementes und Leistungshalbleiter-Modul zur Durchführung des Verfahrens	single use
199801166	Elektrisch programmierbarer Nur-Lese-Speicher sowie Verfahren zum Programmieren und Lesen dieses Speichers.	single use
199801168	Integrierbare Schaltung zur Frequenzaufbereitung eines im UHF-Bereich arbeitenden Funk-Sende-Empfängers, insbesondere eines Schnurlostelefons	single use
199801174	Verfahren zur Verbesserung der akustischen Rueckhoerdaempfung in Freisprecheinrichtungen	dual use
199801180	Verfahren und Vorrichtung zur kryptographischen Bearbeitung anhand einer elliptischen Kurve auf einem Rechner	dual use
199801185	Datentraeger zum kontaktlosen Empfang von Daten und Energie und Verfahren zum Betreiben eines solchen	single use
199801187	Datentraeger sowohl fuer den kontaktlosen als auch den kontaktbehafteten Betrieb	single use
199801191	Verfahren zum Entwurf einer Maske zur Herstellung eines Dummygebiets in einem Isolationsgrabengebiet zwischen elektrisch aktiven Gebieten einer mikroelektronischen Vorrichtung	single use
199801197	EMV-optimierter Leistungsschalter	single use
199801202	Dielektrisch Isolierte Halbleitervorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801203	Halbleiterbauelement mit strukturiertem Leadframe und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199801206	Vorrichtung zur hierarchischen und verteilten Steuerung von programmierbaren Modulen in hochintegrierten Systemen.	single use
199801211	Steuerbarer LC-Oszillator	single use
199801213	Speicherzelle mit MOS-Transistor und Verfahren zu ihrer Herstellung.	single use
199801214	Bidirektionaler Baustein und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199801215	MOS-Transistor, dessen Verwendung in einer EEPROM-Anordnung und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199801221	Halbleitervorrichtung und entsprechendes Herstellungsverfahren	single use
199801222	Elektrisch programmierbare Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801223	Speicherzellenanordnung und entsprechendes Herstellungsverfahren	single use
199801240	Datenpfad fuer Signalverarbeitungsprozessoren	single use
199801242	Anrufbeantworter	dual use
199801244	Elektrisch programmierbare Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801247	Vollintegrierbare spannungsgesteuerte Oszillatorschaltung (VCO)	single use
199801249	Integrierte Schaltung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 125 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199801254	Elektrisch programmierbare Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801257	Vorrichtung und Verfahren zur Belichtung von Photolack	single use
199801267	Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelement	single use
199801268	Integrierter Speicher	single use
199801269	Halbleiterbauelement mit mehreren Halbleiterchips	dual use
199801270	Integrierte Schaltung und Verfahren zu ihrer Prüfung	single use
199801271	Verlustsymmetrierte Treiberschaltung aus MOS-Highside-/Lowside-Schaltern	single use
199801280	Fingertippsensor mit integriertem Tastschalter	dual use
199801290	Differenzverstärkerschaltung und Mischerschaltung mit Differenzverstärkerschaltung	single use
199801296	Vorrichtung zur sofortigen Ausgabe der Antwort eines synchronen Systems auf ein asynchrones Ereignis	single use
199801306	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung.	single use
199801307	MIKROSENSOR, ZU SEINER HERSTELLUNG UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES MIKROSENSORS	single use
199801311	Integrierbare Funkempfängerschaltung für frequenzmodulierte digitale Signale	single use
199801315	Integrierter Schaltkreis für Mobilfunk- UND Mobiltelefonanlagen	single use
199801317	Kollimator, Vorrichtung und Verfahren zum Beschichten eines Substrats	single use
199801320	Haltevorrichtung für Photoblanks	single use
199801322	Verfahren zum Bonden von zwei Wafern	single use
199801325	Schaltung zur temperaturabhängigen Stromversorgung einer LED	single use
199801329	Kondensator in integrierter Schaltung	single use
199801330	Schaltungsanordnung zur Ansteuerung eines Pulsweitenmodulators in einem Schaltnetzteil	single use
199801331	Messvorrichtung zum digitalen Erfassen analoger Messgrößen	single use
199801332	Integrierte elektronische Schaltungsanordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung	single use
199801344	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199801349	Schaltungsanordnung zur Reduzierung des Leckstromes.	dual use
199801360	Verbindungstestvorrichtung zum Testen der elektrischen Verbindungen zwischen Chips oder Chip-Modulen	single use
199801362	Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung einer Störung eines technischen Systems	single use
199801378	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801379	MOS-Transistor in einer Ein-Transistor-Speicherzelle mit einem lokal verdickten Gateoxid und Herstellungsverfahren	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 126 von 186

D: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199801388	Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung	single use
199801399	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801403	Verfahren zur Herstellung von integrierten Schaltungen mit Standardzellen.	single use
199801406	Verfahren zur Programmierung einer Festwert-Speicherzellenanordnung.	single use
199801410	Verfahren zur Programmierung einer Festwert-Speicherzellenanordnung.	single use
199801411	VLSI-Schaltung mit Temperaturüberwachung	single use
199801412	Schaltungsanordnung zur Steuerung und Erfassung des Laststromes durch eine Last	dual use
199801413	Schaltungsanordnung fuer einen Komparator	single use
199801417	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung.	single use
199801419	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung.	single use
199801423	Verfahren zum Vereinzeilen von elektronischen Modulen	single use
199801426	Verfahren zur Herstellung eines Stegwellenleiters in III-V-Verbindungshalbleiter-Schichtstrukturen und Halbleiterlaservorrichtung besonders fuer niedere Serienwiderstaende	single use
199801428	Halbleiterspeicher mit streifenfoermiger Zellplatte	single use
199801431	Mehrfach-Kontaktierungsvorrichtung	single use
199801435	Anordnung zum Erkennen von Kontaktfehlern beim Testen von integrierten Schaltungen	single use
199801436	Schaltungsanordnung und Verfahren zur automatischen Erkennung und Beseitigung von Wortleitungs-Bitleitungs-Kurzschlüssen	single use
199801445	Verfahren zur Anpassung eines Empfangsgeraetes an Uebertragungsbedingungen und Empfangsgeraet hierfuer	dual use
199801450	Anordnung zum Anschliessen einer Vielzahl von Teilnehmerleitungen an eine Telekommunikationseinrichtung	dual use
199801451	Verfahren zum Herstellen eines elektronischen Bauteils	single use
199801454	Vertikalresonator-Laserdiode und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801461	Elektrische Steuereinrichtung	single use
199801473	Verfahren und Vorrichtung zum Testen einer digitalen Halbleiter-Schaltungsanordnung	single use
199801490	Current-Mode-Schaltregler	single use
199801495	Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelement	single use
199801496	Hochvolt-Randabschluss fuer Planarstrukturen	single use
199801497	Verfahren zum Herstellen eines elektronischen Bauteils und Leiterplatten zur Verwendung in einem solchen Verfahren	single use
199801498	Anordnung zur räumlichen Trennung und/oder Zusammenfuehrung optischer Wellenlaengenkanäle	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 127 von 186

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199801499	Anordnung zum Synchronisieren einer Vermittlungseinrichtung und einer Mehrkanalübertragungseinrichtung	dual use
199801500	Musterzeichner fuer Maskenblank	single use
199801501	Verfahren zur Herstellung einer Halbleiter-Speichervorrichtung	single use
199801506	Vorrichtung zur Aufnahme von Gegenstaenden, insbesondere Wafern	single use
199801507	Halbleiter-Speichervorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801510	Gehaeuse fuer Leistungshalbleiter	single use
199801511	Verfahren zur Ueberwachung der Erdung eines Maskenblanks	single use
199801513	Halbleiterbauelement	single use
199801515	Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von Gegenstaenden, vorzugsweise Wafern	single use
199801516	Verfahren zum Herstellen eines SOI-Wafers fuer niederohmige Hochvolt-Halbleiterbauelemente	single use
199801518	Verfahren zum Herstellen eines Stapelkondensators in einer Halbleiteranordnung und nach diesem Verfahren hergestellter Kondensator.	single use
199801519	Universal-Halbleiterscheibe fuer Hochvolt-Halbleiterbauelemente	single use
199801520	Schaltungsanordnung fuer ein Stromversorgungsgeraet	single use
199801526	Integrierte Schaltung	single use
199801531	Vorrichtung zum Beladen und Entladen eines Prozessreaktors mit Gegenstaenden, vorzugsweise Wafern, und Prozessreaktor	single use
199801539	Speicheranordnung mit redundanten Speicherzellen und Verfahren zum	single use
199801543	Verfahren zur Uebertragung von Zusatzinformationssignalen in Auslastluecken eines Videosignales und Vorrichtung zum Empfang dieser Zusatzinformationssignale	single use
199801551	Referenzspannungsschaltung	single use
199801552	Verpolschutzschaltung	dual use
199801553	Verpolschutzschaltung	dual use
199801557	Empfangsgeraet zum Empfangen von Video- UND Teletextsignalen	single use
199801558	Hochvolt-Randabschluss fuer Halbleiterbauelement	single use
199801560	Verfahren zum Schreiben und Lesen von digitalen Informationswerten.	dual use
199801562	Lateraler Hochvolt-Seitenwandtransistor	single use
199801563	Niederohmiger Hochvolt-Feldeffekttransistor	single use
199801565	Superniederohmiger vertikaler MOSFET und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199801577	Schaltungsanordnung fuer eine Ladungspumpe und Spannungsreglerschaltung mit einer derartigen Schaltungsanordnung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtstamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

GPC IC
Seite 128 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199801578	Referenzspannung-Erzeugungsschaltung	single use
199801598	Kontaktanordnung fuer Nadelkarten	single use
199801608	Digitales Mohrteilnehmer-Funk-Nachrichtenuebertragungssystem	dual use
199801609	Interrupt-Anforderungen ausgebende Einrichtung	single use
199801614	VERFAHREN ZUR BILDERKENNUNG UND VERWENDUNG BEI FINGERABDRUECKEN	single use
199801615	MOS-Leistungstransistor	single use
199801616	Halterung fuer Halbleiterbarren	single use
199801618	SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM SENSORELEMENT UND EINEM NICHTFLUECHTIGEN SPEICHERMITTEL	single use
199801622	Kondensator fuer Halbleiter-Speicheranordnung und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199801627	Schaltungsanordnung zur Bereichsumschaltung in Hochfrequenzempfaengern	single use
199801635	Bidirektionales Modul fuer Mehrkanal-Anwendung	single use
199801636	Vorrichtung zum Beladen und Entladen eines Prozessreaktors mit Gegenstaenden, insbesondere Wafern, und Prozessreaktor zur Behandlung solcher Gegenstaende	single use
199801638	Anordnung zum Testen mehrere Speicherchips auf einem Wafer	single use
199801646	Behandeln der Oberflaeche einer Leiterbahn	single use
199801649	SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINZELELEKTRON-BAUELEMENTEN UND VERFAHREN ZU DEREN BETRIEB	dual use
199801656	Gehaeuse fuer einen biometrischen Sensor zur Erfassung von Fingerminutien	dual use
199801665	ZEITGEBER FUER EINEN A/D-WANDLER	single use
199801666	Verfahren zum A/D-Wandeln analoger Signale sowie entsprechende A/D-Wandleranordnung	single use
199801668	Verfahren zum Herstellen einer Epitaxieschicht mit lateralveraenderlicher Dotierung	single use
199801670	MIKROMECHANISCHES BAUELEMENT UND HERSTELLVERFAHREN	single use
199801674	Cache-Speicher fuer zweidimensionale Datenfelder und seine Verwendung in der Bildverarbeitung.	dual use
199801676	HALBLEITERBAUELEMENT MIT DURCH PAD EINGESPARTER CHIPFLAECHE	single use
199801679	Substrate and method for manufacturing the same	single use
199801680	Mikroventil	dual use
199801686	DUENFILM-PIEZORESONATOR	single use
199801688	PERFORIERTES WERKSTUECK UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG.	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 129 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199801693	Elektronische Baugruppe	single use
199801700	Zeitgabevorrichtung und Zeitgabeverfahren	dual use
199801708	Abschaltbarer Thyristor	dual use
199801710	Verfahren zum Vereinzeln und Positionieren von Halbleiter-Bauteilen	single use
199801711	Integrierte Schaltung	single use
199801712	Verfahren und Vorrichtung zum Umschalten eines Feldeffekttransistors	single use
199801716	Verzögerungsoptimierter Multiplexer	single use
199801717	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG KOMPLEMENTÄERER SIGNALE	single use
199801718	Anordnung zur Redundanzauswertung bei einem Halbleiterspeicherchip	single use
199801724	Herstellverfahren fuer einen Kondensator in einer integrierten Speicherschaltung	single use
199801725	Bidirektionaler Schalter mit bidirektionaler Strommessanordnung	dual use
199801732	Haltevorrichtung fuer einen Wafer und Pruefverfahren fuer integrierte Schaltungen auf einem Wafer	single use
199801733	Kartenfoermiger Datentraeger, Verfahren zu seiner Herstellung und Kartengrundkoerper fuer einen kartenfoermiger Datentraeger	single use
199801734	Herstellverfahren fuer einen Kondensator in einer integrierten Halbleiterschaltung	single use
199801736	Klemmschaltung	single use
199801738	Verfahren zur Herstellung eines Kondensators fuer eine Halbleiteranordnung	single use
199801740	Elektronischer Verstaerker	single use
199801741	Vorrichtung zur kontaktlosen Uebertragung von Daten	dual use
199801742	Integrierte elektrische Schaltung mit wenigstens einer Speicherzelle und Verfahren zu ihrer Herstellung.	single use
199801749	Integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens einem Transistor und einem Kondensator und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199801751	Sensoreinrichtung zur Erfassung von biometrischen Merkmale, insbesondere Fingerminutien	dual use
199801753	Sendeeinrichtung und Bussystem zur Datenuebertragung	single use
199801757	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG METALLHALTIGER SCHICHTEN	single use
199801759	Verfahren zur Herstellung von elektrischen Bauelementen sowie elektrisches Bauelement	single use
199801762	Halbleiterspeicher mit differentiellen Bitleitungen	single use
199801767	Vorrichtung zum Schutz vor Verpolung	dual use
199801769	Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schaltungsanordnung.	single use
199801770	Reaktorordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 130 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199801771	Bidirektionale optische Sende- UND Empfangseinrichtung	single use
199801772	Hochfrequenz-Lasermodule und Verfahren zur Herstellung desselben	single use
199801774	Inverterschaltung	single use
199801776	Verfahren zur Herstellung von Schottky-Dioden	single use
199801778	Verfahren zur Herstellung von Schottky-Dioden	single use
199801780	Verfahren zur Herstellung von Schottky-Dioden	single use
199801783	Leistungsdioden-Struktur	single use
199801788	Gehäusenanordnung fuer Lasermodule	single use
199801789	Fuseatch-Schaltung	single use
199801792	Halbleiter-Speicherzellenanordnung und entsprechendes Herstellungsverfahren	single use
199801794	Anordnung zur Uebersprechdaempfung in Wortleitungen von DRAM-Schaltungen	single use
199801801	Grabenkondensator mit Isolationskragen und entsprechendes Herstellungsverfahren	single use
199801805	Schaltungsanordnung fuer Burn-In-Systeme zum Testen von Bausteinen mittels eines Boards	single use
199801809	Verfahren und Anordnung zum Betreiben eines mehrstufigen Zaehlers in einer Zaehrrichtung	single use
199801812	Verfahren und Vorrichtung zum Verschluesseln von Daten	dual use
199801852	Adaptiver CAP-Empfänger	dual use
199801853	Integrierte Halbleiter-Speichervorrichtung	single use
199801854	Integrierte Halbleiter-Speichervorrichtung	single use
199801855	Verfahren zur adaptiven Filtereinstellung in einem QAM/CAP-System	dual use
199801857	Pruefanordnung fuer Bondpads	single use
199801858	Anordnung zur Deaktivierung einer BIST-Schaltung in einem Halbleiterchip	single use
199801860	Logikgatter	single use
199801861	Inverterschaltung	single use
199801865	Phasenregelkreis (PLL; Phase-Locked-Loop) fuer Hochfrequenz(HF)-Signale	dual use
199801866	Integrierte Halbleiterschaltung mit Fuelstrukturen	single use
199801867	Integrierte Halbleiterschaltung mit einer Anschlussflaeche	single use
199801871	Halbleiterbauelement mit einer Polysiliziumverdrahtung und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199801872	Verfahren zur Schraegimplantierung von Untordiffusionen	single use
199801882	Elektronischer Speicher mit vereinfachtem Lesezugriff	single use
199801883	Verfahren zum Testen von Speichern auf Retention	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 131 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199801884	Speicherkondensator fuer DRAM.	single use
199801891	Verfahren zum Umsetzen einer in Form einer Gatternetzlistevorliegenden Schaltungsbeschreibung in eine Hardware-Beschreibungssprache	single use
199801892	Schreib- UND Leseverfahren fuer einen ferroelektrischen Speicher.	single use
199801894	Verfahren zur Messung von gasfoermigen chemischen Bestandteilen in einem Prozessreaktor zum Behandeln von elektrischen Bauelementen, insbesondere Wafern	single use
199801916	Einrichtung zur Vermessung und Analyse von elektrischen Signalen eines integrierten Schaltungsbausteins	single use
199801921	Wellenlaengenslabilierte Laseranordnung	single use
199801926	Anschlussanordnung	single use
199801929	Aktive Arbeitspunkteinstellung fuer Leistungsverstaerker	single use
199801930	Elektronische Speichereinrichtung	single use
199801941	Lateral-Hochspannungstransistor	single use
199801943	Schaltungsanordnung zur Steuerung der Chiptemperatur eines Halbleiterbauelements	single use
199801951	Halbleiteranordnung mit mindestens zwei Halbleiterchips und Verfahren zum Herstellen einer derartigen Halbleiteranordnung	single use
199801959	Integrierter Speicher	single use
199801961	Integrierte Schaltung mit einer Kontaktierungsstelle zum Kontaktieren mit einem Bonddraht	single use
199801962	Chipmodul zum Einbau in einen Chipkartentraeger sowie Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199801970	Verfahren zur Herstellung von Halbleiterbauelementen	single use
199801976	Nichtrekursives digitales Filter und Verfahren zur Berechnung der Koeffizienten dieses Filters	single use
199801986	Verfahren zur digitalen Taktrueckgewinnung und selektiven Filterung	single use
199801988	Dynamische Halbleiter-Speichervorrichtung und Verfahren zur Initialisierung einer dynamischen Halbleiter-Speichervorrichtung	single use
199801989	Dynamische Halbleiter-Speichervorrichtung und Verfahren zur Initialisierung einer dynamischen Halbleiter-Speichervorrichtung	single use
199802007	Integrierter Speicher	single use
199802008	Integrierte Schaltungsanordnung, Verfahren zu deren Herstellung und Wafer mit einer Anzahl integrierter Schaltungsanordnungen	single use
199802009	Ausgangstreiber eines integrierten Halbleiterchips	single use
199802020	Steuervorrichtung zum Schalten eines elektrischen Verbrauchers	single use
199802021	Datenspeichervorrichtung	single use
199802024	Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Taktsignalen	single use
199802029	DRAM-Speicherkondensator und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 132 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802030	Elektrische Steuereinrichtung	single use
199802034	Vertikales Halbleiterbauelement mit reduziertem elektrischem Oberflächenelement	single use
199802037	Schaltung zur Ermittlung der Zeitdifferenz zwischen Flanken eines ersten und eines zweiten digitalen Signals	single use
199802039	Fehler-Rauschformung höherer Ordnung fuer Multi-Bit DA-Wandler.	dual use
199802041	Integrierte Schaltung	single use
199802043	FeRAM-Anordnung	single use
199802045	Verfahren zur Herstellung einer gefuellten Vertiefung in einer Materialschicht sowie eine durch das Verfahren erzeugte integrierte Schaltungsanordnung	single use
199802046	Ferroelektrische Speicheranordnung	single use
199802053	Verfahren zur Lebenderkennung menschlicher Haut	single use
199802054	CAN-Modul	single use
199802058	Halbleiterbauelement mit Passivierung	single use
199802059	Vorrichtung zum Abscheiden von Substanzen	single use
199802060	Elektronisches Bauteil	single use
199802068	Ferroelektrischer Schreib-/Lesespeicher mit in Reihe geschalteten Speicherzellen (CFRAM).	single use
199802074	Verfahren und Vorrichtung fuer den Sendersuchlauf in Funkempfaengern	single use
199802076	Asymmetrisch sperrendes Leistungshalbleiterbauelement	dual use
199802077	Anordnung zum Testen von Chips	single use
199802078	Speichereinrichtung und Verfahren zum Betreiben der Speichereinrichtung	single use
199802079	Anordnung und Verfahren zum Speichern der mit einer BIST-Schaltung erhaltenen Testergebnisse	single use
199802080	Brueckenmodul	single use
199802082	Speicherzellenanordnung, bei der ein elektrischer Widerstand eines Speicherelements eine Information darstellt und durch ein Magnetfeld beeinflussbar ist, und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199802083	Kondensator und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199802086	Anordnung mit einer Vielzahl von Sensorgruppen und Verfahren zur Bestimmung ihrer Intaktheit	dual use
199802088	Halbleiterschicht mit lateral veraenderlicher Dotierung und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199802092	Schaltungsanordnung zum Erzeugen einer Hilfsgleichspannung	single use
199802093	Biometrischer Sensor und Verfahren zu dessen Herstellung	dual use
199802102	Stapelkondensator und entsprechendes Herstellungsverfahren	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 133 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802116	Anordnung zum Testen von integrierten Bausteinen	single use
199802117	Integrierte Schaltung mit einer Selbsttesteinrichtung	single use
199802118	Integrierte Schaltung mit einem Spannungsregler	single use
199802122	Passivierungsschicht fuer Leistungshalbleiter mit an dieOberflaeche tretenden pn-Uebergaengen	single use
199802124	Leistungshalbleiterelement mit einem Emittierbereich, dem eineStoppzone vorgelagert ist	dual use
199802126	Halbleiterbauelement mit einer Schaltungsanordnung zum Ansteuern einer elektrischen Last	single use
199802134	Ferroelektrische Speicheranordnung	single use
199802135	Integrierte Schaltung mit einer Selbsttesteinrichtung zurDurchfuehrung eines Selbsttests der integrierten Schaltung	single use
199802140	Endstufe fuer einen Decoder	single use
199802142	Netzwerkanpassungseinrichtung und zugehoeriges Verfahren	dual use
199802144	Verstaerkerschaltung zur Kapazitaetsmessung	single use
199802146	Verfahren zur Bestimmung sehr kleiner Kapazitaeten und Verwendung	single use
199802147	Schaltungsanordnung zum Schutz einer elektrischen Last	dual use
199802149	Verbundkoerper aus wenigstens zwei integrierten Schaltungen undVerfahren zur Herstellung eines Verbundkoerpers aus wenigstenszwei integrierten Schaltungen	dual use
199802153	Integriertes Bauelement, Verbundkoerper aus einem integriertenBauelement und einer Leiterstruktur, Chip-Karte und Verfahren zurHerstellung des integrierten Bauelementes	single use
199802162	Integrierte Regiervorrichtung	dual use
199802164	Verfahren zur Reinigung von CVD-Anlagen	single use
199802172	Biometrische Sensoreinrichtung mit in einem Flexleiterbandintegrierten elektronischen Bauelementen	dual use
199802183	Leistungshalbleiter mit reduziertem Sperrstrom	dual use
199802185	Integrierter Halbleiterchip mit modularen Fuelstrukturen	single use
199802190	Verstaerkerausgangsstufe	single use
199802191	Getaktete integrierte Halbleiterschaltung und Verfahren zumBetreiben einer solchen	single use
199802192	Datentraeger mit Regelung der Leistungsaufnahme	dual use
199802193	Datentraeger mit einer blockierbaren Taktsignalquelle undVerfahren zum Erzeugen eines Taktsignals in einem Datentraeger	single use
199802200	Spannungsvervielfacherschaltung	dual use
199802207	Schaltungsanordnung zur Signalverzoeigerung	single use
199802212	Speicherzelle und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199802214	Method of and apparatus for generating PCM code sets	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 134 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802217	Biometrische Sensoreinrichtung mit formschlüssiger Zugentlastungseinrichtung zwischen Flexleiterband und Chipgehäuse	dual use
199802223	Verfahren zur Bewegungsschätzung und Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens	single use
199802231	Vorrichtung zum Ablesen eines im Waferverbund vorliegenden Halbleiter-Chips	single use
199802232	Leistungsbauelement in einem Gehäuse	single use
199802243	Integrierte Schaltung mit durch Energieeinwirkung auftrennbarelektrischen Verbindungsstellen	single use
199802244	Integrierte Schaltung mit einer Selbsttesteinrichtung	single use
199802246	Anordnung mit reduzierter elektrischer Feldstärke in einem Metall-Isolator-Verbund	single use
199802248	Verfahren zum Erfassen der Betriebstemperatur von Halbleiterbauelementen	dual use
199802251	Interface-Schaltung und Verfahren zur Übertragung von Daten zwischen einer seriellen Schnittstelle und einem Prozessor	dual use
199802253	Verfahren zum Messen der Temperatur eines Leistungshalbleiters und Bauelement	dual use
199802257	Programmgesteuerte Einheit und Verfahren zum Debuggen derselben	single use
199802258	Programmgesteuerte Einheit und Verfahren zum Debuggen derselben	single use
199802262	Verfahren zum wahlfreien Zugriff auf Bildblöcke in Videobildern	single use
199802288	Mikromechanischer Sensor	single use
199802289	Mikromechanischer Sensor und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199802296	Verfahren zur Leckstromprüfung einer Kontaktierungsstelle einer integrierten Schaltung	single use
199802297	Vorrichtung zur Diffusionslängenmessung in Halbleiterkörpern	single use
199802306	Integrierter Speicher mit Interblockredundanz	single use
199802310	Leistungsschaltkreis mit verminderter Störstrahlung	dual use
199802314	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199802318	Magnetoresistives Element und dessen Verwendung als Speicherelement in einer Speicherzellenanordnung.	single use
199802321	Kombinierte Vorlade- UND Homogenisierschaltung	single use
199802324	Verfahren zur Erzeugung strukturierter Materialschichten	single use
199802330	Integrierter Halbleiterchip mit Zuleitungen zu einem oder mehreren externen Anschlüssen	single use
199802333	Verfahren zur kapazitiven Bilderfassung	single use
199802343	STAGGERED BONDING & CUSTOM LEADFRAME TO REDUCE EXTERNAL POWERSUPPLY PINS & CHIP AREA	single use
199802348	Kantenemitter und Verfahren zur Herstellung desselben	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

GPC IC
Seite 135 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802353	Ausgangstreiberschaltung	single use
199802358	Treiberschaltung	single use
199802359	Dynamischer Speicher	single use
199802363	Halbleiterchip mit Oberflaechenabdeckung	single use
199802365	Halbleiterchip mit Oberflaechenabdeckung	single use
199802367	Schaltung und Verfahren zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Sprache und anderen Tönen in digitalen Mobilfunkgeräten	dual use
199802375	Echodaempfung in digitalen Uebertragungssystemen	dual use
199802377	Schaltnetzteil	single use
199802381	Verfahren zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen sowie Halbleiterwafer, der integrierte Schaltkreise aufweist	single use
199802383	Randsstruktur fuer Hochvolt-Halbleiterbauelemente	single use
199802388	Ansteuerschaltung fuer induktive Lasten	dual use
199802393	Gebuehrenimpuls-Filterschaltung fuer analoge Modems	single use
199802396	Schaltungsanordnung zum Erfassen des Laststromes eines durch Feldeffekt steuerbaren Leistungs-Halbleiterbauelementes	dual use
199802410	Mikromechanischer Sensor mit verschlossenen Membranoeffnungen	single use
199802411	Vor Umwelteinflüssen geschuetzter mikromechanischer Sensor	single use
199802412	Mikromechanische Struktur	single use
199802417	Verfahren zur Reparatur von defekten Speicherzellen eines integrierten Speichers	single use
199802425	Integrierter Halbleiterspeicher mit Steuerungseinrichtung zum taktsynchronen Schreiben und Lesen	single use
199802426	Verfahren zum Erwerb elektronischer Daten unter Verwendung eines Datentraegers und entsprechender Datentraeger	single use
199802436	Energieversorgungseinrichtung und Schaltungsanordnung mit dieser Energieversorgungseinrichtung	dual use
199802440	Mikromechanisches Bauelement und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199802441	Verfahren zur Herstellung von Transistoren	single use
199802444	Mikroelektronische Struktur, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung in einer Speicherzelle.	single use
199802457	Verfahren zum Betrieb einer integrierten Schaltung	single use
199802458	Verfahren und Vorrichtung zur Systemsimulation von Mikrocontrollern/Mikroprozessoren und zugehoerenden Peripheriemodulen	single use
199802462	Schaltungsanordnung zur Steuerung von Luminanzsignalamplituden	single use
199802463	Halbleiterbauelement	single use
199802464	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN EINES AMPLITUDENMODULIERTENTRAEGERSIGNALS	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 136 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802465	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN EINES AMPLITUDENMODULIERTENTRAEGERSIGNALS	single use
199802466	Integrierter Halbleiterspeicher	single use
199802467	Phasenregelkreis mit Verriegelungssignal fuer gerasteten Zustand	single use
199802470	Randstruktur fuer Halbleiterbauelement	single use
199802472	Randstruktur fuer Halbleiterbauelemente	single use
199802473	Siliziumcarbid-Junction-Feldeffekttransistor	single use
199802475	Verfahren zum Linken von in einen Arbeitsspeicher eines Prozessors nachgeladenen Programmmodulen auf einer Chipkarte	single use
199802476	Leistungshalbleiter-Bauelement mit einer Anordnung zum Schutz vor Schaeden durch elektrostatische Entladungen	single use
199802478	Digitaler PLL (Phase Locked Loop)-Frequenzsynthesizer	single use
199802480	Verfahren und Anordnung zur Ueberpruefung einer Stabilitaet eines Arbeitspunktes einer Schaltung	single use
199802482	Verfahren zur Herstellung einer dotierten Siliziumschicht und mikroelektronische Struktur mit einem leitfaehigen Element aus dotiertem Silizium.	single use
199802489	Hochspannungsfeste Randstruktur fuer Halbleiterbauelemente	single use
199802494	Verfahren zum Vereinigen von Halbleiter-Bauelemente	single use
199802495	Schaltungsanordnung zum Schutz einer Serienschaltung aus mindestens zwei Leuchtdioden vor dem Ausfall	dual use
199802497	Ansteuerschaltung zum Erzeugen eines konstanten Stromes durch zumindest eine Leuchtdiode	dual use
199802499	Ferroelektrischer Transistor, dessen Verwendung in einer Speicherzellenanordnung und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199802500	Magnetoresistives Element und dessen Verwendung als Speicherelement in einer Speicherzellenanordnung.	single use
199802501	Halbleiterbauelement fuer integrierte Schaltkreise sowie Verfahren zur Herstellung	single use
199802503	Differentielle Eingangsschaltung fuer ein digitales	single use
199802505	Verfahren zur Herstellung eines MOS-Transistors und nach diesem Verfahren hergestellter MOS-Transistor.	single use
199802516	Verfahren und Vorrichtung zur kapazitiven Bilderfassung	single use
199802518	Schichtanordnung mit einer Materialschicht und einer Diffusionsbarriere gegen diffundierende Materialkomponenten	single use
199802519	Halbleiterbauelement mit einer Polysiliziumverdrahtung und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199802523	Temperatursensor	dual use
199802528	Digitale Schaltung	single use
199802540	Leistungshalbleiterbauelement	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 137 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802546	Ladungspumpenschaltung	dual use
199802549	Gegen Verpolung geschuetzte Schaltungsanordnung zum Erfassen des Laststromes durch eine Last	dual use
199802551	Elektrische Schaltungsanordnung	single use
199802558	Schaltungsanordnung zur Anpassung des Ausgangssignals eines Ausgangstreibers an die gegebenen Verhaeltnisse	single use
199802559	Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements	single use
199802561	Schalttransistor mit reduzierten Schaltverlusten	single use
199802562	Digitale Filterstruktur	single use
199802566	Integrierter Schaltkreis mit zwei Betriebszuständen	single use
199802571	Verfahren zur Herstellung einer Stufe auf der Oberflaeche eines Substrats aus Halbleitermaterial, Anwendung des Verfahrens und Substrat mit einer Stufe	single use
199802581	Auf einem Stuetzgeruest angeordneter Kondensator in einer Halbleiteranordnung und Verstellverfahren	single use
199802583	Kondensator mit einem Hoch-e-Dielektrikum oder einem Ferroelektrikum nach dem Fin-Stack Prinzip und Herstellverfahren	single use
199802584	Schaltung zur Datensignalfueckgewinnung und Taktsignalregenerierung	single use
199802585	Kondensator mit einem Hoch-e-Dielektrikum oder einem Ferroelektrikum nach dem Fin-Stack Prinzip und Herstellverfahren unter Einsatz einer Negativform	single use
199802596	Herstellungsverfahren fuer einen Grabenkondensator mit einem Isolationskragen	single use
199802598	Elektrisch programmierbare, nichtfluechtige Speicherzellenanordnung	single use
199802599	Polierfluessigkeit zum Polieren von Bauelementen, vorzugsweise Wafern, insbesondere zum Chemisch-Mechanischen Polieren derartiger Bauelemente	single use
199802601	Verfahren zum Herstellen eines Dotierungsgebiets	single use
199802605	Integrierter Speicher	single use
199802607	Synchrone Schaltung	single use
199802610	Verfahren und Anordnung zum Uebertragen von digitalen Daten	dual use
199802612	Anordnung mit zumindest einem auf einem Substrat integrierten induktiven Element	single use
199802620	Verfahren zur Bildsignalverarbeitung	single use
199802622	Verfahren und Vorrichtung zum Testen von auf einem Halbleiterchip integrierten Kondensatoren	single use
199802624	Handhabungs- UND Montageschutz	single use
199802627	Integrierte Schaltung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 138 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802628	Halbleiterbauelement	single use
199802629	Burn-In-Testvorrichtung	single use
199802635	Halbleiterchip und Halbleiterbauelement mit einem solchen Halbleiterchip	single use
199802637	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Bild-in-Bild-Einblendung	single use
199802639	Integrierter Speicher mit Selbstreparaturfunktion	single use
199802641	Fuellstandsmesseinrichtung	single use
199802644	Verfahren zur Ermittlung der Treiberfaehigkeit einer Treiberschaltung einer integrierten Schaltung	single use
199802650	Verfahren zur Authentifikation zumindest eines Teilnehmers bei einem Datenaustausch	dual use
199802651	Halbleiterbauelement mit strukturiertem Halbleiterkoerper	single use
199802652	Grabenkondensator mit Isolationskragen und entsprechendes Herstellungsverfahren	single use
199802661	Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199802664	Vorrichtung und Verfahren zur Regelung des Abtasttaktes in einem Datenuebertragungssystem	dual use
199802669	Einrichtung zur loesbaren Montage eines elektronischen Bauteils	single use
199802673	Verbindungssystem	single use
199802675	Verfahren zum Einblenden von Nebenbildern in ein Hauptbild	dual use
199802677	Loesbare Verbindungsanordnung	single use
199802681	Befestigungselement fuer mechanisch beanspruchte Halbleiterstrukturen sowie Halbleiterbauelement	dual use
199802688	Kontrollstruktur zur Herstellung von Hohlräumen oder Unterätzungsbereichen in mikromechanischen und/oder mikroelektronischen Bauelementen, beschichteter Wafer und Verfahren zur Herstellung eines mikromechanischen und/oder...	single use
199802690	Digitaler Empfaenger fuer ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal	dual use
199802691	Speicherzellenanordnung und entsprechendes Herstellungsverfahren	single use
199802694	Schutzschaltung auf einer integrierten Schaltung	single use
199802697	Schaltungsanordnung zur Unterdrueckung von einem digitalen Signal ueberlagerten Stoerimpulsen	single use
199802699	Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauelements	single use
199802700	Oszillatorschaltung mit einem Schwingquarz	single use
199802704	Randstruktur fuer Halbleitervorrichtung	single use
199802705	Verfahren zur Erzeugung von auf einem Bildschirm darstellbaren Blinkzeichen	single use
199802706	Leistungshalbleiterdiode	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 139 von 186

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802707	Integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens einem MOS-Transistor und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199802708	Integrierte Gegentaktschaltungsanordnung	single use
199802709	Kapazitätslade- UND Entladeschaltung mit Ueberspannungsschutz	single use
199802710	Verfahren zur Erzeugung eines auf einem Bildschirm darstellbaren Bildes	single use
199802711	Verfahren zum Anzeigen von Videobildern	single use
199802712	Herstellverfahren fuer eine Halbleiterstruktur	single use
199802713	Herstellverfahren fuer eine Halbleiterstruktur	single use
199802716	Frequenzdetektionsverfahren zur Taktsignalfrequenz-Nachstellung und Frequenzdetektorschaltung zur Durchfuehrung des Verfahrens	single use
199802718	Konfigurierbarer Speicher fuer Prozessoren in Harvard-Architektur	single use
199802722	Schaltungsanordnung mit deaktivierbarem Scanpfad	single use
199802723	Integrierte Schaltung mit einer Kontaktierungsstelle zum Waehlener Betriebsart der integrierten Schaltung	single use
199802725	Integrierter Speicher	single use
199802727	Integrierter Speicher mit einem differentiellen Leseverstärker	single use
199802728	Verfahren zum Empfang und zur Darstellung von Fernsehsendungen mit Sendungsartkennzeichen	single use
199802729	Verfahren zur Bildgrössenänderung von Videobildern	dual use
199802730	Diagnosekonzept fuer einen intelligenten Halbleiter-Schalter	single use
199802731	Vorrichtung zur Transformation von Wertetupeln in andere Wertetupel entsprechend einer bestimmten Transformationsvorschrift	dual use
199802732	Verfahren zur Erzeugung eines pulswidenmodulierten Signals und Vorrichtung hierzu	single use
199802733	Verfahren zur Duplex-Datenuebertragung mit QAM und Demodulator zur Verwendung in diesem Verfahren	dual use
199802739	Verfahren zum Einbauen von Schutz-Bauelementen in aus Standardzellen aufgebauten integrierten Schaltungen	single use
199802743	Schaltungsanordnung zur Steuerung und Erfassung des Laststromes durch eine Last	dual use
199802746	Schaltungsanordnung und Verfahren zum Einstellen von Schaltelementen eines Entscheiders	single use
199802748	Mikromechanischer Sensor auf Basis des Feldeffekts und dessen Verwendung	single use
199802751	Programmgesteuerte Einheit	single use
199802752	Logikpegelkonverter	single use
199802753	Magnetoresistiver Speicher mit Komplementärzellen.	single use
199802754	Digitale Signalverarbeitungseinrichtung mit CORDIC-Prozessor	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 140 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802755	Verfahren zur Ausfuehrung einzelner Algorithmen mittels einer rekonfigurierbaren Schaltung und Vorrichtung zur Durchfuehrung eines solchen Verfahrens	single use
199802760	DECODERELEMENT ZUR ERZEUGUNG EINES AUSGANGSSIGNALS MIT DREIUNTERSCHIEDLICHEN POTENTIALEN UND BETRIEBSVERFAHREN FUER DASDECODERELEMENT	single use
199802761	Rueckwaertsleitender Gate Turn Off-Thyristor	single use
199802766	Magnetoresistiver Speicher mit niedriger Stromdichte.	single use
199802767	Decoderelement zur Erzeugung eines Ausgangssignals mit dreiunterschiedlichen Potentialen	single use
199802769	Verfahren und Vorrichtung zur belichtungsabhaengigen Rausch-Korrektur bei zeilen- UND spaltenadressierbaren Bildsensoren.	single use
199802770	Verfahren zur Justage eines optoelektronischen Bauelements sowie Bauelement	single use
199802773	Schaltungsanordnung zur Arbeitspunktstabilisierung eines Transistors	single use
199802777	Multistandard-Taktrueckgewinnungsschaltung	single use
199802779	Integrierte Schaltungsanordnung mit einer Konfigurations-Baugruppe	single use
199802780	Verfahren und Vorrichtung zur Auswahl und Speicherung von bevorzugten Teletextseitennummern	single use
199802784	Schaltungsanordnung zum Mischen eines Eingangssignals und eines Oszillatorsignals miteinander	single use
199802785	Halbleiterbauelement	single use
199802787	Integriertes Halbleiterbauelement	single use
199802790	Schneller Leseverstärker	single use
199802793	Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199802794	Verfahren zur Absicherung der DES-Verschlüsselung gegen Ausspähuung der Schlüssel durch Analyse der Stromaufnahme des Prozessors	dual use
199802796	Halbleiterchip	single use
199802799	Halbleiterschaltkreis mit integrierter Selbsttestschaltung	single use
199802802	Halbleiterbauelement sowie dieses umfassender Chipkartenmodul	single use
199802803	Vertikaler Feldeffekttransistor mit innenliegendem ringfoermigen Gate und Herstellverfahren	single use
199802804	Vertikaler Feldeffekttransistor mit innenliegendem Gate und Herstellverfahren	single use
199802805	Chipkartenmodul und Chipkarte	single use
199802806	Verfahren zum Konfigurieren einer integrierten Schaltungsanordnung und Schaltungsanordnung zur Durchfuehrung des Verfahrens	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 141 von 186

J:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802807	Substrat mit einer Vertiefung, das fuer eine integrierteSchaltungsanordnung geeignet ist, und Verfahren zu dessenHerstellung	single use
199802811	Integrierte Schaltung mit einer einstellbaren Verzoeigerungseinheit	single use
199802815	Halbleiterschaltkreis	single use
199802816	Dual-Port Speicherzelle	single use
199802817	Verfahren zur Ermittlung von CDM-Testdaten	single use
199802822	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199802825	Netzcomputer und Verfahren zu seinem Betrieb	dual use
199802826	Leistungsabschlussvorrichtung fuer eine Teilnehmeranschlussleitung	dual use
199802829	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199802834	Halbleiterchip und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199802836	Oszillatorschaltung mit einem Schwingquarz	single use
199802840	Schaltungsanordnung zur Erzeugung einer lastunabhaengigenGleichspannung	single use
199802842	Single-Port-Speicherzelle	single use
199802843	Schaltungsanordnung und Verfahren zum Authentifizieren des Inhaltseines Speicherbereichs	dual use
199802847	Frequenzteilerschaltung und Phasenregelkreis mit einer solchenFrequenzteilerschaltung	single use
199802851	Schaltung zur Erzeugung eines Ausgangssignals in Abhaengigkeit vonzwei Eingangssignalen	single use
199802856	Schaltungsanordnung zur Bild-in-Bild-Darstellung	single use
199802858	Testschaltung und Verfahren zum Pruefen einer digitalenHalbleiter-Schaltungsanordnung	single use
199802861	Schaltung zur Wandlung einer Bildrate	single use
199802863	Verfahren und Schaltungsanordnung zum Abgleichen desResonanzschwingkreises eines FM-Demodulators	single use
199802864	Layout fuer einen Halbleiterspeicher	single use
199802865	Vorrichtung zum galvanisch getrennten Verbinden einerTelefonleitung mit einer Signalverarbeitungseinrichtung amTeilnehmerende der Telefonleitung	dual use
199802866	Integrierte Schaltung mit einstellbaren Verzoeigerungseinheitenfuer Taktsignale	single use
199802870	Mikrooptischer Baustein und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199802874	Halbleiter-Bauelement mit hoher Leitfaehigkeit und hoherDurchbruchsspannung	single use
199802875	Nichtfluechtige EPROM-Speicherzelle mit baulich getrenntemProgrammierbereich und Lesebereich	single use
199802878	Verfahren zur Herstellung von Halbleiterchips	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 142 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802886	Optisches Modul	single use
199802887	Elektronisches Bauteil	single use
199802888	Verfahren zur Kontrolle des Zugriffs auf ein zugriffsbeschränktes System und entsprechendes zugriffsbeschränktes System	single use
199802890	Verfahren zur Unterdrückung des Rauschens in Signalen	dual use
199802891	Elektronische Schaltungsanordnung	single use
199802892	Verfahren zur Absicherung von Einsprungsadressen	single use
199802895	Verfahren zur Verbindung von Stackmanipulationsangriffen bei	single use
199802911	Vorrichtung zum Lagern und Kommissionieren von Gegenständen, insbesondere von scheibenartigen Gegenständen wie Wafern oder dergleichen	single use
199802912	A/D-Wandler	dual use
199802917	Halterung	single use
199802925	COPY PROTECTION SYSTEM AND METHOD	single use
199802927	Multibit-CMOS-High Frequency Differencer Digital-Analog-Converter for Recommunication Circuits	single use
199802928	Schaltungsanordnung zur elektronischen Erzeugung einer Nullimpedanz	dual use
199802930	Frequenzstabilisierte Sende-/Empfangsschaltungsanordnung	dual use
199802931	Halbleiterbauelement mit kleiner Durchlassspannung und hoher Sperrfähigkeit	single use
199802933	Anordnung zur Formung von Schaltflanken in einem Leitungsstromkreis	single use
199802934	Bipolares Hochvolt-Leistungselement	single use
199802939	Leistungshalbleiter und Herstellungsverfahren	single use
199802940	Verfahren zur Herstellung eines Leistungshalbleiters mit einer Stoppzone	single use
199802944	Speicherzellenanordnung und Implantationsmaske zum Herstellen von dieser	single use
199802955	Verfahren zur selbstjustierenden Abstimmung von Thyristoren mit Folgezuendung	single use
199802961	Verfahren zur Herstellung eines Kondensators	single use
199802968	Digitale Rechenschaltung	single use
199802980	Schreib-/Lesespeicher mit Selbsttestvorrichtung und zugehöriges Testverfahren.	single use
199802981	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SPEISEN EINER TELEFONTEILNEHMERSCHLEIFE MIT EINER SPEISESPANNUNG	dual use
199802984	Behandlungskammer	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 143 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199802985	Verfahren und Vorrichtung zur optischen Oberflaechenanalyse vonHalbleiterscheiben	single use
199802987	Verfahren zur Reduzierung des Crest-Faktors eines Signals	dual use
199803295	Strahlungsempfindliches Gemisch und dessen Verwendung	single use
199803318	Strahlungsempfindliches Gemisch und dessen Verwendung	single use
199804001	Optische Kopplungsanordnung	single use
199804004	Mehrkanaliges optisches Modul	single use
199804023	Bauelement mit einem Lichtsender und einem Lichtempfaenger	single use
199804026	Bauelement mit einem Lichtsender und einem Lichtempfaenger	single use
199804027	Bauelement mit einem Lichtsender und einem Lichtempfaenger	single use
199804054	Optische Koppelanordnung	single use
199804095	Baugruppe	single use
199804106	Kopplungseinrichtung	single use
199804133	Elektrooptische Baugruppe	single use
199804143	ELEKTROOPTISCHE KOPPELBAUGRUPPE	single use
199804144	Verfahren zum gleichzeitigen Herstellen mehrerer elektrooptischerBaugruppen	single use
199804146	Optische Sendeeinrichtung	single use
199804147	Kabelaufbau fuer Mehrfaser-Lichtwellenleiter	single use
199804148	Optische Sendeeinrichtung	single use
199804150	Verfahren zur Herstellung einer Halbleiter-Isolationsschicht undeines diese Halbleiter-Isolationsschicht enthaltendenHalbleiterbauelements	single use
199804175	Mehrkanalige optische Kopplungseinrichtung	single use
199804176	Optische Sendeeinrichtung	single use
199804207	Optisches Element	single use
199804235	Verbindungsanordnung	single use
199804704	Schaltungsanordnung zur ASK-Modulation	single use
199804705	Ferroelektrischer Transistor und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199804707	Schutzschaltung fuer eine integrierte Schaltung	single use
199804711	Verformungsmesser	single use
199804717	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DATENUEBERTRAGUNG UEBER EINBIDIREKTIONALES BUSSYSTEM MIT einer VIELZAHL VONLEITUNGEN	single use
199804721	Integrierte Schaltung mit geringen Schwellenspannungsunterschiedender Transistoren und zugehoeriges Herstellungsverfahren.	single use
199804725	Schaltungsanordnung zur Spannungseueberwachung und Erzeugung einesRuecksetzsignals	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 144 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199804730	Verfahren zum Herstellen einer strukturierten metalloxidhaltigen Schicht	single use
199804731	Verfahren zum Herstellen einer strukturierten metalloxidhaltigen Schicht	single use
199804734	Scanvorrichtung	single use
199804737	Verfahren zur Verminderung von Ablagerungen in einem CVD-Reaktor sowie ein zur Durchführung eines solchen Verfahrens geeigneter CVD-Reaktor	single use
199804739	Speicherzellenanordnung.	single use
199804744	Frequenzsynthesizer	single use
199804747	Method and apparatus of determining properties of a signal transmission channel	dual use
199804751	Integrierter Halbleiterchip mit ueber Bondpads voreingestellter Dateneingabe-/Datenausgabe-Organisationsform	single use
199804753	Halbleiterbauelement mit einer stueckweise im Substratverlaufenden Verdrahtung und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199804758	Halbleiterbaustein fuer Burn-In-Testanordnung	single use
199804759	Schutz einer digitalen Datenuebertragung ueber Kapazitaetenmittels: a.) gerechneter Checksumme b.) Mehrfachuebertragung von Bits zur linebreak detection c.) Definition einer Rahmenstruktur mittels Datenkodiertem Framesync	single use
199804760	Schaltungsanordnung mit temperaturabhaengiger Halbleiterbauelement-Test- UND Reparaturlogik	single use
199804763	Ferroelektrische Speicheranordnung	single use
199804766	Schaltung zur Erzeugung von digitalen periodischen Signalen	single use
199804774	Mikromechanisches Bauelement und Herstellungsverfahren	single use
199804779	Schleifvorrichtung	single use
199804780	Werkstueckhalter	single use
199804782	Kontaktnadeln	single use
199804783	Feldeffektgesteuerter Transistor und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199804789	Schaltungsanordnung zur Quantisierung digitaler Signale und Filterung des Quantisierungsrauschens	dual use
199804791	Waferfehlpriorisierungserkennung	single use
199804792	Magnetoresistives Element und dessen Verwendung als Speicherelement in einer Speicherzellenanordnung.	single use
199804793	Magnetischer Speicher	single use
199804794	Energieversorgungseinrichtung und Schaltungsanordnung mit dieser Energieversorgungseinrichtung	dual use
199804795	Schaltungsanordnung zum Erzeugen einer stabilisierten Versorgungsspannung fuer mehrere Verbraucher	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 145 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199804796	Verfahren und Mittel zum Waschen von Reinraumkleidung	single use
199805802	Verfahren zur Kompensation von Störungen bei einem mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugten Signal und Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens	dual use
199805804	Frequenzstabilisierte Sende-/Empfangsanordnung	dual use
199805814	Stabantenne aus elektrisch leitfähigem Kunststoff	single use
199805817	Warenetikett	single use
199805820	Halbleiterbauelement mit zumindest einem Kondensator sowie Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199805821	MOS-Feldeffekttransistor mit Hilfselektrode	single use
199805825	Verfahren und Schaltungsanordnung zum Erkennen eines Fehlers, insbesondere eines Kurzschlusses, im Lastkreis eines steuerbaren Leistungsschalters	dual use
199805836	Neue Komplexverbindung eines Elements der IV oder V Nebengruppe zur Bildung einer verbesserten Precursor-Kombination	single use
199805849	Vorrichtung zur Verringerung der elektromagnetischen Emission bei integrierten Schaltungen mit Treiberstufen.	single use
199805855	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199805859	Bauelement als Sensor und Herstellungsverfahren	single use
199805861	Steuerbares Halbleiterbauelement mit einem Gatevorwiderstand	single use
199805863	Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199805873	Multimaster-Bussystem und Verfahren zum Betreiben desselben	single use
199805874	Leistungshalbleiterschalter	single use
199805875	Verbindungsanordnung	single use
199805878	Verfahren zur Herstellung einer Metalloxidschicht bzw. einer strukturierten Metalloxidschicht	single use
199805879	Verfahren zum Strukturieren einer metallhaltigen Schicht	single use
199805880	Laterales Hochvolt-Halbleiterbauelement mit reduziertem spezifischem Einschaltwiderstand	single use
199805881	Montagevorrichtung zur Verarbeitung von in Transportbehältern angeordneten Bauteilen	single use
199805889	Doppelfähige optische Anschlussanordnung	single use
199805891	Verfahren zur Strukturierung einer Schicht und Halbleitersubstrat mit mindestens einer Struktur, die mit dem Verfahren herstellbar ist	single use
199805892	Verfahren zur Herstellung eines integrierten Schaltkreises	single use
199805893	Vorrichtung und Verfahren zur schnurlosen Übertragung von Telefongesprächen über mehrere, räumlich getrennte Basisstationen an Mobiltelefone im DECT-Standard	dual use
199805894	AUTHENTIFIKATION VON AUF SPEICHERMEDIEN GESPEICHERTEN DATEN	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 146 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199805900	Mikroelektronische Struktur	single use
199805901	FEMFET-Vorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199805902	Analog-Digital-Umsetzer	single use
199805919	Leistungshalbleiterbauelement	single use
199805920	VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM TESTEN VON SENSOREN UND VERWENDUNG EINES SENSORS	single use
199805928	Verfahren zur Aenderung des Ablaufs eines in einem Festwertspeicher abgelegten Programms	single use
199805933	Integrierte Schaltung mit kapazitiven Elementen	single use
199805950	Mikroelektronische Struktur sowie Verfahren zu deren Herstellung	single use
199805952	Schaltungsanordnung zur elektronischen Erzeugung einer Rufimpedanz	dual use
199805956	Feldeffekt-Transistoranordnung mit einer grabenfoermigen Gate-Elektrode und einer zusaetzlichen hochdotierten Schicht im Bodygebiet	single use
199805962	Leistungshalbleiterbauelement	single use
199805963	SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS EINEM	single use
199805967	Programmgesteuerte Einheit	single use
199805969	Vorrichtung zur Spannungsvervielfachung mit hohem Wirkungsgrad.	single use
199805976	Integrierte Schaltung mit einem Decoderelement	single use
199805977	Integrierter Speicher mit Redundanz	single use
199805978	Integrierter Speicher mit Redundanz	single use
199805979	Chipkarte als vorzugsweise gesicherter Quittungsbeleg.	single use
199805981	Digitaler Phasen-Frequenz-Detektor	single use
199805990	Verfahren zum Strukturieren eines Substrats	single use
199805991	Herstellverfahren fuer einen Kondensator in einer integrierten Speicherschaltung	single use
199805998	Mikroelektronische Struktur	single use
199806001	Vertikal integrierte Halbleiteranordnung	single use
199806002	Vertikal integrierte Halbleiteranordnung	single use
199806003	Vertikal integrierte Halbleiteranordnung	single use
199806004	KOMMUNIKATIONSSYSTEME MIT ERWEITERTEM FUNKRUFDIENST-ENDGERAET UND ERWEITERTEM TELEFONENDGERAET UND EINE VERWENDUNG DES ERWEITERTEN FUNKRUFDIENST-ENDGERAETES.	dual use
199806005	Verfahren zur Uebertragung von Signalen in einem Kommunikationsgeraet	dual use
199806009	Vertikal integrierte Halbleiteranordnung	single use
199806010	Vertikal integrierte Halbleiteranordnung	single use
199806013	Halbleiteranordnung mit vertikaler Systemintegration	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

OPC IC
Seite 147 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199806017	Schaltungsanordnung fuer ein Mehrstandard-Kommunikationsendgeraet	dual use
199807409	IMPROVED POLICIDE	single use
199807414	DUMMY PATTERNS FOR ALUMINIUM CHEMICAL POLISHING (CMP)	single use
199807415	FABRICATION OF TRENCH CAPACITORS USING DISPOSABLE HARD MASK	single use
199807416	LOW TEMPERATURE REFLOW DIELECTRIC-FLUORINATED BPSG	single use
199807417	HIGH SELECTIVITY OXIDE ETCH PROCESSES	single use
199807422	HIGH SELECTIVITY OXIDE ETCH PROCESSES	single use
199807429	Self-Aligned Channel Implantation	single use
199807430	IMPROVED TECHNIQUES FOR FORMING TRENCH CAPACITORS in AN INTEGRATEDCIRCUIT	single use
199807433	METHOD AND APPARATUS FOR EVALUATING INTERNAL FILM STRESS AT HIGHLATERAL RESOLUTION	single use
199807434	MEMORY CELL STRUCTURE AND FABRICATION	single use
199807435	IMPROVED DYNAMIC ACCESS MEMORY DELAY CIRCUITS AND METHODSTHEREFOR	single use
199807437	REPARABLE SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT MEMORY BY SELECTIVEASSIGNMENT OF GROUPS OF REDUNDANCY ELEMENTS TO DOMAINS	single use
199807438	IMPROVED METHODS AND APPARATUS FOR CHEMICAL MECHANICALPLANARIZATIONS (CMP) OF A SEMICONDUCTOR WAFER	single use
199807439	SIGNALING IMPROVEMENT USING EXTENDED TRANSMISSION ON HIGH SPEEDDIMMS	single use
199807440	FEEDBACK PULSE GENERATORS	single use
199807442	SELF-ALIGNED BURIED PLATE	single use
199807443	REDUCED VOLTAGE INPUT/REDUCED VOLTAGE OUTPUT TRI-STATEBUFFERS AND METHODS THEREFOR	single use
199807444	GUARD CELL FOR ETCHING	single use
199807445	DEVICE STRUCTURE WITH LAYER FOR FACILITATING PASSIVATION	single use
199807451	REDUCTION OF BLACK SILICON in SEMICONDUCTOR FABRICATION	single use
199807468	SEMICONDUCTOR DEVICE WITH VERTICAL TRANSISTOR AND BURIEDWORD LINE	single use
199807471	METHOD FOR THE MEASUREMENT OF DOPANT CONCENTRATIONSIN THE DRIFT REGION OF CERTAIN SEMICONDUCTOR DEVICES	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 148 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199807472	METHOD FOR MEASUREMENT OF MINORITY CARRIER DIFFUSION LENGTH AND MINORITY CARRIER LIFETIME in SEMICONDUCTOR DEVICES	single use
199807473	ARRANGEMENT FOR CONTROLLING VOLTAGE GENERATORS in MULTI-VOLTAGE-GENERATOR CHIPS SUCH AS DRAMS	single use
199807474	METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING MEASUREMENT ERROR FOR	single use
199807475	IMPROVED CONTROLLABILITY OF A BURIED DEVICE LAYER	single use
199807476	IMPROVED DEVICE INTERCONNECTION	single use
199807477	METHOD AND APPARATUS HAVING IMPROVED CONTROL OF A BURIED STRAP in TRENCH CAPACITORS	single use
199807482	IMPROVED DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY CIRCUIT AND METHODS THEREFOR	single use
199807487	NON-DESTRUCTIVE METHOD AND DEVICE FOR MEASURING THE DEPTH OF A BURIED INTERFACE	single use
199807491	A TRENCH CAPACITOR WITH ISOLATION COLLAR	single use
199807492	TRENCH CAPACITOR WITH EPI BURIED LAYER	single use
199807498	Optical Sensor For Detecting An Obstruction	single use
199807501	REMOVAL OF POST-RIE POLYMER ON AL/CU METAL LINE	single use
199807503	PERIPHERAL DEVICE WITH ACCESS CONTROL	single use
199807507	APPARATUS WITH CONTEXT SWITCHING CAPABILITY	single use
199807508	METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING SHIFT OPERATIONS ON PACKED DATA	single use
199807520	STACK CAPACITOR WITH IMPROVED PLUG CONDUCTIVITY	single use
199807537	HIGH THROUGHPUT AL-CU THIN FILM SPUTTERING PROCESS ON SMALL CONTACT VIA FOR MANUFACTURABLE BEOL WIRING	single use
199807539	DEEP TRENCH CAPACITOR	single use
199807540	SEMICONDUCTORS HAVING DEFECT DENUDEZONES	single use
199807541	INTEGRATED CIRCUIT WITH IMPROVED OFF CHIP DRIVERS	single use
199807542	CLOCK LATENCY COMPENSATION CIRCUIT FOR DDR TIMING	single use
199807543	MULTIMEDIA AUTOMATIC CALL DISTRIBUTION SYSTEM	single use
199807544	PULL UP/PULL DOWN LOGIC FOR HOLDING A DEFINED VALUE DURING POWER DOWN MODE	single use
199807546	VERTICAL DEVICE FORMED ADJACENT TO A WORLDLINE SIDEWALL AND METHOD FOR SEMICONDUCTOR CHIPS	single use
199807549	ULTRA COMPACT DRAM CELL AND METHOD OF MAKING	single use
199807552	HIGH DENSITY PLASMA CVD PROCESS FOR MAKING DIELECTRIC ANTI-REFLECTIVE COATINGS	single use
199807553	MEMORY WITH REDUCED WIRE CONNECTIONS	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 149 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199807554	OVERLAY MEASUREMENT TECHNIQUE USING MOIRE PATTERNS	single use
199807555	SEMICONDUCTOR DEVICES	single use
199807557	PHASE SHIFT MASK AND METHODS OF MANUFACTURE	single use
199807558	SEMICONDUCTOR METALIZATION SYSTEM AND METHOD	single use
199807565	SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD	single use
199807566	LOCK ARRANGEMENT FOR A CALABRATED DDL in DDR SDRAM APPLICATIONS	single use
199807568	SEMICONDUCTOR FUSE	single use
199807570	SELF-ALIGNED FORMATION AND METHOD FOR SEMICONDUCTORS	single use
199807573	AN IMPROVED SAC PROCESS FLOW METHOD USING AN ISOLATION SPACER	single use
199807574	SYSTEM AND METHOD FOR OPTICALLY MEASURING DIELECTRIC THICKNESS IN SEMICONDUCTOR DEVICES	single use
199807575	LOW LEAKAGE LOW CAPACITANCE ISOLATION MATERIAL	single use
199807578	AN INTERLEAVED SENSE AMPLIFIER WITH A SINGLE-SIDED PRECHARGED DEVICE	single use
199807579	TRENCH CAPACITOR	single use
199807580	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING METHOD	single use
199807584	SEMICONDUCTOR STRUCTURE INCLUDING A CONDUCTIVE FUSE AND PROCESS FOR FABRICATION THEREOF	single use
199807586	LOW-RESISTANCE SALICIDE FILL FOR TRENCH CAPACITORS	single use
199807587	DEEP TRENCH-BASED DRAM AND METHOD OF FABRICATING	single use
199807588	A CVD/PVD METHOD OF FILING STRUCTURES USING DISCONTINUOUS CVD A1 LINER	single use
199807596	METHOD FOR PERFORMING INTER-FREQUENCY SEARCH in THE CDMA SYSTEM	single use
199807600	TEST VECTOR VERIFICATION SYSTEM	single use
199807607	PREVENTION OF PHOTORESIST POISONING FROM DIELECTRIC ANTI REFLECTIVE COATING in SEMICONDUCTOR FABRICATION	single use
199807608	SILICON OXYNITRIDE CAP FOR FLUORINATED SILICATE GLASS FILM IN INTERMETAL DIELECTRIC SEMICONDUCTOR FABRICATION	single use
199807610	PERIPHERAL CONTROL PROCESSOR	single use
199807612	MEMORY ACTIVATION DEVICES AND METHODS	single use
199807618	TAPERED ELECTRODE FOR STACKED CAPACITOR	single use
199807620	PRECISE OVERLAY CONTROL IN SCAN-TYPE EXPOSURE SYSTEMS	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC

Seite 150 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199807621	APPARATUS AND METHOD FOR FORMING CONTROLLED DEEP TRENCHTOP ISOLATION LAYERS	single use
199807622	A SYSTEM AND METHOD FOR A PREAMPLIFIER WRITE CIRCUIT WITH REDUCED RISE/FALL TIME	single use
199807626	SEMICONDUCTOR STRUCTURES AND MANUFACTURING METHODS	single use
199807628	METHODS TO CONTROL THE THRESHOLD VOLTAGE OF A DEEP TRENCH CORNER DEVICE	single use
199807629	TIMING OF WORDLINE ACTIVATION FOR DC BURN-IN OF A DRAM WITH THE SELF REFRESH	single use
199807632	DRAM CAPACITOR STRAP	single use
199807633	MICROCONTROLLER WITH FLEXIBLE INTERFACE TO EXTERNAL DEVICES	single use
199807634	LOGIC TO ENABLE/DISABLE A CLOCK GENERATOR IN A SECURE WAY	single use
199807636	ELECTRICAL FUSES WITH TIGHT PITCHES AND METHOD OF FABRICATION IN SEMICONDUCTORS	single use
199807641	DATA PROCESSING UNIT FOR EXECUTING INSTRUCTIONS OF DIFFERENT LENGTH	single use
199807852	COMBINED PREANNEAL/OXIDATION STEP USING RAPID THERMAL PROCESSING	single use
199807859	METALLIZATION ETCHING TECHNIQUES FOR REDUCING POST-ETCH CORROSION OF METAL LINES	single use
199807862	COMPOSITION AND METHOD FOR REDUCING DISHING IN PATTERNED METAL DURING CMP PROCESS	single use
199807863	METHOD AND SYSTEM FOR RELIABLY INDICATING TEST RESULTS DURING A SELF-CHECK OPERATION	single use
199807864	WORDLINE DRIVER CIRCUIT USING RING-SHAPED DEVICES	single use
199807870	EMULATION PACKAGE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	single use
199807872	6 1/4 F2 DRAM-CELL STRUCTURE WITH FOUR NODES PER BITLINE-STRAND AND TWO TOPOLOGICAL WORDLINE LEVELS	single use
199807873	STACKED CAPACITOR MEMORY CELL AND METHOD OF FABRICATION	single use
199807874	DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY LAYOUT	single use
199807875	METHOD OF ENHANCING SEMICONDUCTOR WAFER RELEASE	single use
199807877	A MEMORY CELL WITH A STACKED CAPACITOR	single use
199807878	MEMORY CELL WITH TRENCH CAPACITOR	single use
199807882	SYSTEM AND METHOD FOR LOW POWER START-UP CIRCUIT FOR BANDGAP VOLTAGE REFERENCE	single use
199807897	PIPELINED ARBITRATION SYSTEM AND METHOD	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 151 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte**



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199807900	INTEGRATED CHIP DUMMY TRENCH PATTERNS TO EASE TRENCH ETCHPROCESS DEVELOPMENT	single use
199807901	Improved-Reliability Damascene Interconnects And Process Of Manufacture	single use
199807902	METHOD FOR OPTIMIZING THE CONTROL OF METAL CMP PROCESSES	single use
199807903	INTEGRATION SCHEME ENHANCING DEEP TRENCH CAPACITANCE INSEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICES	single use
199807907	PROGRAMMABLE JTAG NETWORK ARCHITECTURE TO SUPPORT PROPRIETARYDEBUG PROTOCOL	single use
199807911	METHOD FOR FABRICATING TRANSISTORS	single use
199807914	DYNAMIC DATA PREFETCHING BASED ON PROGRAM COUNTER AND ADDRESSINGMODE	single use
199807915	FUSE LAYOUT FOR IMPROVED FUSE BLOW PROCESS WINDOW	single use
199807919	DATA PROCESSING UNIT WITH COPROCESSOR INTERFACE	single use
199807921	DATA PROCESSING DEVICE WITH MEMORY COUPLING UNIT	single use
199807924	IN-SITU MEASUREMENT METHOD AND APPARATUS FOR SEMICONDUCTORPROCESSING	single use
199807928	Rutile Dielectric Material For Semiconductor Devices	single use
199807929	DRAM WITH STACKED CAPACITOR AND BURIED WORLD LINE	single use
199807936	IMPROVED DELAY LOCK LOOP	single use
199807938	INTEGRATED CHANNEL INDIVIDUAL A TO MU AND MU TO A LAW CONVERSIONIN DIGITAL ECHO CHANNELING	single use
199807942	FORWARD LINK INTER-GENERATION SOFT HANDOFF BETWEEN 2GAND 3G CDMA SYSTEMS	single use
199807948	MEASUREMENT SYSTEM AND METHOD FOR MEASURING CRITICAL DIMENSIONSUSING ELLIPSOMETRY	single use
199807949	The Effects Of Cleanliness Of The Titanium Under And Over Layers On The Reliability And Functionality Of Aluminum Interconnects	single use
199807952	Slotted Damascene Lines as Low Resistive Wiring Lines for Integrated Circuit	single use
199807955	METHOD AND APPARATUS FOR PREVENTING FORMATION OF BLACK SILICONON EDGES OF WAFERS	single use
199807956	DISTRIBUTED BLOCK REDUNDANCY FOR MEMORY DEVICES	single use
199807957	EXTENDED TRENCH FOR PREVENTING INTERACTION BETWEEN COMPONENTSO F STACKED CAPACITORS	single use
199807966	METHODS FOR ENHANCING THE METAL REMOVAL RATE DURING THECHEMICAL-MECHANICAL POLISHING PROCESS OF A SEMICONDUCTOR	single use
199807967	Adjustable Strength Driver Circuit And Method Of Adjustment	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 152 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199807970	Reduced Diffusion Of A Mobile Specie From A Metal Oxide Ceramic Into The Substrate	single use
199807978	METHOD AND APPARATUS FOR PARALLEL REDUNDANCY IN SEMICONDUCTOR MEMORIES	single use
199807979	METHOD FOR FORMING THE GATE OXIDE OF METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR DEVICES	single use
199807981	Semiconductor Device And Manufacturing Method	single use
199807982	Improved CD Control	single use
199807983	Interconnects With Increased Electromigration Lifetime	single use
199807984	DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY	single use
199807985	Ultra-thin Silicon Nitride/Oxynitride Diffusion Barriers For Controlled Dopant Outdiffusion	single use
199807986	Deep DIVOT Mask For Enhanced Buried-Channel PFET Performance And Reliability	single use
199808001	Verfahren zum Synchronisieren einer elektronischen Einrichtung zur Funktionsueberwachung eines Mikroprozessors sowie elektronische Einrichtung zur Durchfuehrung des Verfahrens	single use
199808003	Verfahren und Vorrichtung zur Konvertierung von Bilddatenbloecken in Bildzeilen.	dual use
199808006	Verfahren zur Verbesserung der akustischen Rueckhoerdaempfung in Freisprecheinrichtungen	dual use
199808007	Flaechiger Traeger mit einer Anzeigeeinrichtung	single use
199808011	An apparatus for and a method of executing instructions of a program	single use
199808017	Datentraeger zum kontaktlosen Empfangen von amplitudenmodulierten Signalen	single use
199808026	Halbleiterbauelement und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199808029	Verfahren zur Herstellung einer mit Fluor belegten Halbleiteroberflaeche	single use
199808033	Verfahren zur Abscheidung eines Metalls auf eine Oberflaeche eines Substrats	single use
199808034	RECOVERY OF FORMING GAS ANNEALED FERROELECTRICS BY LOW TEMPERATURE ANNEALING in AN INERT GAS	single use
199808035	Anordnung zur optischen Isolation mehrerer Lichtwellenleiter	single use
199808041	SOI-Halbleiteranordnung und Verfahren zur Herstellung derselben	single use
199808044	Verfahren und Vorrichtung zum nasschemischen Aetzen bzw. Reinigen von Halbleiterwaefe	single use
199808050	Lateraler IGBT in SOI-Bauweise und Verfahren zur Herstellung	single use
199808051	Statischer Frequenzteiler mit umschaltbarem Teilverhaeltnis.	dual use
199808059	Akquisitionsverfahren und Anordnung zur Durchfuehrung des Verfahrens	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 153 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199808060	Akquisitionsverfahren und Vorrichtung zur Durchfuehrung des Verfahrens	dual use
199808061	Speicheranordnung aus einer Vielzahl von resisitivenferroelektrischen Speicherzellen	single use
199808062	Resistive ferroelektrische Speicherzelle	single use
199808063	Speicheranordnung aus einer Vielzahl von resistivenferroelektrischen Speicherzellen	single use
199808064	Integrierte elektronische Schaltung und Verfahren zum Versehen einer integrierten elektronischen Schaltung mit Anschluessen	single use
199808065	Leiterbahnrahmen, Platine mit Leiterbahnrahmen und Verfahren zur Herstellung eines Leiterbahnrahmens	dual use
199808066	Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199808068	RECOVERY OF FORMING GAS ANNEALED FERROELECTRICS BY ELECTRICAL	single use
199808069	Bauelement mit wenigstens einer integrierten elektronischen Schaltung und Verfahren zur Herstellung des Bauelementes	dual use
199808071	Verfahren zur Herstellung einer Quantenpunktverteilung auf Halbleitermaterial sowie Halbleiterkoeper und Quantenpunkt laser mit einer solchen Verteilung	single use
199808082	ABZUGSVORRICHTUNG	single use
199808083	Scaled Impedance Replica For Echo Attenuation In Digital Transmission Systems	single use
199808087	Speichersystem	single use
199808091	Tracking-Verfahren und Anordnung zur Durchfuehrung des Verfahrens	dual use
199808094	Verfahren zur Entzerrung eines Farbfernsehsignals	single use
199808096	Elektronische Schaltungsanordnung	single use
199808098	Halbleiter-Schaltungsanordnung	single use
199808100	Halbleiterbauelement mit gitterfehlangepassten Halbleitermaterialien	single use
199808104	Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls sowie in diesem Verfahren einsetzbare Komponenten	single use
199808105	Verfahren und Anordnung zur Minimierung des Autokorrelationsfehlers bei der Demodulation eines Spreizspektrum-Signals unter Mehrwegeausbreitung	dual use
199808107	Konfigurierbarer Hardware-Block	single use
199808109	Verfahren zum Konfigurieren eines konfigurierbaren Hardware-Blocks	single use
199808110	Programmgesteuerte Einheit	single use
199808111	Schaltungsanordnung zur Generierung einer Referenzspannung fuer das Auslesen eines ferroelektrischen Speichers	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 154 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199808116	Verfahren und Vorrichtung zur Korrektur defekter Bildpunkte eines Bildsensors.	dual use
199808117	Halbleiterbauelement	single use
199808119	Oberflächenemittierende Diodenstrahlungsquelle	single use
199808120	Verfahren zum Herstellen eines thermoelektrischen Wandlers	single use
199808122	BEFEHLSTRANSFORMATOR FÜR PROZESSOREN	single use
199808166	Verfahren zur ASK-Demodulation und ASK-Demodulator	single use
199808611	Schutzschicht für die Mikrostrukturechnik und deren Herstellung	single use
199901002	Verfahren und Vorrichtung zur Formgebung von Halbleiteroberflächen	single use
199901003	Halbleiterchip und Verfahren zur Herstellung	single use
199901005	Signalverarbeitungseinheit für digitales TV-System	single use
199901008	Halbleiteranordnung mit Gräben zur Trennung von dotierten Gebieten	single use
199901012	Bauelement und Verfahren zur Herstellung eines Bauelementes	dual use
199901013	Verfahren zum Herstellen einer integrierten elektronischen Schaltung und integrierte elektronische Schaltung	single use
199901015	Transportvorrichtung	single use
199901016	Elektrisch programmierbare Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199901029	Leistungs-MOSFET	single use
199901030	Integrierter Speicher	single use
199901032	Halbleiter-Speicher vom wahlfreien Zugriffstyp	single use
199901033	Schichtlager	single use
199901034	Vertikalresonator-Laserdiode mit optimierter aktiver Fläche	single use
199901037	Area Polishing	single use
199901039	Microelectronic Structure	single use
199901040	Fördersystem	single use
199901043	Schreib-/Lesearchitektur für MRAM.	single use
199901045	Verfahren zum Strukturieren einer Schicht	single use
199901046	Verfahren und Anordnung zur Verifikation eines Layouts einer integrierten Schaltung mit Hilfe eines Rechners sowie dessen Anwendung zur Herstellung einer integrierten Schaltung.	single use
199901049	Verfahren zur Reparatur von defekten Speicherzellen eines integrierten Halbleiterspeichers	single use
199901050	Teilnehmerseitiger Leitungsabschlussbaustein eines ISDN-Kommunikationssystems mit erweiterten Leistungsmerkmalen	dual use
199901055	Halbleiterbauelement und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199901056	Integrierbare Schaltung zur automatischen Verstärkungsregelung (AGC - Automatic Gain Control)	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

OPC IC
Seite 155 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199901057	Schaltungsanordnung zur Signalisierung in Telekommunikationsnetzen	single use
199901058	Integrierte Halbleiterschaltung und Verfahren zur Funktionsueberpruefung von Pad-Zellen	single use
199901060	Leistungshalbleiter-Modul mit integrierter Fluessigkeitskuehlung	single use
199901061	Schaltungsanordnung zum Bilden des Abschlusses einer analogen Teilnehmerleitung	dual use
199901063	Randabschluss fuer ein Halbleiterbauelement, Schottky-Diode mit einem Randabschluss und Verfahren zur Herstellung einer Schottky-Diode	single use
199901065	Elektronisches Bauelement und Verwendung einer darin enthaltenen Schutzstruktur	single use
199901073	Verfahren und Vorrichtung zur Decodierung von Faltungscodes	dual use
199901076	Oszillatorschaltung mit einem Schwingquarz	single use
199901077	Elektronischer Phasenregelkreis (PLL)	single use
199901089	Halbleiterbauelement mit Chip-on-Chip-Aufbau	single use
199901094	Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung elektrischer Impulse	single use
199901097	Leistungs transistoranordnung mit hoher Spannungsfestigkeit	single use
199901101	Verfahren zur Verbesserung der Erkennbarkeit von Alignmentmarken	single use
199901103	Integrierter Speicher und entsprechendes Betriebsverfahren	single use
199901104	Integrierter Speicher	single use
199901107	Integrierter Speicher mit segmentierter Wortleitung	single use
199901108	Verfahren zur Verbesserung der Qualitaet von Metallleitbahnen auf Halbleiterstrukturen	single use
199901111	Verfahren zur Herstellung von Strukturen auf der Oberflaeche eines Halbleiterwafers	single use
199901112	Vorrichtung und Verfahren zur nachtraeglichen Erzeugung einer niederohmigen Verbindung in einem Halbleiterbauelement sowie ein Verfahren zur Herstellung dieser Vorrichtung.	single use
199901119	Kontaktloses Datenuebertragungssystem und Verfahren zur kontaktlosen Datenuebertragung	dual use
199901121	Integrierte Schaltung	single use
199901124	Verfahren zur kontaktlosen Datenuebertragung und Transponder fuer ein kontaktloses Datenuebertragungssystem	dual use
199901125	Herstellverfahren fuer einen Isolationsgraben unter Verwendung einer Hilfsschicht	single use
199901128	Halbleitervorrichtung mit Mehrfachdielektrikum	single use
199901131	Ferroelektrischer Halbleiterspeicher vom wahlfreien Zugriffstyp (FRAM) und Verfahren zum Auslesen	single use
199901139	Integrierter Speicher mit globalen Datenleitungen	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 156 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199901141	Mikroelektronische Struktur	single use
199901142	IGBT mit verbesserter Durchlassspannung	single use
199901144	Spannungsregler	single use
199901147	Verfahren und Schaltung zur Kompensationssteuerung von Offsetspannungen einer in einem Schaltungsbaustein integrierten Funkempfangsschaltung	dual use
199901148	Verfahren und Schaltung zur Kompensationssteuerung von Offsetspannungen einer in einem Schaltungsbaustein integrierten Funkempfangsschaltung	dual use
199901152	Verfahren zur Funktionsueberpruefung von Speicherzellen eines integrierten Halbleiterspeichers	single use
199901153	Temperaturgeschuetzter Halbleiterschalter	dual use
199901156	Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schaltungsanordnung	single use
199901168	Komparatorschaltung	single use
199901169	Verfahren und Vorrichtung zur gemeinsamen Darstellung wenigstens einer ersten und zweiten Bildfolge in einem Gesamtbild	single use
199901170	Halbleiterbauelement mit einem Chiptraeger mit Oeffnungen zur Kontaktierung	single use
199901177	Mikroprozessor und Verfahren zur Adressierung in einem Mikroprozessor	single use
199901178	Sprachsteuerungssystem	single use
199901190	Elektrische Teststruktur auf einem Halbleitersubstrat und Testverfahren	single use
199901191	Verfahren zur Detektion von Pilottonen	dual use
199901192	Halbleiterstruktur mit einer Leitbahn	single use
199901208	Halbleiterspeicher mit Speicherbaenenken	single use
199901209	IGBT mit PN-Isolation	single use
199901214	Erweiterte Tendenzsteuerung als Bestandteil einer digitalen Adaptionenrueckkopplung in PCM Equalizerstrukturen zur Stoerunterdrueckung niederfrequentmodullierter Stoereinfluesse auf dem Eingangssignal.	dual use
199901216	Nichtlineare Echokompensation bei DMT-Systemen	dual use
199901218	Verfahren und Einrichtung zur Entzerrung und Decodierung eines Datensignals	dual use
199901219	Verfahren zur Entfernung von Material von einer Oberflaeche	single use
199901221	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Nachsynchronisation eines Taktsignals	dual use
199901223	Verfahren und Vorrichtung zum Berechnen einer diskreten orthogonalen Transformation wie FFT oder IFFT	dual use
199901235	Integrierte Halbleiterspeicheranordnung mit Selbstpufferung von Versorgungsspannungen	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 157 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199901238	Decoder-Anschlussanordnung fuer Speicherchips mit langen Bitleitungen	single use
199901239	Verfahren zum Herstellen einer DRAM-Zelle mit einem Grabenkondensator	single use
199901241	Verfahren zur wahlweisen Nutzung einer in einem hochintegrierten Sender/Empfänger (Transceiver)-Schaltungsbaustein intern vorhandenen oder einer externen HF-PLL-Schaltung	dual use
199901242	Verzögerungsschaltung	dual use
199901245	Integrierte Halbleiterschaltungsanordnung mit stabilisierten Leiterbahnen	single use
199901246	Verfahren zum Herstellen einer integrierten elektronischen Schaltung und integrierte elektronische Schaltung	single use
199901248	Verfahren zum Betrieb einer Speicherzellenanordnung mit selbstverstärkenden dynamischen Speicherzellen.	single use
199901251	Verfahren zum Einstellen der Durchbruchspannung eines Thyristors	single use
199901254	Verfahren und Einrichtung zur Buchstabiererkennung	dual use
199901256	Treiberschaltung	dual use
199901261	Schaltungsanordnung zur einstellbaren Verzögerung eines digitalen Signals	dual use
199901262	Miniaturisierter Kondensator mit Festkörpordielektrikum, insbesondere fuer integrierte Halbleiterspeicher, zum Beispiel DRAMs und Verfahren der Herstellung eines solchen.	single use
199901267	Schaltung zur gemeinsamen Uebertragung von Sprache und Daten ueber eine Telefonleitung	dual use
199901268	Halbleiterspeicheranordnung mit Dummy-Bauelementen auf durchgezogenen Diffusionsgebieten	single use
199901269	Leseverstärkeranordnung mit verschmolzenen Diffusionsgebieten und verteilttem Treibersystem	single use
199901270	Verfahren zum Herstellen eines integrierten elektronischen Bauelementes und integriertes elektronisches Bauelement	single use
199901271	Verfahren zur Herstellung eines integrierten Schaltkreises	single use
199901273	MIKROCOMPUTER	dual use
199901279	Halbleiterspeicheranordnung mit Bitleitungs-Twist	single use
199901283	Integrierter Speicher	single use
199901295	Nichtlineare Echokompensation bei DMT-Systemen	dual use
199901315	Vertikalresonator-Laserdiode mit einer lichtabsorbierenden Schicht	single use
199901316	Vertikalresonator-Laserdiode mit kleiner Aperturoeffnung	single use
199901318	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 158 von 186

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199901319	Verfahren zur Montage eines Halbleiterchips auf einer Tragschicht sowie Vorrichtung zur Durchfuehrung des Verfahrens	dual use
199901320	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199901321	Verfahren zur Kompensation von Störungen bei einem mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugten Signal und Schaltungsanordnung zur Durchfuehrung des Verfahrens	dual use
199901325	Anordnung und Verfahren zum Ermitteln, ob der Zaehlstand eines Zaehlers einen vorbestimmten Zaehlstand erreicht hat oder nicht	dual use
199901327	Verfahren zur Herstellung einer MOS-Transistorstruktur mit erhoelter Bodyleitfaehigkeit	single use
199901329	Analog-Digital-Wandler	dual use
199901330	Verfahren zur Verbesserung thermischer Prozessschritte	single use
199901335	Symmetrischer Thyristor mit verringelter Dicke und Herstellungsverfahren dafuer	dual use
199901336	Leistungshalbleitermodul	single use
199901338	Stromgesteuerte Schaltstufe fuer Digitalschaltungen	dual use
199901346	Verfahren zur Herstellung eines Bodygebietes fuer eine vertikale MOS-Transistoranordnung mit verringertem spezifischem Einschaltwiderstand	single use
199901347	Mikroelektronische Struktur	single use
199901352	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Bild-in-Bild-Einblendung	dual use
199901356	Ladungspumpenschaltung (Charge Pump) in einer elektrischen Phasenregelschleife (PLL)	single use
199901357	Integrierte Schaltung zur Erzeugung zweier Ausgangstakte mit zeitlich nicht ueberlappenden Pegeln	single use
199901358	Verfahren zur Bildeinblendung	dual use
199901359	Ladungspumpenschaltung (Charge Pump)	single use
199901360	Verstaerkerschaltvorrichtung	dual use
199901361	Verstaerkerschaltvorrichtung	dual use
199901366	Anordnung und Verfahren zum Testen mikromechanisch herstellbarer Bauelementstrukturen	single use
199901387	Halbleiter-Festwertspeicheranordnung mit Substratkontakt und Polysilizium-Ueberbrueckungszelle	single use
199901389	Programmgesteuerte Einheit	dual use
199901390	Kompensationsschaltung fuer Treiberschaltungen	dual use
199901392	Schaltungsanordnung zum stoerungsfreien Initialisieren von Delay-Locked-Loop-Schaltungen mit Fast-Lock	dual use
199901399	Grabenisolation fuer elektrisch aktive Bauelemente	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 159 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte****Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.**

199901407	Integrierte Schaltungsanordnung, die eine in einem Substratvergrabene leitende Struktur umfasst, die mit einem Gebiet des Substrats elektrisch verbunden ist, und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199901409	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zur deren Herstellung	single use
199901410	Verfahren zur Herstellung einer mikroelektronischen Struktur	single use
199901414	Leseverstärkeranordnung mit Feldeffekttransistor mit kurzer Kanallänge und einstellbarer Einsatzspannung	single use
199901437	METHOD FOR FILLING GAPS ON A SEMICONDUCTOR WAFER	single use
199901440	Cachen kurzer Programmschleifen innerhalb eines Instruktions-FIFOs	dual use
199901445	Verfahren zur Farbkantenverbesserung bei einer Bildeinblendung	dual use
199901448	Multiplexer-Bus mit lokalen Bus-Knoten	dual use
199901449	Vorrichtung und Verfahren fuer den eingebauten Selbsttest einer elektronischen Schaltung	dual use
199901456	Bauelement und Verfahren zur Herstellung des Bauelementes	single use
199901468	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199901472	Vorrichtung zum Haltern eines Teils und Anwendung der Vorrichtung	single use
199901479	Integrierte Schaltung mit zwei Transistoren unterschiedlichen Leitungstyps	single use
199901488	Integrierter Speicher mit mit seinen Speicherzellen verbundenen Plattenleitungen	single use
199901489	Frequenzsynthesizer	single use
199901490	Integrierter Speicher mit Speicherzellen und Referenzzellen sowie Betriebsverfahren fuer einen solchen Speicher	single use
199901492	Integrierter Speicher mit Speicherzellen und Referenzzellen und entsprechendes Betriebsverfahren	single use
199901494	Vorrichtung und Verfahren zur Detektion eines Werkstueckes in einer automatischen Bearbeitungsvorrichtung	dual use
199901497	Integrierter Speicher mit Speicherzellen, die je einen ferroelektrischen Speichertransistor aufweisen	single use
199901498	MOS-Transistorstruktur mit einer Trench-Gate-Elektrode und einem verringerten spezifischen Einschaltwiderstand und Verfahren zur Herstellung einer MOS-Transistorstruktur	single use
199901501	Mikroprozessor	single use
199901508	Anlage zur Fertigung von Halbleiterprodukten	single use
199901515	Anlage zur Fertigung von Halbleiterprodukten	single use
199901518	Betriebsverfahren fuer einen integrierten Speicher mit beschreibbaren Speicherzellen und entsprechender integrierter Speicher	single use
199901522	Anlage zur Bearbeitung von Wafern	single use
199901525	Manipulationssichere integrierte Schaltung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.CPC IC
Seite 160 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte**Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.**

199901541	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199901551	Vorrichtung zur Bewertung der Zellenwiderstände in einem magnetoresistiven Speicher.	single use
199901552	Vorrichtung zur Bewertung der Zellenwiderstände in einem magnetoresistiven Speicher.	single use
199901558	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199901560	Verfahren zum Übertragen von Daten	dual use
199901568	Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zum elektrischen Anschließen eines Halbleiterbauelements an eine Montageoberfläche und derartige Vorrichtung	single use
199901572	Integrierter Schaltkreis mit Schutzschicht	single use
199901575	Integrierter Speicher, dessen Speicherzellen mit Plattenleitungen verbunden sind	single use
199901581	Verfahren zur Prozessierung einer monokristallinen Halbleiterscheibe und teilweise prozessierte Halbleiterscheibe	single use
199901590	VERBESSERUNG DES ENCAPSULANT-FLUSSES BEIM FBGADURCH OPTIMIERTE GESTALTUNG DER ABSTANDHALTER	single use
199901594	ON CHIP EMV ABSCHIRMUNG VON ICS	dual use
199901595	Linearisierungstechnik fuer schnelle Spannungs-Strom-Wandler	single use
199901596	FFS BEFEHL	single use
199901603	SINGULIERUNGSVERFAHREN VON GEHAEUSEN IN TAPE-MONTAGE	dual use
199901605	KALIBRIERUNGSVERFAHREN ZUR UNTERDRUECKUNG VONGLEICHTAKTANTEILEN BEI TRANSFORMATORLOSER ERZEU...	single use
199901607	3FACH/1FACH-BANDNUTZUNG DES LOKALOSZILLATORS INDUAL BAND TRANSCEIFERN FUEER DEN MOBILFUNK	single use
199901608	SCHREIB-/LESEMODUL ZUR MAGNETO-OPTISCHENNAHFELDSPEICHERUNG	single use
199901609	REALISIERUNG VON MIKROCHIPS MIT ANSCHLUSSFLAEGHEN AN DER CHIPRUECKSEITE	dual use
199901610	Mit einer oder mehreren Verstaerkerschaltungen chipintegrierte Stromspiegel-Spannungsreferenzschaltung zur Arbeitspunkteinstellung	single use
199901616	PERFORMANCE-FREUNDLICHES, LOW-POWER REDUNDANZ-KONZEPT FUEER DATEN-FLASH-SPEICHER MIT MINIMALEM...	dual use
199901620	VERFAHREN ZUR DARSTELLUNG EINES HALBBILDES MITKOMPRESSION	dual use
199901624	FLYING FOUF DOOR OPENER FOR FOUF STOCKER	dual use
199901629	GEBOOSTETE LADUNGSPUMPE MIT RUECKSPEISUNG FUEER LOWVOLTAGE / LOW POWER	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.CPC IC
Seite 161 von 186

J:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199901630	NETZUNTERSCHNUNGSEKENNUNG	dual use
199901631	SCHALTREGLER MIT VERMINDERTER ELEKTROMAGNETISCHERABSTRAHLUNG	dual use
199901633	Halbleiterspeicher mit Speicherbaenken	single use
199901634	Halbleiterspeicher vom wahlfreien Zugriffstyp mit Vorladeschaltung	single use
199901635	Verfahren zur Pruefung von auf der Oberflaeche eines Halbleiterwafers herzustellenden Strukturen	single use
199901639	MULTIPLEXVERFAHREN UND -SCHALTUNGEN ZURANSTEUERUNG EINES CHIP-SICHERUNGSSCHILDS	dual use
199901640	Integrierte Schaltung mit steuerbarem Spannungsregler	single use
199901644	VEREINFACHTER REALISIERUNG DER ZEITLICHEN RAHMEN- SYNCHRONISATION UND DER IDENTIFIKATION DER ZUGE...	dual use
199901647	Schaltungsanordnung zum Burn-In-Test eines Halbleiterbausteins	single use
199901649	IMPROVMENT OF NON-VOLATILE MEMORIESS BY USING WORDLINE ERASE	single use
199901656	Halbleiterspeicher vom wahlfreien Zugriffstyp mit in zwei Ebenen organisiertem Bussystem	single use
199901657	Halbleiterspeicheranordnung mit BIST	single use
199901658	Anordnung zur Durchfuehrung von Burn-In-Behandlungen von Halbleitervorrichtungen auf Waferebene	single use
199901673	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERBESSERUNG DER KURZ- SCHLUSSFESTIGKEIT VON SCHALTNETZTEILEN	single use
199901675	QUERSTROMFREIE LEISTUNGSSCHALTERTREIBER	dual use
199901679	SELBSTEINSCHALTENDE ZELLENSTRUKTUR ZUR INTEGRATIONINTELLIGENTER FUNKTIONEN IN EINER DMOS- LEISTUNG...	single use
199901681	INTEGRIERTER SOFT-UND HARDWARETEST	single use
199901684	UNTERSTROMERKENNUNG AN EINEM LEISTUNGSTRANSISTOR	dual use
199901686	VERZOEGERTES EINSCHALTEN DER LADUNGSPUMPE ZUR VER-BESSERUNG DER ELEKTROMAGNETISCHEN ABSTRAHLUNG	dual use
199901690	VERBESSERUNG DER EMV-ABSTRAHLUNG VON OSZILLIEREN- DEN SCHALTUNGSTEILEN DURCH FREQUENZMODULATION	dual use
199901695	SCHALTUNGSANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM ABGLEICHEINES MEHRSTUFIGEN SELEKTIVEN VERSTAERKERS	dual use
199901696	VEREINFACHUNG DER IQ-SCHNITTSTELLE BEI CELLULARENSYSTEMEN MIT HALBDUPLEXVERFAHREN	dual use
199901704	LOW COST HIGH QUALITY DIGITAL GMSK FILTER	dual use
199901707	SYNCHRONISATION AND CALL SETUP IN A TDMA BASED SYSTEM USING FREQUENCY HOPPING	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 162 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199901716	UEBERWACHUNG DER REINIGUNGSFEDER DES TOROIDAL-ORIFICE AN BEIDEN ENDEN	single use
199901720	LOKALE SLURRYVERSORGUNG FUER CMP-TUNGSTEN-PROZESS	single use
199901727	STRUKTURIERUNG VON BOTTOM-ELEKTRODEN FUER KONDEN-SATOREN: VERSENKEN VON PLATINSILIZIDBEREICHEN	single use
199901733	PROGRAMMIERBARES FRACION DELAY KAMMFILTER	single use
199901736	LATERALER IGBT MIT REDUZIERTEM DURCHLASSPANNUNGS-ABFALL	single use
199901737	KEYPAD INTERFACE FOR GSM BASEBAND CHIPS	dual use
199901738	KONTAKTLOSER BUTTED SUBSTRATKONTAKT	single use
199901751	Integrierter Speicher mit Bitleitungen, Wortleitungen und Plattenleitungen sowie Betriebsverfahren fuer einen entsprechenden Speicher	single use
199901752	Integrierter Speicher mit an gegenueberliegenden Seiten eines Zellenfeldes angeordneten Leseverstaerkern	single use
199901761	CHIPS IN PAPIER ODER FOLIEN	dual use
199901763	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TAKTSYNCHRONISATION BEI QAM/CAP EMPFAENGERN	dual use
199901765	BUS ALIGNMENT	dual use
199901772	THERMISCHE OXIDATION VON POLYSILIZIUM, DAS BEREITS DURCH CVD-OXID EINGEKAPSELT IST	single use
199901775	EMPFANGSBANDSELEKTION BEI LNBS	dual use
199901778	Verfahren und Vorrichtung zur Sicherung eines mehrdimensional aufgebauten Chipstapels	single use
199901783	ARCHITECTURE AND CIRCUITRY FOR COST-EFFICIENT IMPLEMENTATION OF MULTI-BIT SIGMA-DELTA DATA CONVE..	dual use
199901788	TEMPERATURABHAENGIGE SCHALTFLANKENSTEUERUNG	single use
199901790	Schaltungsanordnung zur Programmierung eines elektrisch programmierbaren Elementes	single use
199901809	VERFAHREN ZUR COB-MONTAGE VON ELEKTRONISCHEN CHIPS AUF EINER SCHALTUNGSPLATINE	dual use
199901813	VERFAHREN ZUR VORVERARBEITUNG VON SIGNALEN IN EINEM EMPFAENGER MIT MEHR ALS EINEM EMPFANGSSENSOR	dual use
199901817	DICHTELEMENT ZUM ABDICHTEN VON MOLDKAVITAETEN AUFSTRUKTURIERTEN OBERFLAECHE	dual use
199901821	VERFAHREN ZUR SCHAETZUNG VON KANALPARAMETERN MITSPREIZUNGSCODES	dual use
199901822	NIEDEROHMIGER VDMOS MIT PLANARER GATESTRUKTUR	dual use
199901823	Verfahren zur Montage eines Leadframes	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 163 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199901825	Schaltungsanordnung zur Kontrolle von Zuständen einer Speichereinrichtung	single use
199901829	AENDERUNGEN AM CHIP-LAYOUT ZUR ERZIELUNG VON STANDARD UND MIRROR PACKAGES BEI GLEICHEN INTER...	single use
199901832	Integrierter Speicher mit Schutzschicht und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199901833	HOCHGENAUE REFERENZSTROMMESSUNG OHNE ZUSÄTZLICHES ANALOGPAD ODER PADMODIFIKATIONEN	single use
199901837	Kondensator fuer Halbleiteranordnung und Verfahren zum Herstellen einer dielektrischen Schicht fuer denselben	single use
199901840	DIREKTES PROZESSMONITORING/CONTROLLING	single use
199901841	METHODE UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG VON RBS LINKS UND KOMPENSATION DEREN EFFEKTE FÜR PCM MODEM...	dual use
199901842	FAULT TOLERANT BUS ARCHITECTURE	single use
199901844	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR PROGRAMMIERUNG EINES ELEKTRISCH PROGRAMMIERBAREN ELEMENTES	single use
199901847	ANNEALING VON BEAM LEAD BONDUNGEN MITTELS LASER	dual use
199901853	CMOS-IC MIT INTEGRIERTER HV-ZENERDIODE	single use
199901854	TEMPERATUR-OPTIMIERTE PROZESSFÜHRUNG ZUR KUPFER-BARRIERE ABSCHIEDUNG	single use
199901859	Integrierter Speicher mit Redundanzfunktion	single use
199901860	Verfahren zum Testen eines Halbleiterspeichers und Halbleiterspeicher mit Testeinrichtung	single use
199901861	Integrierter Speicher mit einem Referenzpotential und Betriebsverfahren fuer einen solchen Speicher	single use
199901864	Ausgestaltung der Form einer in Damaszener-Technologie auf einem Substrat hergestellten elektrischen Leiterbahn aus insbesondere Kupfer an einer Stelle einer Richtungsänderung des Verlaufs dieser Leiterbahn.	single use
199901868	MATERIALFLUSS, AUTOMATISCHE VER- UND ENTSORGUNG VON EQUIPMENT	single use
199901877	Verfahren zur Erzeugung einer Speicherzellenanordnung	single use
199901878	HOCHVOLTSCHALTER MIT JFET-REIHE ALS DRIFTSTRECKE	single use
199901885	DOUBLE STACKED CSP-PACKAGE	dual use
199901887	JUNCTIONISOLIERTER LATERAL-MOSFET FÜR HIGH-/LOW-SIDE-SCHALTER	single use
199901888	Halbleitermodul mit mehreren Halbleiterchips und leitenden Verbindungen mittels flexibler Baender zwischen den Halbleiterchips	dual use
199901889	RANDSTRUKTUR MIT FELDPLATTEN-RINGEN	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 164 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199901890	SOURCE- DOWN LEISTUNGSTRANSISTOR IN AUFBAUTECHNIK	single use
199901891	INDIREKTER VERZWEIGUNGSBEFEHL MIT LOOK-UP-TABLE	dual use
199901892	VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR OEKONOMISCHEN EINBLENDUNG VON NICHT 4:3 FERNSEHBILDERN..	dual use
199901895	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR INTERATIVEN (TURBO-)DETEKTION IN MOBILFUNKSYSTEMEN	dual use
199901896	Empfangsverfahren und Empfangseinrichtung fuer Mobilfunkanwendungen	dual use
199901897	Verfahren zur Verhinderung widerrechtlicher Benutzung von Chipkarten	single use
199901919	Schaltungsanordnung zur Reparatur eines Halbleiterspeichers	single use
199901920	VERBESSERUNG DER ZUVERLAESSIGKEIT VON BEAMLEADBONDUNGEN,Z.B. BEI BGA	dual use
199901922	Bauelement	single use
199901923	Differenzverstaerker einer integrierten Halbleiterschaltung	single use
199901925	UMSCHALTBARE AUFLÖSUNG FÜR AD-UMSETZER	dual use
199901927	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR FLEXIBLEN KANALCODIERUNG IN MOBILFUNKSYSTEMEN MIT TURBO-CODES	dual use
199901933	Integrierter Speicher mit redundanten Einheiten von Speicherzellen und Testverfahren fuer seine redundanten Einheiten	single use
199901934	Integrierter Speicher	single use
199901938	PPORTS-FLEXIBLE IO-ARCHITEKTUR FÜR SYSTEMS ON SILICON	single use
199901939	ERHOEHUNG DER ENTLUEFTUNGSMOEGlichkeit WAEHRENDES ENCAPSULIERENS DURCH EIN MODIFIZIERTES	dual use
199901940	Integrierter Speicher mit 2-Transistor/2-Kondensator-Speicherzellen	single use
199901943	Doppel-Gate-MOSFET-Transistor und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199901970	Vorrichtung und Verfahren zur Extraktion physiologischer Daten	dual use
199901971	SCHUTZSCHALTUNG	single use
199901977	INTEGRATION VON SPANNUNGSREGLERFUNKTIONEN AUF USBSYSTEMEN UND REALISIERUNGSMOEGlichkeiten VON INT..	single use
199901981	FLASH/EEPROM MIT OXID-TITANNITRID-TITANOXID("OTTO-FLASH")	single use
199901983	AVALANCHEFESTER TRENCH-MOS-TRANSISTOR	single use
199901986	D-FLIPFLOP	single use
199901987	Integrierter Speicher mit in Kreuzungspunkten von Wortleitungen und Bitleitungen angeordneten Speicherzellen	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 165 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199901989	GROUND KEY DEDEKTION MIT UNTERDRUECKUNG VON SINUS-FOERMIGEN STOERSIGNALEN	single use
199901990	Fuse fuer Halbleiteranordnung	single use
199901993	Halbleiterspeicherbauelement	single use
199901995	Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterspeicherbauelements	single use
199902001	Anordnung von Fuses bei Halbleiterstrukturen mit Cu-Metallisierung	single use
199902004	VERWENDUNG VON ENTSCHEIDUNGSBUCHSTABEN BEI MEHR-DEUTIGEM ERGEBNIS EINER SPRACHERKENNUNG	dual use
199902006	6,3F-FLASH MIT SELF-ALIGNED-FLOATING-GATE UND HIGH-EPSILON-DIELEKTRIKA	single use
199902008	Rechnergestuetztes Verfahren zur parallelen Berechnung des Arbeitspunktes elektrischer Schaltungen	single use
199902015	VERBESSERUNG DER ZUVERLAESSIGKEIT VON NVM ZELLENMITTELS VERKIPPTER INPLANTATIONEN	single use
199902017	Ferroelektrischer Transistor und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199902018	Ferroelektrischer Transistor und Verfahren zu dessen Betrieb.	single use
199902027	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR AUFWANDSGUENSTIGENERZEUGUNG MEHRERER MODULATIONSARTEN	dual use
199902028	Schleifloesung und Verfahren zum chemisch-mechanischen Polieren einer Edelmetall-Oberflaeche	single use
199902031	Verfahren zur Herstellung einer elektrisch leitfaehigen Verbindung in einer mikroelektronischen Struktur	single use
199902032	SEGMENTIERTE BODENPLATTE IN LEISTUNGSHALBLEITER-MODULEN	dual use
199902034	VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN KONTRASTVERBESSERUNGFUER TV UND PLASMABILDSCHIRME	dual use
199902046	OBERFLAECHENBESCHICHTETE KUNSTSTOFFTRAYS ZUR VERMEIDUNG VON LEADS-BZW. SOLDER BALL KONTAMINATI...	dual use
199902047	2 NICHT DURCHGESAEGTE EINZELCHIPS IN LOC-MONTAGEGEBONDET	single use
199902049	DURCH EPITAXIEPROZESSE VERAENDERTE REPRODUZIERBAREJUSTIERSTRUKTUREN FUEHRT FOTOLITHOGRAPHIEPROZESSE	single use
199902050	VERLUSTLEISTUNGSARME UEBERTRAGUNG VON SEHRKURZEN UMPULSEN	single use
199902056	UNIVERSELLE SPEICHERANORDNUNG UND-STEUERUNG FUER VIDEO-ANWENDUNGEN	dual use
199902058	BRANCH CONTROL UNIT	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 166 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199902060	OPTIMIERTE FOLGEZUSTANDSBESTIMMUNG FUER INSOFTWARE REALISIERTE ENDLICHER AUTOAMTEN	single use
199902065	FREI PROGRAMMIERBARER/SKALIERBARER TAKTTEILER	dual use
199902068	DEPOSITION OF AN ADHESION ENHANCING COATING LAYER ON THE SURFACE OF A SEMICONDUCTOR DEVICE	dual use
199902069	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERMEIDUNG DER INJEKTION VON MINORITÄTSTRÄGERN INS SUBSTRAT	single use
199902072	MOS-Transistor und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199902076	FM-DEMULATOR MIT KALIBRIERUNG AUF EIN RAUSCH- SIGNAL	dual use
199902077	Koinzidenz-Demodulator	single use
199902078	ISOLIERENDES SUBSTRAT MIT PLANAREM FELDAUSTRITTS- BEREICH	dual use
199902079	Mehrkanal-MOSFET und Verfahren zu seiner Herstellung.	single use
199902082	RETROGRADE DRAIN-EXTENSION FUER HV-TRANSISTOREN INKOMBINIERTEN CMOS-LV/HV-TECHNOLOGIEN	single use
199902083	MOBILER WERKSTÜCKTRÄGER FUER DÜNNE WAFER	dual use
199902084	Integrierte Schaltung zur Detektion eines Empfangssignals	single use
199902085	VERMINDERUNG VON MECHANISCHEM STRESS AUF HALB- LEITERSTRUKTUREN	dual use
199902086	Elektronischer Schalter zum Schalten einer Last	dual use
199902090	VERPOLSCHUTZ FUER LOGIKSCHALTUNGEN UND PROFET'S	dual use
199902094	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199902105	UMSCHALTBARE AUSGANGSANPASSUNG FUER DUAL BANDLEISTUNGSVERSTÄRKER MIT SELBSTSPERRENDE PIN DIO.	single use
199902106	SPEICHERKONZEPT MIT FLEXIBLEN SEKTORGROESSEN	single use
199902116	VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES HALBLEITERKÖRPER MIT QUASI-VERTIKALEN TRANSISTOREN MIT UNTERSCHIEDLICHEN	single use
199902117	Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Edelmetallschicht	single use
199902118	Phasenregelkreissystem	single use
199902121	PROGRAMMIERBARES PCM-FILTER	single use
199902123	AVANLANCHEFENSTER TRENCH-MOS-TRANSISTOR MIT FELD- PLATTE IM TRENCH	dual use
199902124	EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR UMSCHALTUNG VON ÜBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN ZWISCHEN SPRACH- UND ...	dual use
199902125	SPANNUNGSVERDOPPLERSCHALTUNG FÜR MEHRPHASIGEN MOTORBRÜCKE	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

GPC IC
 Seite 167 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199902127	VERFAHREN UND BAUELEMENT MIT BEI NIEDRIGER TEMPERATUR TIEF DIFFUNDIERTER FELDSTOPSCHICHT	single use
199902129	Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Schicht	single use
199902132	Verfahren zur Herstellung einer nichtfluechtigen Halbleiter-Speicherzelle mit separatem Tunnelfenster	single use
199902136	HOHEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN GENUEGENDE ANORDNUNG FUER SCHNELLEN ELEKTRISCH SCHREIB- . . .	dual use
199902139	Integrierter Speicher	single use
199902142	GENERIERUNG VON TECHNOLOGIEUNABHAENGIGEN, TEMPERA-TURKONSTANTEN UND TEMPERATURPROPORTIONALEN DC-...	single use
199902145	Verfahren zur Herstellung einer ferroelektrischen Speicheranordnung	single use
199902146	RINGZELLE	single use
199902147	Ladungspumpenschaltung, insbesondere fuer eine elektrische Phasenregelschleife	single use
199902149	NEUE METHODE FUER EINEN 2-PUNKT MODULATOR ZURPHASEN/FREQUENZMODULATION EINER PLL (PHASE..),....	dual use
199902150	Substrat und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199902151	MOS-Transistor und Verfahren zu dessen Herstellung sowie DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199902154	Verfahren zur Herstellung einer Elektrode	single use
199902164	Verfahren zur Herstellung von ROM-Speicherzellen	single use
199902167	Integrierte Schaltung mit einer Decodereinheit	single use
199902177	SELBSTREDUNDANTE KONFIGURATION VON FLASHZELLEN	single use
199902180	Isolation von Gate-Elektroden und Herstellungsverfahren	single use
199902190	MIKROWELLENUMSCHALTUNG HOHER GUETE FUER DUAL-BAND-APPLIKATION VON LEISTUNGSVERSTAERKERN	dual use
199902191	INTEGRIERTER LOOP-VERSTAERKER MIT UMSCHALTBARENZEITKONSTANTEN	single use
199902193	INTEGRIERTE SYSTEMAKTGENERIERUNG IN ISDN UND XDSL(ADSL,SDSL,VDSL,HDSL) APPLIKATIONEN ZUR REALISIE..	dual use
199902195	EIN ALTERNATIVES VERFAHREN ZUR ORTHOGONALEN FREQUENZDIVISIONSMODULATION (OFDM)	dual use
199902197	Vorrichtung und Verfahren zum Filtern eines einen digitalen Datenstrom repraesentierenden Signals	dual use
199902198	SCHALTUNGSANORDNUNG UMSCHALTBARER VERSTAERKERSTU-FEN MIT MINIMALER ANSCHLUSSANZAHL BEI INTEGRATION	single use
199902199	Verfahren zur Herstellung von Graeben fuer Speicherkondensatoren von DRAM-Halbleiterspeichern.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 168 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199902201	QUADRICORRELATOR MIT OFFSETAUSGLEICH MIT HILFEEINER GYRATORSCHALTUNG	dual use
199902202	METHODS FOR REALISATION OF HIGHLY FLEXIBLE BUILT-IN-SELF-TEST ON MEMORY SEMICONDUCTORS (METHO.)..	single use
199902204	QUADRICORRELATOR MIT OFFSETAUSGLEICH DURCH POLY-PHASEN-TIEFPASS	dual use
199902205	GESCHWINDIGKEITS- UND PHASENRAUSCHOPTIMIERTEBIPOLAR- NACH CMOS-KONVERTERSTUFE	single use
199902212	SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERBESSERUNG DER SYMMETRIEVON SOURCE-UND SINKSTROEMEN BEI UNTERSCHIEDLI.....	single use
199902214	SELBSTKALIBRIERENDE INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR WANDLUNG VON DIFFERENTIELLEN IOW-SWING-..	single use
199902216	MINIMALE SILIZIUM PACKAGING TECHNOLOGY	single use
199902217	QUADRO MODULUS PRESCALER FUER PLL-SYNTHESIZER	single use
199902222	SYNCHRONER, LADBARER HOCHGESCHWINDIGKEITS-ZAEHLER	single use
199902223	INTEGRIERTER FREQUENZSELEKTIVER LNA, SYMMETRISCH,SCHALTBAR MIT KONSTANTER EIN - UND AUSGANGSIM.....	single use
199902225	Differenzverstaerker	single use
199902226	ECL - MOS PEGELWANDLER	single use
199902227	Vorrichtung zur Erhoehung der Empfangbarkeit eines DCF-77-Signals	single use
199902228	CHARGE PUMPSTUFE MIT OPTIMIERTEM AN- UND ABSCHALT-VERHALTEN, SOWIE OPTIMIERTEM AUSSTEUERBEREICH	dual use
199902229	MISCHER MIT SCHALTBARER LINEARITAET	single use
199902230	NICHTFLUECHTIGER SPEICHER MIT VAKUUMTUNNELKONTAKT	single use
199902231	SPANNUNGSEKKNUNG IN EINEM ZUENDSYSTEM	dual use
199902235	PROZESS ZUR HERSTELLUNG VON NICHT FLUECHTIGENSPEICHERN KOMBINIERT MIT FLUECHTIGEN SPEICHERN.....	single use
199902238	Verfahren zur Herstellung von silizierten Polysiliziumkontakten in integrierten Halbleiterstrukturen.	single use
199902241	EINSATZ DES CHIPKARTEN-INTERFACES ALS EINFACHETASTATUR FUER CHIPKARTEN	dual use
199902242	Nichtfluochtige Halbleiter-Speicherzelle mit separatem Tunnelnfenster und dazugehoeriges Herstellungsverfahren	single use
199902255	Ferroelektrischer Transistor.	single use
199902259	Speicherzellenanordnung.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 169 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199902260	GANZFLECHTIGE NUTZUNG VON CHIPKARTEN FUERELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN	dual use
199902287	ABRUNDUNG DER AUSSCHALTFLANKE DURCH ZUSAETZLICHENLEISTUNGSTRANSISTOR	dual use
199902290	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR SCHAETZUNG VON VER- ZOEGERUNGSPARAMETER DER KANALIMPULSANTWORT	dual use
199902294	PROTECTION OF REPROGRAMMABLE MEMORY	dual use
199902295	SYNCHRONISATION DES SPRACHKANALS MIT DEM DATENKA- NAL AUSGEHEND VON STANDARDTAKT 4.096MHZ AUF DIE..	dual use
199902296	TSOP-Speicherchipgeaacusanordnung	single use
199902299	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUM EMPFANG BANDGE- SPREIZTER SIGNALE IM MOBILFUNK	dual use
199902303	GESAMTARCHITEKTUR EINER KOMBINIERTEN DATEN/SPRACH- LINECARD	dual use
199902305	INTEGRATION DER DATEN-DSP STEUERDATEN IN DEN CON- TROLLDATENFLUSS ZUM CODEC	dual use
199902306	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR NEUARTIGEN BAND- SPREIZUNG BEI MEHRTEILNEHMERKOMMUNIKATIONS. . .	dual use
199902308	SELF BIASED SUPER-DAC-ZELLE	single use
199902309	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR SYNCHRONISATION FUERCODEMULTIPLEX-MOBILFUNK DER DRITTEN GENERATION	dual use
199902312	Verfahren zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio-Signals mit automatischer Indexierung	single use
199902315	Verfahren zur Herstellung eines Vertikal- Halbleitertransistorbauelements und Vertikal- Halbleitertransistorbauelement.	single use
199902318	Halbleiterbauelement, Verwendung desselben und Verfahren zu seiner Herstellung.	single use
199902319	ABGLEICHFREIER KOINZIDENZDEMULATOR	dual use
199902322	Abgleichfreier Demodulator fuer frequenzmodulierte Signale	dual use
199902327	KONZEPT FUER VERSORGUNGSABHAENGIGE CHARGE PUMP EINER PLL	single use
199902328	TESTFREUNDLICHER ENTWURF UND SCHUTZ VOR MANIPULA- TION VON GATTERN MIT SERIENSCHALTUNG VON P-KANAL	single use
199902329	Verfahren zur Herstellung zweier unterschiedlich dotierter benachbarter Gebiete in einem integrierten Halbleiter.	single use
199902332	Nichtfluechtige Halbleiterspeicherzelle und Verfahren zur Herstellung derselben.	single use
199902339	RANDABSCHLUSS VON LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENTENMITTELS VERTEILTER INNERER UND AEUSSERER PONTI....	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 170 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199902340	Integrierter Halbleiterspeicher mit redundanten Einheiten von Speicherzellen und Verfahren zu seinem Betrieb	single use
199902345	Integrierte Halbleiterschaltung mit erhoehter Betriebsspannung	single use
199902350	SELBSTTEST FUER DIGITALFILTER	single use
199902354	A HIGH PERFORMANCE ADDER CIRCUIT	single use
199902357	INTELLIGENTE HALB-BRUECKENKONFIGURATION AUF EINEMCHIPTRAEGER	dual use
199902373	Verfahren zur Beseitigung von Redepositionen auf einem Wafer und Wafer, der frei von Redepositionen ist	single use
199902378	CONSTRUCTING THE PHASE DETECTOR BY USING ONLY ONECHARGE PUMP	single use
199902380	Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterspeicherbauelements	single use
199902382	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER TRENCH-MOS-TRANSISTORZELLE MIT FELDPLATTE IM TRENCH	single use
199902384	MOLDEN VON KERAMIK-SUBSTRATEN	dual use
199902387	OBERFLAECHE NEMITTIERENDE OPTOELEKTRISCHE STRAHLQUELLE IN KUNSTSTOFFGESPRITZTER SMD-BAUWEISE	dual use
199902389	Fernbedienungsanordnung, fernzubedienendes Geraet, Bedienungsgeraet zum Fernbedienen und Haushaltsgeraet	dual use
199902390	AUSLESEN DES MARGIN-WERTES AUS NICHTFLUECHTIGEN SPEICHERZELLEN, WELCHE ALS "ELECTRICAL FUSES" ...	single use
199902391	VERFAHREN UND SCHALTUNGSTECHNISCHE IMPLEMENTIERUNG EINER BITFEHLERKORREKTUR MIT MINIMALEM FLAECHE...	dual use
199902396	UEBERTRAGUNG VON ZWEI ANALOGEN ODER EINEM ISDN TEILNEHMER PARALLEL ZU ADSL LIGHT DURCH NUTZUNG...	dual use
199902401	LOW STRESS WAFER MOUNTING (PREASSEMBLY OF 300 MM WAFERS AFTER BACKSIDE GRINDING BEFORE WAFER. ...	single use
199902403	A PACKET SWITCHING SYSTEM WITH INPUT BUFFERING AND VIRTUAL OUTPUT QUEUEING	dual use
199902406	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR KOMBINIERTEN KANALSCHAE TZUNG IM MOBILFUNK MIT CODE MULTIPLEX	dual use
199902407	KALIBRIERENDER ADC FUER VERSCHIEDENE REFERENZSPANNUNGEN	dual use
199902413	SUBOPTIMALES VERFAHREN ZUR ENTZERRUNG VON INTERSYMBOL INTERFERENZEN	dual use
199902414	VERFAHREN ZUR RATENKOMPATIBLEN PUNKTIERUNG BEISERIELL VERKETTETEN TURBO CODES	dual use
199902415	ZEITSCHALTUNG OHNE EXTERNE KOMPONENTEN FUER INDUKTIVE LASTEN	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 171 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199902416	Kratzfeste Beschichtung fuer Halbleiterbauelemente	single use
199902418	RESTKLASSENBASIERTE MAC UNIT	dual use
199902433	DESIGNMASSNAHMEN ZUR ERHOEHUNG DER KRATZFESTIGKEITFUEER KAPAZITIVE SENSORPASSIVIERUNG	single use
199902454	Verfahren zur biometrischen Erkennung	dual use
199902457	Verfahren zur biometrischen Erkennung	dual use
199902459	Verfahren zur biometrischen Erkennung	dual use
199902460	Vorrichtung zur biometrischen Erkennung	dual use
199902464	SPANNUNGSVERSORGUNG FUEER INTEGRIERTE SCHALTUNGENUEBER SPEZIELLE INPUTPINS	single use
199902475	Kontaktierung von Metalleiterbahnen eines integrierten Halbleiterchips	single use
199902488	Empfangsverfahren und Empfaengeranordnung fuer ein Duplex- Uebertragungssystem	dual use
199902492	Verfahren zur Herstellung einer Isolation	single use
199902497	NEUE AETZE UND NASSCHEMISCHER AETZPROZESS ZUM AETZEN VON BI HALTIGEN, FERROELEKTRISCHEN . . .	single use
199902499	Mikroelektronischer Speicherkondensator und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199902502	Uebertragung eines Musters hoher Strukturdichte durch multiple Belichtung weniger dichter Teilmuster	single use
199902503	BESTIMMUNG VON DIELEKTRIZITAETSKONSTANTEN MITHILFE EINES CMOS-SENSORS	single use
199902504	CMOS-FEUCHTIGKEITSMESSER	dual use
199902515	SYNTHESIZERKONZEPT MIT MEHREREN LADUNGSPUMPEN UNDSCHLEIFENFILTER	dual use
199902523	OVERHEAD TRANSPORT SYSTEM (OHT) VEHICLE FOR OPENCASSETTE TRANSPORT	dual use
199902527	Verfahren zur Strukturierung einer organischen Antireflexionsschicht	single use
199902528	Aetzprozess fuer eine Zwischschicht-Metallisierung	single use
199902562	Ladungspumpe	single use
199902564	WANNEN- UND PROGRAMMIER-/LOESCHKONFIGURATION FUERNVM-ZELLEN	single use
199902565	Grinding Disk zum Konditionieren von CMP-Pads	single use
199902568	EINRICHTUNG ZUM VERSCHIEBEN DES LASTABHAENGIGENFREQUENZGANGS VON FREISCHWINGENDEN SCHALTNETZTEIL.	single use
199902570	Schwingungsfreie Vorrichtung zur Halbleiterbelichtung	single use
199902582	SCHALTUNGSANORDNUNGEN ZUR VERMEIDUNG SCHAEDLICHERAUSWIRKUNGEN VON "STUCK AT" FEHLERN AUF SICHER....	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPO IC
Seite 172 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199902584	SUBCARRIERERKENNUNG BEI ISO14443 TYPB MODULATIONS- VERFAHREN	single use
199902585	Kontakte eines integrierten Halbleiterchips	single use
199902594	CMOS-NEIGUNGSMESSE	single use
199902596	METHOD AND APPARATUS FOR INCREASING CODING EFFICI- ENCY AND DECREASING CODE SIZE USING DATA-ORDER....	dual use
199902598	DISPLAY IN CHIPKARTE	dual use
199902608	Verfahren zur Herstellung einer mikroelektronischen Struktur	single use
199902610	POWER-UND FLAECHENOPTIMIERTE CACHE ARCHITEKTUR	single use
199902615	SYSTEM ZUR FEHLERERKENNUNG UND KORREKTUR IN EINEM"DECISION FEEDBACK/FEEDFORWARD EQUALIZER	dual use
199902617	VERLUSTLEISTUNGSREDUKTION DURCH DIE ERZEUGUNG VONREGISTERN IN REKURSIVEN SCHALTUNGEN (DIGITAL..)...	dual use
199902628	Stacked Via mit besonders ausgebildetem Landing Pad fuer integrierte Halbleiterstrukturen	single use
199902638	ENFERNUNG VON RESTEN EINER GEAETZTEN SCHICHT (SPACER) SELEKTIV ZU NICHT GEEATZTEN BEREICHEN....	single use
199902647	Elektronische Schaltung mit ferroelektrischen Flipflops.	single use
199902650	Schaltungsanordnung und Verfahren zum Bewerten von Kapazitaeten.	single use
199902651	Treiberschaltung und Verfahren zum Betreiben einer Treiberschaltung.	single use
199902653	Stromquelle fuer niedrige Betriebsspannungen mit hohem Ausgangswiderstand.	single use
199902656	Speicher mit Grabenkondensator und Auswahltransistor und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199902658	Epitaxieschicht und Verfahren zu ihrer Herstellung	single use
199902659	Verfahren zur Herstellung integrierter Sensoren	single use
199902664	FINGERPRINT-SENSOR ZUR BIOMETRISCHEN VERTIKATION,BESTEHEND AUS EINEM PASSIVEN SENSOR- ARRAY, HERG...	dual use
199902666	FUNKTIONSERWEITERUNG VON HALBLEITERCHIPS DURCHAUFBRINGEN LEITENDER SCHICHTEN NACH DEM SIL...	dual use
199902669	CHIPKARTEN - MODUL	dual use
199902671	Schaltung und Verfahren zur Sicherung elektronischer Vorrichtungen	dual use
199902672	CHIPKARTE MIT SPULE UM LOCH	dual use
199902673	Verfahren zur Herstellung eines HF-FET und HF-FET	single use
199902674	Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199902684	Floating-Gate-Speicherzelle	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 173 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199902685	SCHALTUNG ZUR ERHOEHUNG DER VERPÖLFESTIGKEIT VONLEISTUNGSSCHALTERN MIT OHMSCHER UND AUCH INDUK....	dual use
199902687	CHIPFEHLERANALYSE MIT OCDS UND SCAN CHAINS	single use
199902696	STROEMUNGSREINIGUNG FUER STENCILMASKEN	single use
199902704	Verfahren zur Herstellung einer DRAM-Zellenanordnung.	single use
199902707	Verfahren zur Bestimmung von Daten fuer eine Maske sowie dessen Verwendung zur Herstellung einer Maske sowie zur Herstellung einer integrierten Schaltung.	single use
199902711	Halbleiterbauelement als Verzögerungselement und Verwendung eines Halbleiterbauelementes	single use
199902713	Kommunikationssystem mit Kommunikationsnetz und Informationsempfänger und einzelner Informationsempfänger	dual use
199902736	Verfahren zum Positionieren einer Marke auf einem wenigstens zwei Schalttaeichen aufweisenden Bildschirm	dual use
199902741	VERFAHREN ZUM VERGLEICH VON MASKENDATEN INTEGRIERTER SCHALTUNGEN MIT HILFE EINES RECHNERS	dual use
199902743	Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Betrieb.	single use
199902747	VERFAHREN UND BAUELEMENT MIT TEILKOMPENSIERTER AKTIVER ZONE	single use
199902748	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG HOCHVOLTSTAUGLICHER RAND-ABSCHLUESSE AUF NACH DEM PRINZIP DER LATERALEN ...	single use
199902750	Kommunikationssystem und entsprechender Empfänger	dual use
199902760	Integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens einem Kondensator und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199902764	EMV- UND LEISTUNGSOPTIMIERTE SIGNALTREIBER	dual use
199902766	Halbleiterbauelement fuer hohe Sperrspannungen bei gleichzeitig niedrigem Einschaltwiderstand und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199902769	DUAL-CHIP HOCHSTROM-BRUECKE	single use
199902770	SCHNELLER QUERSTROMFREIER GATE-TREIBER	dual use
199902778	MOS-Transistor und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199902779	SOLAR DRIVEN VEHICLE FOR OVERHEAD TRANSPORT(OHT) VEHICLE	dual use
199902788	BITFEHLERRATEN-SCHAETZUNG AUS SOFTINFORMATION	dual use
199902800	STRUKTURIERUNG VON PUNKTFOERMIGER STRUKTURENMINIMALER GROESSE MITTELS CHROMLOSER PHASENMASKEN	single use
199902801	Vertikalresonator-Laserdiode mit einer Schutzschicht auf dem Auskoppelfenster	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 174 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199902803	Grabenkondensator mit Kondensatorelektroden und entsprechendes Herstellungsverfahren	single use
199902806	Speicher mit Isolationsgraben zu seiner Herstellung	single use
199902809	PROBING SIGNAL GENERATION AND DETECTION TECHNIQUES FOR NON- LINEARITY MEASUREMENT	dual use
199902810	VERBESSERUNG DER BENETZUNGSFAEHIGKEIT VON LOTKUGELN AUF FBGA PACKAGE MITTELS EINES OPTIMIERTEN...	single use
199902813	USB-ENDGERAETE-POWER-MANAGEMENT-SYSTEM	dual use
199902814	Integrierter Speicher mit zwei Burstbetriebsarten	single use
199902818	INTEGRIERTE SPULEN MIT REDUZIERTERSUBSTRATANKOPPLUNG	single use
199902826	Strukturierung von Kontaktflaechen in Mehrlagen-Metallisierungen	single use
199902827	SELBSTJUSTIERTER WANNENKONTAKT DURCH NACHBEHANDLUNG DER IMPLANTATIONSMASKEN	single use
199902832	SCHUTZRING BEI ELEKTROSTATISCHEN ENTLADUNGEN	single use
199902835	AKTIVE LINSENJUSTAGE AN EINEM OPTISCHENEMPFAENGERBAUTEIL (Z.B. INFRAROT PIN-PD)	single use
199902836	PARABOLISCHE UMLENKOPTIK FUER MAGNETOOPTISCHESCHREIB-UND LESEKOEPE	single use
199902844	Abscheidung verschiedener Untergrundschichten fuer selektives Schichtwachstum in der Halbleiterfertigung	single use
199902857	Verfahren zur Herstellung eines integrierten Leistungsschaltkreises	single use
199902863	Verfahren zur Herstellung einer Maskenschicht mit Oeffnungen verkleinerter Breite	single use
199902870	REGLUNG DER BELICHTUNGSPARAMETER IN DERHALBLEITERFERTIGUNG	single use
199902874	PASSIVE PIXELZELLE FUER HOCHAUFLOESENDE UND PREISGUENSTIGE CMOS-KAMERAS	single use
199902885	NICHTFLUECHTIGE SPEICHERSCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER POLYSI-EBENE UND VERBESSERTE SHALLOW.....	single use
199902889	Verfahren zum Strukturieren einer Metallschicht in der Halbleiterfertigung	single use
199902896	HALBBRUECKENZELLE MIT SOURCE-DOWN LOW-SIDE-SCHALTER	single use
199902898	DUENNFILM-KONDENSATOREN FUER SYSTEM ON CARD (SOC)	dual use
199902914	INSTRUCTION SET WTH BRANCH PREDICTION	dual use
199902920	KONDENSATOREN HOHER SPEZIFISCHER KAPAZITAET FUERINTEGRIERTE SCHALTUNGEN	single use
199902940	Bestimmung der Staerke der Haftung einer Lackschicht auf einer zu strukturierenden Schicht einer integrierten Halbleiterschaltung	single use
199902943	DETECTION LAYER FUER IN-SITU ENDPUNKTERKENNUNG	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 175 von 186

J:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199902954	Magnetoresistiver Schreib/Lese-Speicher sowie Verfahren zum Beschreiben und Auslesen eines solchen Speichers.	single use
199902962	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR REALISIERUNG VON UNGLEICHEM FEHLERSCHUTZ IN NACHRICHTENUEBERTRAG...	dual use
199902964	DOUBLE MEMORY CHIP SCALE PACKAGE	dual use
199902973	EINRICHTUNG ZUR SPEKTRALEN FORMUNG EINES SENDESIGNALS IM TRANSMITTER-PFAD	dual use
199902976	BUS HANDSHAKE	dual use
199902996	Anordnung mit Bildsensoren.	single use
199902997	Grabenkondensator und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
199903144	Herstellung von Kationenaustauschermembran-Duennschichten	dual use
199903279	VERWENDUNG VON BOTTOMRESISTMATERIALIEN FÜR DIE ZWEI LAGEN RESISTTECHNIK MIT CHEMISCH VERSTÄRKTE...	dual use
199903304	Streustrahlenraster, insbesondere für eine medizinische Röntgeneinrichtung, sowie Verfahren zur Bestimmung der Lage der Absorptionselemente eines Streustrahlenrasters	dual use
199903350	Verfahren zum Einbringen von Schlitzen in Siliziumscheiben	dual use
199903594	KONTAKTFREIE DEFECTANALYSE AN HALBLEITER-SCHEIBEN	single use
199904003	Mehrkanalige optische Baugruppe	single use
199904008	Kopplungsteil	single use
199904018	Abschlussanordnung für ein Ende eines optischen Kabels	single use
199904019	Halter	single use
199904020	Kopplungshülse	single use
199904023	Laufzeitenhomogenisiertes Lichtwellenleiterkabel und Verfahren zu dessen Herstellung	single use
199904033	Verfahren und Gießform zum Herstellen eines elektrooptischen Moduls und elektrooptisches Modul	single use
199904035	Optischer Verbinder und Verbindung	single use
199904036	Elektrooptisches Modul	single use
199904044	Sendeanordnung	single use
199904070	SMD-PAROLI.	single use
199904076	Verfahren zum Erzeugen von Lotkontakten für elektrische Bauelemente	dual use
199904090	Verfahren zum Reinigen eines einen Fremdstoff enthaltenden Gases	dual use
199904106	Greifwerkzeug mit einer Haltevorrichtung für elektronische Bauelemente	dual use
199904109	KONZEPT FÜR DEN ELEKTRONISCHEN ABGLEICH VON LASERTREIBERSCHALTUNGEN.	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 176 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199904119	OPTISCHES SENDE- UND EMPFANGSMODUL.	single use
199904122	Verfahren zum elektrischen Verbinden von Kontaktanschlussflächen von elektrischen Bauelementen mit Kontaktflächen einer gedruckten Leiterplatte	dual use
199904145	ANORDNUNG ZUR OPTISCHEN KOPPELUNG VON LICHTLEITER-FASERN MIT SCHRAEGEN STIRNFLAECHEIN IN EINER V-NUT.	single use
199904153	SCHALTUNG ZUM AUSGLEICH VON UNTERSCHIEDLICHENVERZOEGERUNGEN AUF PARALLELEN OPTISCHEN ...	single use
199904155	OPTISCHER STECKVERBINDER.	single use
199904175	SCHALTUNGSANORDNUNG EINES LASERTREIBERS, WELCHEDREI REGELMECHANISMEN VEREINIGT ...	single use
199904176	TAKTRUECKGEWINNUNG UND DATENENTSCHEIDER FUER HOHEDATENRATEN.	dual use
199904230	GEHAEUSTER ELEKTROOPTISCHER UND/ODER OPTOELEK-TRISCHER WANDLER UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG ...	dual use
199904232	REGELUNG UND UEBERWACHUNG DER OPTISCHEN AUSGANGS- LEISTUNG PARALLELER MIT SENDEDIODEN-ARRAYS ...	single use
199904701	Rekonfigurierbares Gate-Array	single use
199904715	PHASENMASKEN - OPTIMIERUNG BEI DER LAYOUT-KOM-PAKTIERUNG	single use
199904724	DEEP TRENCH CAPACITOR WITH HIGH EPSILON NODE DIE-ELECTRIC AND LOW RESISTANCE ELECTRODE MATERIAL	single use
199904730	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR DIGITALEN ERZEUGUNGVON SPREIZMODULATION FUER MOBILFUNKSYSTEME	dual use
199904737	EMV-OPTIMIERTES IC-VERSORGUNGSKONZEPT	dual use
199904750	REFERENZSPANNUNGSERZEUGUNG UND SPANNUNGSREGLER MITSEHR NIEDRIGEM VERSORGUNGSSTROM	dual use
199904759	Verfahren und Schaltungsanordnung zum Bewerten des Informationsgehalts einer Speicherzelle.	single use
199904781	Integrierter dynamischer Halbleiterspeicher mit redundanten Einheiten von Speicherzellen und Verfahren zur Selbstreparatur	single use
199905005	Verfahren zur Umsetzung von Schnittstellendefinitionen und Zwischenformattabelle dafuer.	dual use
199905007	EIN MULTITHREADING NETWORK PROCESSOR MIT SEPARATEMBUS FUER DATENTRANSFER UND PROTOKOLLVERARBEITUNG	dual use
199905009	Optoelektronisches, bidirektionales Sende- und Empfangsmodul in Leadframe-Technik	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 177 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199905011	BEFEHLSSTZ FUER SPLIT UND MERGE VON BITFELDERN	dual use
199905018	RECEPTACLE-BAUFORM MIT PRAEZISE EINSTELLBARER EIN-KOPPLUNG	single use
199905020	PARTIONIERUNG EINER SENDEEINRICHTUNG FUER CODE-MULTIPLEX-MOBILFUNK DER DRITTEN GENERATION	dual use
199905023	KOMPENSIRTER HV-MOSFET MIT RANDINJEKTOR	single use
199905026	CORDIC- BASED FREQUENCY CORRECTION FOR TRANSCEIVERUSING LOW OSCILLATOR	dual use
199905031	Speicheranordnung	single use
199905032	BEGRENZUNG DER AUSGANGSLEISTUNG EINES SYNCHRONISIERBAREN SCHALTNETZTEILES	dual use
199905034	REALISIERUNG TIEFDIFFUNDIRTER N-GEBIETE	single use
199905036	Aetzverfahren fuer Dual-Damascene Anwendungen	single use
199905038	DIFFUSIONSSPERRE BEI EPOXY CHIPKARTENMODULTRAEGER-BAENDER	dual use
199905054	FPGA-Zelle	single use
199905055	KURZSCHLUSSSTROM ROBUSTER COOLMOS	dual use
199905058	Schichterzeugungsverfahren bei der Herstellung eines Halbleiterbauelements und Halbleiterbauelement	single use
199905061	Drehratensensor.	single use
199905063	Kapazitiv messender Sensor und Anordnung.	single use
199905075	ULTRA LOW POWER/HIGH PERFORMANCE SENSE AMPLIFIERFUER NVM	single use
199905077	Integrierte Schaltung mit Regelung der Einsatzspannungen ihrer Transistoren	single use
199905078	Verfahren zur Reinigung einer monokristallinen Silizium-Halbleiterscheibe	single use
199905122	1. OPTIMIERUNG DES STACKZUGRIFFES AUF AKKU. . .2 AKKUMULATORKENNUNG FUER VERSCHIEDENE OPER. . .	single use
199905137	BIDIREKTIONALER IMPULSGEBER	dual use
199905140	Anlage zur Bearbeitung von Wafern	single use
199905164	SYNCHRONISATIONSSCHALTUNG MIT PROGRAMMIERBAREN OZILLATOREN ZUR ZUFALLIGEN LAUFZEITSTEUERUNG VON.	dual use
199905168	Blockverschlüsselungsverfahren zur Datenverschlüsselung mittels Feistel-Netzwerken	dual use
199905171	Echokompensationsvorrichtung	single use
199905177	VERHINDERUNG DES LATCHUPS DES PARASITAERER BIPO-LARTRANSISTORS BEI LATERALEN P-MOS, N-MOS-TRANS...	single use
199905196	TEST SHELL FOR MACROS	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 178 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199905205	Anordnung fuer Hochleistungslaser.	single use
199905221	BESTIMMUNG DER RELATIVEN POSITION MIT HILFE EINESCMOS-SENSORS	dual use
199905226	Verfahren zur Verwendung eines auf Frequenzmodulation basierenden Transceivers fuer mit einem Spreizspektrumverfahren kodierte Signale	dual use
199905227	SONOS-FLASH-EEPROM MIT TITANOXID ("SOTOS")	single use
199905230	Elektronisches Bauelement und Verfahren zum Schuetzen einer in dem Bauelement enthaltenen integrierten Schaltung	single use
199905236	DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199905241	Multi-Chipmodul	dual use
199905245	Schaltungsanordnung zur Versorgung einer elektrischen Last mit elektrischer Leistung	dual use
199905262	VERFAHREN ZUR AUSGABE VON UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	dual use
199905276	SICHERES UMSCHALTEN DER H- ENDSTUFENSPEISESPANNUNGBEI MEHRFREQUENZ- FERNSEHGERAETEN ODER MULTISYSNO.	single use
199905277	CURRENT SENSE AMPLIFIER IN MOS SPEICHERN	single use
199905287	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR OPTIMALEN SIMULTANENDARSTELLUNG VON VIDEO UND GRAFIKDATEN	dual use
199905307	RETROGRADES KOLLEKTORPROFIL ZUR OPTIMIERUNG VONINTEGRIERTEN HF-TRANSISTOREN	single use
199905312	DRAM Zellanordnung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
199905313	Verfahren zur Herstellung eines ferroelektrischen Kondensators und ferroelektrischer Kondensator	single use
199905315	ERHOEHUNG DER SICHERHEIT DER DATEN IN EINEM DREI- DIMENSIONALEN CHIP DURCH VERTEILUNG DER INFORM....	dual use
199905317	AUSFAHRBARER FT SENSOR IM GEHAUSEFORMAT PCMCIA TYP 1 ODER TYP 2	dual use
199905325	FREIGABEVERFAHREN	single use
199905329	VERGROESSERUNG DER KOPPELKAPAZITAET BEI ELEKTRI- SCHEN DIPOLEN	single use
199905335	SOLBRUCHSTELLEN IM MODUL	single use
199905339	DESIGNAENDERUNG FUEER DIFFUSIONSPROGRAMMIERTES ROMBEI C9N-TECHNOLOGIE	single use
199905352	VERBESSERTE DYNAMISCHE SPEICHERUNG IN CMOS-LOGIK- TECHNOLOGIE	single use
199905358	Lithographieverfahren und Maske zu dessen Durchfuehrung.	single use
199905359	VERFAHREN ZUR SICHERUNG VON WERTSCHAFTETENINFORMATIONEN	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 179 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199905363	Herstellungsverfahren einer oxidationsgeschützten Elektrode fuer eine kapazitive Elektrodenstruktur.	single use
199905370	Verfahren zur Herstellung einer Metallschicht mit einer vorgegebenen Dicke.	single use
199905374	Mikroelektronische Struktur und Verfahren zu dessen Herstellung.	single use
199905379	AKTIVE LATCH-UP SCHUTZSCHALTUNG	single use
199905393	ABSICHERUNG DES KORREKTEN TEILUNGSVERHAELTNISSES FUEER STROMSPIEGELSENSOREN	single use
199905395	Laterales Hochvolt-Halbleiterbauelement mit reduziertem spezifischen Einschaltwiderstand	single use
199905810	Verfahren zur Herstellung einer Struktur in einem Substrat mittels einer Hartmaske.	single use
199905811	Verfahren zur Herstellung einer Hartmaske	single use
199905842	VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR KOMPENSATION VON ECHOS BEI DER DISKRETEN MULTITONMODULATION	dual use
199905849	MODELLIERBARER FOLIENSSENSOR	dual use
199905853	FBGA-GEHAUE MIT RAHMEN ALS HEATSINK	dual use
199905856	Datenspeicher und Verfahren	single use
199905864	Integrierter dynamischer Halbleiterspeicher mit zeitlich gesteuertem Lesezugriff	single use
199905865	INTEGRIERTER POLYWIDERSTAND MIT GERINGEM PLATZBEDARF	single use
199905880	Prozessanlage und Prozessverfahren zur Montage von Leadframes	dual use
199905884	Verfahren zum Schuetzen des Frequenzversatzes eines CPFSK-Signals	single use
199905888	SPULENANORDNUNG UND BETRIEBSWEISE FUEER GROSSEREICHWEITE BEI INDUKTIVEN SYSTEMEN	dual use
199905891	Nichtfluechtige NOR-Halbleiterspeichereinrichtung und Verfahren zu deren Programmierung	single use
199905892	Anordnung und Verfahren zur Kontaktierung von Schaltkreisen	dual use
199905900	MONITORING OF ARCING WITH INLINE EQUIPMENT DATA	single use
199905923	VERTIKALE DYNAMISCHE SELBSTVERSTAERKENDE SPEICHER- ZELLE MIT GERINGEM FLAECHENBEDARF	single use
199905964	Verfahren zur Herstellung eines Ball-Grid-Array-Gehaeuses und Ball-Grid-Array-Gehaeuse	single use
199907405	Improved Contact And Deep Trench Patterning	single use
199907418	System and Method For Determining Yield Impact For Semiconductor Devices	single use
199907421	SPEED UP OF VITERBI DECODING BY MEANS OF PARALLELISM	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 180 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199907427	SYSTEM AND METHOD FOR NOISE CANCELLING IN A CMOS IMAGE SENSOR	single use
199907438	ON-CHIP DEBUG SYSTEM	single use
199907440	Improved Sense Amplifier	single use
199907441	Improved Driver Circuit	single use
199907443	Light Absorption Layer On Top Of Damascene Al Fuse Structures	single use
199907445	Delay-Locked-Loop (DLL) Having Symmetrical Rising And Falling Clock Edge Type Delays	single use
199907447	Formation Of Controlled Trench Top Isolation Layers For Vertical Transistors	single use
199907451	FIELD-SHIELD-TRENCH ISOLATION FOR GIGABIT DRAMS	single use
199907452	SHOPPER PROXIMITY SENSOR AND MESSAGE INITIATION	dual use
199907457	Hierarchical Prefetch In DRAM	single use
199907458	Dynamic Logic Circuit	single use
199907460	Improved Top Layer Imaging Lithography For Semiconductor Processing	single use
199907461	CORRELATION BASED OPTICAL RANGING AND PROXIMITY DETECTOR	dual use
199907465	USE OF DUMMY POLY SPACERS AND DIVOT FILL TECHNIQUES FOR DT-ALLIGNED PROCESSING AFTER STI FORMATION FOR ADVANCED DEEP TRENCH CAPACITOR DRAMS	single use
199907467	Vertical Fuse And Method Of Fabrication	single use
199907469	Crack Stop Between Neighboring Fuses For Protection From Fuse Blow Damage	single use
199907472	An Improved System And Method For Automated Defect Inspection Of Photomasks	single use
199907482	Dual Work Function CMOS Device	single use
199907484	Method For Connecting Portions Within A Semiconductor Device	single use
199907490	Synchronized Data Capturing Circuits Using Reduced Voltage Levels And Methods Therefor	single use
199907491	Current Source	single use
199907492	Timer Circuit For Data Synchronization	single use
199907494	Extrusion Enhanced Mask For Improving Window	single use
199907498	Improved CMP Uniformity	single use
199907501	Memory Cell Layout For Reduced Interaction Between Storage Nodes And Transistors	single use
199907506	High-Performance DRAM And Method Of Manufacture	single use
199907508	Improved Skew Pointer Generation	single use
199907509	Frequency Range Trimming For A Delay Line	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 181 von 186

J:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199907511	Capacitor Trench-Top Dielectric For Self-Aligned Device Isolation	single use
199907512	Dynamic Random Access Memory	single use
199907514	Semiconductor Structures And Manufacturing Methods	single use
199907518	In-Situ Method For Preparing And Highlighting Of Defects For Failure Analysis	single use
199907528	Stacked Capacitor Memory Cell And Method Of Manufacture	single use
199907529	System And Method For Compensating Wafer Parameters	single use
199907531	System And Method For A Dual Bandwidth Capacitor Multiplying Filter	single use
199907532	Pulse Width Detection	single use
199907533	System And Method For Reducing Corner Rounding In Mask Fabrication	single use
199907534	Synchronization Scheme For Multiple Chip Configurations With One VCO	single use
199907536	Method Of Improving The Etch Resistance Of Chemically Amplified Photoresists By Introducing Silicon After Patterning	single use
199907566	Shallow Trench Isolation (STI) With Bilayer Of Oxide-Nitride For VLSI Applications	single use
199907567	Improved Process For Buried-Strap Self-Aligned To Deep Storage Trench	single use
199907568	Dynamic-Latch-Receiver With Self-Reset Pointer	single use
199907569	Manufacturing of Cavity-Fuses on GC Level	single use
199907570	Metal Wire Fuse Structure With Cavity	single use
199907571	AIR GAP BETWEEN FUSES TO CONFINE PASSIVATION CRACKING DURING LASER FUSING	single use
199907621	Non-Destructive Method And Device For Measuring The Depth Of A Recessed Material	single use
199908001	Integrierter Schaltkreis	single use
199908002	Fertigungsanlage	single use
199908007	Lesegeraet fuer tragbare Datentraeger	single use
199908011	Analoges Echofilter	dual use
199908014	Vorrichtung und Verfahren zur Geraeuscherdrueckung inFernsprecheinrichtungen	dual use
199908026	Verfahren zum Verbinden eines Anschlussdrahtes mit einem Anschlusskontakt eines integrierten Schaltkreises.	dual use
199908027	Elektrische Schaltung sowie Verfahren zu deren Herstellung.	single use
199908029	Bauelement.	single use
199908041	ULTRAFLACHE KAMERA ZUR INTEGRATION IN CHIPKARTENUND ANDERE MOBILE GERAETE SOWIE ZUR UNAUFFAELL....	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 182 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199908050	LEITSTAND	single use
199908051	FLAECHENDECKENDES TRANSPORTSYSTEM	single use
199908052	MODULARES FERTIGUNGSZELLENKONZEPT	single use
199908053	AMPELPRINZIP	single use
199908063	VARIABLE LOSGROESSE IN DER FERTIGUNG	single use
199908069	FREQUENCY HOPPING STRATEGIES FOR WDCT	dual use
199908072	RECONFIGURABLE RISC (RRISC-ARCHITEKTUR)	single use
199908083	Elektrisch-mechanische Verbindung zwischen elektronischen Schaltungssystemen und Substraten sowie Verfahren zu deren Herstellung.	dual use
199908084	Loetmittel zu Verwendung bei Diffusionsloetprozessen sowie Verfahren zur Herstellung von Loetverbindungen unter Verwendung des Loetmittels.	dual use
199908094	UNIVERSAL CONFIGURABLE BLOCKS	single use
199908096	Arrangement and method for manually moving a container for storing objects through an environment	single use
199908102	Mechanischer Resonator fuer Rotationssensor	dual use
199908107	Eventscheduler und Verfahren zur Zerlegung von ereignisorientiertem Programmcode.	dual use
199908117	KUEHLUNG VON EINZELNEN BLOECKEN EINES ICS	dual use
199908152	Methode zur Ausrichtung der Polarisierung von ferroelektrischen Materialien, insbesondere SBT	single use
200001002	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES LEITBAHN- UND KONTAKTSYSTEMS FUEER INTEGRIERTE SCHALTKREISE MIT ...	single use
200001006	UEBERWINDUNG VON CHIPFLAECHEEN-LIMITIERUNGEN DURCHDREIDIMENSIONALE INTEGRATION	dual use
200001007	JUSTIERMARKE FUEER METALLEBENEN	dual use
200001009	STROMPROFIL-VERSCHLEIERUNG BEI CACHE-ZUGRIFFEN INSICHERHEITS-ICS	single use
200001011	CHIP IDENTIFICATION SYSTEM (EINDEUTIG IDENTIFIZIERBARER CHIP) "CHIP MIT FINGERABDRUCK"	dual use
200001032	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR AKQUISITION VONBANDGESPREIZTEN SIGNALEN IM MOBILFUNK	dual use
200001035	HETEROSTRUKTUR-IGBT MIT NIEDRIGER DURCHLASSSPANNUNG	single use
200001037	Verfahren und Schaltungsanordnung zur Grafikdarstellung, insbesondere in einem digitalen Fernsehgeraet	single use
200001039	TECHNOLOGIEABHAENGIGE KOPPELELEMENTE FUEER MIXEDSIGNAL-ANALOG/DIGITALKOPPLUNG	single use
200001058	SCHALTNETZTEIL-BURSTBETRIEB MIT RUECKMELDUNG	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 183 von 186

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

200001059	LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT AKTIVER ZENERUNG BEI DEM DIE DURCHBRUCHSPANNUNG UNABHÄNGIG VON...	single use
200001073	SCHUTZVORRICHTUNG GEGEN STATISTISCHE ANALYSEN BEISICHERHEITSENSITIVEN OPERATIONEN	single use
200001077	UEBERTRAGUNG VON ZUFALLSZAHLN SOLANGE SIGNAL-LEITUNGEN ZUR UEBERTRAGUNG NICHT GENUTZT WERDEN	dual use
200001083	ANLAUFSCHALTUNG FÜR DAS PROZESSORGESTEUERTESCHALTNETZTEIL	single use
200001090	VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR LEISTUNGSREGELUNG IMMOBILFUNKSYSTEMEN MIT CODEMULTIPLEX	dual use
200001094	OPTISCHES SMD MIT UP-SIDE-DOWN MONTIERTENSUBMOUNTS.	single use
200001099	VORRICHTUNG ZUR ERFASSUNG EINES DREHWINKELS MIT BELIEBIG GROSSER PRÄZISION BZW. ZUR UMWANDLUNG...	dual use
200001101	DOUBLE-HEATSINK-DIODE IM SMD-GEHÄUSE	single use
200001108	Treiberschaltung.	single use
200001203	Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauelementes mit Silizium-Traegersubstrat	single use
200001221	Vorrichtung für die Emission elektromagnetischer Strahlung und Verfahren zu deren Herstellung	single use
200001223	Verfahren und Anordnung zur gegenseitigen Authentifizierung zweier Datenverarbeitungseinheiten	single use
200001243	Schaltungsanordnung und Verfahren zum Betrieb eines Fingerabdrucksensors.	single use
200001246	Fingerabdrucksensor und Betriebsverfahren	single use
200001249	Verfahren zur Schätzung von Kanalparametern von Funkkanälen eines W-CDMA-Mobilfunksystems	dual use
200001373	Integrierter Speicher mit Plattenleitungssegmenten	single use
200001399	Schreib-/Leseverstärker mit Vertikaltransistoren für DRAM-Speicher	single use
200001403	Verfahren zum Einsatz eines Fingerabdrucksensors	single use
200001421	Programmgesteuerte Einheit	dual use
200001433	Berührungsschaltfeld	single use
200001489	Integrierte DRAM-Speicherzelle sowie DRAM-Speicher	single use
200001500	Testumgebung und Verfahren zum Testen von Systemen	single use
200001520	Vertikalresonator-Laserdiode mit komplanaren elektrischen Anschlusskontakten	single use
200001560	Systemträger für einen Halbleiterchip mit einem Leiterraum	single use
200001587	Vorrichtung zum Herstellen einer Vielzahl von Bondverbindungen	dual use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien, korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 184 von 186

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte



Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

200001595	Optisches Modul zur Wellenlaengen-Referenzmessung in WDM-Systemen	single use
200001597	Verfahren zur Herstellung eines Trenchkondensators	single use
200001647	Gehaeusebaugruppe fuer ein elektronisches Bauteil	dual use
200001679	Testanordnung zur Funktionspruefung eines Halbleiterchips	single use
200001702	Verfahren zur Uebermittlung von Informationen durch Datenpakete und Netzwerk zur Uebermittlung von Daten	dual use
200001708	Elektronisches Bauteil mit mikroskopisch kleinen Kontaktflaechen und Verfahren zu seiner Herstellung	single use
200001969	Vorrichtung und Verfahren zum Durchfuehren eines Viterbi-Algorithmus	dual use
200004001	BIDIWDM-PAROLI	single use
200004003	MISCHPHASENMASKE FUER DIE PROJEKTIONSFOTOLITHOGRAFIE ZUR VERBESSERUNG DER STRUKTURABBILDUNGSQUALI..	single use
200004031	Verfahren zur Herstellung einer ferroelektrischen Kondensatoranordnung	single use
200004034	Verfahren zum Auffuellen von Vertiefungen in einer Oberflaeche einer Halbleiterstruktur und eine auf diese Weise aufgefuellte Halbleiterstruktur	single use
200004044	Verfahren zur Herstellung einer Leiterstruktur fuer einen integrierten Schaltkreis	single use
200004077	MRAM-Speicher	single use
200004106	Verfahren zum Aetzen	single use
200004114	DRAM-SPEICHERZELLE FUER DRAM-SPEICHERVORRICHTUNG UND DEREN HERSTELLUNGSVERFAHREN.	single use
200004115	Verfahren zum Aetzen einer Isolierschicht eines Bauelements	single use
200004119	Verfahren zur Herstellung einer Barrierschicht	single use
200004125	Verfahren zur Herstellung eines Feldeffekttransistors mit einem Floating Gate	single use
200008001	A handling device and method for moving a pod	single use
200011910	Elektronisches Bauteil aus einem Gehäuse und einem Substrat	single use
200012820	Lithografisches Belichtungs- und Strukturierungsverfahren unter Verwendung einer Antireflexionsschicht	single use
200013369	Elektronisches Chipbauteil mit einer integrierten Schaltung und Verfahren zur Herstellung	single use
200014614	TEMPERVERFAHREN ZUR AUSHEILUNG VON AETZSTRUKTURSCHAEDEN BEI FERROELEKTRISCHEN KERAMISCHEN DUE..	single use
200014806	Regelsystem für photolithographische Prozesse	single use
200014889	Simulator zur Simulation von Ereignissen und Verfahren zur Simulation von Ereignissen	single use
200015517	Integrierte Halbleiteranordnung	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
 korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
 Seite 185 von 186

J:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

**Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte****Aufgeführte Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingebracht.**

200015823	Siegel zur Authentifizierung von versiegelten Objekten und Verfahren zur Herstellung und Prüfung der Siegel	single use
200015967	Integrierter Halbleiterspeicher	single use
200016150	Detektorschaltung	single use
200016764	Magnetoresistiver Speicher und Verfahren zu seinem Auslesen	single use
200016880	Magnetoresistiver Speicher und Verfahren zu seinem Auslesen	single use
200017086	A NOVEL METAL ETCH PROCESS FOR ADVANCED SEMICONDUCTOR METALLIZATION	single use
200019527	Verfahren zur Strukturierung von Metallschichten	single use

Diese Liste enthält die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeführten Schutzrechtsfamilien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001.

CPC IC
Seite 186 von 186

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:09

SIEMENS RECHTSABT MCH M

+49 89 722 48877

S.22

30-APR 10:35 DI UON:ZFR 1 MCH/M

+49 89 234 32882

ANK:VEICKSTEDT

SEITE:35

DRNR.

Dr.A

Einbringungsvertrag

zwischen der

Siemens Aktiengesellschaft,
Berlin und München,
- nachstehend "Siemens" genannt -

und der

Infinson Technologies AG i.Gr., München,
- nachstehend "Infineon" genannt -

Heute, den einunddreißigsten März
neunzehnhundertneunundneunzig
- 31. März 1999 -
erschieden vor mir,

Dr. Manfred A s a m ,

Notar mit dem Amtssitz in München, an der Geschäfts-
stelle in 80333 München, Residenzstraße 25-26 II;

- 1) a) Herr Niels H a r t w i g ,
Rechtsanwalt in Tutzing
geschäftsmässig in 80333 München,
Finkenstraße 10,

b) Herr Michael v o n E i c k s t e d t ,
Rechtsanwalt in Planegg,
geschäftsmässig in 81379 München,
Hofmannstraße 51,

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 200/235

Fax Server

J:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:09

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48077

S.03

30-MRZ 10:35 DI

VON:ZFR 1 MCHPW

+49 89 234 32002

AN:UEICKSTEDT

SEITE:36

- 2 -

beide mir, Notar, persönlich bekannt,

nach ihrer Erklärung hier h a n d e l n d
nicht im eigenen Namen, sondern für die

Siemens Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Berlin und München,

(Zuschriften: 80312 München,
z.Hd. Hr. Hartwig)

und zwar zugleich aufgrund Vollmacht vom 3. Dezem-
ber 1998 und Untervollmacht vom 29. März 1999,
die jeweils heute in Urschrift vorgelegt wurden
und dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift
beigefügt sind;

hierzu bescheinige ich, Notar, nachdem das Han-
delregister des Amtsgerichts München HRB 5684 am
29. März 1999 eingesehen worden war, daß die
Herren Hartwig und von Eickstedt als Prokuristen
zur gemeinschaftlichen Vertretung der vorgenann-
ten Gesellschaft berechtigt sind;

2) a) Herr Dr. Ulrich S c h u e s s e r ,
Diplom-Ingenieur in Starnberg.

b) Herr Peter F i s c h l ,
Industriekaufmann in Murnau,

beide geschäftsansässig in 81541 München,
St.-Martin-Straße 53,
mir, Notar, persönlich bekannt,

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 201/235

Fax Server

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

22-APR-1999 15:09

SIEMENS RECHTSABT MCH M

+49 89 722 48877

S.04

30-MRZ 10:35 DI VON:ZFR I NOV-W

+49 89 234 32822

AN:UEICKSTEDT

SEITE:37

- 3 -

nach ihrer Erklärung hier h a n d e l n d
nicht im eigenen Namen, sondern als Vorstandsmit-
glieder für die mit Urkunde Nr. A/1999 des
Notars Dr. Manfred Asem in München gegründete

Infineon Technologies AG

mit dem Sitz in München

(Zuschriften: 81541 München, St.-Martin-Str. 53);

beglaubigte Abschrift des die Bestellung dieser
Herren zu gemeinschaftlich vertretungsberechtig-
ten Vorstandsmitgliedern der in Gründung befindli-
chen Aktiengesellschaft ausweisenden Protokolls
über die konstituierende Aufsichtsratsitzung vom
30. März 1999 ist dieser Urkunde beigelegt.

Auf Ansuchen der Erschienenen beurkunde ich ihren
bei gleichzeitiger Anwesenheit vor mir abgegebenen
Erklärungen entsprechend folgenden

E i n b r i n g u n g s v e r t r a g

Präambel

Mit Urkunde des Notars Dr. Manfred Asem in München
Nr. A/1999 haben die Siemens Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Berlin und München (nachstehend
"Siemens" genannt) und die Siemens Nederland N.V.
mit dem Sitz in Den Haag (in folgenden als "Siemens
Nederland" bezeichnet) am 30. März 1999 die Infineon
Technologies AG mit dem Sitz in München (nachstehend
als "Infineon" bezeichnet) errichtet.

PATENT

REEL: 024120 FRAME: 0219

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 202/235

Fax Server

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:10

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48077

5.05

30-APR 10:35 01 MON:ZFR 1 MCH/W

+49 89 234 32982

MUNICH/STEDT

SEITE:38

- 4 -

Siemens hat dabei als Gründerin 80.912.544 nennbe-
tragslose Stückaktien an der Infineon ohne Übernahme
einer Aufgeldverpflichtung gegen Sacheinlage durch
Einbringung ihrer Aktivitäten im Bereich Halbleiter
übernommen.

§ 1

Gegenstand der Einbringung

1. Siemens bringt mit wirtschaftlicher Wirkung zum
01.04.1999, 00:00 Uhr, (nachstehend "Stichtag"
genannt), ihre gesamten Aktivitäten im Bereich
Halbleiter mit dem ausschließlich diesen Aktivitä-
ten dienenden Vermögen, wie in diesem Vertrag
näher beschrieben (nachfolgend insgesamt "Teilbe-
trieb" genannt), zur Leistung ihrer Sacheinlage im
Weg der Einzelrechtsnachfolge in das Vermögen
der Infineon ein.
2. Die Einbringung des Teilbetriebs erfolgt zu den
nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelten
Buchwerten nach Maßgabe der für den eingebrachten
Teilbetrieb auf den Stichtag unter Beibehaltung
der bisherigen und bei der Erstellung der nach-
genannten vorläufigen Einbringungsbilanz angewen-
deten Bilanzierungsgrundsätze aufzustellenden und
von einem Wirtschaftsprüfer zu bestätigenden
endgültigen Einbringungsbilanz (nachfolgend
"Stichtagsbilanz"). Da diese Bilanz derzeit noch
nicht vorliegt, erfolgt die Einbringung zunächst
auf Grundlage einer auf den 28.02.1999 aufgestell-
ten vorläufigen Einbringungsbilanz, die dieser

PATENT

REEL: 024120 FRAME: 0220

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 203/235

Fax Server

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

28-APR-1999 15:10

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 45077

5.06

30-MRZ 10:36 01 VON:ZFR : MCH/W

+49 89 234 33062

AN:UEICKSTEDT

SEITE:39

- 5 -

Urkunde als Anlage A beigelegt ist. Hieraus ergibt sich ein vorläufiger Buchwert (Reinvermögen) der Einbringung von DM 736.126.717,--, das entspricht (gerundet auf volle Cents)
EUR

Die Beteiligten verpflichten sich zur unverzüglichen Aufstellung der Stichtagsbilanz und deren Übergabe an den vertretenden Notar im Rahmen einer Nachtragsverhandlung zu gegenwärtiger Beurkundung samt zugehöriger Anhänge.

Der von Siemens laut Satzung der Infineon vom 30.09.1999 im Wege der Sacheinlage aufzubringende Betrag von EUR 161.825.088,--, wird gegen Ausgabe von 80.912.544 Nennbetragelosen Stückaktien geleistet. Der den von Siemens aufzubringenden Betrag übersteigende Buchwert der Sacheinlage gemäß vorläufiger Einbringungsbilanz wird der Kapitalrücklage der Infineon zugeführt.

Ergibt die Stichtagsbilanz einen gegenüber dem Buchwert der Einbringung laut vorläufiger Einbringungsbilanz abweichenden Buchwert der Sacheinlage, so ist die Zuführung zur Kapitalrücklage entsprechend zu berichtigen und gegebenenfalls ein Fehlbetrag gegenüber dem aufzubringenden Betrag in der einzulegen.

Die Infineon wird die ertragsteuerlichen Buchwerte gemäß § 20 UmwStG in ihre Steuerbilanz übernehmen und fortführen.

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:10

SIEMENS RECHTSABT MOH H

+49 89 722 48877

S. 37

30-APR-1999 10:36 DI VON: ZFR 1 MOH H

+49 89 234 32882

MUNICH

SEITE: 40

- 5 -

3. Eingbracht werden alle diejenigen Vermögensgegenstände, die ausschließlich dem eingebrachten Teilbetrieb zugehören oder sich darauf beziehen, auch wenn sie in diesem Vertrag oder seinen Anlagen nicht ausdrücklich aufgeführt sind.

§ 2

Kinbringung von beweglichem Sachanlagevermögen und Umlaufvermögen

1. Siemens bringt das ausschließlich dem in § 1 genannten Teilbetrieb dienende bewegliche Sachanlagevermögen (in der Stichtagsbilanz auszuweisen als "bewegliche Sachanlagen" und genauer zu beschreiben im Anhang 1 zur Stichtagsbilanz) ^{des} dieses Teilbetrieb dienende Umlaufvermögen (in der Stichtagsbilanz auszuweisen als "Umlaufvermögen" und genauer zu beschreiben im Anhang 2 zur Stichtagsbilanz) mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag in die Infineon ein.
2. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, daß das Eigentum und die sonstigen Rechte an den in Abs. 1 genannten Gegenständen mit Wirkung zum Stichtag auf die Infineon übergehen. Siemens wird die Infineon unverzüglich in den Besitz dieser Gegenstände versetzen. Soweit eingebrachte Gegenstände sich im Besitz von Dritten befinden, wird die Übergabe dadurch ersetzt, daß Siemens hiermit die Herausgabeansprüche mit sofortiger Wirkung an die Infineon abtritt. Die Infineon nimmt diese Abtretung an. Soweit an den von der Überweisung erfaßten Gegenständen Eigentumsvorbehaltsrechte

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:11

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 46077

S.003

30-APR 10:36 DI VON: ZFR 1 MCH/M

+49 89 224 32882

DN: WEIDENSTEDT

SEITE: 41

- 7 -

oder andere Sicherungsgrechte Dritter bestehen, werden die entsprechenden Anwartschaftsrechte auf die Infineon übertragen.

3. Siemens tritt hiermit alle in der Stichtagebilanz ausgewiesenen Forderungen mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag an die Infineon ab. Die Infineon nimmt diese Abtretung an.
4. Soweit eine rechtswirksame Übertragung der in Abs. 1 bis Abs. 3 genannten Gegenstände zum Stichtag nicht möglich ist, werden sich die Vertragsparteien im Innenverhältnis so stellen, als wäre die Übertragung mit Wirkung zum Stichtag erfolgt. Wenn und soweit die Übertragung des Eigentums, der Forderungen oder sonstiger Rechte noch besonderer Rechtshandlungen bedarf, werden die Vertragsparteien diese unverzüglich vornehmen.

§ 3

Einbringung von Grundstücken

1. Grundbuchbeschriftung

- 1.1. Laut Vortrag im Grundbuch des Amtsgerichtes Regensburg

Band 280 Blatt 8715

ist Siemens (noch eingetragen unter ihrer vorrealigen Firma Siemens und Helke Aktiengesellschaft) Alleineigentümerin des folgenden Grundstücks der

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 206/235

Fax Server

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:11

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48077

S.05

30-MRZ 10:37 01 UCN:2FR 1 MCH/W

+49 89 234 32882

AN:WEICKSTEDT

SEITE:48

- 8 -

Gemarkung R e g e n s b u r g

Flurstück 3972 Wernerwerkstraße 2,
Gebäude- und Freifläche
zu 19,9129 ha,

welches lediglich in Abteilung II, und zwar
wie folgt belastet ist:

lfd. Nr. 1:

Auflösungsvormerkung für die Stadt Regens-
burg; gemäß Bewilligung vom 25. November
1959, eingetragen am 14. September 1960 im
Gleichrang mit Abt. II Nr. 2

lfd. Nr. 2:

Kanalbelassungsrecht, Kanalüberbauungsverbot
und Zugangs- und Zufahrtsrecht für die Stadt
Regensburg; gemäß Bewilligung vom 13. Novem-
ber 1959 eingetragen im Gleichrang mit Abt.
II Nr. 1

lfd. Nr. 3:

Abwasser-Ableitungsrecht für den jeweiligen
Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 3827/13
und 3827/14; gemäß Bewilligung vom 29. Au-
gust 1960 im Gleichrang mit Abt. II Nr. 4

lfd. Nr. 4:

Böschungsfuß-Bildungsverpflichtung zugunsten
des jeweiligen Eigentümers der Grundstücke

PATENT

REEL: 024120 FRAME: 0224

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

28-APR-1999 15:11

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48077

9.10

30-APR 10:37 DI

VON:ZFR 1 MCH/H

+49 89 234 38882

AN:VEICKSTEDT

SEITE:43

- 2 -

Fl.Nr. 3827/13 und 3827/14: gemäß Bewilligung vom 29. August 1960 im Gleichrang mit Abt. II Nr. 3

lfd. Nr. 10:

Kanalrecht für die Stadt Regensburg: gemäß Bewilligung vom 03.07.1986

lfd. Nr. 15:

Auflassungsvorwerkung bezüglich Teilfläche von 292 qm und 583 qm für Stadt Regensburg: gemäß Bewilligung vom 03.11.1993

lfd. Nr. 16:

Auflassungsvorwerkung bezüglich Teilfläche von 8.594 qm (VN 944) - Anspruch bedingt - für die Stadt Regensburg: gemäß Bewilligung vom 29.09.1987 und 03.11.1993.

Wegen des Nachweises der Änderung der Firma der Grundstückseigentümerin in nunmehr "Siemens Aktiengesellschaft" wird auf die dieser Urkunde lediglich zu Beweiszwecken in beglaubigter Abschrift beigelegte Bescheinigung des Amtsgerichts Charlottenburg vom 23. Juli 1991 verwiesen.

1.2. Laut Vortrag im Grundbuch des Amtsgerichtes München von

G i e s i n g

Band 718 Blatt 22139

ist Siemens Alleineigentümerin des dort lastenfrei vorgetragenen Grundstückes der

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 208/235

Fax Server

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:12

SIEMENS RECHTSABT MOH H

+49 89 722 48877

S.11

10-MRZ 10:37 DI VEN:2FR 1 MON/W

+49 89 234 32882

ANLEICHSTEXT

SEITE:44

- 10 -

Gemarkung München (Haidhausen)

Flurstück 16355 Mainstraße 73,

Fabrikanlage, Hofraum

zu

4.3575 ha.

2. Siemens bringt das im vorstehenden Absatz 1.1. näher bezeichnete Grundstück - wirtschaftlich mit Ausnahme der in dem dieser Urkunde als Anlage A beigelegten Lageplan schraffierten und rot umrandeten Flächen -, ~~Siemens durch nachfolgende das dort näher bezeichneten Veränderungswünsche~~ ~~aus-schreiben-wird~~, mit allen Rechten und Bestandteilen, insbesondere mit den darauf befindlichen Gebäuden und Nebengebäuden sowie sonstigen baulichen Anlagen, zum Stichtag in die Liniennetze ein.

Desweiteren bringt Siemens das im vorstehenden Absatz 1.2 näher bezeichnete Grundstück insoweit mit allen Rechten und Bestandteilen, insbesondere mit den darauf befindlichen Gebäuden und Nebengebäuden sowie sonstigen baulichen Anlagen, zum Stichtag in die Liniennetze ein, als es sich innerhalb der in dem dieser Urkunde als Anlage C 1 beigelegten Lageplan farblich markierten Fläche befindet. Es handelt sich dabei um eine Teilfläche von ca. 9.350 m².

3. Die Übereinstimmung oder ein bestimmtes Maß der Annäherung von Messungsergebnis und angenommenen Flächengröße ist nicht Geschäftsgrundlage dieses Vertrages.

PATENT

REEL: 024120 FRAME: 0226

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 209/235

Fax Server

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:12

SIEMENS RECHTSABT MCH H

149 89 722 48277

9.12

30-APR 18:37 DI KON:2FR 1 MO+M

149 89 234 32992

AN:WEICKSTEDT

SEITE:45

- 12 -

Der laut 2. eingebrachte Grundbesitz ist Siemens und Infineon (nachfolgend "Vertragsparteien" genannt) in der Natur nach Lage, Größe und Gestalt genau bekannt.

Für die Größe der eingebrachten Teilfläche ist nicht das genannte geschätzte Maß, sondern die Einzeichnung im Lageplan maßgeblich. Die Übereinstimmung oder ein bestimmter Grad der Annäherung von Messungsergebnis und vorstehend angenommener Flächengröße ist nicht Geschäftsgrundlage dieses Vertrages.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, unverzüglich nach Eingang des für das Grundbuchamt bestimmten Auszugs aus dem Veränderungsnachweis beim Notar das Messungsergebnis in einer Nachtragsurkunde anzuerkennen und zur nachfolgenden Auflassung bezüglich der Teilfläche aus Flurstück 16355 eine Identitätserklärung abzugeben.

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, daß das Eigentum an Flurstück 3972 der Gemarkung Regensburg und an der aus Flurstück 16355 der Gemarkung München eingebrachten Teilfläche von Siemens auf Infineon übergeht.

Siemens bewilligt und Infineon

b e s t r a g t

die Eintragung der Rechtsänderungen im Grundbuch.

PATENT

REEL: 024120 FRAME: 0227

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:12

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48077

S.13

30-MRZ 10:38 DI VONZFR 1 MCH-W

+49 89 234 30002

AN: WEICKSTEDT

SEITE: 46

- 12 -

Zur Sicherung des Anspruchs von Infineon auf Übertragung des Eigentums an der aus Flurstück 16355 der Gemarkung München eingebrachten Teilfläche wird an diesem Stueckgrundstück von Siemens die Eintragung einer Vormerkung gemäß § 883 BGB von Siemens bewilligt und von Infineon

b e a n t r a g t .

Diese Vormerkung ist, was schon heute allseits bewilligt und beantragt wird, Zug um Zug mit Eigentumsumschreibung im Grundbuch zu löschen, vorausgesetzt, daß im Rang nach dieser Vormerkung nichts eingetragen ist.

Weiterhin gibt Infineon unter Bezugnahme auf den einschlägigen Veränderungsnachweis schon heute die nicht eingebrachte Restfläche von Flurstück 16355 frei und bewilligt den entsprechenden Grundbuchvollzug; vorsorglich wird in diesem Zusammenhang der antzierende Notar allseits ermächtigt, die freigegebene Fläche grundbuchsmäßig zu bezeichnen.

Hinsichtlich des eingebrachten Grundstückes Flurstück 3972 der Gemarkung Regensburg wird auf die Eintragung einer Vormerkung nach Belehrung über den damit verbundenen Sicherungszweck durch den Notar seitens der Infineon verzichtet.

4. Vollzugsmittlung wird für die Beteiligten und den Notar an den Notar erbeten.

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:13

SIEMENS RECHTSABT MOH H

+49 89 922 49077 5.14

30-MRZ 10:38 01 VON: ZFR 1 MOH/W

+49 89 234 32002

AN: VEICKSTEDT

SEITE: 47

- 13 -

Der antretende Notar wird allseits ermächtigt, ohne Beschränkung auf seine gesetzlich vermutete Vollmacht sämtliche Anträge aus dieser Urkunde - auch geteilt und beschränkt - zu stellen sowie alle Grundbucheintragungen abzuändern und zu ergänzen.

5. Die laut Absatz 1.1 in Abteilung II des Grundbuchs am eingebrachten Grundbesitz in Regensburg eingetragenen Belastungen werden mit Ausnahme der Vormerkung lfd.Nr. 1 von der Infineon unter Eintritt in alle sich aus den ihrer Eintragung zugrunde liegenden Bewilligungen und Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen zum Stichtag zur weiteren Duldung und Erfüllung übernommen, die Vormerkung lfd.Nr. 16 jedoch nur dann, wenn sie nicht auf erstes Ersuchen des antretenden Notars von der Berechtigten zur Löschung bewilligt wird.

Sämtlichen zur danach von Siemens geschuldeten Lastenfreistellung erforderlichen und geeigneten Erklärungen wird hierdurch mit dem Antrag auf Vollzug im Grundbuch allseits zugestimmt.

6. Der Besitz, die Gefahren und Haftungen aller Art, die Nutzungen und alle öffentlichen Lasten und Abgaben der gem. Abs. 2 eingebrachten Grundstücke gehen mit Wirkung zum Stichtag auf die Infineon über. Sämtliche im Hinblick auf die eingebrachten Grundstücke bestehenden Nutzungs- und sonstigen Vertragsverhältnisse werden zum selben Zeitpunkt von Infineon übernommen.

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

22-APR-1999 15:13

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48377

S.15

30-APR-1999 10:39 DI VON: ZFR 1 MCH/W

+49 89 234 32882

AN: VEICKSTEDT

SEITE: 48

- 14 -

7. Siemens leistet nur Gewähr für den ungehinderten Übergang von Eigentum und Besitz.
8. Hinsichtlich der Erschließungsbeiträge i.S. §127 Abs. 2 BauGB und Anliegerbeiträge einschließlich Kostenersatzungsansprüche nach Kommunalabgabenrecht haftet Siemens lediglich dafür, daß alle ihr bis heute bereits in Rechnung gestellten Maßnahmen bezahlt sind. Im übrigen treffen alle Kosten für Erschließungs- und Aufschließungsmaßnahmen im weitesten Sinne die Infitoren.
9. Weitergehende Gewährleistungs- bzw. Haftungsansprüche gegen Siemens sind ausgeschlossen. Siemens haftet insbesondere nicht für die Richtigkeit der im Grundbuch verlautbarten Flächenmaße, nicht für Sebaubarkeit, nicht für Bodenbeschaffenheit und Verwertbarkeit der in Abs. 1 genannten Grundstücke, nicht für einen bestimmten Bauzustand aufstehender Gebäude, ebenso wenig für die Freiheit von Asbest und sonstigen Sachmängeln aller Art. Darüber hinaus haftet Siemens nicht für etwaig im Boden, in Gebäuden, in sonstigen Grundstücksbestandteilen oder im Grundwasser vorhandene Verunreinigungen aller Art (z.B. durch wasser- oder sonstige umweltgefährdende Stoffe).
10. Trennung des Standorts im Sinne von Abs. 1.2
 - 10.1 Der vorstehend in Abs. 1.2 aufgeführte Grundbesitz ist mit dem restlichen Standort München Balanstraße (nachfolgend "MchB" genannt und in der dieser Urkunde beigelegten Anlage C 2 gelb schraffiert) hinsicht-

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 213/235

Fax Server

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:13

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48777

S.16

20-APR-1999 15:13 DI. MON:ZFR 1 MCH/H

+49 89 234 32002

AN:LEITOSTEDT

SEITE:49

- 15 -

lich der Infrastruktur vielfältig verbunden. Sobald Infineon einzelne Gebäude von MCHB oder MCHB insgesamt nicht mehr anmietet, und Ver- oder Entsorgungseinrichtungen, die zur Ver- bzw. Entsorgung des in 1.2 vor- genannten Grundbesitzes notwendig sind, einer Baurechtsentwicklung von MCHB hinderlich sind, verpflichtet sich Infineon gegenüber Siemens, die Ver- und Entsorgungseinrichtungen auf dem an sie hier eingebrachten Grundstücksteil von Flurstück 16353 zu verlegen und dieses Grundstück autark zu versorgen. Gleiches gilt, wenn MCHB an einen Dritten veräußert wird oder die Gesellschaftsanteile des jeweiligen Eigentümers von MCHB veräußert werden, und der Erwerber nicht bereit ist, die Versorgung des an Infineon aus Flurstück 16355 eingebrachten Grundbesitzes sicherzustellen. Infineon ist verpflichtet, die jeweiligen Maßnahmen möglichst bis zur Übergabe der nicht mehr angemieteten Teile von MCHB, spätestens innerhalb von zwei Jahren nach Zugang einer entsprechenden Aufforderung seitens des jeweiligen Eigentümers von MCHB in Abstimmung mit diesem vorzunehmen. Für die Mitnutzung der auf MCHB befindlichen Infrastruktureinrichtungen wird sich Infineon an den dafür entstehenden Kosten im Verhältnis der tatsächlichen Inanspruchnahme beteiligen.

10.2 Um die derzeit für die Versorgung der auf der vorstehend aus dem in 1.2 näher bezeichneten Grundstück eingebrachten Fläche be-

PATENT

REEL: 024120 FRAME: 0231

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:14

SIEMENS RECHTSABT MOH M

+49 89 722 48877

S.17

30-APR-10 10:39 01 KONZERN 1 MOH M

+49 89 234 30002

MUNICH/STEDT

SEITE: 50

- 16 -

findlichen Gebäude benötigten Medien abzrechnen zu können, werden die Vertragsteile die dafür erforderlichen Zähleranlagen installieren.

Die dafür aufzuwendenden Kosten trägt Infineon. Der Anteil der von Infineon zu tragenden Kosten für Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen von Versorgungseinrichtungen bestimmt sich nach dem Verhältnis von deren tatsächlicher Inanspruchnahme.

- 10.3 Desweiteren verpflichten sich Infineon und Siemens mit Wirkung für seine Rechtsnachfolger im Eigentum des bei MohB verbleibenden Grundbesitzes auf Verlangen des jeweils anderen Teils für die derzeitige oder künftige Nutzung von MohB bzw. der aus dem in 1.2 näher bezeichneten Grundstück eingebrachten Fläche notwendige Dienstbarkeiten und sonstige Rechte zu bewilligen und im Grundbuch zu sichern. Dienstbarkeitsbestellungen zugunsten Infineon müssen entsprechende Löschungsbewilligungen, hilfsweise Lösungsverpflichtungen, enthalten, die der Vereinbarung in vorstehend 10.1 Rechnung tragen.

Desweiteren verpflichtet sich Infineon, gegen die derzeitige und künftige Nutzung von MohB keine Einwände zu erheben. Siemens wird den jeweiligen Eigentümer von MohB verpflichten, gegen die derzeitige Nutzung auf dem vorstehend zur Flurstück 16355 eingebrachten Grundstücksteil keine Einwände zu erheben.

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

26-APR-1999 15:14

SIEMENS RECHTSABT MOH H

+49 89 722 40077

S.18

30-MRZ 10:39 DI VON:ZFR 1 MOH/H

+49 89 234 32382

AN:WEICKSTEDT

SEITE:51

- 17 -

10.4 Soweit für die Durchführung der Teilung die Bestellung von Dienstbarkeiten oder sonstigen Rechten notwendig wird, verpflichten sich die Vertragsparteien einvernehmlich zusammenzuwirken und die entsprechenden Erklärungen in der notwendigen Form ~~abzugeben~~^{abzugeben} zu geben.

10.5 Alle mit der Teilung der Grundstücke entstehenden Kosten trägt Infineon.

10.6 Infineon und Siemens verpflichten sich gegenseitig, alle vorstehend von ihnen übernommenen Verpflichtungen an künftige Sonderrechtsnachfolger im Eigentum der betreffenden Grundstücke weiterzugeben.

11. Regelungen zum Standort Regensburg

11.1 Infineon wird gegen die derzeitige und gegen künftige Nutzungen des an den Standort Regensburg Wernerwerkstraße anschließenden Rennplatzes keine Einwände erheben.

Siemens wird den jeweiligen Eigentümer des Rennplatzes verpflichten, seinerseits gegen die derzeitige Nutzung des Standortes Regensburg Wernerwerkstraße keine Einwände zu erheben.

11.2 Infineon verpflichtet sich, mit den auf dem Standort Regensburg Wernerwerkstraße ansässigen Bereichen von Siemens Mietverträge

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

22-APR-1999 15:14

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48077

S.19

31-APR-1999 13:58

NOTARIAT PÖLSTERL U. ASAM

+49 89 27092222

S.01

- 18 -

auf der Basis der derzeitigen Nutzungskonditionen abzuschließen.

§ 4

Einbringung immaterieller Wirtschaftsgüter

1. Soweit hierzu berechtigt, überträgt Siemens die in der beigefügten Anlage II aufgeführten, am 26. März 1999 bestehenden bzw. angemeldeten Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographieschutzrechte, die in der beigefügten Anlage I aufgeführten, am 26. März 1999 bestehenden bzw. angemeldeten Marken sowie ihre Copyrights (nachfolgend insgesamt "Schutzrechte" genannt) mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag auf die Infineon. Die Infineon nimmt die Übertragung an. Siemens wird die für die Übertragung der Schutzrechte erforderlichen Erklärungen, Erläuterungen und Unterschriften gegenüber den zuständigen Behörden und Gerichten abgeben. Sofern für die Übertragung der Schutzrechte die Zustimmung Dritter erforderlich ist, wird Siemens diese Zustimmung einholen. Wenn diese Zustimmung nicht erteilt wird, wird Siemens sich darum bemühen, daß die Infineon an dem betreffenden Schutzrecht ein Verwertungsrecht erhält, und zwar in dem Umfang, wie er sich aus Abs. 5 ergibt. Andere oder weitergehende Ansprüche gegen Siemens sind hiermit ausgeschlossen. Veränderungen hinsichtlich dieser Schutzrechte bis zum Stichtag werden in einer noch zu erstellenden und der Nachtragsurkunde zu diesem Einbringungsvertrag als Anlage I II beizufügenden Veränderungsliste aufgeführt.

GESAMT S.01

GESAMT S.19

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1993 15:22

SIEMENS RECHTSABT MCH 14

+49 69 722 40077

5.01

30-MRZ 10:40 DT UON: ZFR 1 MCH*W

+49 69 234 32862

AM: VEICKSTEUT

SEITE: 53

FAX V. FROBER

- 19 -

2. Soweit hierzu berechtigt, überträgt Siemens der Infineon mit Wirkung zum Stichtag das in dem eingebrachten Teilbetrieb vorhandene Know-how einschließlich aller Rechte an Erfindungen, Betriebsgeheimnissen, Verfahren, Formeln und anderen immateriellen Gegenständen, die keinem Sonderrechtsschutz für geistiges Eigentum unterliegen, sowie Geschäftsgeheimnisse, Verwaltungs- und Vertriebsverfahren (nachstehend "Know-how" genannt). Hierzu übergibt und übereignet Siemens der Infineon sämtliche in den Geschäftsräumen und in den Betriebsstätten des Teilbetriebs vorhandenen Verkörperungen dieses Know-how. Die Infineon nimmt diese Übertragung und Übereignung an.
3. Soweit hierzu berechtigt, überträgt Siemens der Infineon mit Wirkung zum Stichtag alle Siemens zum Stichtag zustehenden Rechte an der dem eingebrachten Teilbetrieb ausschließlich zuzuordnenden Software in Objektcode und in Quellcode sowie an allen zur übertragenen Software gehörigen Unterlagen, insbesondere an der dazugehörigen Dokumentation. Dazu übergibt und übereignet Siemens & - soweit hierzu berechtigt - die sachlichen Verkörperungen des Objekt- und Quellcodes der oben genannten Software sowie sämtliche zu dieser Software gehörenden Unterlagen, insbesondere die dazugehörige Dokumentation, die sich zum Stichtag im Besitz des Teilbetriebs befinden. Die Infineon nimmt diese Übertragung und Übereignung an.

J. BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-MAR-1999 13:27

SIEMENS RECHTSANWALT MOH N

+49 89 722 48377

S. 02

20-MAR 18:40 01 LENZGER 1 MOH N

+49 89 834 20332

ANLEITUNGSTEXT

SEITE 34

- 20 -

4. Alle Dritten vor den Übertragungen gemäß Abs. 1 bis 3 eingeräumten Rechte bleiben von der jeweiligen Übertragung unberührt.

5. Von den gemäß Abs. 1 Übertragenen Schutzrechten laut Anlage D werden diejenigen Schutzrechte zusätzlich in einer noch zu erstellenden und der Nachtragsurkunde zu diesem Einbringungsvertrag beizufügenden Anlage D 2 aufgeführt, bei deren Verwertung, einschließlich eigener Benutzung, Lizenzerteilung an Dritte und Durchsetzung von Verbotungsrechten, Infineon frei ist.

Weiterhin werden in einer ebenfalls noch zu erstellenden und der Nachtragsurkunde zu diesem Einbringungsvertrag beizufügenden Anlage D 3 diejenigen gemäß Abs. 1 Übertragenen Schutzrechte der Anlage D aufgeführt, für welche Folgendes gilt:

Infineon ist in der Benutzung dieser Schutzrechte auf dem vom Übertragenen Teilbetrieb ausgeübten Tätigkeitsgebiet frei. Soweit Infineon die Schutzrechte der Anlage D 3 außerhalb des vom Übertragenen Teilbetrieb ausgeübten Tätigkeitsgebiet benutzen oder gegenüber Dritten als Verbotungsrecht einsetzen oder lizenzieren will, bedarf sie hierzu, soweit dadurch Tätigkeitsgebiete von Siemens oder von in- und ausländischen, mit Siemens verbundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 ff. AktG mit berührt werden, der vorherigen Zustimmung von Siemens. Diese Zustimmung darf jedoch nicht unbillig verweigert werden.

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

21-MPR-1999 18/23

SIEMENS ZFR 2

+49 89 722 28048

5.02/03

- 21 -

5. Siemens und ihre in- und ausländischen verbundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 ff. AktG behalten an den gemäß Abs. 1 übertragenen Schutzrechten der Anlage D 2 jeweils unwiderrufliche, nicht ausschließliche, inhaltlich, zeitlich und örtlich unbegrenzte Benutzungsrechte für die Erfordernisse ihres Geschäftes.

An den gemäß Abs. 1 übertragenen Schutzrechten der Anlage D 3 und der gemäß Abs. 3 übertragenen Software behalten Siemens und ihre in- und ausländischen verbundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 ff. AktG jeweils unwiderrufliche, nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Verwertungsrechte mit dem Recht zur eigenen beliebigen Benutzung, der Lizenzerteilung an Dritte und der Durchsetzung von Verbotungsrechten.

Siemens und ihre in- und ausländischen verbundenen Gesellschaften sind im Sinne der §§ 15 ff. AktG weiterhin berechtigt, das Übertragene Know-how zur Erfüllung eventueller rechtlicher Verpflichtungen, die noch im Zusammenhang mit dem übertragenen Teilbetrieb gegenüber Siemens geltend gemacht werden, beliebig zu nutzen.

7. Soweit ohne Zahlung an Dritte berechtigt, gewährt Siemens der Infineon und ihren verbundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 ff. AktG an zum Stichtag neben den gemäß Abs. 1 übertragenen Schutzrechten, dem gemäß Abs. 2 übertragenen Know-how und der gemäß Abs. 3 übertragenen Software bei Siemens und ihren verbundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 ff. AktG ebenfalls bestehenden und an Siemens lizenzierten Schutzrechten, Know-how

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

21-APR-1999 18:03

SIEMENS ZFR 2

+49 89 722 28240

S.03/03

- 22 -

und Software in Objekt- und in Quellcode, die vom übertragenden Teilbetrieb vor dem Stichtag benutzt wurden, oder für deren Benutzung vom übertragenden Teilbetrieb bereits erforderliche Maßnahmen getroffen wurden, ein unwiderrufliches, nicht ausschließliches, zeitlich und örtlich unbegrenztes Benutzungsrecht auf dem vom eingebrachten Teilbetrieb ausgeübten Tätigkeitsgebiet.

8. Die in § 4 Abs. 5, 6 und 7 gewährten Rechte sind kostenlos. Die Einzelheiten der Lizenzvereinbarung werden die Vertragsparteien in einem gesondert zu vereinbarenden Lizenztauschvertrag regeln.

§ 5

Einführung von Verbindlichkeiten und Risiken

Die Infineon übernimmt mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag alle in der Stichtagsbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten und alle mit dem Teilbetrieb verbundenen Risiken, selbst wenn die Ursache für diese Risiken vor dem Stichtag gesetzt wurde. Siemens überträgt zum Stichtag sämtliche für den Teilbetrieb gebildeten und in der Stichtagsbilanz ausgewiesenen Rückstellungen auf die Infineon.

§ 6

Verträge, öffentlich-rechtliche Erlaubnisse

1. Siemens bringt sämtliche, insbesondere die in Anlage F aufgeführten, ausschließlich den einge-

GESAMT S.03/03

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:25

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 49077

9.03

30-APR 18:41 DI VON:ZFR 1 MCH/W

+49 89 234 32992

MUNICH/STEDT

SEITE:57

- 23 -

brachten Teilbetrieb betreffenden Verträge sowie Angebote aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verträge zwischen Siemens und Dritten mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag in die Infineon ein. Die Infineon verpflichtet sich zur Erfüllung und Abwicklung der eingebrachten Verträge unter Anwendung der unter Kaufleuten üblichen Sorgfalt.

Verträge und Angebote aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verträge zwischen Siemens und Dritten, die nicht ausschließlich des eingebrachten Teilbetrieb zugehören, sondern auch andere Aktivitäten von Siemens betreffen, werden - sofern diese Verträge und Angebote rechtlich und tatsächlich teilbar sind - von Siemens hinsichtlich der auf den hier eingebrachten Teilbetrieb bezogenen Vertragsbestandteile auch mit allen Rechten und Verpflichtungen in die Infineon eingebracht. Soweit solche Verträge und Angebote rechtlich oder tatsächlich nicht teilbar sind, werden sie in die Infineon nicht eingebracht, sondern von Siemens hinsichtlich der auf den eingebrachten Teilbetrieb bezogenen Rechte und Verpflichtungen auf Kosten und insoweit auf Risiko der Infineon fortgeführt.

2. Siemens tritt hiermit sämtliche Rechte aus den in Abs. 1 genannten Verträgen und Angeboten mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag an die Infineon ab. Die Infineon nimmt diese Abtretung an und übernimmt zum Stichtag sämtliche Verpflichtungen aus diesen Verträgen.

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

23-APR-1999 15:28

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 45977

3.04

30-APR 18:42 DI VON:ZFR 1 MCH/H

+49 89 234 32882

AN:VEICKSTEDT

SEITE:38

- 24 -

3. Die Parteien werden sich nach besten Kräften bemühen, die Zustimmung Dritter, soweit diese zur Wirksamkeit der vorstehenden Übertragung von Rechten und Verpflichtungen aus den genannten Verträgen erforderlich ist, zu erwirken. Soweit erforderliche Zustimmungen nicht erteilt werden oder es unzulässig erscheint sie einzuholen, werden sich die Vertragsparteien wirtschaftlich und - sofern rechtlich zulässig - auch rechtlich im Innenverhältnis so stellen, als ob der Dritte der Vertragsübertragung zum Stichtag zugestimmt hätte. Dies bedeutet insbesondere - sofern rechtlich zulässig: Infineon wird die entsprechenden Verträge im Namen von Siemens, aber auf eigene Rechnung erfüllen und abwickeln bzw. Siemens wird die ihr in entsprechenden Verträgen eingeräumten Nutzungsrechte und sonstigen Rechte an Infineon gegen Erstattung etwaiger Lizenzgebühren und sonstiger Kosten lizenzieren. Andere oder weitergehende Ansprüche gegen Siemens sind hiermit ausgeschlossen.
4. Soweit rechtlich möglich, bringt Siemens sämtliche, den eingebrachten Teilbetrieb betreffenden Rechte und Pflichten aus behördlichen Erlaubnissen und Genehmigungen sowie sonstigen öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen in die Infineon ein. Abs. 2 und Abs. 3 gelten entsprechend. Es obliegt der Infineon, die für eine Übertragung gegebenenfalls erforderlichen Rechtshandlungen vorzunehmen.

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

22-APR-1999 15:29

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48277

5.05

22-APR 10:42 DI VON: ZFR 1 MCH/H

+49 89 234 2222

AN: VEICKSTEDT

SEITE: 59

- 25 -

§ 7

Einbringung von Beteiligungen

1. Siemens hält an den im folgenden Absatz 2 berechneten Gesellschaften die dort näher beschriebenen Beteiligungen; alle diese Anteile von Siemens sind voll eingezahlt.
2. In Erbringung ihrer Sacheinlage in die Infineon überträgt Siemens jeweils mit dinglicher und wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag und mit dem Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr die folgenden Gesellschaftsanteile auf die Infineon AG, die diese Übertragungen ausdrücklich annimmt:

- Gesellschaftsanteile im Nennwert von DM 240.000.000,-- an der im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRA 1769 eingetragenen Siemens Microelectronics Center GmbH & Co. OHG, Dresden,
- Geschäftsanteile im Nennwert von DM 50.000,-- an der im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 2982 eingetragenen Siemens Microelectronics Center Verwaltungsgesellschaft mbH, Dresden,
- Gesellschaftsanteile im Nennwert von DM 55.300.000,-- an der im Handelsregister des Amtsgerichts Warstein unter HRA 346 eingetragenen EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH & Co. KG, Warstein-Bielecke,

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 224/235

Fax Server

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:29

SIEMENS RECHTSABT MOH H

+49 89 722 48077

S.06

30-APR 18:42 DI VIN:ZFR 1 MOH-H

+49 89 234 32002

MUN:VERGOSTEDT

SEITE:60

- 26 -

- Geschäftsanteile im Nennwert von DM 50.000,--
an der im Handelsregister des Amtsgerichts
Warstein unter HRA 273 eingetragenen SUPAC Euro-
päische Verwaltungsgesellschaft für Leistungs-
halbleiter mbH, Warstein-Belecke,
- Gesellschaftsanteile im Nennwert von
DM 4.279.065,-- an der im Handelsregister des
Amtsgerichts Regensburg unter HRA 6036 eingetra-
genen Oerow Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG,
Regensburg,
- Geschäftsanteile im Nennwert von DM 24.500,--
an der im Handelsregister des Amtsgerichts
München unter HRA 123984 eingetragenen Oerow Un-
ternehmensverwaltung GmbH, München,
- Gesellschaftsanteile im Nennwert von
DM 100.000,-- an der im Handelsregister des Amt-
sgerichts München unter HRA 73932 eingetragenen
Siemens Halbleiter GmbH & Co. OHG, München,
- Geschäftsanteile im Nennwert von DM 50.000,--
an der im Handelsregister des Amtsgerichts Mün-
chen unter HRA 118166 eingetragenen Siemens
Halbleiter Verwaltungsgesellschaft mbH, Mün-
chen,
- Gesellschaftsanteile im Nennwert von
DM 15.030.000,-- an der im Handelsregister des
Amtsgerichts Dresden unter HRA 3104 eingetrage-
nen Semiconductor 300 GmbH & Co. KG, Dresden.

PATENT

REEL: 024120 FRAME: 0242

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:29

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 732 48077

5.07

30-PRZ 10:42 DI VON:ZFR 1 MCH-H

+49 89 234 38882

AN:WEICKSTEDT

SEITE:61

- 27 -

- Geschäftsanteile im Nennwert von DM 25.100,-- an der im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 18763 eingetragenen Saxicon-ductor 300 Verwaltungsgesellschaft mbH, Dresden,
- Gesellschaftsanteile im Nennwert von DM 2.000.000,-- an der im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 6429 eingetragenen Epos GmbH & Co. KG, Duisburg,
- Geschäftsanteile im Nennwert von DM 25.000,-- an der im Handelsregister Duisburg unter HRB 7688 eingetragenen Epos Verwaltungsgesellschaft mbH, Duisburg,
- Geschäftsanteile im Nennwert von DM 125.000,-- an der im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 11609 eingetragenen Freiburger Compound Material GmbH, Freiberg/Sachsen,

Der nicht unter die Gesellschafter verteilte Gewinn früherer Geschäftsjahre, d.h. vorgetragener Gewinn oder Gewinn früherer Geschäftsjahre, für den kein Beschluß über die Ergebnisverwendung gefaßt worden ist, steht ebenfalls allein der Infineon zu. Die Infineon nimmt die Abtretung an.

3. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, daß das Eigentum und alle sonstigen Rechte an und aus den vorstehend in Abs.2 bezeichneten Gesellschaftsanteilen mit Wirkung zum Stichtag auf die Infineon übergehen. Sofern dies aus Rechtsgründen nicht zu diesem Zeitpunkt bereits geschieht, wird Siemens der Infineon unverzüglich

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 226/235

Fax Server

J: BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:30

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 49077

S.08

30-MRZ 18:43 DI VON: ZFR 1 MCH/H

+49 89 234 32882

AN: UELCKSTEDT

SEITE: 62

- 28 -

diese Rechte verschaffen. Die Vertragsparteien werden gegebenenfalls alle Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um die vollständige Übertragung der Rechte zu bewirken. Im Innenverhältnis werden sich die Vertragsparteien wirtschaftlich so stellen, als sei die vollständige Übertragung sämtlicher Rechte in Hinsicht auf die in Abs. 2 bezeichneten Gesellschaftsanteile zum Stichtag erfolgt.

4. Siemens überträgt weiter ihre Gesellschaftsanteile (721.800.000 shares) im Nennbetrag von TWD 7.218.000.000,-- an der PROMOS Technologies Inc., mit Sitz in Hsin-Chu, Taiwan mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag auf Infineon.
- Zur dinglichen Übertragung der Gesellschaftsanteile der PROMOS Technologies Inc. bedarf Siemens noch der Zustimmung der Mitgesellschafterin in der PROMOS Technologies Inc. Außerdem ist die dingliche Übertragung der Gesellschaftsanteile der PROMOS Technologies Inc. nach den Vorschriften des taiwanesischen Börsenrechts seitlichen Beschränkungen unterworfen. Siemens hat die Mitgesellschafterin um die Erteilung der Zustimmung *bei den* und die zuständigen Behörden *die Zustimmung* und *die Zustimmung* gebeten. Die Parteien vereinbaren daher, daß Siemens der Infineon das Eigentum an den Gesellschaftsanteilen der PROMOS Technologies Inc. entweder unverzüglich nach Erteilung der Zustimmung und der *Ausnahme genehmigung* oder sukzessive entsprechend den Vorschriften des taiwanesischen Börsenrechts zu den in einem gesonderten Vertrag definierten Zeitpunkten innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung der Infineon in das Handelsregister verschaffen wird.

*es ist das
für das Hof-
S. 7*

PATENT

REEL: 024120 FRAME: 0244

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

28-APR-1999 15:30

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 49877

S.09

30-APR 10:43 DI

CON:2FR 1 MCH/W

+49 89 234 32882

AN:VERGOSTEDT

SEITE:63

- 29 -

Im Innenverhältnis werden sich die Vertragsparteien wirtschaftlich so stellen, als sei die vollständige Übertragung sämtlicher Rechte hinsichtlich der Gesellschaftsanteile an PROMOS Technologies Inc. zum Stichtag erfolgt.

5. Siemens steht nur dafür ein, daß die abgetretenen Gesellschaftsanteile voll eingezahlt sind, zu ihrer freien Verfügung stehen, soweit nicht in Abs. 4 etwas anderes geregelt ist, und nicht mit Rechten Dritter belastet sind. Jede andere oder weitergehende Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausdrücklich und einvernehmlich ausgeschlossen.

§ 8

Arbeitsverhältnisse

1. Da der eingebrachte Teilbetrieb einen Betriebsteil im Sinne des § 613 a SGB darstellt, gehen die Arbeitsverhältnisse mit den Arbeitnehmern, die in diesem Betriebsteil beschäftigt sind, und alle damit verbundenen Rechte und Pflichten auf die Infineon über, sofern sich nicht aus Abs. 2 etwas anderes ergibt. Die in dem eingebrachten Teilbetrieb beschäftigten Arbeitnehmer ergeben sich aus Anlage G.
2. Sofern einzelne Mitarbeiter dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses definitiv widersprechen, verbleiben die Arbeitnehmer bei Siemens und es findet ein Ausgleich zwischen den Parteien nur in der Weise statt, daß in Höhe der in Bezug auf die

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:30

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48877

S.10

30-APR-1999 10:43 DI

VON: ZFR 1 MCH/H

+49 89 234 38882

AN: WEICKSTEIT

SEITE: 64

- 30 -

betreffenden Mitarbeiter gebildeten Rückstellungen in der Einbringungsbilanz ein Ausgleich durch die Infineon an Siemens geleistet wird.

Die Vertragsparteien werden erforderlichenfalls in angemessener Zeit nach dem Stichtag ergänzende Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Übergang der Arbeitsverhältnisse treffen.

3. Sofern Siemens nach dem Stichtag für Übergangene Arbeitsverhältnisse Personalaufwendungen entstehen, wird Infineon Siemens diese Aufwendungen erstatten.

§ 9

Gewährleistungen

Siemens gewährleistet,

1. daß die von Siemens in die Infineon eingebrachten und in der Stichtagsbilanz aufgeführten Gegenstände zum Stichtag vorhanden sind und - geschäftsübliche Eigentumsvorbehalte ausgenommen - in unbelasteten Eigentum von Siemens stehen;
2. daß sämtliche, dem eingebrachten Teilbetrieb ausschließlich zuzuordnenden Vermögensgegenstände einschließlich der Verpflichtungen und Risiken zum Stichtag in der Stichtagsbilanz berücksichtigt und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung bewertet worden sind. Insbesondere, daß für solche Verbindlichkeiten, die das Personal betreffen, und soweit für

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 229/235

Fax Server

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:31

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 43377

S.11

30-APR 18:44 01 VON:2FR 1 MCH/H

+49 89 234 32882

AN:WEIDKSTEDT

SEITE:65

- 31 -

diese keine gesetzliche Pflicht zum Ausweis als Verbindlichkeit in der Bilanz besteht, wie z.B. Urlaub, Altersversorgung, Hinterbliebenenversorgung und andere Verpflichtungen oder Zusagen, soweit diese vor dem Stichtag begründet worden sind, ausreichende Rückstellungen gebildet worden sind.

3. Sämtliche Gewährleistungsansprüche bezüglich der gemäß § 3 dieses Vertrages einzubringenden Grundstücke sind abschließend in § 3 geregelt.
4. Sämtliche Gewährleistungsansprüche bezüglich der gemäß § 7 dieses Vertrages einzubringenden Beteiligungen sind abschließend in § 7 geregelt.
5. Außer den in diesem Vertrag ausdrücklich übernommenen Gewährleistungen ist jegliche Gewährleistung oder Haftung von Siemens für die gemäß diesem Vertrag eingebrachten Gegenstände und Rechte ausdrücklich und einvernehmlich ausgeschlossen.

§ 10

Freistellungsansprüche

Soweit ein Dritter gegen Siemens Ansprüche geltend macht, für die nach den Regelungen dieses Vertrages im Innenverhältnis Infineon verantwortlich ist, wird Infineon Siemens vollumfänglich von derartigen Ansprüchen freistellen.

USPTO

3/1/2010 2:23:38 PM

PAGE 230/235

Fax Server

O:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

28-APR-1999 15:31

SIEMENS RECHTSABT MCH H.

+49 89 722 48877

S.12

28-APR 18:44 DI VON:ZFR 1 MCH:W

+49 89 234 33332

AN:UEICSTEDT

SEITE:65

- 32 -

§ 11

Schiedsgericht

Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V., Bonn, unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das Schiedsgericht kann auch über die Gültigkeit dieser Schiedsklausel bindend entscheiden.

Sitz des Schiedsgerichts ist München.

§ 12

Kosten, Steuern

Die mit diesem Vertrag verbundenen Kosten und Steuern einschließlich anfallender Grunderwerbsteuer trägt Siemens.

§ 13

Sonstiges

1. Sämtliche dieser Urkunde beigefügten Anlagen sind förmliche Bestandteile dieses Einbringungsvertrages; mitsaufzufertigen sind jedoch nur die Anlagen A, B, C 1, und C 3.

Handwritten notes and signatures:
 A, B, C 1, und C 3
 durch
 durch
 Vertrag
 7.

PATENT

REEL: 024120 FRAME: 0248

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

28-APR-1999 15:31

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48277

S.13

38-APR 18:44 DI JUN:ZFR 1 12:14

+49 89 234 32882

PN:VEICKSTEDT

SEITE:67

- 33 -

Hinsichtlich der Anlagen A sowie D fortlaufend bis einschließlich E haben die Beteiligten auf das Vorlesen mit der Erklärung verzichtet, daß ihnen der Inhalt dieser Anlagen genau bekannt ist. Sie wurden den Beteiligten zur nochmaligen Kenntnisnahme vorgelegt und von ihnen auf jeder einzelnen Seite unterschrieben.

2. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch der übrige Inhalt des Vertrages nicht berührt.

Die Vertragspartner werden freundschaftlich zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die im wirtschaftlichen Ergebnis den unwirksamen Bestimmungen möglichst weitgehend entspricht; entsprechendes gilt, falls sich eine ergänzungsbedürftige Lücke des Vertrages herausstellen sollte.

4. Von dieser Urkunde erhalten jeder Vertragspartei eine Ausfertigung und drei beglaubigte Abschriften, die Grundbuchämter München und Regensburg je eine Ausfertigung im Auszug (Urkundeneingang, § 3, § 12, § 13 und Schlußvermerk), die Grunderwerbssteuerstellen der Finanzämter Mühldorf am Inn und Regensburg je eine einfache Abschrift im vorgenannten Auszug, sowie das Registergericht München und das Finanzamt München für Körperschaften je eine beglaubigte Abschrift.

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:32

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48377

S.14

30-MRZ 19:44-DI

VON: ZFR 1 MCH/W

+49 89 234 32882

AN:UEICKSTUT

SEITE: 68

- 34 -

5. Die Vertragsparteien erkennen an, durch den entziehenden Notar anhand mündlicher Erläuterungen insbesondere darauf hingewiesen worden zu sein, daß

- das Eigentum an den hier eingebrachten Grundstücken erst mit der Umschreibung im Grundbuch auf die Infineon übergeht und die Vorlage der Urkunde an das Grundbuchamt dazu erst möglich ist, nachdem erforderliche Genehmigungen, Zustimmungen bzw. Negativatteste und die Grunderwerbssteuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegen sowie geforderte Kosten bezahlt sind,
- diese Urkunde sämtliche Vereinbarungen der Vertragsteile richtig enthalten muß und die Nicht- oder Falschbeurkundung von Abreden in jedem Falle deren Nichtigkeit, regelmäßig die Nichtigkeit des gesamten Vertrages zu Folge hat; hierzu wird allseits versichert, daß Nebenabreden nicht getroffen wurden,
- die Vertragsparteien gesamtschuldnerisch für die anfallenden Kosten bei Notar und Grundbuchamt sowie für eine etwaige Grunderwerbssteuer haften.

Vorgelesen vom Notar,
nach Vorlage und Drucksicht der beigefügten
Planunterlagen B, C.1 und C.2
von den Beteiligten genehmigt
und eigenhändig unterschrieben;

0:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

22-APR-1999 15:32 SIEMENS RECHTSABT MCH H +49 89 722 48877 5.15
 30-MRZ 18:45 DI VON:ZFR 1 MCH/H +49 89 234 32882 AN:UEIOKSTEDT SEITE:59

Anlage A

Teilbetrieb NL
 Vorläufige Einbringungsabrechnung auf den 28.2.1999

Infinicon Tech.
 28.02.1999

Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	318.602.362
II. Kapitalrücklage	418.524.155
III. Gewinnrücklagen	
1. Gesetzliche Rücklage	
2. Andere Gewinnrücklagen	
IV. Bilanzgewinn	

Summe Eigenkapital 736.126.517

B. Sonderposten mit Rücklagenanteil 902.000

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionsformen	235.406.283
2. Steuerrückstellungen	
3. Sonstige Rückstellungen	255.309.000
4. Rückstellungen für sonstige Steuern	900.000.000
Summe Rückstellungen	1.090.715.283

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.048.000
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.967.103.000
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	434.834.000
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	162.595.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	117.600.000
-davon aus Steuern	40.400.000
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	76.000.000
Summe Verbindlichkeiten	2.815.120.000

E. Rechnungsabgrenzungsposten 11.872.822

SUMME PASSIVA 4.757.236.000

D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:32

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 40277

S. 16

30-APR 10:45 DI VON: ZFR 1 MCH/W

+49 89 234 32882

FRUECKSTEDT

SEITE: 79

Teilbetrieb H.

Vorläufige Bilanzierungsübersicht auf dem 31.12.1998

Anlage A

between Tech.

28.02.1999

Aktiva**A. Anlagevermögen**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	143.144.000
II. Sachanlagen	608.069.000
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	59.366.000
2. Technische Anlagen und Maschinen	321.833.000
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.111.000
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	67.889.000
III. Finanzanlagen	1.968.445.000
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.205.000
3. Beteiligungen	2.965.140.000
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	
6. Sonstige Ausleihungen	
Summe Anlagevermögen	2.787.658.000

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte	324.609.000
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.359.000
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	130.917.000
3. fertige Erzeugnisse und Waren	155.337.000
4. erhaltene Anzahlungen	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.873.824.000
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	608.221.000
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	903.770.000
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.850.000
4. Sonstige Vermögensgegenstände	159.582.000
III. Wertpapiere	
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.000
Summe Umlaufvermögen	1.988.442.000
(dann aufgerechnet Abchreib. auf Ford. U. R. Mittel)	

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.125.000

SUMME AKTIVA

4.767.238.000

GESAMT S. 16

D:\BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY\C/O MORRISON & FOERSTER LLP

20-APR-1999 15:09

SIEMENS RECHTSABT MCH H

+49 89 722 48877 5.01

Fax
→ K. FISCHER

Kontak
20. APR 1999

Fax-Empfänger:		Fax-Absender Siemens AG	
Fax-Nr.	96-27052	Fax-Nr.	99-28040
Abt.	MP ALI PAT	Abt.	STR 2
Ort	Mch B	Ort	Mch H
Name	H. Dehländer	Name	H. Stang
in 24917 Schenzen 36 1/2		in 62732	Datum 20.4.99